

無線電製作

售價港幣 \$2.00

1975 增刊 ①

ALL JAPANESE TRANSISTOR DATA MANUAL

SECTION 1 LISTING OF ALL TRANSISTORS

SECTION 2 SUBSTITUTION GUIDE

SECTION 3 LISTING OF
FIELD EFFECT TRANSISTORS
(WITH AMERICAN TYPE INCLUDED);
APPLICATION CIRCUITS;
SUPPLEMENT TO SECTION 1;
TERMINATION DRAWINGS

全日本晶體管——場效應管
特性資料與換用手冊

(上篇)

全港晶體管供應零售店索引

恒達電子公司	九龍大埔道 140 號東廬大廈 B 座 七樓 5 號室 電話：3-807964 3-818902	三三無線電行	九龍紅磡馬頭圍道 27 號 C 地下 電話：3-652182
寶昌無線電行	香港灣仔莊士敦道 33 號 A 地下 電話：5-280805	佳年無線電行	九龍油蔴地吳淞街 8A 號地下 電話：3-842241
寶光無線電行	九龍通菜街 65 號地下 電話：3-960304	登美洋行	九龍油蔴地庇利金街 38 號閣樓 電話：3-685648
安利無線電行	九龍通菜街 83 號地下 電話：3-958826	發達無線電行	九龍花園街 80 號地下 電話：3-959620 3-961593
偉音無線電行	九龍油蔴地吳淞街 53 號 A 電話：3-840920	電子零件公司	紅磡黃埔街 1 號 A 地下 2 號舖 電話：3-331222
偉利無線電行	香港灣仔灣仔道 156 號 A 地下 電話：5-749597	榮記無線電行	香港灣仔軒尼詩道 274 號 E 電話：5-746350
通用無線電行	九龍青山道 8 號 A 地下 電話：3-807242	麥氏無線電行	九龍通菜街 75 號地下 電話：3-957838
中明無線電行	九龍新蒲崗康莊街 2 號後座商場 電話：3-205780	通用電子店	上環急庇利街（港澳碼頭對面） 電話：3-457202
泰華無線電行	九龍深水埗鴨寮街 156 號 電話：3-708908	凱旋無線電行	香港北角英皇道 315 號地下 電話：5-711735
華深電子公司	九龍爵祿街 70 號 電話：3-206259 3-208533	寶森無線電行	九龍旺角登打士街 34 號 A 電話：3-889859
良益電業	九龍土瓜灣浙江街 24 號 電話：3-633882	寶生無線電行	九龍深水埗青山道 433 C 號 電話：3-717858
寶林無線電行	香港灣仔軒尼詩道 111 號 電話：5-275601	寶樹無線電行	九龍旺角花園街 60 號地下 電話：3-852429 3-840197
（分行）	九龍油蔴地吳淞街 119 號 電話：3-848015	（分行）	九龍彌敦道 317 — 321 號 金漢大廈 L 座地下 電話：3-853564

（接封底裡頁）

（如有遺漏請來信或賜電話本刊俾便補充）

全日本晶體管一場效應管 特性資料與換用手冊

INTRODUCTION

Although primarily intended to provide technical information to assist in the using and identification of Japanese bipolar transistors and FET's, this book has a special interest to the professional engineer and technician as a general work of guidance in the selection of Japanese transistors for particular applications. The guide to possible alternatives of different manufactures in Section 2 is probably the most comprehensive.

The following colours are used in the printing of this book to assist in locating the required section.

Section 1	Listing of All Bipolar Transistors	Black
Section 2	Substitution Guide of Bipolar Transistors	Blue
Section 3	Listing of FET's (with American type included)	Brown
	Application Circuits of FET;	Brown
	Supplement to Section 1;	Black
	Termination Drawings of Transistor	Black

本書彙列了全部日製的普通晶體管之詳盡技術數據，足供一切專業上之使用及設計上之參考，全書分為三大部份，並以不同顏色印刷，以便於索查。

上篇：全日本晶體管特性資料（黑色）

中篇：各廠晶體管的互換（藍色）

下篇：全日本場效應管特性資料及接腳識別（附美式管特性，棕色）；場效應管典型應用綫路（棕色）；晶體管特性補篇及接腳識別圖（黑色）。

ALL JAPANESE TRANSISTOR DATA MANUAL

SECTION 1 — LISTING OF ALL TRANSISTORS

（ 上 篇 ）

晶 體 管 特 性 資 料

CHARACTERISTICS OF LISTINGS

This section lists all the bipolar transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. The Chinese — English translation key given below may help the user makes full use of the data provided in the listings.

- 1 TYPE NUMBER
- 2 ORIGINAL MANUFACTURER
- 3 USES
- 4 MATERIAL AND STRUCTURE
- 5 MAXIMUM RATINGS

晶體管規格表用法概覽

晶體管若能使用得的當，是可以保持其應有的長久使用壽命的；但若使用得超過其規格或使用不當，則會反較真空管為更差。基於此，在使用晶體管之前，或在購買前，能好好地調查一下其規格及特性，是很為重要的。

本篇所刊載的，均為在日本電子機械工業（簡稱 EIAJ）會登記的晶體管，其中包括一些專用品種及作通訊、工業用的，故並非單純只用於無線電的。當然，在廠方還在試製階段的，並不加以錄入。

下面是此規格一覽表各欄所用的記號及略號，並加以說明。

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)					電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)												外 形	備 考	
				V_{CB0} (V)	V_{EB0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^{\circ}\text{C}$)	I_{CB0} 最大值 (μA)	V_{CB} (V)	直 流 及 脈 沖 下 之 h_{FE}		偏 置 情 況		h_{fe}	h_{ie} h_{ie}^* (Ω)	h_{re} h_{re}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{oe}^* (μU)	f_{ab} f_T^* (Mc)	C_{ob} (pF)			$r_{bb'}$ $r_{bb'}^*$ (Ω)
1	2	3	4	5					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17	18

- 6 I_{CB0} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CB0}).
- 7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})
- 8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)
- * INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.
- 9 f_{ab} OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T .
- 10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (REAL)
- 11 OUTLINE
- 12 REMARKS

: 之對稱 : COMPLEMENTARY TO

- ① 是在 EIAJ 所登記的晶體管編號。
- ② 將此型名（編號）及規格在 EIAJ 登記的公司名稱。
- ③ 在 EIAJ 登記時所說明的用途。但要注意並非除此以外即無別的用途。
- ④ 晶體管的製造材料及構造。
- ⑤ 晶體管的最大規格值。
- ⑥ I_{CB0} 的最大值與在其測定條件時的 V_{CB} 值。
- ⑦ 直流 h_{FE} 或脈沖 h_{FE} 的標準值，與在此測定條件下所用的 V_{CE} 、 I_C 各值。
- ⑧ h 參數的標準值與在此測定條件下所用的偏壓 V_{CB} 、 I_E 的值。
- 這通常為射極接地時的數值，有 * 符號者則為基極接地時之數值。
- ⑨ 高頻特性的 f_{ab} 。有 * 符號時所指為 f_T 值。
- ⑩ 高頻特性的 C_{ob} 與 $r_{bb'}$ 。 $r_{bb'}$ 欄內有 * 時，則為 h_{ie} (real) 的數值。
- ⑪ 於本書下篇後面（黑色）所列出的接腳圖索引。
- ⑫ 必要時的註釋。

晶體管規格表的想法

1 型號

每一晶體管是根據 JIS (日本工業總會) 所給予的命名方法而加以命名後, 即將規格在 EIAJ 予以登記。EIAJ 即電子機械工業會, 以往簡稱之為 CES 型號, 現在則叫 EIAJ 型號, 正當的叫法應為 JIS 型號。型號的編排方法有如下的意義包括在內。

2S	文字	數字	文字
(例) 2S	A	244	A

最先的 2S 表示為有效極數為 3 的半導體元件。諸如二極管為 1S, 有效電極為 4 的晶體管 (四極晶體管) 則為 3S。

隨着 2S 後的文字是可用 ABCD 任何一個的, 其使用法有如下述的分別:

- A..... PNP 型高頻用
- B..... PNP 型低頻用
- C..... NPN 型高頻用
- D..... NPN 型低頻用

高頻與低頻的分野, 並無明確的界綫, 只因是廠商在登記時指定其用途。其 f_T 為 200MHz 左右的為高頻用, 相反的在 50MHz 左右的為低頻用, 根據此一準則, 便會是恰當的。跟隨於 2S 後的以表示構造的元素的文字, 除了 A、B、C、D 外, 還有其他文字, 下面是其一個意義:

- F..... SCR
- H..... 單結晶體管
- J..... P 通道 FET
- K..... N 通道 FET
- M..... TRIAC

其次, 緊接於文字之後的數字, 登記編號以 11 為開始。

最後的英文字母是表示改良品種, 其文字有用到 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K 等, 它與第二項的文字是不相同的。

使用時, 將改良品種代替於以前

的品種, 是必要而無碍的, 但若把以前的品種代替於改良品種使用於電路中, 那是不可以的。

如明白上述的命名原則, 舉例如 2SA244A 的 PNP 型高頻晶體管, 就是 2SA244 的一種改良品種。

2 廠名

一晶體管的型號與規格在 EIAJ 登記後, 同時亦將製造者廠名加以記錄下來, 這就是最原始的廠名登記。

在 EIAJ 登記完畢後, 此一型號及其規格則為同業界所共有, 可以在原始登記的廠家以外的廠家進行生產此一同型號的晶體管。

在本規格表有使用如下述的各廠家的商標:

富士通	富士通有限公司
日立	日立製作有限公司
松下	松下電子工業有限公司
三菱	三菱電機有限公司
日電	日本電氣有限公司
冲	冲電氣工業有限公司
SAK	Sanken 電氣有限公司
三洋	東京三洋電機有限公司
新電元	新電元工業有限公司
SON	SONY 有限公司
東芝	東京芝浦電氣有限公司
八歐	General 有限公司
協同	協同技術研究所有限公司
芝電	芝電氣有限公司
新日無	新日本無線電有限公司
Alp	Alps Motorola 半導體有限公司
東洋電具	東洋電具製作所有有限公司
ORG	Origin 半導體有限公司

3 用途

是在 EIAJ 所登記的用途。故在其他使用上是不論的。在本規格表上

有如下的記述。

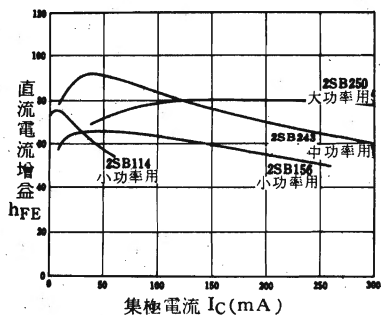
AF	低頻放大
Conv	變頻
Ch	Chopper
Diff	差動放大器
IF	中頻放大
LN	低雜音放大
Mix	混頻
Osc	振盪
PA	功率放大
RF	高頻放大
SN	Switching

4 構造

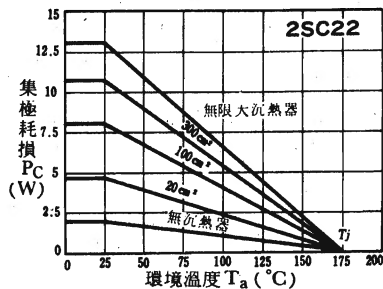
晶體管有鍍質及矽質的, 同時亦記有接合的製作方法。

從使用晶體管的立場來看, 接合的製作方法等等, 究竟如何才是好的呢? 而晶體管的各種特性及其偏置的依存性等, 均與構造有關, 因而可作大概的推斷, 這裡不厭其詳將各種製作方法加以列明。

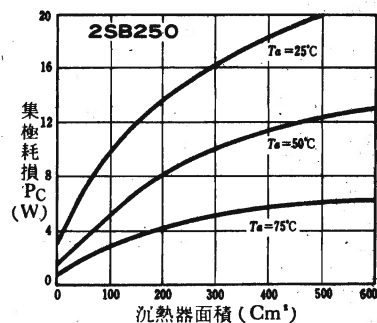
Ge	鍍質
Si	矽質
A	合金接合
AD	合金擴散
D	漂移
DB	基極擴散
DJ	擴散接合
E	外延
Eb	外延基極型
EMe	外延台面型
EP	外延平面型
G	成長接合
GD	成長擴散
MA	微型合金接合
MD	微型漂移
Me	台面型
P	平面型
TMe	三重擴散台面型
TP	三重擴散平面型
Pa	鈍化



圖(1) hFE 隨集極電流而改變的例子



圖(2) 沉熱器與 $T_a - P_C$ 曲線間的變化關係



圖(3) 沉熱器面積與容許集極耗損之關係

5 最大規格

此為廠方開列出，當使用時超過此規格界限即屬危險的數字。因此，無論此為強性的晶體管或脆弱的晶體管，都不應超越此界限的。當然，也不會是全都立即損壞了的，但其性能變劣、壽命縮短則不能避免了。

本欄中有如下記號：

V_{CBO} 集極—基極間電壓

V_{EBO} 射極—基極間電壓

I_C 集極電流

P_C 集極損耗（通常有規定了周圍溫度 T_a 及外殼溫度 T_c ，一般 $T_a = 25^\circ C$ ）

T_j 結面溫度

一般 V_{CBO} 、 V_{EBO} 等的耐壓係由 PN 結的擊穿電壓決定，故若不嚴格遵守此一電壓規定則是有危險的。

電流的最大規格有 I_C ，普通的破壞界限如圖(1)，大電流的地方 hFE 下降而失真增加。在一般使用中，會在當放大元件已足夠而仍不能令工作滿意時，而略略增大其電流的，但是太大的電流則會使集極電壓下降， $V_{CE(sat)}$ 急劇增加，集極的消耗電力也會增加，這是要注意的。此外，在非常大電流的地方，會有二次擊穿現象引起，因急劇電壓下降而告損壞的。

集極損耗有如真空管之有屏極損耗，是在集極容許範圍內的一種電力

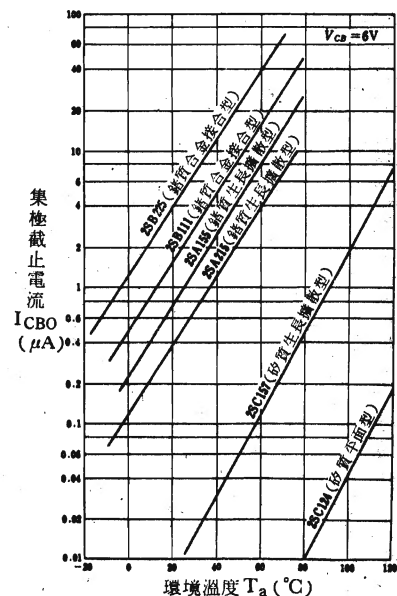
損耗。將集極損耗而轉化為熱量，這使內部溫度上升。集極損耗 P_C 與晶體管內部工作時的接點溫度的界限 T_j 的關係，示如圖(2)，也就是在 $25^\circ C$ 以上的溫度及在 $25^\circ C$ 時的 P_C 與 T_j 而構成此圖。由圖可見， P_C 的容許範圍是與所加散熱板大小成比例，而當取 T_j 為最大限度時， P_C 即降至為零點。但功率晶體管則常以外殼溫度作為基準。

所謂外殼溫度的 $25^\circ C$ ，是在周圍環境為 $25^\circ C$ 時加以無限大散熱板並以強力空氣吹動的情形下而作為理想值的，在實用上只是加以適當大的散熱板而已，故所能得到的 P_C 容許極限當應為較少的數值，此是可以理解的。圖(2)及圖(3)是其例子。

在本規格表是以通常的 $T_c = 25^\circ C$ 為準則，若在其他條件時，在 P_C 欄則是全將此條件以小字體列於其側的。

6 集極截止電流 I_{CBO}

在集極—基極間加以反向電壓時的漏電流值以小為佳（圖4），矽晶體管的漏電流值很小，這具有很大的實用價值。當溫度上升 10 倍時只增加 2 倍，一般均以 $25^\circ C$ 時的值列在規格表上。在實際上的中心值，以鍍質弱訊號用小型晶體管為 $0.5 \sim 5 \mu A$ ，功率晶體管為 $100 \mu A \sim 5 mA$ 。在矽晶體管方面，小型的約為 $0.0001 \sim$



圖(4) I_{CBO} 的溫度特性之例子

$0.001 \mu A$ ，功率晶體管為 $10 \mu A \sim 1 mA$ 左右。

在本規格表是於此欄的左側列 I_{CBO} 的最大值，而於右側註明一定此 I_{CBO} 時的集極電壓 V_{CB} 。

7 直流電流放大率或脈冲電流放大率 hFE

以直流測得的射極接地電流放大率，即為集極電流 I_C 與基極電流 I_B 的比率，故為 I_C / I_B 。

開關用或功率用晶體管等，為要在在大電流使用，是不可能以小訊號參數來設計的；進一步以大的電壓及電

流來測定時，由於偏壓的電力發熱而令致它損壞，故只能在極短的時間內以脈沖加入來進行測量，故無論何時要討論其 h_{FE} 之大小，必須要注意到其測定條件為何才能得到合適的答案。

如圖(1)的弱電流品種，只要很小電流 h_{FE} 就會很快上升，而於大電流時反下降。而大電流用的品種則是 h_{FE} 上升得緩慢亦不會下跌，在設計上是具有良好的線性。

本規格表是將 h_{FE} 標準值書於左側，右側是其測定條件如集極電壓 V_{CE} 與集極電流 I_C 。

8 h 參數

h 參數是包含了電流放大率 h_f ，輸入阻抗 h_i ，電壓回輸率 h_r ，輸出導納 h_o 等四種參數，並把基極接地 b 或射極接地 e 分別註於各種項目之內以資識別。

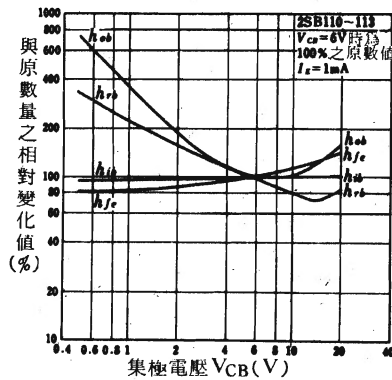
- h_{fe} 電流放大率 (射極接地)
- h_{fb} 電流放大率 (基極接地)
- h_{ie} 輸入阻抗 (射極接地)
- h_{ib} 輸入阻抗 (基極接地)
- h_{re} 電壓回輸率 (射極接地)
- h_{rb} 電壓回輸率 (基極接地)
- h_{oe} 輸出導納 (射極接地)
- h_{ob} 輸出導納 (基極接地)

這方面，基極接地與射極接地之參數之間，可由下面公式來換算。

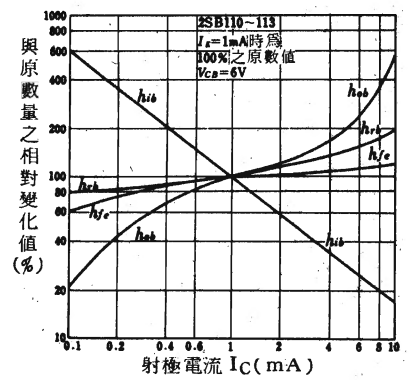
$$\begin{aligned} h_{ie} &= \frac{h_{ib}}{1+h_{fb}} & h_{ib} &= \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}} \\ h_{fe} &= \frac{-h_{fb}}{1+h_{fb}} & h_{fb} &= \frac{-h_{fe}}{1+h_{fe}} \\ h_{re} &= \frac{h_{ib} \times h_{ob}}{1+h_{fb}} & h_{rb} &= \frac{h_{ie} \times h_{oe}}{1+h_{fe}} \\ & & & -h_{rb} & -h_{re} \\ h_{oe} &= \frac{h_{ob}}{1+h_{fb}} & h_{ob} &= \frac{h_{oe}}{1+h_{fe}} \end{aligned}$$

兩種方式的偏壓都有較大的變化，圖(5)及圖(6)是典型的合金接合型晶體管的 h 參數的偏壓變化情形。

在本規格表於上欄內，首先有測



圖(5) h參數之電壓特性例子



圖(6) h參數之電壓特性例子

定條件的集極電壓 V_{CB} 及射極電流 I_E 記入，其次則順序記入 h_{fe} 、 h_{ie} 、 h_{re} 、 h_{oe} 。通常都是射極接地的標準值，在有*符號時則表示為基極接地的數值。 h 參數一般是在270Hz或1KHz時的低頻實測值；但是在射極接地時的電流放大率 h_f ，也會是用高頻時的實測值。此時高頻 h_{fe} 若無單位數值(倍率)時，則為dB，此點必須要注意。

還有，當此欄 h 參數為空欄時，則以工作的實際例子記入，如電力增益 $PG=25dB(f=1MC)$ ，或開關

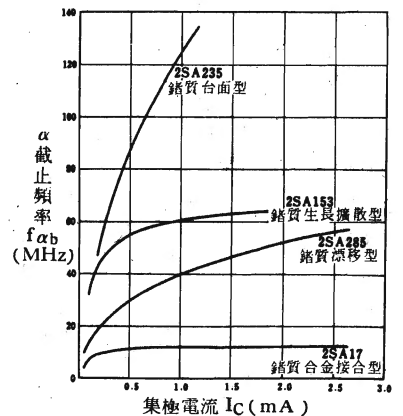
時間 $t_{on} < 80nS$, $t_{stg} < 200nS$, $t_{off} < 400nS$ 等等。

這類記載大抵有如下的內容。

NF	雜音指數	
PG或GP	電力放大增益	} 工作例子
CG或Ge	電力變換增益	
P_o	輸出功率	
t_d	延遲時間	} 開關時間
t_r	上升時間	
t_s	存儲時間	
t_f	下落時間	
t_{on}	接通時間	
t_{off}	斷開時間	
t_{stg}	存儲時間	

9 截止頻率特性

截止頻率是有基極接地的(圖7)的 f_{ab} 及射極接地的 f_{ae} 兩種。無論



圖(7) f_{ab} 的電流特性例子

是那一種，此頻率時之電流放大率較低頻時的數值有3dB的低落。一般上是以 f_{ab} 來表示，但功率晶體管則會有用 f_{ae} 的。基極內部有漂移電場的晶體管(高頻用管幾乎均如此)，其相位回輸也大，以 f_{ab} 來決定高頻特性是不適當的，此時最好使用增益與波段寬乘積之 f_T 。 f_T 也有寫作 f_1 的，此即射極接地在電流放大為1(=0dB)時的頻率。

晶體管的高頻率 h_{fe} 對於工作頻率的升高是會作每倍頻程6dB的低落的，故

f_T = 高頻 h_{fe} × 測定頻率
即 f_T 又叫作增益波段寬積。 f_{ab} 、 f_{ae} 、 f_T 間是有如下的關係存在，其中 m 是合金接合型的常數，微型合金接合型約0.21，其他高頻晶體管約為

0.5~0.7。

$$f_{ae} = \frac{f_T}{h_{fe}} = \frac{f_{ab} \cdot (1+h_{fb})}{(1-h_{fb} \times m)}$$

這樣所示出的晶體管特性，當然是以高的數字為佳，但在使用時並非意味着要把頻率數用到最高的值為止。 C_{ob} （正確為 C_o ）與 $r_{bb'}$ 的總合是決定了高頻特性的好或壞， $C_c \cdot r_{bb'}$ 若小，則可以補救了低的 f_T 。

在本規格表中， f_{ab} 是照原值記入， f_T 則加印※符號。在極罕有的情形下，有把 f_{ab} 作 f_{ae} 的記載的。

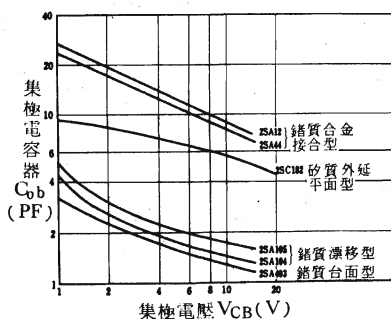
10 集極容量 C_{OB} 及基極擴展電阻 $r_{bb'}$

基極擴展電阻 $r_{bb'}$ （base spreading resistance）與集極容量 C_{ob} ，係與 f_T 一起，為決定晶體管高頻特性的重要參數。當功率增益為0dB的頻率也即是最高振盪的可能頻率 f_{max} 是由

$$f_{max} = \frac{f_T}{8\pi \cdot C_{ob} \cdot r_{bb'}}$$

示出，當然以 C_{ob} 及 $r_{bb'}$ 小的為佳。集極容量 C_{ob} 是集極電壓高時則變得小，此一趨勢見於圖（8）。

此一集極容量，正確的應為集極



圖（8）構造方式影響集極電容量的趨向例子

一基極間的容量，這應記為 C_c ，一般是將從外部測得的值作為 C_{ob} 。在 C_{ob} 本身而言，是包含了寄生元件的容量，甚至在外殼的浮游容量等。最近的 C_c 小的超高頻晶體管將上式之 C_{ob} ，以 C_c 來計算，是與實際會有出入的，此時就非要用到 C_c 與 $r_{bb'}$ 或 $C_c \cdot r_{bb'}$ 的積不可。

於EIAJ的登記上，高頻用晶體管的 $r_{bb'}$ 是以 $h_{ie}(\text{real})$ 來代替，也就是射極接地高頻輸入阻抗的實數部份，在本規格表若為 $h_{ie}(\text{real})$ 的數值，則會於 $r_{bb'}$ 欄的數字附以*符號以作分別。此外， $C_c \cdot r_{bb'}$ 時則會於 $r_{bb'}$ 欄內作如 $C_c \cdot r_{bb'}$ 的寫法。

11 晶體管的外形

晶體管的外形即使大多類似，但

只要調查一下廠家的說明書，不難發現是頗有不同之處的。其中即使有，引入了RCA技術的日立、東芝、神戶工業、三洋等廠亦各自有其不同之處。

現在，日本廠家多已採用適合國際的統一標準尺寸，其中有不同的廠家，均已在本表內註上最大及最小及直徑等尺寸，以至引綫的長度等。功率晶體管的接腳均有固定的長度及腳孔位置尺寸，而個別廠家的不同出品，則是在一般標準尺寸上加有若干容許誤差，如 4.2 ± 0.2 等。

12 備考

此欄係供註入各式事項，如

- (1)現在的EIAJ名稱決定前的舊式名稱或試製名稱。
- (2)在規格表上難以表明的特別特性，如正向AGC，雙向性等。
- (3)特殊組合的複合元件
例如封入兩元件的複合管，然納二極管組合等。
- (4)互補對稱的品種
如 2SC828 之對稱 等記入
- (5)在規格表左欄外有☆符號的，乃其廠家已指明為保守型式或廢品種。



TRANSISTOR SPECIFICATIONS

晶體管特性表

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)										電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)										外 形	備 考
				V_{CB0} (V)	V_{EB0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_J ($^{\circ}\text{C}$)	I_{CBO} 最大值 (μA) $V_{CB}(V)$		直 流 及 脉 冲 下 之 h_{FE}		偏 置 情 况		h_{FE}	h_{ib}^* (Ω)	h_{re}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe}^* (μU)	f_{β} (Mc)	C_{ob} (pF)	r_{be} (Ω)	$r_{be(rea)}$ (Ω)			
2SA 12	日 立	IF	Ge. A	-16	-0.5	-15	80	85	-6	-12				-6	1	60	PG = 31 dB ($f = 455 \text{ kc}$)	8	10	70		12A	2N218 HJ22D		
" 13	"	"	"	-12	-0.5	-15	80	85	-10	-12				-6	1	55	PG = 31 dB ($f = 455 \text{ kc}$)	8	10	70		12A	2N410 HJ 56		
" 14	"	"	"	-16	-0.5	-15	80	85	-6	-12				-6	1	50		4	10	90		12A	2S148 HJ 62		
" 15	"	Conv	"	-16	-0.5	-15	80	85	-6	-12				-6	1	60	CG = 35 dB ($f = 1.5 \text{ Mc}$)	12	10	70		12A	2N219 HJ23D		
" 16	"	"	"	-12	-0.5	-15	80	85	-10	-12				-6	1	60	CG = 35 dB ($f = 1.5 \text{ Mc}$)	12	10	70		12A	2N412		
" 17	"	Mix	"	-12	-0.5	-15	50	85	-6	-12				-6	1		CG = 20 dB ($f = 12 \text{ Mc}$)	19	9.5	110		12A	2S146 HJ 60		
" 18	"	RF	"	-21	-0.5	-15	80	85	-7	-23				-6	1			19	9.5	110		12A	2S148 HJ 62		
★ " 19	日 電	IF	Ge. GD	-12	-0.5	-2	15	55	-10	-9				-6	1	20	PG = 36 dB ($f = 455 \text{ kc}$)	50	1.5			19A			
★ " 20	"	"	"	-12	-0.5	-2	15	55	-10	-9				-6	1	30	PG = 39 dB ($f = 455 \text{ kc}$)	55	1.5			19A			
★ " 21	"	"	"	-12	-0.5	-2	15	55	-10	-9				-6	1	50	PG = 42 dB ($f = 455 \text{ kc}$)	55	1.5			19A			
" 22	富士通	RF. IF	Ge. A	-20		-20	100	70	-5	-20				-6	1	-0.98*	30*	6*	0.4*	12	12	120	76	2S125	
" 23	"	"	"	-20		-15	100	70	-5	-20				-6	1	-0.96*	30*	6*	0.4*	8	12	120	76	2S126	
" 24	"	RF	Ge. D	-30		-10	60	70	-5	-6				-6	1	-0.975*	27*	1*	0.2*	100	3.5	150	61		
★ " 25	"	"	"	-25		-15	50	70	-5	-6				-6	1	-0.975*	27*	1*	0.2*	100	3.5	100	61		
" 26	日 電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. A	-20	-15	-50	200	85	-12	-16				-6	1	60	30*	12	0.8	6	15	100	84A	ST20B ST20C	
" 27	東 芝	Conv	Ge. D	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-18				-6	1				50	2	40	13A	2S60		
" 28	"	RF	"	-18	-0.5	-5	55	75	-8	-12				-6	1	75	$h_{re} = 8-44$ ($f = 1.5 \text{ Mc}$)		2	40	13A	2S92			
" 29	"	IF	"	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-18				-6	1			35	2	35	23	2S93			
" 30	富士通	Conv	Ge. A	-12	-0.5	-10	80	85	-10	-12				-6	1	75	PG = 30 dB ($f = 1.5 \text{ Mc}$)	10	10	85	4	2NJ8A 2S30			
" 31	"	IF	"	-12	-0.5	-10	80	85	-10	-12				-6	1	50	PG = 37 dB ($f = 455 \text{ kc}$)	5	10	75	12A	2NJ5A 2S31			
" 32	"	RF. IF	"	-20	-10	-50	100	70	-5	-20				-6	1	-0.985*	29*		0.4*	10	12	150	78		
" 33	"	"	"	-20	-10	-25	100	70	-5	-20				-6	1	-0.985*	29*		0.4*	6	12	150	78		
" 35	"	Conv	"	-16	-0.5	-15	80	85	-6	-12				-6	1	75	2570	4.23	32.7	10	10	85	12A	2S35	
" 36	"	IF	"	-16	-0.5	-15	80	85	-6	-12				-6	1	50	1520	3.16	24.6	5	10	75	12A	2S36	
" 37	東 芝	Conv	"	-18	-12	-5	25	75	-10	-18				-6	1	-0.985*	CG = 32 dB ($f = 1 \text{ Mc}$)	7	10.5	80	5				
" 38	"	IF	"	-18	-12	-5	25	75	-10	-18				-6	1	-0.985*	$h_{re} = 18$ ($f = 455 \text{ kc}$)	10	10.5	80	5				
" 39	"	"	"	-18	-12	-5	25	75	-10	-18				-6	1	-0.98*	$h_{re} = 9$ ($f = 455 \text{ kc}$)	5.5	10.5	80	5				
" 40	富士通	SW	"	-25	-12	-50	80	85	-6	-12				-6	1	65	$t_{re} = 0.3 \mu\text{S}$ $t_{re} = 0.4 \mu\text{S}$	5	10	<75	12A				
" 41	日 立	RF	"	-35	-20	-40	250 (脈冲耐)	70	-6	-12				-6	1	45			6	10	95	64	2S191 HJ 41		
" 42	"	"	"	-45	-20	-40	250 (脈冲耐)	70	-6	-12				-6	1	45			6	10	95	64	2S192 HJ 42		
2SA 43	富士通	RF	Ge. D	-35	-0.5	-10	80	85	-10	-12				-9	1	60	PG = 24 dB ($f = 10.7 \text{ Mc}$)	40	2.3	40	13A	2S 43			
" 44	松 下	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. A	-15	-10	-10	80	75	-10	-10				-6	1	100	CG = 28 dB ($f = 1 \text{ Mc}$)	15	10.5	110	20	OC 44			
" 45	東 芝	IF	"	-18	-12	-5	60	75	-12	-18				-6	1		$h_{re} = 5$ ($f = 455 \text{ kc}$)		11	80	12A	2S 45			
" 46	富士通	RF. IF	"	-12	-0.5	-25	100	70	-10	-12				-6	1	-0.985*	29*		0.4*	10	12	150	78		
" 47	"	"	"	-12	-0.5	-25	100	70	-10	-12				-6	1	-0.985*	29*		0.4*	6	12	150	78		
" 48	東 芝	RF	"	-18	-12	-5	60	75	-12	-18				-6	1		$h_{re} = 14$ ($f = 1.5 \text{ Mc}$)		11	80	12A	2S 48			
" 49	"	IF	"	-18	-12	-5	60	75	-10	-18				-6	1	30-200	$h_{re} = 16$ ($f = 455 \text{ kc}$)		10.5	90	12A	2S 49			
★ " 50	"	SW	"	-18	-12	-24	60	75	-3	-12	100	-1	-24	-6	1				14	10	<150	12A	2S 50		
" 51	"	RF	"	-18	-12	-5	60	75	-10	-18				-6	1	-0.985*	PG = 36 dB ($f = 1 \text{ Mc}$)	14	10.5	90	12A	2S 51			
" 52	"	Conv	"	-18	-12	-5	60	75	-10	-18				-6	1	25-180	$h_{re} = 8-22$ ($f = 1 \text{ Mc}$)		10.5	80	12A	2S 52			
" 53	"	IF	"	-18	-12	-5	60	75	-10	-18				-6	1	20-140	$h_{re} = 9$ ($f = 455 \text{ kc}$)		10.5	90	12A	2S 53			
★ " 54	日 電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. Me	-20	-0.2	-5	75	85	-5	-12				-6	2	10	PG = 12 dB ($f = 200 \text{ Mc}$)	400*	1.5	40	59				
" 55	松 下	"	Ge. A	-15	-10	-10	80	75	-10	-10				-6	1	50			6	10.5	75	20	OC 45		
★ " 56	日 電	SW	Ge. Me	-15	-3.5	-50	150	100	-5	-5	40	-0.3	-10	-3	10		$t_{re} = 22 \text{ nS}$, $t_{re} = 65 \text{ nS}$ $t_{re} = 28 \text{ nS}$, $t_{re} = 45 \text{ nS}$	300*	5		49C				
" 57	東 芝	RF	Ge. D	-18	-0.5	-5	55	75	-10	-18				-6	1	20-350	PG = 16 dB ($f = 50 \text{ Mc}$)	85	2	45	13A	2S 57			
" 58	"	RF. Conv	"	-18	-0.5	-5	55	75	-10	-18				-6	1	20-350	PG = 24 dB ($f = 20 \text{ Mc}$)	75	2	45	13A	2S 58			
" 59	"	Conv	"	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-18				-6	1	70	CG = 23 dB ($f = 18 \text{ Mc}$)	65	2	40	13A	2S 59			
" 60	"	"	"	-18	-0.5	-5	55	75	-10	-18				-6	1	40-350	CG = 26 dB ($f = 12 \text{ Mc}$)	55	2	40	13A	2S60A			
" 61	松 下	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. AD	-20	-0.5	-10	100	75	-13	-6				-6	1	80			70	2	50	12A			
" 64	富士通	SW	Ge. A	-16	-9	-40	80	85	-6	-12				-6	1	65	$t_{re} = 0.2 \mu\text{S}$, $t_{re} = 1.5 \mu\text{S}$ $t_{re} = 0.35 \mu\text{S}$	15	10	<85	12A	2S 64			
" 65	東 芝	"	"	-18	-12	-200	150	75	-7	-12	80	-0.5	-100	-6	1		$t_{re} = 0.1 \mu\text{S}$, $t_{re} = 0.1 \mu\text{S}$ $t_{re} = 0.14 \mu\text{S}$	6	<16	<140	12A				
" 66	"	"	"	-18	-12	-200	150	75	-7	-12	80	-0.5	-100	-6	1		$t_{re} = 0.085 \mu\text{S}$, $t_{re} = 0.085 \mu\text{S}$ $t_{re} = 0.14 \mu\text{S}$	10	<16	<140	12A				
" 67	"	"	"	-18	-12	-200	150	75	-7	-12	80	-0.5	-100	-6	1		$t_{re} = 0.06 \mu\text{S}$, $t_{re} = 0.06 \mu\text{S}$ $t_{re} = 0.14 \mu\text{S}$	14	<16	<140	12A				
★ " 68	松 下	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. AD	-20	-0.5	-10	100	75	-13	-6				-6	1	80	$\frac{h_{re}}{3 \text{ mU}}$, $\frac{h_{re}}{20 \text{ mU}}$, $\frac{h_{re}}{90 \text{ mU}}$	70			72A				
★ " 69	"	"	"	-20	-0.5	-10	100	75	-13	-6				-6	1	80	$\frac{h_{re}}{3 \text{ mU}}$, $\frac{h_{re}}{27 \text{ mU}}$, $\frac{h_{re}}{90 \text{ mU}}$	70			72A	OC169			
★ " 70	"	"	"	-20	-0.5	-10	100	75	-13	-6				-6	1	80	$\frac{h_{re}}{2.5 \text{ mU}}$, $\frac{h_{re}}{32 \text{ mU}}$, $\frac{h_{re}}{60 \text{ mU}}$	70	2	50	72A	OC170			
★ " 71	"	"	"	-20	-0.5	-10	100	75	-13	-6				-6	1	80	$\frac{h_{re}}{23 \text{ mU}}$, $\frac{h_{re}}{14 \text{ mU}}$, $\frac{h_{re}}{350 \text{ mU}}$	100	2	50	72A	OC171			
" 72	東 芝	RF	Ge. D	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-18				-6	1	50	$h_{re} = 19$ ($f = 1.5 \text{ Mc}$)	40	2	40	13A				
" 73	"	Conv	"	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-18				-6	1	50	$h_{re} = 15$ ($f = 1.5 \text{ Mc}$)	35	2	40	13A				
" 74	"	RF	"	-50	-0.5	-50	120	75	-8	-12				-9	1	70	2000	0.3	15	70	2.2	30	13A		

		用 途	構造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 気 的 特 性 (T _a = 25℃)										外 形 影 像	備 考			
				V _{CE0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (℃)	I _{CBO} 最大値 (μA)	V _{CB} (V)	直 流 及 脈 沖 下 の h _{FE}		偏 置 情 況		h _{FE} h _{FE} *	h _{ie} * (Ω)	h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} * (μS)			f _β * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{in} (Ω)
											V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
2SA 75	東 芝	RF	Ge. D	-20	-0.5	-50	120	75	-8	-12			-9	1	70	2000	0.3	15	30	2.2	30	13A	
* 76	"	"	"	-18	-0.5	-5	55	75	-15	-18			-6	1	20~350	PG = 13 dB (f = 100Mc)			130	1.7	40	13A	
* 77	"	Osc	"	-18	-0.5	-5	55	75	-15	-18			-6	1	20~350	V _{osc} = 100mV (f = 110.7Mc)			110	1.7	40	13A	
* 78	"	SW	"	-40	-2	-400	125	75	-8	-12	60	-1	-400	-6	1				40	< 6	< 120	13A	
* 79	"	"	Ge. A	-20	-12	-200	60	75	-7	-12	70	-0.5	-100	-6	1				> 4	< 15	< 140	12A	
* 80	日 立	RF. Conv	Ge. D	-20	-0.5	-10	80	85	-20	-12			-9	1	80	PG = 16 dB (f = 12 Mc)			60	1.7	35	13A	2S140 HJ 70
* 81	"	Osc	"	-20	-0.5	-10	80	85	-20	-12			-9	1	80				40	1.7	41	13A	2S141 HJ 71
* 82	"	Mix	"	-20	-0.5	-10	80	85	-8	-12			-9	1	6	CG = 24 dB (f = 12 Mc)			40	1.7	25	13A	2S142 HJ 72
* 83	"	IF	"	-25	-0.5	-10	80	85	-8	-12			-9	1	60	PG = 39 dB (f = 455kc)			30	1.7	25	13A	2S143 HJ 73
* 84	"	Conv	"	-25	-0.5	-10	80	85	-8	-12			-9	1	60	CG = 41 dB (f = 1.5Mc)			35	1.7	35	13A	2S144 HJ 74
* 85	"	RF	"	-25	-1	-10	80	85	-8	-12			-9	1	60	PG = 31 dB (f = 1.5Mc)			55	1.7	30	13A	2S145 HJ 75
* 86	"	"	"	-45	-1	-50	225 (最大耐付)	85	-12	-12			-9	1	80				35	1.7	45	67	2S190 HJ 76
* 87	"	"	"	-30	-0.5	-10	80	85	-12	-12			-12	1.5	100				100	1.9	40	13A	
* 88	"	Osc	"	-30	-0.5	-10	80	85	-12	-12			-12	1.5	60				100	1.9	60	13A	
* 89	"	Mix	"	-30	-0.5	-10	80	85	-12	-12			-12	1.5	80				90	2.3	60	13A	
* 90	"	RF	"	-30	-0.5	-20	200 (最大耐付)	85	-12	-12			-12	1.5	>20				>60	< 3	60	67	
* 92	東 芝	Osc	"	-18	-0.5	-5	55	75	-10	-18			-6	1	40~350				50	1.9	40	13A	2S92A
* 93	"	Mix	"	-18	-0.5	-5	55	75	-10	-18			-6	1	20~350	CG = 25 dB (f = 12 Mc)			45	1.9	30	13A	2S93A
* 94	日 立	Conv	"	-9	-0.5	-10	80	85	-15	-9			-3	1					45	5	65	13A	
* 95	富士通	RF	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1					50	2.3	50	72B	2S 95
* 96	"	"	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1					45	2.3	50	72B	2S 96
* 97	"	"	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1					40	2.3	50	72B	2S 97
* 98	"	Osc	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1					30	2.3	50	72B	2S 98
* 99	"	Mix	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1					20	2.3	50	72B	2S 99
* 100	松 下	RF. IF. Conv Mix. Osc	"	-40	-0.4	-10	60	75	-16	-10			-6	1	150		1.5 *		20	1.7	100	12A	
* 101	"	"	"	-40	-0.4	-10	60	75	-16	-10			-6	1	30		1.5 *		15	1.7	30	12A	MC101
* 102	"	"	"	-40	-0.4	-10	60	75	-16	-10			-6	1	40		1.5 *		25	1.7	40	12A	MC102
* 103	"	"	"	-40	-0.4	-10	60	75	-16	-10			-6	1	50		1.5 *		35	1.7	50	12A	MC103
* 104	"	"	"	-40	-0.4	-10	60	75	-16	-10			-6	1	60		1.7 *		50	1.7	50	12A	MC104
* 105	富士通	Conv	"	-6	-0.5	-10	80	85	-10	-6			-3	1	50	PG = 20 dB (f = 12 Mc)			75	3	50	13A	
2SA106	富士通	Conv. Mix Osc	Ge. D	-6	-0.5	-10	80	85	-10	-6			-3	1	50	PG = 26 dB (f = 1.5Mc)			30	3	50	13A	
* 107	"	IF	"	-6	-0.5	-10	80	85	-10	-6			-3	1	40	PG = 40 dB (f = 455kc)			20	3	50	13A	
* 108	"	RF	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1	70	PG = 17 dB (f = 20 Mc)			50	2.3	50	13A	2S108
* 109	"	"	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1	60	PG = 15 dB (f = 20 Mc)			45	2.3	50	13A	2S109
* 110	"	Conv	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1	60	PG = 20 dB (f = 12 Mc)			40	2.3	50	13A	2S110
* 111	"	Osc	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1	40	V _{osc} = 0.4 V (f = 12 Mc)			30	2.3	50	13A	2S111
* 112	"	Mix	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1	45	PG = 15 dB (f = 12 Mc)			20	2.3	50	13A	2S112
* 113	"	Conv. Mix	"	-34	-1	-10	80	85	-7	-12			-12	1	45	CG = 40 dB (f = 1 Mc)			20	2	50	13A	
* 114	"	IF	"	-34	-1	-10	80	85	-7	-12			-12	1	40	PG = 39 dB (f = 455kc)			20	2	50	13A	
* 115	"	RF	"	-34	-1	-10	80	85	-5	-12			-12	1	60	PG = 28 dB (f = 1.5Mc)			30	2	50	13A	
* 116	"	"	"	-30	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-12	1.5	60	PG = 15 dB (f = 50 Mc)			120	2	50	13A	
* 117	"	Osc	"	-30	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-12	1.5	40	V _{osc} = 0.25V (f = 60.7Mc)			110	2	50	13A	
* 118	"	Mix	"	-30	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-12	1.5	60	PG = 15 dB (f = 50 Mc)			100	2	50	13A	
* 121	SON	RF. Conv Mix. Osc	Ge. GD	-15		-2	15	65	-8	-15			-6	1	-0.96	50 *	5 *	0.25 *	100	1.3		18	2S173 2T201
* 122	"	"	"	-15		-2	15	65	-8	-15			-6	1	-0.96	50 *	5 *	0.25 *	100	1.3		18	2T201
* 123	"	"	"	-15		-2	15	65	-8	-15			-6	1	-0.96	50 *	5 *	0.25 *	100	1.3		18	2T201
* 124	"	"	"	-15		-2	15	65	-8	-15			-6	1	-0.97	50 *	5 *	0.25 *	120	1.3		18	2S138
* 125	"	"	"	-15		-2	15	65	-2	-15			-6	1	-0.98	40 *	5 *	0.25 *	120	1.3		18	2S139
* 126	日 電	SW	Ge. Me	-12	-1	-50	150	100	-5	-5	40	-0.5	-10	-3	10			t _r = 22nS, t _f = 65nS t _r = 28nS, t _f = 45nS	300 *	5	49C		
* 127	東 芝	RF	Ge. D	-70	-0.5	-50	150	75	-50	-12			-6	1	-0.98				25	15	40	13A	
* 128	"	SW	"	-40	-2	-600	170	75	-50	-12	35	-1.5	-600	-6	1		t _r = 0.35μS, t _f = 1.1μS t _r = 0.8μS		>15	<25	<70	13A	
* 129	"	"	"	-40	-2	-600	170	75	-50	-12	70	-1.5	-600	-6	1		t _r = 0.35μS, t _f = 1.1μS t _r = 0.8μS		>15	<25	<70	13A	
* 130	日 立	RF. Conv	Ge. Me	-9	-0.5	-10	80	85	-15	-9			-3	1	80	PG = 19 dB (f = 12 Mc)			65	4	55	13A	
* 131	"	Osc	"	-9	-0.5	-10	80	85	-15	-9			-3	1	50				45	4	60	13A	
* 132	"	Mix	"	-9	-0.5	-10	80	85	-15	-9			-3	1	80	CG = 25 dB (f = 12 Mc)			50	4	70	13A	
* 133	"	IF	"	-9	-0.5	-10	80	85	-15	-9			-3	1	.60	PG = 39 dB (f = 455kc)			40	4	110	13A	
* 134	"	"	"	-20	-0.5	-10	80	85	-30	-20			-6	1					140	3	100	72A	
* 135	"	RF. Conv	"	-20	-0.5	-10	80	85	-30	-20			-6	1					150	3	80	72A	
* 136	富士通	Conv	Ge. A	-6	-0.5	-10	80	85	-10	-6			-3	1	75	CG = 25 dB (f = 1.5Mc)			10	13	85	12A	
* 137	"	IF	"	-6	-0.5	-10	80	85	-10	-6			-3	1	50	PG = 28 dB (f = 455kc)			5	13	75	12A	

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)				電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)												外 形	備 考			
				V_{CB0} (V)	V_{EB0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^{\circ}\text{C}$)	ICBO 最大値		直 流 及 脈 沖 下 之 h_{FE}				偏 置 情 況		h_{fe} h_{ib}^*	h_{re} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{ib}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)	f_{β} f_T^* (Mc)	C_{ob} (pF)	r_{bb} $r_{be}(\text{real})^*$ (Ω)	
									I_{CBO}	$V_{CB(V)}$	$V_{CE(V)}$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB(V)}$	$I_E(\text{mA})$										
2SA138	富士通	SW	Ge. A	-20	-10	-25	80	85	-5	-20	70	-1	-10	-6	1						15	10	150	12A
* 139	"	RF. IF	"	-20	-10	-50	80	85	-5	-20	70	-1	-50	-6	1	-0.985	29*		0.4*		8	12	150	12A
* 141	三 菱	IF	"	-15	-1.5	-15	80	85	-5	-12				-6	1	70*	PG = 33 dB ($f = 455\text{kc}$)				4	12	60	12A
* 142	"	Conv	"	-15	-1.5	-15	80	85	-5	-12				-6	1	70*	CG = 28 dB ($f = 1\text{ Mc}$)				8	12	60	12A
* 143	"	RF. Conv	"	-15	-1.5	-15	80	85	-5	-12				-6	1	70*	PG = 15 dB ($f = 1.5\text{ Mc}$)				15	12	60	12A
* 144	松 下	RF. IF. Conv	"	-15	-10	-10	80	75	-10	-10				-6	1	100	CG = 28 dB ($f = 1\text{ Mc}$)				15	10.5	110	12B
* 145	"	"	"	-15	-10	-10	80	75	-10	-10				-6	1	50					6	10.5	75	12B
* 146	三 菱	IF	Ge. D	-20	-0.5	-10	60	85	-15	-12				-6	1	50	PG = 37 dB ($f = 455\text{kc}$)				20	2.5	40	13B
* 147	"	Conv. Mix	"	-20	-0.5	-10	60	85	-15	-12				-6	1	70					30	2.5	40	13B
* 148	"	Conv	"	-20	-0.5	-10	60	85	-15	-12				-6	1	70	CG = 36 dB ($f = 1\text{ Mc}$)				40	2.5	45	13B
* 149	"	RF	"	-20	-0.5	-10	60	85	-15	-12				-6	1	70					50	2.5	50	13B
* 151	日 立	IF	Ge. A	-9	-0.5	-15	80	85	-5	-6				-3	1						6	13.5	90	12A
* 152	"	Conv	"	-9	-0.5	-15	80	85	-5	-6				-3	1						10	13.5	110	12A
* 153	日 電	Mix	Ge. GD	-15	-0.5	-4	20	65	-5	-9				-6	1	60	CG = 28 dB ($f = 12\text{ Mc}$)				60	1.3		19A
* 154	"	IF	"	-15	-0.5	-4	20	65	-5	-9				-6	1	20	PG = 36 dB ($f = 455\text{kc}$)				50	1.5		19A
* 155	"	"	"	-15	-0.5	-4	20	65	-5	-9				-6	1	30	PG = 39 dB ($f = 455\text{kc}$)				55	1.5		19A
* 156	"	"	"	-15	-0.5	-4	20	65	-5	-9				-6	1	50	PG = 42 dB ($f = 455\text{kc}$)				55	1.5		19A
* 157	"	Osc	"	-15	-0.5	-4	20	65	-5	-9				-6	1	50	$V_{osc} = 3\text{ V}$ ($f = 18.455\text{Mc}$)				65	1.5		19A
* 159	"	Conv	Ge. GD	-15	-0.5	-4	20	65	-5	-9				-6	1	50	CG = 36 dB ($f = 1.6\text{ Mc}$)				55	1.5		19A
* 160	"	"	"	-15	-0.5	-4	20	65	-5	-9				-6	1	60	CG = 39 dB ($f = 1.6\text{ Mc}$)				55	1.5		19A
* 161	SON	RF	Ge. Me	-20		-15	50	85	-5	-15				-6	2	-0.93*					400*	1.2	80	51
* 162	"	"	"	-20		-15	50	85	-5	-15				-6	2	-0.96*					400*	1.2	80	51
* 163	"	"	"	-20		-15	50	85	-5	-15				-6	2	-0.985*					400*	1.2	80	51
* 164	"	Osc	"	-20		-15	50	85	-5	-15				-6	2	-0.93*					400*	1.2	80	51
* 165	"	"	"	-20		-15	50	85	-5	-15	24	-3	-1	-6	2	-0.96*	PG = 20 dB ($f = 100\text{Mc}$)				450*	1.7	80	51
* 166	"	"	"	-20		-15	50	85	-5	-15				-6	2	-0.985*					400*	1.2	80	51
* 167	日 電	RF	Ge. A	-20	-10	-50	125	75	-8	-20				-6	1	70	28*	13*	0.8*		9	15	120	84A
* 168	"	"	"	-20	-10	-50	175	75	-8	-20				-6	1	70	28*	13*	0.8*		9	15	120	91
* 168A	"	"	"	-20	-10	-50	175	75	-8	-20				-6	1	70	28*	13*	0.8*		9	15	120	91
* 169	"	SW	"	-20	-10	-50	125	75	-8	-20	70	-1	-10	-6	1						15	11	250	84A
2SA170	日 電	SW	Ge. A	-20	-10	-50	175	75	-8	-20	70	-1	-10	-6	1						15	11	250	91
* 171	"	"	"	-20	-10	-50	125	75	-8	-20	60	-1	-10	-6	1						8	11	230	84A
* 172	"	"	"	-20	-10	-200	175	75	-8	-20	40	-0.35	-200	-6	1						8	11	230	91
* 173	"	"	"	-20	-10	-50	125	75	-8	-20	60	-1	-10	-6	1						4	13	200	84A
* 174	"	"	"	-20	-10	-50	175	75	-8	-20	60	-1	-10	-6	1						4	13	200	91
* 175	東 芝	RF	Ge. D	-18	-0.5	-5	55	75	-15	-18				-6	1	20~350	PG = 16 dB ($f = 50\text{ Mc}$)				85	2	40	13A
* 176	"	"	"	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-18				-6	1						85	2.5	45	13A
* 178	"	"	"	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-18				-6	1	$h_{fe} = 13$ (-1.5 V , 1 mA , $f = 1.5\text{ Mc}$)					2	40	13A	
* 180	三 洋	Conv	Ge. A	-15	-15	-10	50	75	-10	-15				-6	1	-0.985	28*	4.7*	0.3*		10	12	100	12A
* 181	"	IF	"	-15	-15	-10	50	75	-10	-15				-6	1	-0.979	29*	2.8*	0.4*		5	12	80	12A
* 182	"	"	"	-15	-15	-10	50	75	-10	-15				-6	1	-0.964	29*	2.9*	0.5*		5	12	80	12A
* 183	"	"	"	-15	-15	-10	50	75	-10	-6				-6	1	-0.988	28*	6*	0.5*		16	12	120	12A
* 184	"	"	"	-15	-15	-10	50	75	-10	-6				-6	1	-0.95*	29*	2.4*	0.5*		3	12	70	12A
* 188	富士通	RF. IF. Conv	"	-12	-0.5	-15	80	85	-10	-12				-6	1	70					10	10	150	12A
* 189	"	IF	"	-12	-0.5	-15	80	85	-10	-12				-6	1	70					6	10	100	12A
* 190	沖	Mix	Ge. D	-20	-0.5	-15	80	80	-20	-20				-6	1	60					40	2.6	60	13A
* 191	"	"	"	-20	-0.5	-15	80	80	-20	-20				-6	1	25					20	2.6	50	13A
* 192	"	Conv	"	-20	-0.5	-15	80	80	-20	-20				-6	1						13	3.2	40	13A
* 193	"	"	Ge. A	-15	-12	-15	80	80	-12	-15				-6	1	50					13	10	100	12A
* 194	"	IF	"	-15	-12	-15	80	80	-12	-15				-6	1	40					7	10	90	12A
* 195	"	"	"	-15	-12	-15	80	80	-12	-15				-6	1	30					4	10	75	12A
* 196	"	"	"	-15	-12	-15	80	80	-12	-15				-6	1	25					2.5	10	60	12A
* 197	三 洋	"	"	-15	-15	-10	50	75	-10	-15				-6	1		$h_{fe} = 2.5$ ($f = 455\text{kc}$)				12	55	12A	
* 198	"	"	"	-15	-5	-5	30	75	-25	-15				-6	1		$h_{fe} = 4 - 50$ ($f = 455\text{kc}$)				12	55	12A	
* 199	"	RF	"	-15	-5	-5	30	75	-10	-15				-6	1		$h_{fe} = 9$ ($f = 1.5\text{ Mc}$)				11	95	12A	
* 200	"	"	"	-15	-5	-5	30	75	-10	-15				-6	1		$h_{fe} = 9$ ($f = 1.5\text{ Mc}$)				11	95	6	
* 201	"	IF. Conv	"	-15	-5	-15	100	75	-10	-15				-6	1	50	CG = 32 dB ($f = 1\text{ Mc}$)				8	11	65	12A
* 202	"	"	"	-15	-5	-15	100	75	-10	-15				-6	1	55	PG = 34 dB ($f = 455\text{kc}$)				12	11	70	12A
* 203	"	IF	"	-15	-5	-15	100	75	-10	-15				-6	1	30	PG = 30.5 dB ($f = 455\text{kc}$)				5	11	55	12A
* 204	日 電	RF	"	-30	-20	-200	150	85	-6	-10	60	-1	-10	-6	1	65	28*	12*	0.9*		6	15	130	84A

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)										電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)										外 形	備 考
				V_{CBO}	V_{EBO}	I_{C}	P_{C}	T_j	I_{CBO} 最大值	直 流 及 脉 冲 下 之 h_{FE}			偏 置 情 况		h_{FE}	h_{FE}	h_{FE}	f_{os}	C_{os}	r_{os}					
				(V)	(V)	(mA)	(mW)	($^{\circ}\text{C}$)	(μA)	V_{CE} (V)	I_{C} (mA)	V_{CB} (V)	I_{E} (mA)	h_{FE}	h_{FE}	h_{FE}	(μU)	(pF)	(Ω)						
2SA264	三 洋	RF	Ge.Me	-20	-0.4	-10	100	85	-15	-15			-6	2	15	PG = 10 dB ($f = 200\text{Mc}$)	450	1.5			48C				
" 265	"	"	"	-20	-0.4	-10	100	85	-15	-15			-6	2	15	CG = 28 dB ($f = 25\text{Mc}$)	300	1.5			48C				
" 266	富士通	RF, IF, Conv Mix. Osc	Ge.D	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-6	1	75	PG = 17 dB ($f = 20\text{Mc}$)	60	2.2	30		12A				
" 267	"	"	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-6	1	60	CG = 20 dB ($f = 12\text{Mc}$)	50	2.2	50		12A				
" 268	"	"	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-6	1	45	$V_{\text{osc}} = 0.4\text{V}$ ($f = 12.455\text{Mc}$)	40	2.2	70		12A				
" 269	"	"	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-6	1	45	CG = 35 dB ($f = 1\text{Mc}$)	30	2.2	70		12A				
" 270	"	Conv	"	-9	-0.5	-10	80	85	-10	-6			-3	1	75	CG = 20 dB ($f = 12\text{Mc}$)	50	3	50		12A				
" 271	"	"	"	-9	-0.5	-10	80	85	-10	-6			-3	1	60	CG = 28 dB ($f = 1.5\text{Mc}$)	30	3	50		12A				
" 272	"	IF	"	-9	-0.5	-10	80	85	-10	-6			-3	1	45	PG = 40 dB ($f = 455\text{kc}$)	20	3	50		12A				
" 273	"	Conv	"	-34	-1	-10	80	85	-7	-12			-12	1	45	CG = 40 dB ($f = 1\text{Mc}$)	40	2	50		12A				
" 274	"	IF	"	-34	-1	-10	80	85	-7	-12			-12	1	40	PG = 40 dB ($f = 455\text{kc}$)	30	2	50		12A				
" 275	"	RF	"	-34	-1	-10	80	85	-5	-12			-12	1	60	PG = 28 dB ($f = 1.5\text{Mc}$)	45	2	50		12A				
" 276	東 芝	SW	Ge.Me	-15	-2	-20	75	75	-5	-12	60	-0.5	-10	-6	2			210*	3.5			48C			
" 277	"	"	Ge.A	-18	-12	-40	65	75	-3	-12	50	-1	-24	-6	1			3.5 -13				84A			
" 278	"	"	"	-18	-12	-40	65	75	-3	-12	100	-1	-24	-6	1			>11				84A			
" 279	松 下	RF, IF, Conv Mix. Osc	Ge.AD	-30		-30	120	75	-6	-6			-2	10	200			150*	4	50		72A			
" 280	"	RF, Conv. Mix Osc. PA	"	-30		-30	120	75	-6	-6			-2	10	200			70	2	50		72A			
" 281	"	"	"	-50		-30	120	75	-6	-6			-2	10	200			100	2	50		72A			
" 282	東 芝	SW	Ge.A	-18	-12	-200	150	75	-7	-12	80	-0.5	-100	-6	1		$t_r = 0.6\mu\text{S}$, $t_f = 0.35\mu\text{S}$ $t_r = 0.32\mu\text{S}$	6				84A			
" 283	"	"	"	-18	-12	-200	150	75	-7	-12	80	-0.5	-100	-6	1		$t_r = 0.4\mu\text{S}$, $t_f = 0.2\mu\text{S}$ $t_r = 0.3\mu\text{S}$	10				84A			
" 284	"	"	"	-18	-12	-200	150	75	-7	-12	80	-0.5	-100	-6	1		$t_r = 0.3\mu\text{S}$, $t_f = 0.2\mu\text{S}$ $t_r = 0.28\mu\text{S}$	14				84A			
" 285	日 電	Conv	Ge.D	-18	-0.5	-5	50	75	-15	-18			-6	1	70	CG = 40 dB ($f = 1.6\text{Mc}$)	40	2	40		13A				
" 286	"	Conv. Mix	"	-18	-0.5	-5	50	75	-15	-18			-6	1	70	CG = 30 dB ($f = 12\text{Mc}$)	50	2	40		13A				
" 287	"	RF	"	-18	-0.5	-5	50	75	-15	-18			-6	1	70	PG = 29 dB ($f = 10\text{Mc}$)	60	2	40		13A				
" 288	日 立	"	Ge.Me	-20	-0.5	-10	80	85	-30	-20			-6	3	20	PG = 18 dB ($f = 100\text{Mc}$)	330*	0.88	65		72C				
" 289	"	"	"	-20	-0.5	-10	80	85	-30	-20			-6	3	20	PG = 20 dB ($f = 100\text{Mc}$)	350*	0.82	65		72C				
" 290	"	"	"	-20	-0.5	-10	80	85	-30	-20			-6	3	20	PG = 21 dB ($f = 100\text{Mc}$)	370*	0.78	65		72C				
" 291	富士通	RF, IF, Conv Mix. Osc	Ge.MD	-20		-50	50	85	-5	-6			-6	4	40			100	1.5	40		60			
" 293	"	RF	"	-15		-50	50	85	-5	-6			-6	4	40			300*	1.5	50		60			
" 296	八 欧	IF	Ge.A	-15		-15	80	85	-5	-12			-6	1	45			5	13	80		12B			
2SA297	八 欧	RF	Ge.A	-16		-15	80	85	-5	-12			-6	1	65			10	13	80		12B			
" 298	"	Conv. Mix Osc	Ge.D	-40		-10	80	85	-8	-12			-6	1	55			35	2.5	40		13B			
" 299	三 洋	RF, IF	Ge.A	-15		-10	50	75	-11	-6			-6	1	60	PG = 31 dB ($f = 455\text{kc}$)					6				
" 300	"	"	"	-15		-10	50	75	-11	-6			-6	1	60	PG = 31 dB ($f = 455\text{kc}$)					12B				
" 301	松 下	SW	Ge.AD	-30	-0.5	-30	120	75	-6	-6	125	-1	-10									72B			
" 302	"	"	Ge.A	-20	-15	-100	83	75	-3	-5	20	-0.7	-100									20			
" 303	"	"	"	-20	-15	-100	83	75	-3	-5	50	-0.7	-100									20			
" 304	東 芝	RF, IF, Conv Mix. Osc	"	-18	-12	-40	65	75	-4	-12			-6	1	70	PG = 38 dB ($f = 455\text{kc}$)	4.5	11	80		84A				
" 305	"	"	"	-18	-12	-40	65	75	-4	-12			-6	1	70	PG = 38 dB ($f = 1\text{Mc}$)	10	11	80		84A				
" 306	八 欧	"	Ge.D	-40		-10	80	85	-8	-12			-6	1	65			55	2.3	50		13B			
" 307	"	"	"	-40		-10	80	85	-8	-12			-6	1	70			75	2.2	50		13B			
" 308	松 下	"	Ge.AD	-20	-0.3	-5	83	75	-13	-12	>20	-12	-1	-12	1	250			450*	0.5	35		72A		
" 309	"	"	"	-20	-0.3	-5	83	75	-13	-12	>20	-12	-1	-12	1	250			600*	0.5	20		72A		
" 310	"	"	"	-32	-0.3	-25	166	75	-13	-12	>20	-12	-1	-12	1	250			650*	0.7	60		72A		
" 311	東 芝	SW	Ge.D	-40	-2	-400	150	75	-6	-12	65	-1	-400	-6	1		$t_r = 0.34\mu\text{S}$, $t_f = 0.15\mu\text{S}$ $t_r = 0.18\mu\text{S}$	50	3	40		84A			
" 312	"	"	"	-40	-2	-400	150	75	-6	-12	40	-1	-200	-6	1		$t_r = 0.4\mu\text{S}$, $t_f = 0.14\mu\text{S}$ $t_r = 0.18\mu\text{S}$	50	3	40		84A			
" 313	"	RF, IF, Conv Mix. Osc	"	-18	-0.5	-20	60	75	-6	-12			-6	1	60	$h_{\text{FE}} = 15$ ($f = 1.5\text{Mc}$)	40	2	40		84A				
" 314	"	"	"	-18	-0.5	-20	60	75	-6	-12			-6	1	100	$h_{\text{FE}} = 15$ ($f = 1.5\text{Mc}$)	40	2	40		84A				
" 315	"	"	"	-18	-0.5	-20	60	75	-6	-12			-6	1	110	$h_{\text{FE}} = 22$ ($f = 1.5\text{Mc}$)	55	2	40		84A				
" 316	"	"	"	-18	-0.5	-20	60	75	-6	-12			-6	1	110	$h_{\text{FE}} = 28$ ($f = 455\text{kc}$)	75	2	40		84A				
" 321	三 洋	IF	"	-20	-1.5	-15	70	75	-15	-15			-6	1	70			30	2.5-4.5	30		12A			
" 322	"	"	"	-20	-1.5	-15	70	75	-15	-15			-6	1	70	CG = 36 dB ($f = 1\text{Mc}$)	35	2-5	30		12A				
" 323	"	Conv	"	-20	-1.5	-15	70	75	-15	-15			-6	1	80			40	1.5-5.5	30		12A			
" 324	"	RF, IF	"	-20	-1.5	-15	70	75	-15	-15			-6	1	70			55	3.5	35		12A			
" 325	八 欧	SW	Ge.A	-20	-15	-80	80	85	-5	-12	60	-1	-80									12B			
" 326	"	"	"	-20	-15	-80	80	85	-5	-12	60	-1	-80									12B			
" 327	"	"	Ge.D	-40	-2	-80	80	85	-5	-12	30	-1	-80									13B			
" 328	三 洋	IF	"	-20	-0.5	-10	50	75	-20	-9			-6	1	60							13B			
" 329	"	"	"	-20	-1.5	-10	50	75	-15	-12			-6	1	13-550			5-6	1.5-6.5	<90		12A			
" 330	"	RF, IF	"	-20	-1.5	-10	50	75	-15	-12			-6	1	13-550				1.5-6.5			12A			

型	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)				電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)										外 形	備 考			
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_J ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大值 (μA)	$V_{CE(V)}$	直流及脉冲下之 h_{FE} $V_{CE(V)}$ $I_C(\text{mA})$	偏置情况 $V_{CE(V)}$ $I_E(\text{mA})$	h_{FE} h_{FE}	h_{ie} h_{ie} (Ω)	h_{re} h_{re} ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{oe} (μS)	f_{β} f_T (Mc)	C_{ob} (pF)	r_{in} r_{in} (Ω)			
2SA331	三 洋	Conv	Ge. D	-40	-1.5	-50	120	75	-15	-15			-6	1	30~300		>40	2~5	50	12A		
* 332	"	"	"	-20	-0.5	-10	50	75	-20	-9			-6	1	110		60	3	150	13B		
* 333	"	Osc	"	-20	-0.5	-10	50	75	-20	-9			-6	1	30		55	3	150	13B		
* 334	"	Mix	"	-20	-0.5	-10	50	75	-20	-9			-6	1	30		65	3	150	13B		
* 336	日 立	IF	"	-9	-0.5	-10	80	85	-15	-9			-3	1	70	PG = 38 dB ($f = 455 \text{ kc}$)	30	2.6	40	13A		
* 337	"	Conv	"	-9	-0.5	-10	80	85	-15	-9			-3	1	70	CG = 36 dB ($f = 1.5 \text{ Mc}$)	35	2.6	40	13A		
* 338	松 下	RF. IF. Conv Mix. Osc	"	-20	-0.5	-5	50	75	-16	-10			-6	1	30		15	2.5	15	4		
* 339	"	"	"	-20	-0.5	-5	50	75	-16	-10			-6	1	50		30	2.5	20	4		
* 340	"	RF. Conv Mix. Osc	Ge. AD	-20	-0.5	-10	63	75	-13	-6			-6	1	100		70	2	50	50C		
* 341	"	"	"	-20	-0.5	-10	63	75	-13	-6			-6	1	100		70	2	50	50C		
* 342	"	"	"	-20	-0.5	-10	63	75	-13	-6			-6	1	100		100	2	40	50C		
* 343	"	RF. Conv. Mix Osc. PA	"	-20	-0.4	-5	86	75	-12	-10			-6	1	100	PG = 16 dB ($f = 100 \text{ Mc}$)	100*	1.5	50	72B		
* 344	"	"	"	-30	-0.5	-30	120	75	-6	-6			-2	10	200		100	4	35	13B		
* 345	三 菱	RF	Ge. Me	-20	-0.5	-10	60	85	-30	-30			-6	1	30	PG = 18 dB ($f = 200 \text{ Mc}$)	>250*	1.2	<100	48C		
* 346	"	"	"	-20	-0.5	-10	60	85	-30	-30			-6	1	30	PG = 20 dB ($f = 200 \text{ Mc}$)	>250*	1.2	<100	48C		
* 347	"	"	"	-20	-0.5	-10	60	85	-30	-30			-6	1	30	PG = 21 dB ($f = 200 \text{ Mc}$)	>250*	1.2	<100	48C		
* 348	"	"	"	-20	-0.5	-10	60	85	-30	-30			-6	1	10	PG = 15 dB ($f = 100 \text{ Mc}$)	>200*	1.5	<120	48C		
* 349	"	"	"	-20	-0.5	-10	60	85	-30	-30			-6	1	10	PG = 15 dB ($f = 50 \text{ Mc}$)	>100*	1.5	<120	48C		
* 350	日 立	RF. Conv Mix. Osc	Ge. D	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1	90	PG = 14 dB ($f = 20 \text{ Mc}$)	40	2.5	30*	12A		
* 351	"	RF. Osc	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1	70	PG = 11 dB ($f = 12 \text{ Mc}$)	40	2.5	30*	12A		
* 352	"	RF. Conv Mix	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1	75	CG = 22.5 dB ($f = 12 \text{ Mc}$)	40	2.5	30*	12A		
* 353	"	RF	"	-25	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1	70	PG = 39 dB ($f = 455 \text{ kc}$)	30	2.5	30*	12A		
* 354	"	Conv. Mix	"	-25	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1	70	CG = 40 dB ($f = 1 \text{ Mc}$)	30	2.5	30*	12A		
* 355	"	RF	"	-25	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1	70	PG = 33 dB ($f = 1.5 \text{ Mc}$)	30	2.5	30*	12A		
* 356	"	"	"	-9	-0.5	-10	80	85	-15	-9			-3	1	80	PG = 40 dB ($f = 455 \text{ kc}$)	25	2.8	30	12A		
* 357	"	Conv. Mix	"	-9	-0.5	-10	80	85	-15	-9			-3	1	70	CG = 40 dB ($f = 1.5 \text{ Mc}$)	30	1.8	30	12A		
* 358	"	RF	"	-75	-1	-50	225 (脈衝動作)	85	-12	-12			-9	1	90		40	2.5	35*	64		
* 359	三 洋	"	Ge. Me	-20	-0.4	-20	270	85	-15	-20			-6	5	30		300*	3.5	75	84B		
* 360	三 菱	"	Ge. DB	-20	-0.5	-10	80	85	-30	-20			-6	1	70		110	2.3	85	13A		
* 361	"	RF. Conv Mix. Osc	"	-20	-0.5	-10	80	85	-30	-20			-6	1	70		125	2.3	80	13A		
2SA362	三 菱	PA	Ge. DB	-30	-0.5	-30	100	85	-30	-30			-6	5	70		150*	3	70	13A		
* 363	"	SW	"	-10	-1.2	-30	100	85	-5	-10			-3	20	80					13A		
* 364	"	RF	"	-9	-0.5	-10	80	85	-30	-9			-3	1	60		45	6	100	13A		
* 365	"	Mix. Osc	"	-9	-0.5	-10	80	85	-30	-9			-3	1	60		50	6	70	13A		
* 366	"	RF. Conv	"	-9	-0.5	-10	80	85	-30	-9			-3	1	60		75	6	50	13A		
* 367	"	RF	Ge. D	-20	-0.5	-10	80	85	-15	-12			-9	1	70		30	2.5	40	12A		
* 368	"	Conv. Mix Osc	"	-20	-0.5	-10	80	85	-15	-12			-9	1	70		40	2.5	30	12A		
* 369	"	RF	"	-20	-0.5	-10	80	85	-15	-12			-9	1	80		50	2.5	30	12A		
* 370	"	"	"	-75	-1	-50	120	85	-12	-12			-9	1	70		40	2.5	40	65		
* 371	"	SW	Ge. A	-20	-12	-15	80	85	-6	-12	70	-1.5	-10				10.5*	10	110	12A		
* 372	東 芝	"	Ge. EMc	-15	-2	-200	100	75	-10	-12	25	-1	-10	-3	5	$i_{B+I_B} = 6 \text{ nS}$, $i_f = 15 \text{ nS}$ $i_e = 30 \text{ nS}$	450*	2	120	49C		
* 373	日 立	RF	"	-25	-0.5	-150	250	85	-15	-10			-10	5	40		400*	3.2	100	84A		
* 373A	"	"	"	-25	-0.5	-150	250	85	-15	-10			-10	5	40		400*	3.2	100	84A		
* 374	松 下	RF. Conv. Mix Osc. PA	Ge. AD	-34	-0.5	-300	1.5 W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	90	-12	-10			-2	150	100		300*	13	10	84A		
* 375	三 菱	RF. Conv. Mix Osc. SW	Ge. D	-30	-1.5	-100	80	85	-6	-12	40	-1	-50	-9	1	80		40	2.5	30	12A	
* 376	SON	RF. Conv. Mix Osc	Ge. DB	-22	-10	-60	85	-6	-10	-10	48	-3	-1	-6	2	0.96*	$h_{re} = 16 \text{ dB}$ ($f = 100 \text{ Mc}$)		0.4	70*	52	
* 377	松 下	RF. Conv. Mix Osc	Ge. AD	-20	-0.4	-5	50	75	-13	-10			-6	1	100		200*	1.5	60	50C		
* 378	"	"	"	-20	-0.4	-5	50	75	-13	-10			-6	1	100		250*	1.5	30	50C		
* 379	"	"	"	-20	-0.4	-5	50	75	-13	-10			-6	1	100		300*	1.5	30	50C		
* 380	八 欧	RF. Conv	Ge. D	-25	-0.5	-10	80	85	-12	-12			-6	1	70		60	2.2	40	12A		
* 381	"	Osc	"	-25	-0.5	-10	80	85	-12	-12			-6	1	50		35	2.5	40	12A		
* 382	"	Mix	"	-25	-0.5	-10	80	85	-12	-12			-6	1	55		30	2.2	40	12A		
* 383	"	RF	"	-25	-0.5	-10	80	85	-12	-12			-6	1	40		25	2.5	40	12A		
* 384	"	Conv	"	-25	-0.5	-10	80	85	-12	-12			-6	1	60		40	2.5	40	12A		
* 385	松 下	RF	Ge. A	-16	-10	-10	80	75	-12	-10			-6	1	120		10	8	120	12A		
* 386	"	RF. Conv. Mix Osc	Ge. AD	-32	-0.5	-300	1.85 W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	90	-12	-10			-2	100	80		350*	12	8	84B		
* 387	三 洋	"	Ge. A	-10		-15	100	85	-50	-10			-6	1	30	$h_{re} = 9$ ($f = 455 \text{ kc}$)		10	50	12A		
* 388	"	"	"																			
* 389	日 立	RF	Ge. Me	-20	-0.3	-10	50	85	-30	-20			-10	2	30	PG = 8.5 dB ($f = 800 \text{ Mc}$)	600*	0.4	$C_{r_{in}}$ 10 pS	50C		
* 390	"	"	"	-20	-0.3	-10	50	85	-30	-20			-10	2	30	PG = 9.5 dB ($f = 800 \text{ Mc}$)	700*	0.4	$C_{r_{in}}$ 9.5 pS	50C		

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)						電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)											外 形	備 考			
				V_{CE0} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_J ($^{\circ}\text{C}$)	I_{CBO} 最大 (μA)	$V_{CB(V)}$	直 流 及 脈 沖 下 之 h_{FE}				偏 置 情 況		h_{FE} h_{FS}^*	h_{re} h_{rb}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{re} h_{rb}^* (μU)	f_{α} f_T^* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $r_{bb'(real)}^*$ (Ω)		
											$V_{CE(V)}$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB(V)}$	$I_E(\text{mA})$	h_{FE} h_{FS}^*										
2SA391	沖	RF	Ge. A	-18	-12	-200	150	85	-6	-6					-5	1	70				7	10	150	84B	
" 392	"	"	"	-18	-12	-200	150	85	-6	-6					-5	1	100				11	9.5	175	84B	
" 393	"	"	"	-18	-12	-200	150	85	-6	-6					-5	1	150				16	9.2	200	84B	
" 393A	"	"	"	-30	-12	-200	150	85	-6	-6					-5	1	150				16	9.2	230	84B	
" 394	"	"	"	-18	-12	-200	150	85	-6	-6					-5	1	200				22	8.7	230	84B	
" 395	"	"	"	-18	-12	-200	150	85	-6	-6					-5	1	300				29	8.5	260	84B	
" 396	"	"	"	-15	-15	-200	200	85	-10	-12					-5	1	85				6	20	150	84B	
" 397	"	"	"	-23	-15	-200	200	85	-10	-12					-5	1	100				8	20	150	84B	
" 398	"	"	"	-30	-20	-200	200	85	-10	-12					-5	1	120				10	19	160	84B	
" 399	"	"	"	-30	-20	-200	200	85	-10	-12					-5	1	70				12	17	160	84B	
" 400	富士通	RF. Conv. Mix Osc	Ge. D	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12					-6	1	70				70	2.3	50	13A	
" 401	日立	RF	Ge. Me	-30	-0.5	-40	130	85	-30	-30					-6	5	70				30	3	70	13A	
" 402	東芝	"	Si. EP	-35		-100	250	175	-1	-15	200	-6	-2		-6	1					200*	6	30	49C	
" 403	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. Me	-20	-0.2	-5	75	85	-10	-12					-6	2	10			PG = 16dB ($f = 70\text{Mc}$)	280*	1.5	40	19B	
" 404	"	"	"	-20	-0.2	-5	75	85	-10	-12					-6	2	10			PG = 12dB ($f = 200\text{Mc}$)	400*	1.5	40	59	
" 405	"	SW	"	-15	-3.5	-50	150	100	-3	-5	40	-0.5	-10	-3	10				$t_d = 22\text{nS}$, $t_r = 65\text{nS}$ $t_f = 28\text{nS}$, $t_j = 45\text{nS}$	300*	5		49C		
" 406	"	"	Ge. A	-30	-20	-200	200	85	-7	-15	50	-1	-10	-6	1	60			28*	10*	0.8*	9	15	120	84A
" 407	"	"	"	-30	-20	-200	200	85	-7	-12	60	-1	-10	-6	1	70			28*	11*	0.8*	14	15	130	84A
" 408	富士通	"	Ge. MA	-15	-15	-50	50	80	-5	-6	100	-1	-15	-6	1						50	3		60	
" 409	"	"	"	-15	-15	-50	50	80	-5	-6	100	-1	-15	-6	1						80	3		60	
" 410	日電	"	Ge. EMe	-12	-1	-150	150	100	-5	-5	40	-0.3	-10	-3	10				$t_d = 10\text{nS}$, $t_r = 50\text{nS}$ $t_f = 15\text{nS}$, $t_j = 40\text{nS}$	300	1.5		49C		
" 411	"	"	"	-15	-2.5	-150	150	100	-5	-5	40	-0.3	-10	-3	10				$t_d = 10\text{nS}$, $t_r = 40\text{nS}$ $t_f = 15\text{nS}$, $t_j = 35\text{nS}$	300	1.5		49C		
" 412	日立	"	Ge. Me	-13	-1	-100	150	85	-3	-6	50	-0.5	-30	-3	10						40*	7		12A	
" 413	松下	"	Ge. AD	-20	-2.5	-30	100	75	-5	-5	90	-1	-30	-2	30						>300*	4		49C	
" 414	"	"	Ge. A	-30	-20	-200	150	85	-3	-5	40	-0.5	-100	-5	3						7*	9		84A	
" 415	"	"	"	-25	-20	-200	150	85	-3	-3	60	-0.5	-100	-5	3						10*	9		84A	
" 416	"	"	Ge. AD	-70	-1.5	-700	6W $T_J = 85^{\circ}\text{C}$	75	-1mA	-60	100	-0.5	-600	-10	300						$t_d + t_r < 70\text{nS}$, $t_r + t_f < 100\text{nS}$ $t_f < 50\text{nS}$	120*	35		103
" 417	日電	"	Ge. EMe	-15	-2.5	-200	150	100	-5	-10	70	-0.3	-10											46C	
" 419	三洋	"	Ge. Me	-20		-5	50	85	-10	-12					-6	2	20			PG = 12dB ($f = 200\text{Mc}$)				48C	
" 420	"	"	"	-20		-5	50	85	-10	-12					-6	2	25			PG = 12dB ($f = 200\text{Mc}$)	550	2		48C	
2SA421	三洋	SW	Ge. Me	-20		-5	50	85	-10	-12					-12	2	25			PG = 8.5dB ($f = 800\text{Mc}$)				48C	
" 422	"	RF	"	-20	-0.3	-5	50	85	-10	-12					-12	2	25			PG = 10dB ($f = 800\text{Mc}$)	800	0.8		48C	
" 423	"	"	Ge. EMe	-20		-5	50	85	-10	-12					-12	2	25			PG = 8.5dB ($f = 800\text{Mc}$)				48C	
" 424	"	"	"	-20		-5	50	85	-10	-12					-12	2	25			PG = 10dB ($f = 800\text{Mc}$)				48C	
" 425	八咫	"	Ge. Me	-30		-30	200	85	-10	-15					-6	2	25				350*	3.3	60*	84B	
" 426	"	"	"	-30		-30	200	85	-10	-15					-6	2	30				500*	2.5	60*	84B	
" 427	三洋	"	Ge. D	-20	-0.5	-15	100	75	-15	-15					-6	1	60				45	3.5	40	13B	
" 428	"	"	"	-20	-0.5	-15	100	75	-15	-15					-6	1	80				50	3.5	30	13B	
" 429	東芝	"	Si. TP	-150	-3	-30	150	125	-1	-50	60	-2	-2	-10	2						100*	4	50	33	
" 430	"	"	Ge. Me	-20		-5	70	85	-10	-12					6	1	-0.95*			PG = 10dB ($f = 800\text{Mc}$)	>450*	<0.8	<50	50C	
" 431	"	"	"	-20		-5	70	85	-10	-12					-6	1	-0.94*			PG = 16dB ($f = 200\text{Mc}$)				50C	
" 432	"	"	"	-20		-5	70	85	-10	-12					-6	1	-0.94*			PG = 14dB ($f = 200\text{Mc}$)				50C	
" 433	"	"	Ge. D	-18		-5	55	75	-8	-12					-6	1	50			PG = 21dB ($f = 10.7\text{Mc}$)		<3.5		13A	
" 434	日立	RF. Conv. Mix Osc	Ge. Me	-20	-0.5	-10	80	85	-30	-20					-6	8	80			PG = 16.5dB ($f = 100\text{Mc}$)	880*	0.9	80	72A	
" 435	"	"	"	-20	-0.5	-10	60	85	-30	-20					-6	3	30			PG = 16.5dB ($f = 100\text{Mc}$)	330*	0.9	80	9	
" 436	"	"	"	-20	-0.5	-10	60	85	-30	-20					-6	3	30			PG = 18.5dB ($f = 100\text{Mc}$)	400*	0.98	65	9	
" 437	"	"	"	-20	-0.5	-10	60	85	-30	-20					-6	3	30			PG = 19.3dB ($f = 100\text{Mc}$)	400*	0.92	65	9	
" 438	"	"	"	-20	-0.5	-10	60	85	-30	-20					-6	3	30			PG = 20dB ($f = 100\text{Mc}$)	520*	0.88	65	9	
" 439	"	"	"																						
" 440	三洋	RF. Conv. Mix Osc	Ge. Me	-20	-0.4	-5	60	85	-30	-20					-6	2	50			PG = 14dB ($f = 100\text{Mc}$)	350*	1.5	70*	48C	
" 441	"	"	"	-20		-10	150	85	-30	-20					-6	2	40				500*	3.5	70	84B	
" 442	"	"	"																						
" 443	日立	Ch	Ge. A	-21	-12	-15	60	85	-6	-12	200	-6	-2	-6	1					$h_{FE}/h_{FEZ} = 0.8 \sim 1.0$	25	10	70	15 複合管	
" 444	"	"	"	-16	-12	-12	60	85	-6	-12	80	-6	-1	-6	1	80				內裝有熱納二極管	12	7	70	14	
" 445	"	差動放大	"	-16	-12	-15	60	85	-6	-12	75	-6	-1	-6	1					$h_{FE}/h_{FEZ} = 0.8 \sim 1.0$	10	10	70	15 複合管	
" 446	東芝	SW	Ge. EMe	-15	-2	-200	200	85	-10	-12	70	-1	-100							$t_d + t_r < 35\text{nS}$, $t_r + t_f < 170\text{nS}$ $t_f < 140\text{nS}$				84B	
" 447	松下	RF. Conv. Mix Osc	Ge. AD	-25		-15	90	75	-3.5	-10					-10	2	80				650*	1.6	20	57	
" 448	SON	RF. Conv	Ge. Me	-15	-0.5	-5	40	75	-10	-10	20	-3	-3	-3	3	30				PG = 8dB ($f = 1000\text{Mc}$)	1700*	0.15		52	
" 449	日立	SW	Ge. EMe	-10	-1.25	-100	150	100	-5	-6	30	-1	-50	-1	20					$t_d + t_r < 80\text{nS}$, $t_r + t_f < 120\text{nS}$ $t_f < 100\text{nS}$	300*	4		49C	
" 450	"	"	"	-12	-1.5	-100	150	100	-3	-6	40	-1	-50	-1	20					$t_d + t_r < 60\text{nS}$, $t_r + t_f < 95\text{nS}$ $t_f < 80\text{nS}$	500*	2.5		49C	

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)										外 形	備 考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CB0} 最大値		直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}		偏 置 情 况		h _{FE}	h _{FE}	h _{FE}	h _{FE}			f _β	C _{ob} (pF)	r _{bb} (Ω)
									(μA)	V _{CB(V)}	V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	V _{CB(V)}	I _{E(mA)}									
2SA451	日 立	SW	Ge.Eme	-12	-1.5	-100	150	100	-3	-6	70	-1	-50	-1	20		$t_d + t_r < 60\text{nS}, t_f < 90\text{nS}$	500*	2.5		49C		
" 452	"	"	"	-12	-1.5	-100	150	100	-3	-6	150	-1	-50	-1	20		$t_d + t_r < 60\text{nS}, t_f < 110\text{nS}$	500*	2.5		49C		
" 453	SON	RF.Conv.Mix Osc	Ge.DB	-22		-10	60	85	-5	-15	6	-3	-1	-6	2	-0.93*	PG = 25dB (f = 100Mc)	630*	0.45	70*	52		
" 454	"	"	"	-22		-10	60	85	-5	-15	12	-3	-1	-6	2	-0.96*	PG = 25dB (f = 100Mc)	630*	0.45	70*	52		
" 455	"	"	"	-22		-10	60	85	-5	-15	24	-3	-1	-6	2	-0.978*	PG = 25dB (f = 100Mc)	630*	0.45	70*	52		
" 456	"	"	"	-22		-10	60	85	-5	-15	48	-3	-1	-6	2	-0.988*	PG = 25dB (f = 100Mc)	630*	0.45	70*	52		
" 457	東 芝	RF	Ge.D	-18	-0.5	-20	55	75	-10	-12				-6	1	200	$h_{FE} > 18$ (f = 1.5Mc)	45	3	150	13A		
" 458	三 菱	SW	Ge.A	-25	-15	-200	150	85	-5	-12	60	-1	-10				$t_d + t_r < 1\mu\text{S}, t_f < 0.7\mu\text{S}$				68		
" 459	"	"	"	-25	-15	-200	150	85	-5	-12	120	-1	-10				$t_d + t_r < 1\mu\text{S}, t_f < 0.7\mu\text{S}$				68		
" 460	"	RF.Osc	Ge.Me	-20	-0.5	-10	60	85	-30	-20				-6	3	30	PG = 17dB (f = 100Mc)	400*	0.9	80*	11A		
" 461	"	RF.Mix.Osc	"	-20	-0.5	-10	60	85	-30	-20				-6	3	30	PG = 18dB (f = 100Mc)	400*	0.9	65*	11A		
" 462	"	RF	"	-20	-0.5	-10	60	85	-30	-20				-6	3	30	PG = 20dB (f = 100Mc)	400*	0.9	65*	11A		
" 463	"	RF.Conv.Mix Osc	"	-20	-0.5	-10	75	85	-30	-20				-6	3	10	PG = 16.5dB (f = 100Mc)	300*	1	80*	11A		
" 464	"	"	"	-15	0.3	-10	60	85	-10	-15				-6	3	30		850*	0.8	C _{ob} max 12 pS	11A		
" 465	松 下	RF.Conv.Mix Osc	Ge.AD	-20		-5	50	75	-13	-10				-10	1	250	PG = 8 dB (f = 800Mc)	600*	0.5	20	57		
" 466	東 芝	RF.Conv.Mix Osc	Ge.D	-18		-10	55	85	-12	-18				-6	1	40		15*	3	50	12A		
" 467	"	RF	Si.EP	-40	-5	-400	300	125	-0.5	-20	100	-1	-100	-10	10	80		200*	10	30	33	2SC367 之封筒	
" 468	"	RF.Conv.Mix Osc	Ge.D	-18	-0.5	-10	55	85	-12	-18				-6	1	70		30*	3	40	12A		
" 469	"	"	"	-18	-0.5	-10	55	85	-12	-18				-6	1	50		30*	3	40	12A		
" 470	"	"	"	-18	-0.5	-10	55	85	-12	-18				-6	1	75		30*	3	40	12A		
" 471	"	"	"	-18	-0.5	-10	55	85	-12	-18				-6	1	50	PG = 21dB (f = 10.7Mc)		<3.5		12A		
" 472	"	"	"	-18	-0.5	-10	55	85	-12	-18				-6	1	80		30*	3	40	12A		
" 473	"	RF.PA	Si.DJ	-30	-5	-3A	$10W$ (T _c = 25℃)	150	-11	-20	40-400	-2	-500	-12	500			100*	40	15	119		
" 474	"	RF.Conv.Mix Osc	Ge.D	-50	-0.5	-50	120	85	-12	-12				-6	1	50		70	4	30	12A		
" 475	"	"	"	-20	-0.5	-50	120	85	-12	-12				-6	1	50		30	4	30	12A		
" 476	"	"	"	-18	-0.5	-10	55	85	-12	-18				-6	1	60		65	1.5	40	12A		
" 477	"	RF	"	-18	-0.5	-10	55	85	-12	-18				-6	1	60	PG = 27dB (f = 10.7Mc)		1.5		12A		
" 478	"	SW	"	-40	-2	-400	125	85	-8	-12	60	-1	-400	-6	1		$t_r < 85\text{nS}, t_f < 250\text{nS}$ $t_r < 85\text{nS}$	>25	<6	<120	12A		
" 479	"	"	"	-40	-2	-200	125	85	-8	-12	50	-1	-200	-6	1		$t_r < 80\text{nS}, t_f < 70\text{nS}$ $t_r < 300\text{nS}$	>25	3	<120	12A		
" 480	SON	RF	Si.E	-30	-5	-100	150	150	-3	-25	60	-3	-3	-6	1	120	$h_{FE} = 3.0\text{dB}$ (f = 100Mc)		3	C _{ob} max 100pS	60		
2SA481																							
" 482	東 芝	PA	Si.EP	-40	-5	-600	600	150	-1	-30	50	-2	-150	-10	10	50		70*	20	10	84B		
" 483	"	RF.AF.PA	Si.TMe	-150	-5	-1A	$20W$ (T _c = 25℃)	150	-100	-150	30-240	-10	-100	-10	100			10*	50	25	99		
" 484	"	PA	Si.EP	-110	-5	-1.5A	800	175	-10	-30	80	-2	-200	-10	30			20*	60	10	84B	2SC484 之封筒	
" 485	"	"	"	-80	-5	-1.5A	800	175	-10	-30	80	-2	-200	-10	30			20*	60	10	84B		
" 486	"	"	"	-50	-5	-1.5A	800	175	-10	-30	80	-2	-200	-10	30			20*	60	10	84B	2SC486 之封筒	
" 487																							
" 488																							
" 489	東 芝	RF.PA	Si.Eme	-70	-5	-4A	$30W$ (T _c = 25℃)	150	-30	-50	40-240	-5	-500	-5	500			>3*	230	15	119		
" 490	"	PA	"	-50	-5	-3A	$25W$ (T _c = 25℃)	150	-20	-30	40-240	-2	-500	-2	500			>3*	150	15	119		
" 491																							
" 492																							
" 493	東 芝	RF.LN	Si.EP	-50	-5	-50	200	125	-0.1	-30	70-400	-6	-2	-6	1		3500	0.6	19.2	200*	5	30	33
" 494	"	LN	"	-35	-5	-30	200	125	-0.5	-15	70-400	-6	-0.1	-6	0.1	NF = 24dB (f = 120 ³)	10kΩ	1	3	200*	4	30*	33
" 495	"	RF	"	-35	-5	-100	200	125	-0.5	-15	70-240	-1	-10	-10	10			200*	4	30	33	2SC390 之封筒	
" 496	"	PA	"	-40	-5	-800	550	125	-1	-30	40-240	-2	-50	-10	10			100*	20	10	164	2SC496 之封筒	
" 497	"	"	"	-80	-5	-800	600	150	-1	-30	40-240	-2	-200	-10	10			70*	33	15	84B		
" 498	"	"	"	-50	-5	-800	600	150	-1	-30	40-240	-2	-200	-10	10			70*	33	15	84B		
" 499	"	"	"	-40	-5	-100	200	150	-0.5	-15	60-200	-1	-10	-10	10			250*	5	30	49C		
" 500	"	RF	"	-30	-5	-100	250	175	-0.5	-15	60-200	-1	-10	-10	10			250*	5	30	49C		
" 501	"	"	"	-40	-5	-200	750	175	-1	-30	70	-1	-10	-10	10			200*	10	30	84B	2SC501 之封筒	
" 502	"	"	"	-90	-5	-40	300	125	-0.5	-50	40-240	-1	-20	-10	10			750	8	50	33		
" 503	"	RF	"	-60	-5	-600	800	150	-0.5	-30	30-300	-2	-150	-10	10			130*	18	10	84B	2SC503 之封筒	
" 504	"	"	"	-40	-5	-600	800	150	-0.5	-30	30-300	-2	-150	-10	10			130*	18	10	84B	2SC504 之封筒	
" 505	"	PA	"	-60	-5	-800	600	125	-1	-30	40-240	-2	-50	-10	10			100*	20	10	164	2SC495 之封筒	
" 506	"	RF.Conv.Mix Osc	Ge.Eme	-20		-5	75	85	-10	-12				-6	1	20		300*	1	25	10		
" 507	"	"	"	-20		-5	75	85	-10	-12				-6	1	20		250*	1	25	10		
" 508	"	"	"	-20		-5	75	85	-10	-12				-6	1	8		200*	1	25	10		
" 509	"	RF.PA	Si.EP	-35	-5	-500	600	150	-0.1	-20	100	-2	-50	-10	10			140*	22	10	131	2SC509 之封筒	
" 510	"	PA	"	-120	-5	-1.5A	800	150	-1	-30	30-150	-2	-200	-10	30			60*	43	10		2SC510 之封筒	

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)											外 形	備 考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CB0} 最大值 (μA)	V _{CB} (V)	直流及脉冲下之h _{FE}		偏置情况		h _{fe} h _{fs} *	h _{ie} h _{is} *	h _{re} h _{rs} *	h _{oe} h _{os} *	f _β f _T *			C _{ob} (pF)	r _{bb'(real)} * (Ω)	
											V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)										
2SA511	東 芝	PA	Si.TP	-90	-5	-1A	800	150	-1	-30			-10	50	50				50*	43	10	84B	2SC511 之封裝	
512	"	"	Si.EP	-80	-5	-1.5A	800	150	-1	-30	30~150	-2	-200	-10	30				60*	43	10	84B	2SC512 之封裝	
513	"	"	"	-50	-5	-1A	800	150	-1	-30			-10	50	50				50*	43	10	84B	2SC513 之封裝	
514	"	"	"																					
515	"	"	"																					
516	東 芝	RF.PA	Si.DB	-80	-5	-1.5A	800	175	-0.5	-30	60	-2	-200	-5	200	60				50*	43	10	84B	
516A	"	"	"	-120	-5	-1.5A	800	175	-0.5	-30	60	-2	-200	-5	200	60				50*	43	10	84B	
517	"	RF	Ge.D	-18	-0.5	-10	55	85	-12	-18			-6	1	60				60	1.8	45	12A		
518	"	RF.Conv.Mix Osc	"	-18	-0.5	-10	55	85	-12	-18			-6	1	60				45	1.8	45	12A		
519	"	"	"																					
520	"	"	"																					
521	"	"	"																					
522	東 芝 富士通	RF	Si.EP	-25	-5	-100	250	175	-0.1	-15	30~120	-1	-10	-10	10	50				200*	4	25	49C	
522A	"	"	"	-50	-5	-100	250	175	-0.1	-15	30~120	-1	-10	-10	10	50				200*	4	25	49C	
523	富士通	RF.PA	"	-40	-5	-300	650	175	-0.1	-10	30~120	-10	-10	-10	10	60				200*	4.5	50*	84B	
523A	"	"	"	-60	-5	-300	650	175	-0.1	-10	30~120	-10	-10	-10	10	60				200*	4.5	50*	84B	
524	"	"	"	-25	-3	-100	350	175	-0.1	-10			-10	10	50				250*	4.5	50*	49C		
525	東 芝	RF.Conv.Mix Osc	Ge.EMe	-20		-5	75	35	-10	-12			-6	1	20	PG = 21dB (f = 70Mc)			250*	1	25	48C		
526	SON	PA	Si.E	-50	-5	-1A	500	150	-5	-50	70	-2	-100	-6	1	50	$h_{fe} = 5\text{dB}$ (f = 50Mc)		18	$C_{rpk} = 100\text{pS}$		84C		
527	"	"	"	-50	-5	-2A	$\frac{5\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-5	-50	50	-2	-200	-6	1	50	$h_{fe} = 5\text{dB}$ (f = 50Mc)		18	$C_{rpk} = 100\text{pS}$		97C		
528	"	"	"	-50	-5	-2A	$\frac{5\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-5	-50	70	-2	-100	-6	1	50	$h_{fe} = 5\text{dB}$ (f = 50Mc)		18	$C_{rpk} = 100\text{pS}$		97C		
529	"	RF.PA	Si.EMe	-50	-5	-1A	$\frac{5\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-5	-50	80	-2	-100	-10	50	$h_{fe} = 5\text{dB}$ (f = 50MHz)		18	$C_{rpk} = 100\text{pS}$		181			
530	日 立	SW	Si.EP	-50	-5	-100	200	175	-1	-20			-1	-10	65	$t_{on} < 200\text{nS}$, $t_{off} < 300\text{nS}$ $t_{sig} < 300\text{nS}$		300*	5		49C			
531	"	"	"																					
532	三 洋	RF.PA	Si.TP	-50	-5	-200	500	150	-10	-40	80	-6	-6	10					90*	7	$C_{rpk} = 45\text{pS}$	84B	2SC532 2SC533 之封裝	
533	"	"	"																					
534	"	"	"																					
535	三 洋	"	"	-75	-4	-700	500	150			60	-6	-50						80*				2SC535 2SC536 之封裝	
536	"	"	"	-50	-4	-700	500	150			60	-6	-50						80				"	
537	日 立	RF	Si.EP	-60	-4	-700	750	200	-10	-30			-4	50	50				200*	15	30	84A	2SC708 之封裝	
2SA537A	日 立	RF	Si.EP	-90	-4	-700	750	200	-10	-30			-4	50	50				200*	15	30	84A	2SC708A 之封裝	
538	東 芝	"	Ge.A	-25	-12	-50	120	75	-50	-25			-6	1	70				8	10	100	12A		
539	日 電	RF.PA	Si.EP	60	-5	-200	250	125	-0.2	-30	80	-10	-10	-10	10	80			200*	8.5	20	43	2SC815 之封裝	
540	"	"	"																					
541	"	"	"																					
542	日 電	RF.AF	Si.EP	-30	-5	-50	150	150	-0.05	-25	160	-10	-0.5	-5	1	180	5000	2	28	100*	5	20*	23	
543	"	RF.LN	"	-30	-5	-50	150	150	-0.05	-25	160	-10	-0.5	-5	1	180	5000	2	28	100*	5	20*	23	
544	"	RF	"	-60	-5	-200	750	175	-0.2	-45			-10	10	100				160*	8	30	84A	2SC532 之封裝	
545	"	RF.PA	"	-70		-200	400	125	-0.1	-60	70	-2	-150	-10	10	110			200*	8.5	20	44	2SC533 之封裝	
546	松 下	PA	"	-70	-5	-1A	750	175	-3	-30	80	-3	-100	-10	50				80*	50	20	84B	2SC536 之封裝	
546A	"	"	"	-90	-5	-1A	750	175	-3	-30	80	-3	-100	-10	50				80*	50	20	84B	2SC536A 之封裝	
547	"	"	"	-70	-5	-1A	$\frac{10\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	-3	-30	80	-3	-100	-10	50				80*	50	20	97B	2SC537 之封裝	
547A	"	"	"	-90	-5	-1A	$\frac{10\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	-3	-30	80	-3	-100	-10	50				80*	50	20	97B	2SC537A 之封裝	
548	日 立	RF.SW	"	-50	-5	-100	200	175	-1	-20	100	-12	-1	-10	20	$t_{on} = 90\text{nS}$, $t_{off} = 160\text{nS}$ $t_{sig} = 150\text{nS}$			400*	4	$C_{rpk} = 30\text{pS}$	8 C		
549	"	RF	Si.T	-70	-5	-100	200	175	-1	-20	80	-1	-10	-10	10				200*	2.5	80*	182C		
550	松 下	RF.AF	"	-25	-5	-100	300	175	-1	-10	250	-5	-2	-5	2	150	3000	3	50	120*	5	100	49C	2SC538 之封裝
550A	"	"	"	-45	-5	-100	300	175	-1	-10	250	-5	-2	-5	2	150	3000	3	50	120*	5	100	49C	2SC538A 之封裝
551	"	"	"																					
552	日 電	RF.SW	Si.EP	-60	-5	-200	750	175	-0.1	-45	100	-10	-10	-10	10	100	$t_{on} < 100\text{nS}$, $t_{off} < 300\text{nS}$ $t_{sig} < 270\text{nS}$		150*	8	10*	84C		
553	富士通	RF	"	-40		-300	250	175	-0.1	-10			-10	10	60				200*	4.5	50*	49C		
554	"	"	"	-25		-300	250	175	-1	-10			-10	10	60				200*	4.5	50*	49C		
555	"	"	"	-40		-200	200	125	-1	-10			-10	10	60				200*	5	50*	30		
556	"	"	"	-20		-200	200	125	-1	-10			-10	10	60				200*	5	50*	30		
557	"	"	"	-20		-250	300	125	-1	-10			-10	10	60				200*	5	50*	32		
558	"	SW	"	-40	-5	-200	350	175	-0.1	-10	50	-1	-10			$t_r = 10\text{nS}$, $t_f = 25\text{nS}$ $t_s = 90\text{nS}$			200*	4.5	50*	49C		
559	"	"	"	-20	-5	-200	350	175	-0.5	-10	50	-1	-10			$t_r = 10\text{nS}$, $t_f = 25\text{nS}$ $t_s = 90\text{nS}$			200*	4.5	50*	49C		
560	東 芝 富士通	RF	Si.TP	-80	-5	-800	800	175	-0.5	-30	30~120	-2	-150	-10	50	70				150*	11	15	84B	2SC560 之封裝
561	東 芝	"	Si.EP	-50	-5	-150	300	125	-0.1	-18	70~400	-1	-20	-6	1				70*	13	10	33	2SC734 之封裝	
562	"	"	"	-30	-5	-400	300	125	-0.1	-18	70~400	-1	-100	-6	2					13	10	33	2SC735 之封裝	
563	"	"	"																					

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)										外 形	備 考					
				V _{CEO} (V)	V _{EMO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値		直 流 及 脈 沖 下 之 h _{FE}				偏置情況		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)			h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{αB} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ib'(real)} * (Ω)
									(μA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)										
2SA564	松 下	RF. AF	Si. EP	-25	-5	-100	250	125	-1	-10	150	-5	-2	-5	2	150	3000	3	50	120 *	5	100	42	2SC828 之對稱	
* 564A	"	"	"	-45	-5	-100	250	125	-1	-10	150	-5	-2	-5	2	150	3000	3	50	120 *	5	100	42	2SC828A 之對稱	
* 565	日 立	RF	"	-50	-4	-500	300	175	-0.5	-20	80	-3	-10	-6	1					60 *	5	30 *	12C	2SC984 之對稱	
* 566	"	PA	"	-100	-4	-700	10 W (T _a = 25°C)	175	-10	-30	35 ~ 200	-4	-50	-6	30					100 *	30	20 *	99	2SC680 之對稱	
* 567	"	RF	"	-30	-4	-100	200	175	-0.5	-15	400	-6	-0.1	-6	1	300	10K	4	25	70 *	5	25 *	12A		
* 568	三 菱	PA	"	-35	-4	-250	200	125	-1	-25	100	-2	-150	-6	10					150 *	10	C _o F _{AB} 100pS	41		
* 569	"	PA	"	-50	-4	-250	200	125	-1	-25	100	-2	-150	-6	10					150 *	10	C _o F _{AB} 100pS	41		
* 570	"	"	"	-65	-4	-250	200	125	-1	-25	80	-2	-150	-6	10					150 *	10	C _o F _{AB} 100pS	41		
* 571	日 電	SW	"	-60	-5	-1A	800	175	-0.1	-45	80	-10	-50	-10	50	t _{on} < 40nS, t _{off} < 160nS t _{sig} < 130nS				300 *	16	30	84C		
* 572	新日無																								
* 573	"	RF. AF	Si. EP	-30		-100	300	125	-0.1	-20	100	-6	-1	-6	1		5000	1.5	20	130 *	4	C _o F _{AB} 50pS	138	再登錄	
* 574	"	RF	"	-60		-100	300	125	-0.1	-20	130	-1	-50	-10	2					150 *	4	C _o F _{AB} 50pS	138	再登錄	
* 575	"	"	"	-90		-100	300	125	-0.1	-20	100	-1	-50	-10	2					150 *	4	C _o F _{AB} 50pS	138	再登錄	
* 576	"	RF. PA	"	-30		-200	600	125	-0.5	-20	80	-1	-100	-10	5					200 *	5	C _o F _{AB} 50pS	31		
* 577	"	"	"	-60		-400	600	125	-0.5	-20	100	-1	-100	-10	5					200 *	5	C _o F _{AB} 50pS	31		
* 578	日 電	RF. AF. LN	"	-50	-5	-30	300	150	-0.05	-30	370	-3	-1	-3	1		12K	2.5	40	120 *	7	20 *	49C		
* 579	"	RF. AF	"	-50	-5	-30	300	150	-0.05	-30	370	-3	-1	-3	1		12K	2.5	40	120 *	7	20 *	49C		
* 580	富士通	RF. AF. PA	"	-60	-6	-600	800	175	-1	-30	120	-2	-200	-6	1		4000	0.5	15	100 *	18	20 *	84B		
* 581	"	"	"	-100	-6	-600	800	175	-1	-30	120	-2	-200	-6	1		4000	0.5	15	100 *	18	20 *	84B		
* 582																									
* 583																									
* 584																									
* 585																									
* 586																									
* 587																									
* 588																									
* 589																									
* 590																									
* 591																									
* 592																									
2SA593																									
* 594	東 芝	RF	Si. EP	-60	-5	-200	750	175	-0.1	-30	40~240	-1	-10	-10	10					400 *	3	<128 *	84B	2SC594 之對稱	
* 595																									
* 596																									
* 597	東 芝	RF. PA	Si. EP	-50	-4	-1A	6 W (T _a = 25°C)	175	-1	-30	50	-3	-150	-10	100					400 *	10	10 *	84B		
* 598																									
* 599																									
* 600																									
* 601																									
* 602																									
* 603	日 電	RF	Si. EP	-60	-8	-200	300	150	-0.5	-40	150	-1	-10	-10	10					220 *	6.5	70	124		
* 604	"	"	"	-120	-5	-30	300	150	-0.5	-100	80	-3	-1	-10	10					170 *	3	20	49C		
* 605	"	RF. SW	"	-180	-5	-50	300	150	-1	-100	100	-6	-15	-10	10					100 *	4	40	49C		
* 606	"	PA	"	-100	-5	-700	0.7	150	-3	-80	100	-5	-200	-5	150					115 *	20	45 *	84B	2SC960 之對稱	
* 607	"	"	"	-100	-5	-700	1 W	150	-3	-80	80	-5	-300	-10	100					100 *	30	45 *	97B	2SC960 之對稱	
* 608	日 洋	RF. AF. SW	"	-30	-5	-100	100	125	-1	-25	150	-1	-10	-6	10					180 *	7	C _o F _{AB} 100pS	166		
* 609	"	RF. AF	"	-30	-5	-100	100	125	-1	-25	85	-6	-1	-6	1					80 *	7	C _o F _{AB} 100pS	166		
* 610	新日無	"	"	-30	-5	-100	150	125	-1	-20	100	-6	-1	-6			5000	1.5	20	170 *	3.3	C _o F _{AB} 50pS	29		
* 611	"	"	"	-60	-5	-100	150	125	-1	-20	100	-6	-1	-6	1		5000	1.5	20	170 *	3.3	C _o F _{AB} 50pS	29		
* 612	"	RF. SW	"	-90	-5	-50	150	125	-0.1	-20	100	-6	-1	-10	2					100 *	4	C _o F _{AB} 50pS	29		
* 613	日 電	PA	"	-60	-7	-1A	15W (T _a = 25°C)	150	-1mA	-40	80	-5	-500	-10	200					30 *	60	140 *	134	2SD150 之對稱	
* 614	"	"	"	-80	-7	-1A	15W (T _a = 25°C)	150	-1mA	-60	80	-5	-500	-10	200					30 *	60	140 *	134		
* 615																									
* 616	日 電	PA	Si. EMe	-80	-5	-3A	25W (T _a = 25°C)	150	-1mA	-60	70	-5	-1A	-10	200					15 *	100	60 *	134	2SD155 之對稱	
* 617	日 立	RF	Si. T	-150	-5	-50	200	175	-1	-100	80	-3	-15	-10	10					60 *	3.5	C _o F _{AB} 40pS	244		
* 618	"	"	"	-180	-5	-50	200	175	-1	-150	80	-3	-15	-10	10					60 *	3.5	C _o F _{AB} 40pS	244		
* 619																									
* 620	新日無	RF. AF. LN	Si. EP	-30	-5	-50	200	175	-50nA	-20	250	-6	-1	-6	0.3		50k	4	10	120 *	4.5	C _o F _{AB} 55pS	169		
* 621	"	RF. AF	"	-60		-200	400	175	-0.5	-20	80	-1	-50	-6	1		5000	1.5	20	200 *	6	C _o F _{AB} 50pS	84B		
* 622	"	SW	Si. EP 通孔型	-30	-10	-300	150	125	-0.1	-20	40,000	-6	-100			t _{on} < 600nS, t _{off} < 1.2μS t _{sig} < 600nS							194		

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)				電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)														外 形	備 考	
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_J ($^{\circ}\text{C}$)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB} (V)	直 流 及 脉 冲 下 之 h_{FE}			偏 置 情 况		h_{fe}	h_{ie} (Ω)	h_{re} ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} (μS)	f_{β} (MHz)	C_{ob} (pF)	T_{β} (ns)		
2SA623	三 菱	SW. PA	Si. EP	-35	-5	-1.5A	7 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-1	-25	100	-4	-500										132	2SC1013 之對稱
" 624	"	"	"	-50	-5	-1.2A	7 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-1	-25	100	-4	-500										132	2SC1014 之對稱
" 625	富士通	RF	"	-100	-6	-500	700 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	-1	-30	120	-2	-200	-10	10					100*	18	20	84B	
" 626	日 電	PA	Si. EMe	-80	-5	-5A	60W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-2mA	-60	50	-5	-2A	-10	200					15*	140	60*	102	2SD180 之對稱
" 627	"	"	"	-100	-5	-5A	60W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-2mA	-80	50	-5	-2A	-10	200					15*	140	60*	102	2SD188 之對稱
" 628	三 菱	RF. AF. SW	Si. EP	-30	-5	-100	150 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	-0.1	-25	200	-6	-1	-6	1		6500	0.3	14	100*	3.5	$C_{eT_{\beta}}$ 100pS	138B	再登錄
" 629	"	RF. AF. LN	"	-30	-5	-30	150 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	-0.1	-25	200	-6	-1	-6	1		6500	0.3	14	100*	3.5	$C_{eT_{\beta}}$ 60pS	138B	
" 630																								
" 631																								
" 632																								
" 633	日 電	PA	Si. E	-30	-5	-2A	10W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-10	-30	80	-5	-1A	-5	150					60*	60	10*	167	
" 634	"	"	"	-40	-5	-2A	10W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-100	-30	80	-5	-1A	-5	150					60*			167	2SC1096 之對稱
" 635	日 電	PA	"	-60	-5	-1A	10W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-10	-40	80	-5	-500	-5	150					50*	60	10*	167	
" 636	"	"	"	-90	-5	-1A	10W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-100	-40	80	-5	-500	-5	150					40*			167	2SC1098 之對稱
" 637	松 下	RF. AF	Si. TP	-150	-5	-50	300 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	-1	-100	150	-3	-15	-10	3	67	540	0.4	7.7	150*	4	$C_{eT_{\beta}}$ 150pS	49C	
" 638	日 電	"	Si. E	-150	-5	-50	250 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	-1	-100	100	-6	-15	-3	1		4000	0.9	6.5	100*	4	40	138	
" 639	"	"	"	-180	-5	-50	250 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	-1	-100	100	-6	-15	-3	1		4000	0.9	6.5	100*	4	40	138	
" 640	"	RF. LN	"	-50	-5	-30	250 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	-0.1	-40	300	-3	-0.5	-3	1		9200	2.7	3.3	100*	8	20*	138	2SC1222 之對稱
" 641	"	RF. AF	"	-50	-5	-30	250 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	-0.1	-40	300	-3	-0.5	-3	1		9200	2.7	3.3	100*	8	20*	138	2SC923 之對稱
" 642	"	RF. PA	"	-30	-5	-300	250 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	-0.1	-15	120	-1	-50	-3	50					200*	15	12	138	2SD227 之對稱
" 643	"	"	"	-40	-5	-500	500 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	-0.2	-25	120	-1	-100	-6	50					180*	24	10	44	2SD261 之對稱
" 644																								
" 645	三 菱	PA. SW	Si. EP	-70	-5	-800	7 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-10	-25	100	-4	-300										132	
" 646	"	"	"	-90	-5	-800	7 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-10	-25	100	-4	-300										132	
" 647	"	"	"	-110	-5	-800	7 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-10	-25	100	-4	-300										132	
" 648	日 電	PA	Si. EMe	-120	-5	-7A	60W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-2mA	-80	50	-5	-3A	-10	200					10*	200	30*	102	2SD217 之對稱
" 649	"	"	"	-150	-5	-7A	80W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-2mA	-80	50	-5	-3A	-10	200					10*	200	30*	102	2SD218 之對稱
" 650	"	"	"	-150	-5	-10A	100 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-1mA	-80	70	-5	-2A	-10	200					10*	500	20*	102	
" 651	"	"	"	-150	-5	-10A	100 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-1mA	-100	70	-5	-2A	-10	200					10*	500	20*	102	
" 652	"	"	"	-150	-6	-1A	15W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-1mA	-60	80	-5	-200	-10	200					15*	100	30*	134	
2SA653	日 電	PA	Si. EMe	-150	-6	-1A	15W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-1mA	-60	80	-5	-200	-10	200					15*	100	30*	134	
" 654																								
" 655																								
" 656	東 芝	PA	Si. EMe	-130	-5	-7A	50W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	100~300	60	-5	-1A	-10	1A					5*	250	20	102	2SC519A 之對稱
" 657	"	"	"	-100	-5	-7A	50W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	100~300	60	-5	-1A	-10	1A					5*	250	20	102	2SC520A 之對稱
" 658	"	"	"	-70	-5	-7A	50W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	100~300	60	-5	-1A	-10	1A					5*	250	20	102	2SC521A 之對稱
" 659																								
" 660																								
" 661	東 芝	RF. AF. PA	Si. EP	-70	-5	-200	600 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-0.1	-20	100	-2	-50	-10	10					100*	9	10	131	
" 662																								
" 663	東 芝	RF. AF. PA	Si. TMe	-100	-5	-7A	60W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-1mA	-50	80	-5	-1A	-5	1A					6*	600	15	102	2SC783 之對稱
" 664																								
" 665																								
" 666	松 下	RF. AF. LN	Si. EP	-25	-5	-50	150 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	-1	-10	250	-5	-2	-5	-2	200	5000	0.7	10	130*	2.8	$C_{eT_{\beta}}$ 160pS	138	
" 667																								
" 668	三 菱	RF. SW	Si. EP	-100	-5	-100	150 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	-0.1	-25	100	-6	1	-6	1		$t_{on} < 120\text{nS}$ $t_{off} < 100\text{nS}$			100*	3.5	$C_{eT_{\beta}}$ 100pS	138B	
" 669	"	SW	"	-160	-5	-100	150 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	-0.1	-25	70	-6	1										138B	
" 670	日 立	PA	Si. T	-50	-4	-3A	25W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-100	-20	100	-4	-1A	-4	500					11*	200	6*	158	2SC1060 之對稱
" 671	"	"	"	-50	-4	-3A	25W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-100	-20	100	-4	-1A	-4	500					11*	200	6*	159	2SC1061 之對稱
" 672	"	RF. LN	"	-50	-4	-200	200 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	-0.5	-18	110	-12	-2	-12	2					80*	16	12*	170	
" 673	日 立	RF	Si. EP	-35	-4	-500	400 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	-0.5	-20	130	-3	-10	-6	1					50*	7	12*	170	2SC1213 之對稱
" 674																								
" 675	日 電	AF. RF	Si. E	-80	-5	-100	250 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	-1	-60	120	-3	-20	-3	1		3200	0.9	11	100*	5	30	138	
" 676																								
" 677	SON	RF. SW	Si. E	-25	-5	-200	250 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	100	-0.5	-25	250	-3	-1	-6	2		$h_{fe} = 3\text{dB}$ ($f = 100\text{MHz}$)			6	$C_{eT_{\beta}}$ 60pS	168		
" 678	"	"	"	-50	-5	-200	320 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	120	-0.5	-25	250	-3	-1	-6	2		$h_{fe} = 3\text{dB}$ ($f = 100\text{MHz}$)			6	$C_{eT_{\beta}}$ 60pS	168		
" 679	東 芝	PA	Si. EMe	-120		-12A	100 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-100	-50	40~140	-5	-2A	-5	2A					6*	900	20	102	2SC1079 之對稱
" 680	"	"	"	-80		-12A	100 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-100	-50	40~140	-5	-2A	-5	2A					6*	900	20	102	2SC1080 之對稱
" 681	"	RF. PA	Si. EP	-100	-5	-1A	800 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-1	-30	120	-2	-150	-2	150					50*	40	10	164	
" 682	"	"	"	-80	-5	-750	800 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	-0.5	-30	70~240	-2	-150	-2	150					100*	15	15	164	2SC1382 之對稱

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)												外 形	備 考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CBO} 最大值		直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}				偏 置 情 况		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)			f _{αb} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie'(real)} * (Ω)
									(μA)	V _{CB(V)}	V _{CE(V)}	I _C (mA)	V _{CB(V)}	I _E (mA)	V _{CE(V)}										
2SA683	松下	PA	Si.EP	-30	-5	-1A	750	135	-0.1	-20	160	-10	-500	-10	50						200*	20	3.5*	165	
* 684	"	"	"	-60	-5	-1A	750	125	-0.1	-20	160	-10	-500	-10	50						200*	20	3.5*	165	
* 685	"	AF	Si.TP	-150	-5	-50	300	125	-1	-100	150	-3	-15	-10	3	67	540	0.4	77		100*	5	35	138	
* 686																									
* 687																									
* 688																									
* 689																									
* 690																									
* 691																									
* 692																									
* 693																									
* 694																									
* 695	三菱	RF.PA	Si.EP	-25	-4	-700	500	125	-1	-25	100	-1	-500	-6	10						150*	20	C _{r_{bb}} 100pS	138B	2SC1209 之對稱
* 696	"	"	"	-45	-4	-500	500	125	-1	-25	100	-2	-150	-6	10						150*	10	C _{r_{bb}} 100pS	138B	2SC1210 之對稱
* 697	"	"	"	-65	-4	-500	500	125	-1	-25	100	-2	-150	-6	10						150*	10	C _{r_{bb}} 100pS	138B	2SC1211 之對稱
* 698	"	PA.SW	"	-130	-5	-800	7 W (T _c =25°C)	150	-10	-25	100	-4	-300			t _{on} <200nS, t _{off} <800nS t _{sig} <600nS							132		
* 699	松下	PA	"	-40	-5	-2A	10 W (T _c =25°C)	150	-1	-20	120	-5	-1A	-5	500						150*	50	3.3*	161	2SC1226 之對稱
* 700	日立	"	Si.E	-35		-1.5A	8 W (T _c =25°C)	150	-10	-35	100	-2	-200	-4	500						11*	200	6*	159	
* 701	三 洋	RF.LN	Si.EP	-30	-5	-50	100	125	-1	-25	200	-6	-1	-6	1		2200	0.5	7	80*	12	C _{r_{bb}} 100pS	166		
* 702	"	"	"	-50	-5	-50	100	125	-1	-45	200	-6	-1	-6	1		2200	0.5	7	80*	12	C _{r_{bb}} 100pS	166		
* 703	三 菱	SW.PA	"	-25	-5	-1.5A	7 W (T _c =25°C)	150	-1	-16	100	-4	-500			t _{on} <0.2μS, t _{off} <0.8μS t _{sig} <0.6μS							132	2SC1243 之對稱	
* 704	SQN	RF.AF.LN SW	Si.Eme	-25	-5	-200	250	100	-0.5	-25	250	-3	-1	-6	1		6600	0.76	16.2	h _{re} =3dB (100MHz)		C _{r_{bb}} 60pS	168		
* 705	"	"	Si.E	-50	-5	-200	320	120	-0.5	-25	250	-3	-1	-6	1		h _{re} =3dB (f=100MHz)				6	C _{r_{bb}} 60pS	168		
* 706	"	RF	Si.DB	-60	-6	-1A	950	120	-1	-50	150	-2	-100	-10	10						120*	10	C _{r_{bb}} 150pS	174	
* 707	日 電	RF.PA	Si.E	-40	-5	-500	750	135	-0.2	-25	120	-1	-100	-3	50						180*	24	10	177	
* 708	"	RF	"	-80	-8	-700	800	150	-0.1	-60	150	-2	-50	-10	50						50*	25	25*	84B	
* 709																									
* 710	日 電	RF.SW	Si.E	-50	-5	-100	300	150	-0.1	-30	120	-1	-10	-10	10		t _{on} <80nS, t _{off} <180nS t _{sig} <140nS				600*	2.5	34*	49C	
* 711	"	"	"	-50	-5	-100	300	150	-0.1	-30	120	-1	-10	-10	10		t _{on} <70nS, t _{off} <170nS t _{sig} <130nS				1000*	2.5	34*	49C	
* 712	"	"	"	-150	-5	-500	750	175	-0.1	-100	110	-10	-50	-10	50						350*	5.5	11*	84B	
2SA713	日 電	RF	Si.E 邊林結構	-15	-10	-300	250	125	-0.1	-10	20,000	-5	-100	-10	10						180*	6	200*	138	
* 714																									
* 715	日 立	RF.PA	Si.EP	-35	-5	-1.5A	10 W (T _c =25°C)	150	-20	-35	130	-2	-500	-2	200						160*	35	9*	160	
* 716																									
* 717	日 電	RF.SW	Si.EP	-60	-5	-1A	800	175	-0.1	-40	80	-10	-50	-10	50						260*	18	10*	84B	
* 718	"	"	"	-60	-8	-200	300	150	-0.1	-40	140	-1	-10	-10	10						220*	6	30*	49C	
* 719	松下	PA	"	-30	-5	-500	400	125	-0.1	-20	160	-10	-150	-10	50						200*	6	3.5*	138	2SC1317 之對稱
* 720	"	"	"	-50	-5	-500	400	125	-0.1	-20	160	-10	-150	-10	50						200*	6	3.5*	138	2SC1318 之對稱
* 721	"	RF.LN	"	-35	-5	-50	150	125	-0.1	-10	540	-5	-2	-5	2		3500	3	60	250*	5	100	138		
* 722	"	"	"	-55	-5	-50	150	125	-0.1	-10	540	-5	-2	-5	2		3500	3	60	250*	5	100	138		
* 723	日 電	RF.PA	Si.E	-40	-5	-500	250	125	-0.2	-25	120	-1	-100	-3	50						180*	24	10	138	2SD1327 之對稱
* 724	"	RF	"	-35	-5	-50	250	125	-0.1	-25	150	-10	-0.5	-1	10						300*	3.5	20*	138	
* 725	三 菱	RF.AF.LN	Si.EP	-35	-5	-100	150	125	-0.1	-25	500	-6	-1	-6	1		15k	1.2	28	100*	3	C _{r_{bb}} 140pS	138B		
* 726	"	"	"	-50	-5	-100	150	125	-10	-50	500	-6	-1	-6	1		15k	1.2	28	100*	3	C _{r_{bb}} 60 pS	138B		
* 727																									
* 728	三 菱	RF.AF	Si.EP	-30	-5	-100	100	125	-0.1	-25	200	-6	-10	-6	1		6500	0.3	14	100*	3.5	C _{r_{bb}} 100pS	175		
* 729																									
* 730	松下	PA	Si.EP	-30	-5	-500	600	125	-0.1	-20	160	-10	-150	-10	50						200*	6	3.5*	171	
* 731	"	"	"	-60	-5	-500	600	125	-0.1	-20	160	-10	-150	-10	50						200*	6	3.5*	171	
* 732	富士通	RF	"	-40	-4	-300	650	175	-0.1	-10	60	-10	-10	-10	10						200*	4.5	50*	84B	
* 733	日 電	RF.AF	Si.E	-50	-5	-100	250	125	-0.1	-40	200	-6	-1	-6	1		5500	7.5	28	180*	8	12	138	2SC945 之對稱	
* 734																									
* 735																									
* 736																									
* 737																									
* 738	日 立	RF.PA	Si.E	-25	-5	-1.5A	8 W (T _c =25°C)	150	-20	-25	130	-2	-500	-2	200						160*	35	9*	160	2SC1368 之對稱
* 739	東 芝	SW	Si.TMe	-400	-5	-3A	50 W (T _c =25°C)	150	-100	-300	20~300	-5	-500	-50								100		102	
* 740	"	RF.PA	"	-150	-5	-1.5A	25 W (T _c =25°C)	150	-20	-100	75	-10	-500	-10	500						5*	100	25	119	
* 741	日 立	SW	Si.EP	-20	-4	-100	360	175	-0.2	-16	70	-0.5	-30	-10	10		t _{on} <70nS, t _{off} <120nS t _{sig} <100nS				350*			49C	
* 742	"	"	"	-55	-5	-500	700	175	-0.5	-20	130	-1.6	-100				t _{on} <40nS, t _{off} <100nS t _{sig} <80nS							84B	

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)												外 形	備 考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CB0} 最大値		直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}		偏 置 情 况		h _{FE}	h _{ie} h _{ib} ※ (Ω)	h _{re} h _{rb} ※ (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} ※ (μU)	f _β f _T ※ (Mc)	C _π (pF)			r _{bb} (real)※ (Ω)		
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)											
2SA743	日 立	RF. PA	Si. E	-50	-4	-1A	8 W (T _c =25℃)	150	-1mA	-50	120	-4	-50	-4	30				120*	30	4*	160	2SC1212 之封裝		
" 744	SAK	PA	Si.EMe	-80	-6	-8A	70W (T _c =25℃)	150	-1mA	-80	60	-4	-3A	-12	500				10*	220	10*	102			
" 745	"	"	"	-100	-6	-8A	70W (T _c =25℃)	150	-1mA	-100	60	-4	-3A	-12	500				10*	220	10*	102			
" 746	"	"	"	-80	-6	-10A	100W (T _c =25℃)	150	-1mA	-80	60	-4	-3A	-12	500				10*	255	10*	102			
" 747	"	"	"	-120	-6	-10A	100W (T _c =25℃)	150	-1mA	-120	60	-4	-3A	-12	500				10*	255	10*	102			
" 748	松 下	RF. PA	Si. EP	-70	-5	-2A	15W (T _c =25℃)	150	-1	-40	130	-5	-1A	-5	500				150*	50	3*	172			
" 749	"	SW	"	-100	-5	-50	250	125	-0.1	-50	80	-1	-20	-10	10			t _{on} < 350nS, t _{off} < 150nS t _{avg} < 200nS	>40*			138			
" 750	日 電	RF. AF	Si. E	-50	-5	-30	250	125	-0.1	-40	300	-3	-0.5	-6	1			4200	2.7	33	100*	8	20*	138	
" 751	松 下	PA	Si. EP	-30	-5	-1A	1 W	135	-0.1	-20	160	-10	-500	-10	50				200*	20	3.5*	173			
" 752	"	"	"	-60	-5	-1A	1 W	135	-0.1	-20	160	-10	-500	-10	50				200*	20	3.5*	173			
" 753	日 立	"	Si. T	-140	-5	-10A	100W (T _c =25℃)	150	-1mA	-30	100	-5	-1A	-5	1 A				20*	220	7*	102	2SC1343 之封裝		
" 754	"	"	"	V _{CB0} -50	-4	-2A	20W (T _c =25℃)	150	-100	-20	35-120	-4	-1A									158	2SC1418 之封裝		
" 755	"	"	"	V _{CB0} -50	-4	-2A	20W (T _c =25℃)	150	-100	-20	35-120	-4	-1A									159	2SC1419 之封裝		
" 756	"	"	"	-100	-6	-6A	50W (T _c =25℃)	150	-1mA	-30	80	-5	-1A	-5	1 A				20*	240	12*	102	2SC1030 之封裝		
" 757	"	"	"	-120	-6	-7A	60W (T _c =25℃)	150	-1mA	-30	100	-5	-1A	-5	1 A				20*	250	10*	102	2SC897 之封裝		
" 758	"	"	"	-130	-5	-7A	80W (T _c =25℃)	150	-1mA	-30	100	-5	-1A	-5	1 A				20*	250	10*	102	2SC898 之封裝		
" 759	日 電	RF. PA	Si. E	-60	-5	-200	150	125	-0.1	-45	180	-1	-50	-10	10				200*	8.5	20	176			
" 760	"	"	"	-50	-5	-30	150	125	-0.1	-40	350	-3	-0.5	-3	1				100*	8	20*	176			
" 761	SON	"	Si. EP	-110	-5	-2A	6.3 W (T _c =25℃)	120	-10	-50	100	-2	-400	-2	200				80*	50	C _π r _{bb} 98pS	181			
" 762	"	"	"	-110	-5	-2A	1.5 W	150	-10	-50	100	-2	-400	-2	200				80*	50	C _π r _{bb} 95pS	99			
" 763	新日無	RF. AF. LN	"	-30	-5	-50	200	125	-50nA	-20	250	-6	-1	-6	0.3			50 k	4	10	120*	4.5	C _π r _{bb} 55pS	138	
" 764	SAK	PA	Si.TMe	-60	-6	-6A	40W (T _c =25℃)	150	-1mA	-60	80	-4	-1A	-10	500				10*	90	8*	99			
" 765	"	"	"	-80	-6	-6A	40W (T _c =25℃)	150	-1mA	-80	80	-4	-1A	-10	500				10*	90	8*	99			
" 766	松 下	"	Si. Me	-150	-5	-400	20W (T _c =25℃)	150	-30	-60	60	-5	-100	-10	100				20*	100	25	99			
" 767	東 芝	RF	Si. EP	-55	-5	-100	200	150	-0.1	-30	120	-1	-10	-10	1				150*	5	20	195			
" 768																									
" 769																									
" 770																									
" 771																									
" 772	SON	RF. PA	Si. EP	-16	-6	-2A	750	120	-0.2	-16	350	-2	-100	-2	-10				60*	50	C _π r _{bb} 600pS	259			
2SA773	SON	RF. PA	Si. EP	-50	-6	-1A	750	120	-0.2	-25	250	-2	-100	-2	10				65*	25					
" 774	松 下	RF. LN	Si. EP	-35	-5	-50	150	175	-0.1	-10	540	-5	-2	-5	2			3500	3	60	120*	5	100	54	
" 775																									
" 776	東 芝	RF. LN	Si. EP	-55	-5	-50	200	150	-0.1	-30	300	-6	-2	-6	1	285	7300	1	21	180*	3	35	195		
" 777	松 下	PA	"	-80	-5	-500	750	135	-0.1	-20	160	-10	150	-10	50				120*	20	2 k	165			
" 778	日 立	RF	Si. T	-150		-50	200	125	-1	-100	80	-3	-15	-10	10				60*	4	C _π r _{bb} 40pS	170			
" 779	"	RF. PA	Si. EP	-35	-5	-1.5A	10W (T _c =25℃)	150	-20	-30	150	-2	-50	-2	200				110*	50	9*	234			
" 780	"	RF	Si. P	-50	-4	-1A	10W (T _c =25℃)	150	-1	-30	120	-4	-50	-4	50				120*	8	50*	234			
" 781	"	SW	Si. EP	-20	-4	-200	200	125	-0.2	-16	80	-0.5	-30	-1	10			t _{on} < 80nS, t _{off} < 160nS t _{avg} < 100nS	650*	25	C _π r _{bb} 32pS	170			
" 782	東洋電機	RF. Conv. Mix Osc. PA. AF	"	-80	-5	-30	150	125	-1	-50	150	-6	-1	-6	1			7.1k	0.4	6.7	200*	3	C _π r _{bb} 160pS	235	
" 783	"	"	"	-50	-5	-30	150	125	-1	-30	150	-6	-1	-6	1			7.1k	0.4	6.7	200*	3	C _π r _{bb} 160pS	235	
" 784	"	"	"	-25	-5	-30	150	125	-1	-15	130	-6	-1	-6	1			7.1k	0.4	6.7	200*	3	C _π r _{bb} 160pS	235	
" 785	"	"	"	-80	-5	-50	150	125	-1	-50	150	-3	-10	-6	1			6.7k	0.8	10	180*	6.5	C _π r _{bb} 150pS	235	
" 786	"	"	"	-50	-5	-50	150	125	-1	-30	150	-3	-10	-6	1			6.7k	0.8	10	180*	6.5	C _π r _{bb} 150pS	235	
" 787	"	"	"	-20	-5	-50	150	125	-1	-15	150	-3	-10	-6	1			6.7k	0.8	10	180*	6.5	C _π r _{bb} 150pS	235	
" 788	"	RF. Conv. Mix Osc. PA. AF. LN	"	-50	-5	-30	150	125	-1	-30	150	-3	-10	-6	1			NF= 2dB (f=1kHz)	7.1k	0.4	6.7	200*	3	C _π r _{bb} 160pS	235
" 789	"	"	"	-25	-5	-30	150	125	-1	-15	150	-3	-10	-6	1			NF= 2dB (f=1kHz)	7.1k	0.4	6.7	200*	3	C _π r _{bb} 160pS	235
" 790	"	RF. Conv. Mix Osc. PA	"	-40	-6	-300	300	125	-1	-24	10,000	-5	-100	-5	10				200*	5.5	C _π r _{bb} 100pS	235			
" 791	"	"	"	-25	-6	-300	300	125	-1	-15	10,000	-5	-100	-5	10				200*	5.5	C _π r _{bb} 100pS	235			
" 792																									
" 793																									
" 794	松 下	PA	Si. EP	-100	-5	-500	1.2 W	150	-1	-100	160	-10	-150	-10	50				120*	20	3.5k	222			
" 795	"	"	"	-150	-5	-250	10W (T _c =25℃)	150	-30	-60	120	-10	-100	-10	50				120*	15	15	236			
" 796	新日無	SW	"	-30	-10	-300	300	125	-0.1	-20	40,000	-6	-100					t _{on} < 600nS, t _{off} < 1.2μS t _{avg} < 600nS				138			
" 797																									
" 798	三 菱	Diff. LN	Si. EP	-50	-5	-100	200 unit	125	-0.1	-35	250- 1200	-6	1	-6	1			ΔV _{BE} = 10mVmax h _{FE} 小/h _{FE} 大 = 0.8	100*	3.0		276			
" 799																									
" 800																									
" 801																									
" 802																									

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)													外 形	備 考		
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大值		直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}				偏 置 情 况		h _{FE} h ₁₈ *	h _{ie} h ₁₈ * (Ω)	h _{re} h ₁₈ * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h ₁₈ * (μU)	f _{sk} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie} (real) * (Ω)
									-A	V _{CB} (V)	V _{CB} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)											
2SA803																									
" 804																									
" 805																									
" 806																									
" 807																									
" 808																									
" 809	富士通	RF	Si.EP	-150	-5	-50	700	175	-1	-140	150	-5	-10	-5	10	t _{on} <1μS t _{off} <9.5μS		t _{on} /t _{off} <10μS			100 *	3	70 *	248	
" 810	"	"	"	-150	-5	-50	700	175	-1	-140	150	-5	-10	-5	10	t _{on} <1μS t _{off} <9.5μS		t _{on} /t _{off} <10μS			100 *	3	70 *	248	
" 811	日 電	RF. AF	Si.PaE	-50	-5	-30	150	125	-0.05	-40	400	-3	-0.5	-3	1	9200		2.7		33	100 *	8	20 *	176	
" 812	"	"	Si.E	-50	-5	-100	150	125	-0.1	-40	200	-6	-1	-6	10	5500		7.5		28	180 *	8	C _o r _{bb'} 35pS	176	
" 813	"	RF. PA	"	-60	-5	-200	150	125	-0.1	-45	80	-1	-50	-10	10						200 *	8.5	20	176	
" 814	東 芝	"	Si.Eb	-120		-750	1.5W	150	-0.5	-50	130	-2	-150	-2	150						25 *	30	5	119	
" 815	"	"	"	-100		-750	1.5W	150	-0.5	-50	130	-2	-150	-2	150						25 *	30	5	119	
" 816	"	"	Si.EP	-80		-750	1.5W	150	-0.5	-30	130	-2	-150	-2	150						100 *	20	5	119	
" 817	"	"	"	-70		-750	600	150	-0.1	-20	130	-2	-50	-2	50						150 *	9	5	131	
" 818	"	"	Si.TP	-180		-50	1 W	150	-1	-100	130	-5	-10	-10	10						120 *	4.5	10	249	
" 819																									
" 820																									
" 821																									
" 822																									
" 823																									
" 824																									
" 825																									
" 826																									
" 827																									
" 828																									
" 829																									
" 830																									
" 831																									
" 832																									
2SA833																									
" 834																									
" 835																									
" 836																									
" 837	松 下	RF.PA	Si.EMe	-80	-5	-4A	50W (T _c =25°C)	150	-1mA	-50	100	-4	-1A	-10	500						10 *	200	10	102	
" 838	"	"	"																						
" 839	東 芝	RF.PA	Si.TMe	-150	-5	-1.5A	25W (T _c =25°C)	150	-20	-100	100	-10	-500	-10	500						5 *	100	25	268	
" 840																									
" 841																									
" 842																									
" 843	松 下	RF.PA	Si.EMe	-200	-5	-500	20W (T _c =25°C)	150	-500	-200	120	-10	-400	-10	200						35 *	80	25	268	
" 844																									
" 845																									
" 846																									
" 847	三 菱	AF, LN, RF	Si.EP	-90	-5	-50	200	125	-0.1	-50	250~ 1200	-6	1	-6	1						100	2.5		138B 2SC1706 之耐熱	
" 848																									
" 849																									
" 850	三 菱	AF.Drive	Si.EP	-100	-5	-300	800	135	-1	-50	55~300	-6	-10	-6	10						130 *			242	
" 851																									
" 852																									
" 853																									
" 854																									
" 855																									
" 856																									
" 857																									
" 858																									
" 859	ALP	RF	Si.E	-300	-5	-500	625	150	-0.25	-200	125	-10	-10	-20	10						120 *	3	C _o r _{bb'} 300pS	138D MPSA92	
" 860	"	"	"	-200	-5	-500	625	150	-0.25	-160	125	10	-10	-20	10						120 *	3	C _o r _{bb'} 300pS	138D MPSA93	
" 861																									
" 862																									

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)														外 形	備 考	
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CB0} 最大値		直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}				偏 置 情 况		h _{fe}	h _{ie} * (Ω)	h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{os} * (μU)	f _{βT} * (Mc)	C _{ob} (pF)			r _{bb} * h _{ie} (res) * (Ω)
									I _{CB0}	V _{CB(V)}	V _{CE(V)}	I _C (mA)	V _{CB(V)}	I _E (mA)	h _{fs} *										
★ 2SB 12	富士通	AF	Ge. A	-30		-50	50	70	-15	-30					-6	1	-0.98	30 *	3.5 *	0.4 *	0.8		61	2S113	
" 13	"	"	"	-30		-50	100	70	-15	-30					-6	1	-0.98	30 *	3.5 *	0.4 *	0.8		61	2S114	
" 14	"	LN	"	-30		-50	100	70	-15	-30					-6	1	-0.98	30 *	3.5 *	0.4 *	0.8	NF = 5 dB (f = 1kc)	61	2S115	
" 15	"	AF	"	-60		-50	100	70	-15	-60					-6	1	-0.98	30 *	3.5 *	0.4 *	0.8		61	2S116	
" 16	"	PA	"	-16		-600	1.8W (T _J = 25℃)	70	-20	-5	50	-2	-50										93	2S119	
" 16A	"	"	"	-20		-600	1.8W (T _J = 25℃)	70	-20	-5	50	-2	-50										93		
" 17	"	"	"	-32		-600	1.8W (T _J = 25℃)	70	-20	-5	50	-2	-50										93	2S120	
" 17A	"	"	"	-40		-600	1.8W (T _J = 25℃)	70	-20	-5	50	-2	-50										93		
" 18	"	"	"	-60		-600	1.8W (T _J = 25℃)	70	-20	-5	50	-2	-50										93	2S121	
" 18A	"	"	"	-80		-600	1.8W (T _J = 25℃)	70	-20	-5	50	-2	-50										93		
" 19	"	"	"	-16		-2.5A	5.5W (T _J = 25℃)	70	-100	-5	50	-2	-50										94	2S122	
" 20	"	"	"	-32		-2.5A	5.5W (T _J = 25℃)	70	-100	-5	50	-2	-50										94	2S123	
" 21	"	"	"	-60		-2.5A	5.5W (T _J = 25℃)	70	-100	-5	50	-2	-50										94	2S124	
" 22	三 洋	"	"	-25	-12	-200	300	85	-15	-20	100	-1.5	-100								1		63	2SD30 之對稱	
" 23	"	AF	"	-15	-5	-10	40	75	-10	-15					-6	1	70	3000	6	30	1.5		12A		
" 24	"	"	"	-15	-10	-15	100	75	-15	-15					-6	1	70	3000	6	30	1.5	12		6	
" 25	東 芝	PA	"	-60	-12	-1.5A	20 W (T _J = 25℃)	75	-160	-12	60	-1.5	-1A	-1.5	500						0.25		102	2S26A	
" 26	"	"	"	-32	-12	-1.5A	20 W (T _J = 25℃)	75	-160	-12	60	-1.5	-1A	-1.5	500						0.25		102	2S 26	
★ 26A	"	"	"	-60	-12	-1.5A	20 W (T _J = 25℃)	75	-160	-12	60	-1.5	-1A	-1.5	500						0.25		102		
" 27	SON	"	"	-15	-10	-0.5A	5 W (T _J = 25℃)	85	-800	-15	29	-1.5	-200								f _{αβ} = 7kc	200	103	2T305	
" 28	"	"	"	-15	-10	-0.5A	5 W (T _J = 25℃)	85	-800	-15	68	-1.5	-200								f _{αβ} = 7kc	200	103	2T305	
" 29	"	"	"	-15	-10	-0.5A	5 W (T _J = 25℃)	85	-800	-15	115	-1.5	-200								f _{αβ} = 7kc	200	103	2T305	
" 30	"	"	"	-15	-10	-0.5A	5 W (T _J = 25℃)	85	-800	-15	68	-1.5	-200								f _{αβ} = 7kc	200	103	2T306	
" 31	"	"	"	-15	-10	-0.5A	5 W (T _J = 25℃)	85	-800	-15	115	-1.5	-200								f _{αβ} = 7kc	200	103	2T306	
" 32	富士通	AF	"	-20	-2.5	-50	150	85	-14	-12					-9		40	1500	4.2	16.5	0.8		12A	2S 32	
" 33	"	PA	"	-20	-2.5	-50	150	85	-14	-12	70	-1	-50	-6	1	80	2600	5.5	20.8	1		12A	2SD33 之對稱		
" 34	"	"	"	-20	-2.5	-150	250	85	-14	-12	70	-1	-150	-6	1	85	2450	4.9	22.5	0.8		71A	2SD34 之對稱		
" 37	"	"	"	-30	-12	-50	150	85	-14	-30	70	-1	-50	-6	1	80	2600	5.5	20.8	1		12A	2SD37 之對稱		
" 38	"	"	"	-30	-12	-150	250	85	-16	-30	70	-1	-150	-6	1	85	2450	4.9	22.5	0.8		71A	2SD38 之對稱		
" 39	"	LN	"	-10	-10	-2	50	85	-10	-10					-4	0.5	65	3570	9.44	25	NF = 4 dB (f = 1kc)		12A	2S 39	
★ 2SB 40	東 芝	SW	Ge. A	-40	-12	-100	80	75	-10	-12	100	-1	-100	-6	1						t _r = 0.55μS, t _f = 0.35μS t _s = 0.6μS	>0.7	<50	<180	12A
" 41	富士通	PA	"	-40	-12	-1.2A	44 W (T _J = 25℃)	91	-2mA	-30	65	-1.5	-1A	-14.4	50						PG = 30 dB P _O = 10 W (B級 PP Z _L = 24Ω)		102	2S 41	
" 42	"	"	"	-60	-12	-1.2A	44 W (T _J = 25℃)	91	-2mA	-30	65	-1.5	-1A	-14.4	50						PG = 30 dB P _O = 10 W (B級 PP Z _L = 24Ω)		102	2S 42	
★ 43	東 芝	"	"	-25	-12	-50	150	75	-10	-12	70	-1	-50	-6	1						1	35	12A		
" 43A	"	"	"																				12A		
" 44	"	AF	"	-30	-12	-50	80	75	-10	-12					-6	1	85	2500	5	30	>0.5	30	12A	2S, 44	
" 46	"	"	"	-25	-12	-50	80	75	-5	-12					-6	1	140	4200	6	30		35	12A	2S 46	
" 47	"	LN	"	-25	-12	-50	80	75	-14	-25					-6	1	140	4200	6	30	NF < 5 dB (f = 1kc)		12A	2S 47	
★ 48	SON	AF. PA	"	-16		-100	140	65	-16	-16	43	-1	-20	-6	1	-0.973	28 *	8 *	0.6 *	2.5	25		84A	2T 31	
" 49	"	"	"	-16		-100	140	65	-16	-16	83	-1	-20	-6	1	-0.985	28 *	8 *	0.6 *	3.0	25		84A	2T 31	
" 50	"	"	"	-16		-100	140	65	-16	-16	131	-1	-20	-6	1	-0.990	28 *	8 *	0.6 *	3.5	25		84A	2T 31	
" 51	"	PA	"	-30	-3	-200	200	85	-16	-25	43	-1	-20	-6	1	-0.973	28 *	8 *	0.6 *	2.0	25		84A	2T 32	
" 52	"	"	"	-30	-3	-200	200	85	-16	-25	83	-1	-20	-6	1	-0.985	28 *	8 *	0.6 *	3.0	25		84A	2T 32	
" 53	"	"	"	-30	-15	-250	200	85	-10	-30	70	-1	-20	-6	1	-0.982	28 *	7 *	0.6 *	3.0	25		84A	2T 38	
" 54	東 芝	AF	"	-30	-12	-150	150	75	-14	-30					-6	1	140	4200	6	30	1 *	35	120	12A	2S 54
" 55	"	PA	"	-60	-12	-50	150	75	-14	-25	80	-1	-50	-6	1						1	35		12A	2S56A
" 56	"	"	"	-30	-12	-150	150	75	-14	-30	80	-1	-50	-6	1						1	35	120	12A	2S 56
★ 56A	"	"	"	-45	-12	-150	150	75	-14	-25	80	-1	-50	-6	1						1	35		12A	
" 57	富士通	AF	"	-30	-10	-100	100	70	-15	-30					-6	1	70	30 *	3 *	0.3 *			78		
" 58	"	"	"	-12	-2.5	-50	100	70	-15	-12					-6	1	-0.98	30 *	3 *	0.3 *			78		
" 59	"	SW	"	-30	-10	-100	150	85	-15	-30	70	-1	-50										12A		
" 60	"	AF	"	-20	-2.5	-50	150	85	-14	-12					-6	1	70	30 *	3 *	0.3 *			12A		
★ 60A	"	"	"	-20	-2.5	-50	150	85	-14	-12	70	-1	-50										12A		
" 61	"	"	"	-30	-12	-50	150	85	-10	-30					-6	1	85	3000	7	30	1	40	12A	2S 61	
" 62	東 芝	PA	"	-60	-12	-500	2 W (T _J = 35℃)	75	-70	-12	60	-1	-500	-1	100						0.4		101		
" 63	"	"	"	-32	-12	-500	2 W (T _J = 35℃)	75	-70	-12	60	-1	-500	-1	100						0.4		101		
" 64	"	"	Ge. D	-100	-1	-6A	25 W (T _J = 25℃)	75	-330	-12	70	-1.5	-1A	-1.5	500						1		102		
" 65	富士通	SW	Ge. A	-30	-12	-100	150	85	-15	-30					-6	1	65	t _r = 3μS, t _f = 4μS t _s = 3μS			1	40	12A	2S 65	
" 66	日 立	AF	"	-30	-12	-50	100	85	-15	-30					-6	1	-0.984	30 *	<8 *	0.38 *	PG > 24 dB (f = 1kc)		12A	2S 11 2N215C	
" 67	"	PA	"	-55	-12	-150	350 (脈動負荷)	70	-10	-12	63	-1	-150	-6	1	45	1360	2.1	21	1	45	70	66	2S193 HJ 43	

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)														外 形	備 考
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _c (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大值 (μA)	V _{CE(V)}	直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE} I _C (mA)	偏 置 情 况 V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{FE} h _{FS} *	h _{ie} h _{ib} *	h _{re} h _{rb} *	h _{oe} h _{ob} *	f _β f _T *	C _{ob} (pF)	r _{ib} (real) (Ω)				
2SB 68	日 立	SW	Ge. A	-105	-50	-100	50	85	-14	-2.5	60	-0.35 - 5	-4	500							84A	2N398		
★ 69	東 芝	PA	Ge. D	-60	-1	-6A	25W (T _c =85°C)	75	-330	-12	70	-1.5 - 1A	-1.5	500			1				102			
★ 70	松 下	AF	Ge. A	-30	-10	-10	125	75	-12	-10		-2	0.5	30	2200	9	23	f _β =15kc			20	OC 70		
★ 71	"	"	"	-30	-10	-10	125	75	-12	-10		-2	3	50	800	5.4	80	f _β =15kc			20	OC 71		
★ 73	日 立	LN	"	-10	-10	-2	20	85	-7	-10		-4	0.5	65	3900	3.8	11.8	NF < 6 dB (f = 1kc)			12A	2N220		
★ 74	"	AF	"	-16	-0.5	-15	80	85	-6	-12		-6	1	48							12A	2S148 HJ 62		
★ 75	"	"	"	-25	-12	-100	150	85	-14	-30	65	-1.5 - 50	-6	1	55	1750	3	17.5	2		12A	2S175 之封端		
★ 75A	"	"	"	-45	-12	-100	150	85	-25	-45	65	-1.5 - 50	-6	1	55	1750	3	17.5	2		12A			
★ 76	"	"	"	-12	-2.5	-100	150	85	-14	-12	65	-1.5 - 50	-6	1	55	1750	3	17.5	2		12A	2N406		
★ 77	"	PA	"	-25	-12	-100	150	85	-14	-25	85	-1 - 50	-6	1	70	1900	3.8	26	2		12C	2SD77 之封端		
★ 77A	"	"	"	-45	-12	-100	150	85	-25	-45	85	-1 - 50	-6	1	70	1900	3.8	26	2		12C	2SD77A 之封端		
★ 78	"	"	"	-12	-2.5	-100	150	85	-14	-12	85	-1.5 - 50	-6	1	70						12A	2N408 HJ 51		
★ 79	"	"	"	-25	-12	-150	250	85	-16	-30	70	-1 - 150									70	2S 91 HJ34A		
★ 80	"	"	"	-25	-10	-1A	4 W (T _c =41°C)	85	-100	-12	70	-1.5 - 0.5A									101	2S177 HJ 36		
★ 81	"	"	"	-80	-12	-0.5A	2 W (T _c =85°C)	85	-50	-50	45	-2 - 100	-6	100	40	40	6	1200	0.5	40	101	2S177 HJ 47		
★ 82	"	"	"	-100	-12	-0.5A	2 W (T _c =85°C)	85	-35	-50	40	-2 - 100	-6	100	40	40	6	1200	0.5	40	101	2S177 HJ 47		
★ 83	"	"	"	-40	-10	-3A	11 W (T _c =85°C)	91	-3mA	-40	70	-1.5 - 0.7A									103	2N301		
★ 84	"	"	"	-60	-10	-3A	11 W (T _c =85°C)	91	-3mA	-60	70	-1.5 - 0.7A									103	2N301A		
★ 85	"	"	"	-40	-20	-10A	50 W (T _c =85°C)	91	-3mA	-40	30	-1.5 - 4A									103	HS102		
★ 86	"	"	"	-60	-20	-10A	50 W (T _c =85°C)	91	-3mA	-60	30	-1.5 - 4A									103	HS102		
★ 87	"	"	"	-80	-60	-10A	50 W (T _c =85°C)	91	-3mA	-80	30	-1.5 - 4A									103	HS102		
★ 88	"	"	"	-100	-60	-10A	50 W (T _c =85°C)	91	-3mA	-100	30	-1.5 - 4A									103	HS102		
★ 89	"	"	"	-25	-12	-150	250	85	-16	-25	70	-1 - 150	-6	1	55	1800	3.3	20			71A			
★ 89A	"	"	"	-45	-12	-150	250	85	-50	-45	70	-1 - 150	-6	1	55	1800	3.3	20			71A			
★ 90	東 芝	AF	"	-18	-12	-5	40	75	-14	-18		-6	1	70	30*	3.5*	0.4*	> 1	12		5			
★ 91	"	PA	"	-18	-12	-30	40	75	-14	-18	70	-1 - 30	-6	1				> 1			5			
★ 92	松 下	"	"	-32	-10	-125	125	75	-12	-10	50	-1 $I_B = -2mA$	-6	10				0.35			16	OC 72		
★ 93	"	AF	"	-30		-10	125	75	-12	-20		-2	3	90							20	MC 75		
★ 94	東 芝	PA	"	-25	-12	-50	150	75	-14	-25	80	-1 - 50	-6	1				1	35		12A	2S 56		
★ 95	"	"	"	-25	-12	-50	150	75	-14	-30	60	-1 - 50									12A			
2SB 96	松 下	PA	Ge. A	-32	-10	-125	125	75	-12	-10	80	-1 $I_B = -2mA$									16	OC 76		
★ 97	東 芝	LN	"	-18	-12	-5	40	75	-14	-30		-6	1	70	NF = 4 dB (V _{CE} = -3V, I _E = 0.5mA, f = 1kc)						5			
★ 98	日 電	AF	"	-30		-50	125	75	-20	-6	35	-1 - 50	-6	1	40	30*	3.5*	0.3*	1	35	84A	ST340		
★ 99	"	AF	"	-30		-50	125	75	-20	-6	130	-1 - 50	-6	1	120	30*	3.5*	0.25*	1.5	35	84A	ST340		
★ 100	"	LN	"	-30	-10	-50	100	75	-10	-30		-6	1	60	30*	2.5*	0.3*	1.2	NF = 3.5dB (f = 1kc)		84A	2S100 ST34H		
★ 101	"	AF, PA	"	-30	-10	-50	125	75	-10	-30		-6	1	60	30*	2.5*	0.3*	1.2	35		84A	2S101 ST34F		
★ 102	"	"	"	-30	-10	-50	180	75	-10	-30		-6	1	60	30*	2.5*	0.3*	1.2	35		91	2S102 ST34FR		
★ 103	"	"	"	-30	-10	-100	125	75	-10	-30	70	-1 - 50	-6	1		$P_D = 400mW/B級 PP$ $P_G = 25dB$ (Z _i = 300Ω)		1.2		84A	2S103 ST34G			
★ 104	"	"	"	-30	-10	-100	180	75	-10	-30	70	-1 - 50	-6	1		$P_D = 400mW/B級 PP$ $P_G = 25dB$ (Z _i = 300Ω)		1.2		91	2S104 ST34GR			
★ 105	"	"	"	-30	-10	-500	500	75	-100	-30	70	-2 - 200	-2	200				0.5			81	2S105 ST35		
★ 106	"	"	"	-30	-10	-500	3 W (散熱附)	75	-100	-30	70	-2 - 200	-2	200				0.5			95	2S106 ST35R		
★ 107	"	"	"	-30		-2A	10 W (T _c =85°C)	75	-500	-30	70	-2 - 1A	-2	200		$P_D = 7 W$ (B級 PP) $P_G = 30dB$ (Z _i = 25Ω)		0.4		104	2S107 ST36			
★ 107A	"	"	"	-60		-3A	20 W (T _c =85°C)	75	-500	-60	70	-2 - 1A	-2	200		$P_D = 7 W$ (B級 PP) $P_G = 30dB$ (Z _i = 25Ω)		0.4		104	2S107 ST36A			
★ 108	"	PA	"	-40	-10	-500	500	75	-100	-40	70	-2 - 200	-2	200				0.5			81			
★ 108A	"	"	"	-60	-10	-500	500	75	-100	-60	70	-2 - 200	-2	200				0.5			81			
★ 108B	"	"	"	-80	-10	-500	500	75	-100	-80	70	-2 - 200	-2	200				0.5			81			
★ 109	"	"	"	-40	-10	-500	3 W (散熱附)	75	-100	-40	70	-2 - 200	-2	200				0.5			95			
★ 109A	"	"	"	-60	-10	-500	3 W (散熱附)	75	-100	-60	70	-2 - 200	-2	200				0.5			95			
★ 109B	"	"	"	-80	-10	-500	3 W (散熱附)	75	-100	-80	70	-2 - 200	-2	200				0.5			95			
★ 110	"	AF	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6		-6	1	30	30*	2.5*	0.5*	1			19A	ST330		
★ 111	"	"	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6		-6	1	45	30*	2.5*	0.5*	1			19A	ST331		
★ 112	"	"	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6		-6	1	60	30*	2.5*	0.5*	1			19A	ST332		
★ 113	"	"	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6		-6	1	80	30*	2.5*	0.5*	1			19A	ST333		
★ 114	"	PA	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6	65	-1 - 20	-6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5		19A	ST381		
★ 115	"	"	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6	85	-1 - 20	-6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5		19A	ST382		
★ 116	"	"	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6	110	-1 - 20	-6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5		19A	ST383		
★ 117	"	"	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6	140	-1 - 20	-6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5		19A			
★ 118	松 下	"	"	-15	-10	-1.5A	50 W (T _c =85°C)	75	-100	-14	60	-7 - 0.3A	-7	300					0.2		102			
★ 119	"	"	"	-32	-10	-1.5A	50 W (T _c =85°C)	75	-100	-14	60	-7 - 0.3A	-7	300					0.2		102	OC 19		
★ 120	富 士 通	AF	"	-32	-2.5	-20	150	85	-6.5	-12		-12	2	70	PG = 41 dB (A 級 S)						12A			

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)												外 形	備 考	
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (℃)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB(V)}	直流及脉冲下之h _{FE} V _{CE(V)} /I _C (mA)	偏置情况 V _{CB(V)} /I _E (mA)	h _{FE} h _{FE} *	h _{ie} h _{ie} * (Ω)	h _{re} h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{oe} * (μΩ)	f _β * f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)				
2SB121	富士通	SW	Ge. A	-105	-50	-100	50	85	-14	-2.5	60	-0.35	-5	-6	1				0.5			12A	
" 122	東 芝	"	"	-80	-40	-1.5A	20 W (T _c =25℃)	75	-160	-12	60	-1.5	-1A	-1.5	500				0.25			102	
" 123	"	"	"	-40	-30	-5A	20 W (T _c =25℃)	75	-1mA	-40								0.25	<300	<40	102		
" 124	"	"	"	-60	-25	15A	40 W (T _c =25℃)	75	-1.2mA	-12	70	-1.5	-15A	-6	500				0.3			107	
" 125	"	"	"	-36	-25	-15A	40 W (T _c =25℃)	75	-1.2mA	-12	70	-1.5	-15A	-6	500				0.3			107	
" 126	松 下	PA	"	-32	-10	-3.5A	30W (T _c =25℃)	90	-220	-14	35	-1	-1A	-6	1A				f _β = 6 kc			102	OC 26
" 127	"	"	"	-32	-10	-3.5A	30W (T _c =25℃)	90	-220	-14	75	-1	-1A	-6	1A				f _β = 6 kc			102	OC 27
" 128	"	"	"	-80	-40	-6A	30W (T _c =25℃)	90	-220	-14	40	-1	-1A								102	OC 28	
" 128A	"	"	"	-120	-60	-6A	54 W (T _c =25℃)	90	-200	-14	50	-1	-1A								102		
" 129	"	"	"	-80	-40	-6A	54 W (T _c =25℃)	90	-200	-14	85	-1	-1A								102	OC 29	
" 129A	"	"	"	-120	-60	-6A	54 W (T _c =25℃)	90	-200	-14	85	-1	-1A								102		
" 130	"	"	"	-32	-10	-1.5A	6.5 W (T _c =25℃)	75	-200	-14	60	-7	-0.3	-7	300				0.2			100	OC 30
" 131	富士通	"	"	-40	-12	-1.5A	65 W (T _c =25℃)	90	-2mA	-30	65	-1.5	1A	-14.4	50			PG = 30dB (B&RPP) P _β = 12W (Z _i = 24Ω)	f _β = 5 kc			102	2S131
" 131A	"	"	"	-40	-12	-1.5A	65 W (T _c =25℃)	90	-2mA	-30	65	-1.5	1A						f _β = 5 kc			102	
" 132	"	"	"	-60	-12	-1.5A	65 W (T _c =25℃)	90	-2mA	-30	65	-1.5	1A	-14.4	50			PG = 30dB (B&RPP) P _β = 12W (Z _i = 24Ω)	f _β = 5 kc			102	
" 134	三 菱	AF, LN	"	-30	-15	-100	100	85	-10	-25				-6	1	70	2100	3.2	21	NF = 4 dB (f = 1kHz, I _C = 0.5mA)		12B	
" 135	"	AF	"	-30	-15	-100	100	85	-10	-25				-6	1	70	2100	3.2	21			12B	
" 136	"	PA	"	-25	-12	-150	150	85	-10	-25	120	-1.5	-50									12B	
" 137	"	"	"	-30	-15	-5A	30 W (T _c =25℃)	85	-500	-20	80	-1.5	-1A									103	
" 138	"	"	"	-60	-30	-5A	30 W (T _c =25℃)	85	-500	-30	80	-1.5	-1A									103	
" 140	SON	"	"	-40	-12	-1.5A	12 W (T _c =25℃)	85	-600	-40	74	-1.5	-1A						f _β = 7 kc	200		103	2T301
" 141	"	"	"	-60	-12	-1.5A	12 W (T _c =25℃)	85	-600	-60	74	-1.5	-1A						f _β = 7 kc	200		103	2T302
" 142	"	"	"	-30	-12	-1A	10 W (T _c =25℃)	85	-1mA	-30	24	-1.5	-1A						f _β = 7 kc	200		103	2T303
" 143	"	"	"	-30	-12	-1A	10 W (T _c =25℃)	85	-1mA	-30	37	-1.5	-1A						f _β = 7 kc	200		103	2T303
" 144	"	"	"	-30	-12	-1A	10 W (T _c =25℃)	85	-1mA	-30	75	-1.5	-1A						f _β = 7 kc	200		103	2T303
" 145	"	"	"	-30	-12	-1A	10 W (T _c =25℃)	85	-1mA	-30	37	-1.5	-1A						f _β = 7 kc	200		103	2T304
" 146	"	"	"	-30	-12	-1A	10 W (T _c =25℃)	85	-1mA	-30	75	-1.5	-1A						f _β = 7 kc	200		103	2T304
" 147	"	"	"	-60	-12	-1.5A	12 W (T _c =25℃)	85	-600	-50	60	-1.5	-200						f _β = 7 kc	200		103	
" 148	東 芝	SW	"	-80	-25	-15A	40 W (T _c =25℃)	75	-1.2mA	-12	70	-1.5	-15A	-6	0.5A				0.3			107	
" 149	"	"	"	-40	-30	-8A	25 W (T _c =25℃)	75	-230	-12	60	-1.5	-8A	-1.5	0.5A				0.25	<400	<30	102	
2SB150	東 芝	SW	Ge. A	-105	-50	-40	50	75	-50	-105	35	-0.35	-5	-6	1				0.5	<20	<370	12A	2S150
" 151	富士通	"	"	-80	-60	-5A	50 W (T _c =25℃)	100	-500	-30	40	-1.5	-3A	-1.5	1A				f _β = 5 kc			102	
" 152	"	"	"	-100	-60	-5A	50 W (T _c =25℃)	100	-500	-30	40	-1.5	-3A	-1.5	1A				f _β = 5 kc			102	
152A	"	"	"	-100	-60	-5A	50 W (T _c =25℃)	100	-3mA	-100	70	-1	-1A						f _β > 4.5kc			102	
" 153	日 立	AF	"	-12	-2.5	-70	150	85	-14	-12				-3	1	70	2200	5	35			12A	
" 154	"	PA	"	-12	-2.5	-70	150	85	-14	-12	70	-1.5	-50									12A	
" 155	"	AF	"	-16	-2.5	-300	150	85	-14	-12				-4	1	30	875	1.66	10.7	1.4		12A	
" 156	"	PA	"	-16	-2.5	-300	150	85	-14	-12	70	-1	-150	-4	1	45			P _β = 600mW (B&R PP) PG = 27dB (Z _i = 86Ω)			12A	
156A	"	"	"	-20	-6	-300	150	85	-14	-20	70	-1	-150	-4	1	45						12A	
" 157	松 下	AF	"	-7	-7	-5	10	55	-10	-2				-0.5	0.25	35				f _β > 10kc		2A	OC 57
" 158	"	"	"	-7	-7	-5	10	55	-10	-2				-0.5	0.25	55				f _β > 10kc		2A	OC 58
" 159	"	AF	"	-7	-7	-5	10	55	-10	-2				-0.5	0.25	80				f _β > 10kc		2A	OC 59
" 160	"	PA	"	-7	-7	-5	10	55	-10	-2	75	-2	-0.5									2A	OC 60
" 161	日 電	"	"	-30		-100	125	75	-10	-6	50	-1	-50	-6	1				0.65			84A	2S161 ST341
" 162	"	"	"	-30		-100	180	75	-10	-6	50	-1	-50	-6	1				0.65			91	2S162 ST341R
" 163	"	"	"	-30		-100	125	75	-10	-6	70	-1	-50	-6	1				0.8			84A	2S163 ST342
" 164	"	"	"	-30		-100	180	75	-10	-6	70	-1	-50	-6	1				0.8			91	2S164 ST342R
" 165	"	"	"	-30		-100	125	75	-10	-6	100	-1	-50	-6	1				1			84A	2S165 ST343
" 166	"	"	"	-30		-100	180	75	-10	-6	100	-1	-50	-6	1				1			91	2S166 ST343R
" 168	富士通	AF	"	-9	-2.5	-100	150	85	-14	-9				-3	1	60	1300	4.9	20	0.8		12A	
" 169	"	PA	"	-9	-2.5	-100	150	85	-14	-9	80	-1	-50	-3	1				PG = 22dB (B&R PP) P _β = 100mW (Z _i = 100Ω)			12A	
" 170	松 下	AF	"	-30	-10	-100	125	85	-12	-10				-2	0.5	30	2200	9	23	f _β = 15kc		12B	OC 70
" 171	"	"	"	-30	-10	-100	125	85	-12	-10				-2	3	50	800	5.4	80	f _β = 15kc		12B	OC 71
" 172	"	PA	"	-32	-10	-125	125	85	-12	-10	50	-1	I _B = -2mA	-6	10				0.35			12B	2SD31 之對稱 r_{be}
" 173	"	LN	"	-20	-10	-100	125	85	-12	-10				-2	3	50	800	5.4	80	NF = 3 dB (V _{CE} = -2V, I _E = 0.5mA)		4	2S 74
" 174	"	PA	"	-20	-6	-300	225	75	-20	-12	65	-0.5	-300	-6	50				1.5			12B	OC 74
" 175	"	AF	"	-30	-10	-100	125	85	-12	-10				-2	3	100	1300	8	125			12B	OC 75
" 176	"	PA	"	-32	-10	-125	125	85	-12	-10	90	-1	I _B = -2mA									12B	2SD32 之對稱 r_{be}
" 177	"	"	"	-60	-10	-125	125	85	-12	-10	90	-1	I _B = -2mA									12B	OC 77
" 178	"	"	"	-20	-6	-300	225	85	-20	-12	56	V _{CB} = 0V	-300									17	2SD178 之對稱 r_{be}

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)										外 形	備 考					
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CB0} 最大値		直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}				偏 置 情 况		h _{FE}	h _{ie} * (Ω)			h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} * (μU)	f _{αβ} * (Mc)	C _{ob} (pF)	τ _{αβ} h _{ie} (res)* (Ω)
									I _{CB0} (μA)	V _{CB0} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{FE} *										
2SB178A	松 下	PA	Ge. A	-40	-6	-320	225	85	-20	-12	56	V _{CB} =0V	-300											17	
* 179	東 芝	AF	"	-25	-12	-50	80	75	-14	-30			-6	1	50									12A	2S179
* 180	富士通	PA	"	-40	-12	-0.5A	5.5 W (T _c =25℃)	92	-1mA	-40	70	-1.5	-500	-12	15		PG = 26dB (B級 PP P _o = 4W (Z _L = 60Ω))							83	
* 180A	"	"	"	-40	-12	-0.5A	12 W (T _c =25℃)	90	-500	-30	70	-1.5	-500						f _{αβ} = 13kc					83	
* 181	"	"	"	-60	-12	-0.5A	5.5 W (T _c =25℃)	92	-1mA	-60	70	-1.5	-500	-12	15		PG = 26dB (B級 PP P _o = 4W (Z _L = 60Ω))							83	
* 181A	"	"	"	-60	-12	-0.5A	12 W (T _c =25℃)	90	-200	-30	70	-1.5	-500						f _{αβ} = 13kc					83	
* 183	日 立	AF	"	-12	-2.5	-20	50	85	-12	-12			-0.5	0.25	55									3	
* 184	"	PA	"	-12	-2.5	-20	50	85	-12	-12	100	-2	-5											3	
* 185	三 洋	"	"	-25	-12	-150	200	85	-15	-20			-6	1	45	2000	5	20	1					12A	
* 186	"	"	"	-25	-12	-150	200	85	-15	-20			-6	1	120	6000	13	40	1	25				12A	
* 187	"	"	"	-25	-12	-150	200	85	-15	-20			-6	1				1						12A	2SD187 之對稱
* 188	"	"	"	-25	-12	-150	200	85	-15	-20			-6	1	20			1						12A	2S188
* 189	東 芝	"	"	-25	-12	-250	250	75	-14	-25	75	-1	-100	-6	1			1						62	2S189
* 190	沖	AF	"	-25	-12	-50	90	80	-15	-25			-6	1	150	PG = 45 dB (f = 1kc)								12A	
* 191	"	"	"	-25	-12	-50	90	80	-15	-25			-6	1	70	PG = 43 dB (f = 1kc)								12A	
* 192	"	"	"	-25	-12	-50	90	80	-15	-25			-6	1	35	PG = 41 dB (f = 1kc)								12A	
* 193	"	"	"	-25	-12	-100	200	80	-15	-25			-6	1	150	PG = 45 dB (f = 1kc)								75	
* 194	"	"	"	-25	-12	-100	200	80	-15	-25			-6	1	70	PG = 43 dB (f = 1kc)								75	
* 195	"	"	"	-25	-12	-100	200	80	-15	-25			-6	1	35	PG = 41 dB (f = 1kc)								75	
* 196	"	"	"	-30	-12	-500	500	80	-100	-30	50	-2	-200											82	
* 197	"	"	"	-50	-12	-500	500	80	-100	-50	50	-2	-200											82	
* 198	沖	"	"	-70	-12	-500	500	80	-100	-70	50	-2	-200											82	
* 199	富士通	PA	"	-12	-2.5	-300	250	85	-14	-12	80	-1	-150	-3	1		PG = 22dB (B級 PP P _o = 250mW (Z _L = 50Ω))						71A		
* 200	東 芝	"	"	-32	-12	-400	225	75	-40	-12	75	-1	-150	-1	100			0.5						77	
* 201	"	SW	"	-35	-12	-400	300	75	-30	-12	150	-1	-150	-1	100	t _r = 0.6μS, t _f = 0.7μS t _s = 5 μS			0.5					84A	
* 202	"	PA	"	-32	-12	-400	225	75	-40	-12	140	-1	-150	-1	100			0.5						77	
* 203	新電元	"	"	-40	-40	-20A	80 W (T _c =25℃)	85	-5mA	-40	40	-1.5	-15A											105	L10
* 204	"	"	"	-40	-40	-30A	80 W (T _c =25℃)	85	-5mA	-40	100	-1.5	-15A											105	
* 205	"	"	"	-80	-40	-20A	80 W (T _c =25℃)	85	-5mA	-80	40	-1.5	-15A	-6	2A				f _{αβ} = 2.5kc					105	H10
* 206	"	"	"	-80	-40	-30A	80 W (T _c =25℃)	85	-5mA	-80	100	-1.5	-15A	-6	2A				f _{αβ} = 2.5kc					105	
2SB207	新電元	PA	Ge. A	-100	-40	-20A	80 W (T _c =25℃)	85	-5mA	-100	40	-1.5	-15A											105	
* 208	"	"	"	-100	-40	-30A	80 W (T _c =25℃)	85	-5mA	-100	100	-1.5	-15A											105	
* 209	"	"	"	-40	-40	-20A	80 W (T _c =25℃)	85	-5mA	-40	40	-1.5	-15A	-6	2A				f _{αβ} = 2.5kc					105	L15A
* 210	"	SW	"	-40	-40	-30A	80 W (T _c =25℃)	85	-5mA	-40	100	-1.5	-15A	-6	2A				f _{αβ} = 2.5kc					105	L15B
* 211	"	"	"	-80	-40	-20A	80 W (T _c =25℃)	85	-5mA	-80	40	-1.5	-15A	-6	2A				f _{αβ} = 2.5kc					105	H15A
* 212	"	"	"	-80	-40	-30A	80 W (T _c =25℃)	85	-5mA	-80	100	-1.5	-15A	-6	2A				f _{αβ} = 2.5kc					105	H15B
* 213	"	"	"	-100	-40	-20A	80 W (T _c =25℃)	85	-5mA	-100	40	-1.5	-15A	-6	2A				f _{αβ} = 2.5kc					105	U15A
* 214	"	"	"	-100	-40	-30A	80 W (T _c =25℃)	85	-5mA	-100	100	-1.5	-15A	-6	2A				f _{αβ} = 2.5kc					105	U15B
* 215	三 洋	"	"	-100	-20	-3A	24 W (T _c =25℃)	85	-500	-12	100	-1.5	-1A	-3	100				<0.15	<400	<50			102	
* 216	"	PA	"	-60	-10	-3A	24 W (T _c =25℃)	85	-500	-12	80	-1.5	-200	-1.5	200				0.25					102	
* 217	"	PA	"	-25	-10	-3A	24 W (T _c =25℃)	85	-500	-12	80	-1.5	-1A	-1.5	200				0.5					102	
* 218	日 電	SW	"	-80	-20	-100	225	85	-10	-50	50	-1	-100	-5	1				2.5	<30	<200			84A	2SD19 之對稱
* 219	"	PA	"	-30	-10	-200	225	85	-16	-25	31	-1	-20	-6	1	30*			1.5	25				84A	2SD20 之對稱
* 219A	"	"	"	-30	-10	-500	225	85	-16	-25	31	-1	-20	-5	1				1.5					84A	2SD21 之對稱
* 220	"	"	"	-30	-10	-200	225	85	-16	-25	50	-1	-20	-6	1	30*			2	25				84A	2SD22 之對稱
* 220A	"	"	"	-30	-10	-500	225	85	-16	-25	50	-1	-20	-5	1				2					84A	2SD23 之對稱
* 221	"	"	"	-30	-10	-200	225	85	-16	-25	72	-1	-20	-6	1	30*			2	25				84A	2SD24 之對稱
* 221A	"	"	"	-30	-10	-500	225	85	-16	-25	72	-1	-20	-5	1				2.5					84A	
* 222	"	"	"	-30	-10	-200	225	85	-16	-25	97	-1	-20	-6	1	30*			2.5	25				84A	
* 222A	"	"	"	-30	-10	-500	225	85	-16	-25	97	-1	-20	-5	1				2.8					84A	
* 223	"	"	"	-30	-10	-200	225	85	-16	-25	150	-1	-20	-6	1	30*			3.0	25				84A	
* 223A	"	PA	Ge. A	-30	-10	-500	225	85	-16	-25	150	-1	-20	-5	1				3					84A	
* 224	"	"	"	-45	-15	-500	225	85	-10	-30	35	-1	-20	-5	1	30	31*	4*	0.65*	2	25			84A	2N524
* 225	"	"	"	-45	-15	-500	225	85	-10	-30	52	-1	-20	-5	1	44	31*	5*	0.6*	2.5	25			84A	2N525
* 226	"	"	"	-45	-15	-500	225	85	-10	-30	73	-1	-20	-5	1	64	30*	6.5*	0.42*	3	25			84A	2N526
* 227	"	"	"	-45	-15	-500	225	85	-10	-30	91	-1	-20	-5	1	81	29*	8*	0.37*	3.3	25			84A	2N527
* 228	日 立	"	"	-80	-50	-5A	50 W (T _c =25℃)	91	-5mA	-80	28	-1.5	-4A											103	
* 229	"	"	"	-100	-50	-5A	50 W (T _c =25℃)	91	-5mA	-100	28	-1.5	-4A											103	
* 230	"	"	"	-120	-50	-5A	50 W (T _c =25℃)	91	-5mA	-120	28	-1.5	-4A											103	
* 231	東 芝	SW	Ge. D	-120	-1	-6A	25 W (T _c =25℃)	75	-5mA	-120	50	-1.5	-5A											102	

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)												外 形	備 考
				V _{CBO} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CBO} 最大値 (μA)	V _{CE(V)}	直 流 及 脈 冲 下 之 h _{FE} V _{CE(V)} I _C (mA)	偏 置 情 况 V _{CE(V)} I _E (mA)	h _{FE} h _{FE} *	h _{ie} h _{ie} * (Ω)	h _{re} h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{ob} h _{ob} * (μU)	f _β f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie(rea)} * (Ω)			
★ 2SB282	松 下	SW	Ge. A	-80	-40	-6A	30 W (T _c = 25°C)	90	-100	-0.5	21	-1	-6A	-6	1 A				0.25	160	103	
★ " 283	"	"	"	-60	-20	-6A	30 W (T _c = 25°C)	90	-100	-0.5	53	-1	-6A	-6	1 A				0.25	160	103	
★ " 284	"	"	"	-60	-20	-6A	30 W (T _c = 25°C)	90	-100	-0.5	30	-1	-6A	-6	1 A				0.25	160	103	
★ " 285	"	"	"	-80	-40	-6A	30 W (T _c = 25°C)	90	-100	-0.5	36	-1	-6A	-6	1 A				0.25	160	103	
★ " 286	"	"	Ge. D	-80	-0.5	-6A	43 W (T _c = 25°C)	90	-220	-14	17	-1	-6A								103	
★ " 287	"	"	"	-80	-1.3	-6A	43 W (T _c = 25°C)	90	-220	-14	36	-1	-6A								103	
★ " 288	"	"	Ge. A	-32	-10	-125	125	75	-10	-10	50	-0.7	-125								12A	
★ " 289	"	"	"	-60	-10	-125	125	75	-10	-10	50	-0.7	-125								12A	
★ " 290	東 芝	LN	"	-18	-12	-40	65	75	-4	-12			-3	0.5	110	3500	6	20	5	9.5	84A	
★ " 291	"	AF	"	-30	-12	-150	150	75	-10	-12	70	-1	-50	-6	1	100	4200	6	30	1	35	84A
★ " 292	"	PA	"	-30	-12	-150	150	75	-10	-12	80	-1	-50	-6	1	100	4200	6	30	1	35	84A
★ " 292A	"	"	"	-60	-12	-150	150	75	-10	-12	80	-1	-50								84A	
★ " 293	八 欧	"	"	-18		-250	150	85	-10	-12	70	-1	-150								12B	
★ " 294	"	AF	"	-18		-250	150	85	-10	-12			-4	1	36	1000	2.9	18			12B	
★ " 295	富士通	SW	"	-100	-40	-5A	40 W (T _c = 25°C)	85	-3mA	-100	70	-1	-1A	-1	1 A				f _β = 4.5 kc		102	
★ " 296	東 芝	"	Ge. D	-130	-3	-10A	35 W (T _c = 25°C)	75	-1mA	-50	35	-1.5	-10A								102	
★ " 297																						
★ " 298																						
★ " 299	八 欧	SW	Ge. A	-30	-25	-150	150	85	-10	-12	65	-1	-150								12B	
★ " 300	東 芝	PA	Ge. D	-100	-1	-10A	35 W (T _c = 25°C)	75	-330	-12	60	-1.5	-5A								102	
★ " 301	"	"	"	-60	-1	-10A	35 W (T _c = 25°C)	75	-330	-12	60	-1.5	-5A								102	
★ " 302	日 立	LN	Ge. A	-10	-5	-2	40	85	-6	-10			-4	0.5	80	4500	4	26	NF = 4dB (f = 1 kc)		12B	
★ " 303	三 洋	LN, AF	"	-25	-12	-20	100	75	-15	-15			-2	0.5	180	12KΩ	30	50	NF = 3.5dB (V _{CE} = -6V, I _E = 1mA)		12B	
★ " 304	富士通	SW	"	-30	-10	-500	225	70	-15	-30	70	-1	-50								84C	
★ " 304A	"	"	"	-45	-15	-500	225	70	-10	-35	70	-1	-50								84B	
★ " 305																						
★ " 306	東 芝	SW	Ge. A	-100	-50	-20	75	75	-10	-105	60	-0.35	-2								84A	
★ " 307																						
★ " 308																						
★ " 309	松 下	PA	Ge. DB	-75	-1	-8A	43 W (T _c = 25°C)	90	-200	-0.5	62	V _{CB} = 0V I _E = 1A	-4	1 A					f _β = 17 kc		102	
★ 2SB310	松 下	SW	Ge. DB	-140	-1	-8A	43 W (T _c = 25°C)	90	-220	-0.5	62	V _{CB} = 0V I _E = 1A	-4	1 A					f _β = 17 kc		103	
★ " 311	"	"	"	-180	-1	-10A	50 W (T _c = 25°C)	90	-220	-0.5	62	V _{CB} = 0V I _E = 1A	-4	1 A					f _β = 17 kc		103	
★ " 312	"	"	"	-140	-1	-8A	43 W (T _c = 25°C)	90	-220	-0.5	27	V _{CB} = 0V I _E = 8A									103	
★ " 313	"	"	"	-180	-1	-10A	43 W (T _c = 25°C)	90	-220	-0.5	27	V _{CB} = 0V I _E = 8A									103	
★ " 314	冲	PA	Ge. A	-30		-500	3 W	80	-100	-30	45	-2	-200								96	
★ " 315	三 菱	AF	"	-16		-300	150	85	-14	-12			-3	1	50	1100	1.5	20			12A	
★ " 316	"	PA	"	-16		-300	150	85	-14	-12	60	-1	-150								12A	
★ " 317	"	"	"	-16		-300	250	85	-14	-12	60	-1	-150								71A	
★ " 318	富士通	"	Ge. D	-60	-1	-5A	50 W (T _c = 25°C)	100	-1mA	-40	100	-2	-1A	-5	500				2 *		102	
★ " 319	"	SW	"	-100	-1	-5A	50 W (T _c = 25°C)	100	-1mA	-40	100	-2	-1A	-5	500				3 *		102	
★ " 320	"	"	"	-100	-2	-5A	50 W (T _c = 25°C)	100	-1mA	-40	100	-2	-1A	-5	500	t _r = 1.6μS t _s = 1.3μS	t _f = 1μS		2 *		102	
★ " 321	東 芝	LN	Ge. A	-12	-12	-50	40	75	-4	-12			-1.5	0.5	100	4000	6	20	NF = 3dB (V _{CE} = -3V, I _E = 0.5mA)		1	
★ " 322	"	AF	"	-12	-12	-50	40	75	-4	-12			-1.5	0.5	50	3000	5	19			1	
★ " 323	"	"	"	-12	-12	-50	40	75	-4	-12			-1.5	0.5	100	4000	6	20			1	
★ " 324	松 下	PA	"	-32	-10	-1A	200	90	-10	-10	53	V _{CB} = 0V I _E = -0.3A	-2	10					f _β > 10 kc		12A	
★ " 325	富士通	SW	"	-120	-50	-0.6A	1.8 W (T _c = 25°C)	85	-20	-5	50	-2	-50								93	
★ " 326	日 電	PA	"	-30	-15	-500	225	85	-10	-30	65	-1	-20	-5	1				3		84A	
★ " 327	"	"	"	-30	-15	-500	225	85	-10	-30	110	-1	-20	-5	1				3.3		84A	
★ " 328	"	"	"	-25	-10	-200	150	85	-10	-15	70	-1	-20	-6	1				2		19A	
★ " 329	"	"	"	-25	-10	-200	150	85	-10	-15	100	-1	-20	-6	1				2		19A	
★ " 330	"	SW	"	-110	-50	-150	225	85	-20	-50	35	-1	-20	-5	1				0.5		84A	
★ 2SB331	日 立	"	"	-40	-20	-15A	80 W (T _c = 25°C)	100	-4mA	-40	70	-2	-5A								109	
★ " 332	"	"	"	-60	-40	-15A	80 W (T _c = 25°C)	100	-4mA	-60	60	-2	-5A								109	
★ " 333	"	"	"	-80	-40	-15A	80 W (T _c = 25°C)	100	-4mA	-80	60	-2	-5A								109	
★ " 334	"	"	"	-100	-60	-15A	80 W (T _c = 25°C)	100	-4mA	-100	40	-2	-5A								109	
★ " 335	松 下	AF	"	-20	-10	-60	83	75	-10	-10	36-110	-1	I _B = -250μA	-6	1	70	2800	2.6	10		4	
★ " 336	"	PA	"	-20	-10	-60	83	75	-10	-10	80	-1	-60								4	
★ " 337	日 立	"	"	-40	-10	-7A	30 W (T _c = 25°C)	100	-1mA	-30	90	-2	-1A	-2	1A				0.3		103	
★ " 338	"	"	"	-60	-10	-7A	50 W (T _c = 25°C)	90	-1mA	-30	75	-4	-1A								103	
★ " 339	"	"	"	-80	-50	-10A	50 W (T _c = 25°C)	90	-250	-30	75	-4	-1A	-4	1 A				0.25		103	

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)				電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)														外 形	備 考
				V_{CB0} (V)	V_{EB0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^{\circ}\text{C}$)	I_{CB0} 最大値 (μA)	$V_{CB}(V)$	直 流 及 脉 冲 下 之 h_{FE}		偏 置 情 况		h_{FE}	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μS)	$f_{\alpha\beta}$ f_{T}^* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $r_{bb'(real)}^*$ (Ω)		
2SB340	日 立	PA, SW	Ge. A	-100	-50	-10A	50 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	90	-250	-30	35	-1	-8A	-4	1 A					0.25		103	
“ 341	“	“	“	-120	-50	-10A	50 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	90	-250	-30	35	-1	-8A									103	
“ 342	三 洋	“	Ge. D	-120	-1	-6A	30 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-5mA	-120	50	-1.5	-5A	-1.5	500				1.5			103	
“ 343	“	“	“	-150	-1	-6A	30 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-5mA	-150	50	-1.5	-5A	-1.5	500				1.5			103	
“ 344	“	“	“																				
“ 345	松 下	AF	Ge. A	-32	-10	-100	165	85	-10	-10			-5	2	90	1700	6.5	80	$f_{\alpha\beta} = 17 \text{ kc}$			12A	
“ 346	“	“	“	-32	-10	-100	165	85	-10	-10			-5	2	120	2400	8	100	$f_{\alpha\beta} = 17 \text{ kc}$			12A	
“ 347	“	LN	“	-32	-10	-100	165	85	-10	-10			-5	2	90	1700	6.5	80	$f_{\alpha\beta} = 17 \text{ kc}$	NF = 3dB ($I_E = 0.5 \text{ mA}$)		12A	
“ 348	“	“	“	-32	-10	-100	165	75	-10	-10			-5	2	120	2400	8	100	$f_{\alpha\beta} = 17 \text{ kc}$	NF = 3dB ($I_E = 0.5 \text{ mA}$)		12A	
“ 349	三 洋	AF	“	-20		-10	50	75	-20	-10	150	-1.5	-10									12A	
“ 350	“	PA	“	-25		-50	50	75	-20	-10	100	-1.5	-30									12A	
“ 351	富士通	SW	“	-40	-20	-15A	70 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	100	-4mA	-40	70	-2	-5A									109	
“ 352	“	“	“	-60	-40	-15A	70 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	100	-4mA	-60	70	-2	-5A									109	
“ 353	“	“	“	-80	-40	-15A	70 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	100	-4mA	-80	70	-2	-5A									109	
“ 354	“	“	“	-100	-60	-15A	70 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	100	-4mA	-100	70	-2	-5A									109	
“ 355	三 菱	PA	“	-25	-12	-1A	4 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-100	-12	60	-1.5	-0.5A									101	
“ 356	“	“	“	-80	-12	-1A	4 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-50	-50	50	-1.5	-0.5A									101	
“ 357	“	“	“	-100	-12	-1A	3 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-50	-50	40	-1.5	-0.5A									101	
“ 358	“	“	Ge. D	-80	-1.5	-6A	50 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-5mA	-80	30	-1.5	-4A	1.5	200				2			103	
“ 359	“	SW	“	-120	-1.5	-10A	50 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-5mA	-80	25	-1.5	-4A	1.5	200							103	
“ 360	“	“	“	-180	-1.5	-10A	50 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-5mA	-80	30	-1.5	-4A	1.5	200				2			103	
“ 361	日 立	PA	Ge. DB	-80	-1	-5A	40 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	100	-500	-40	110	-2	-1A	-5	0.7A				$f_{\alpha\beta} = 50 \text{ kc}$			103	
“ 362	“	“	“	-100	-1	-7A	50 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	90	-500	-30	75	-2	-5A	-5	0.7A				$f_{\alpha\beta} = 50 \text{ kc}$			103	
“ 363	日 立	SW	Ge. D	-140	-1	-8A	43 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	90	-10mA	-140	50	-1.5	-5A									102	
“ 364	東 芝	PA	Ge. A	-20	-12	-400	150	75	-14	-20	60~150	-0.5	-100	-6	1				1			12A	
“ 365	“	“	“	-20	-12	-400	150	75	-14	-20	35~190	-0.5	-100	-6	1				1			12A	
“ 366	“	SW	Ge. D	-140	-1	-8A	43 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	90	-330	-12	50	-1.5	-5A									102	
“ 367	日 立	PA	Ge. A	-25	-12	-1A	6.6 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-100	-12	90	-1.5	-0.5A									100	
“ 368	“	“	“	-45	-12	-1A	6.6 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-100	-12	90	-1.5	-0.5A									100	
“ 369	“	“	“																				
2SB370	日 立	PA	Ge. A	-25	-12	-500	200	85	-20	-12	150	-1	-150	-6	1	110						12A	
“ 370A	“	“	“	-32	-12	-500	200	85	-20	-12	150	-1	-150	-6	1	110						12A	
“ 371	松 下	“	“	-32	-10	-200	165	75	-15	-10	790	$V_{CE} = 1 \text{ A}$	-2	10				$f_{\alpha\beta} > 10 \text{ kc}$				12A	
“ 372	三 洋	“	“	-25	-10	-1A	1.5 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-50	-20												84B	
“ 373	“	“	“	-25	-10	-1A	1.5 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-50	-20	150	-1.5	-200	-1.5	200				0.7			84B	
“ 374	“	“	“	-60	-10	-1A	1.5 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-50	-20	150	-1.5	-200									84B	
“ 375	“	SW	Ge. D	-135	-3	-9A	30 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-5mA	-150	50	-1.5	-8A	-1.5	500					1.5		103	
“ 376	松 下	PA	Ge. A	-20	-6	-300	225	75	-20	-12	50	-0.5	-300									17	
“ 377	SON	LN	“	-32		-150	270	85	-10	-32			-6	0.5	134	53*	5*	0.3*	NF = 2dB ($f = 1 \text{ kc}$)			84A	
“ 378	“	AF, PA	“	-18		-150	180	65	-10	-18	42	-1	-20	-6	1	34	27*	3.5*	0.5*	2.5	25	84A	
“ 378A	“	“	“	-23		-300	270	85	-10	-23	42	-1	-20	-6	1	34	27*	3.5*	0.5*	2.5	25	84A	
“ 378B	“	“	“	-23		-500	270	85	-10	-23	42	-1	-20	-6	1	34	27*	3.5*	0.5*	2.5	25	84A	
“ 379	“	“	“	-18		-150	180	65	-10	-18	84	-1	-20	-6	1	68	27*	5*	0.5*	3	25	84A	
“ 379A	“	“	“	-23		-300	270	85	-10	-23	84	-1	-20	-6	1	68	27*	5*	0.5*	3	25	84A	
“ 379B	“	“	“	-23		-500	270	85	-10	-23	84	-1	-20	-6	1	68	27*	5*	0.5*	3	25	84A	
“ 380	“	“	“	-18		-150	180	65	-10	-18	169	-1	-20	-6	1	136	27*	5*	0.3*	3.5	25	84A	
“ 380A	“	“	“	-23		-300	270	85	-10	-23	169	-1	-20	-6	1	136	27*	5*	0.3*	3.5	25	84A	
“ 381	“	“	“	-32		-300	270	85	-10	-32	42	-1	-20	-6	1	34	27*	3.6*	0.5*	2.5	25	84A	
“ 382	“	“	“	-32		-300	270	85	-10	-32	84	-1	-20	-6	1	68	27*	5*	0.5*	3	25	84A	
“ 383	“	PA	“	-32		-500	270	85	-10	-32	84	-1	-20	-6	1				3	25		84A	
“ 384	八 欧	AF	“	-20		-30	80	85	-10	-12			-6	1	60	1600	3.5	2.3				12A	
“ 385	“	PA	“	-20		-30	80	85	-10	-12	50	-1	-50									12A	
“ 386	三 菱	SW	“	-30	-15	-300	150	85	-10		80	-0.5	-50									12A	
“ 387	日 立	AF	“	-12	-2.5	-20	30	85	-10	-12			-0.5	0.25	55	6000	4.5	21	4			2 B	
“ 388	“	“	“																				
“ 389	富士通	LN	Ge. A	-12	-0.5	-10	80	85	-6	-12			-4	0.5	100	8000	15	25	NF = 3dB ($f = 1 \text{ kc}$)			12A	
“ 390	三 洋	PA, SW	Ge. D	-80	-1	-6A	30 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-200	-15	50	-1.5	-3A	-1.5	-500					1.5		103	
“ 391	“	“	“	-50	-1	-6A	30 W ($T_j = 25^{\circ}\text{C}$)	85	-5mA	-50	75	-1.5	-3A	-1.5	-500					1.5		103	
“ 392	沖	AF, SW	Ge. A	-20	-13	-200	200	85	-7	-12	75	-0.5	-10	-5	1	90	30*	8*	0.3*			84B	
“ 393	“	“	“	-28	-13	-200	200	85	-7	-12	38	-0.5	-10	-5	1	45	30*	8*	0.3*			84B	

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考	
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB(V)}	直 流 及 脈 冲 下 之 h _{FE}		偏 置 情 况		h _{FE}	h _{FE} [*] (Ω)	h _{FE} [*] (×10 ⁻⁴)	h _{FE} [*] (μt)	f _β [*] (Mc)			C _{ob} (pF)
2SB394	沖	AF, SW	Ge. A	-28	-13	-200	200	85	-7	-12	75	-0.5	-10	-5	1	90	30	8	0.3			84B
" 395	"	"	"	-28	-13	-200	200	85	-7	-12	150	-0.5	-10	-5	1	180	30	8	0.3			84B
" 396	"	"	"	-40	-13	-200	150	85	-7	-12	75	-0.5	-10	-5	1	90	30	8	0.3			84B
" 397	"	SW	"	-48	-15	-80	200	85	-10	-12	45	0.5	-5									84B
" 398	"	"	"	-110	-30	-80	200	85	-15	-100	45	-0.5	-5									84B
" 399	"	"	"	-110	-30	-80	200	85	-15	-100	25	-0.5	-20									84B
" 400	三 洋	LN	"	-20	-10	-40	100	85	-15	-10				-6	1	100	3000	8	35	1	25	12A
" 401	松 下	SW	Ge. A	-40	-10	-300	240	85	-10	-10	60	-0.5	-300	-5	10				>0.3 [*]			84A
" 402	"	"	"	-60	-10	-300	240	85	-10	-10	60	-0.5	-300	-5	10				>0.3 [*]			84A
" 403	"	"	"	-40	-20	-300	240	85	-10	-10	100	-0.5	-300	-5	10				>0.7 [*]			84A
" 404	三 洋	"	"	-100	-40	-100	100	85	-20	-100	100	-1.5	-30									84B
" 405	"	PA	"	-25		-1A	720 (T _a = 25°C)	85	-50	-20	100	-1.5	-200						0.7			12A
" 406	"	SW	Ge. D	-200	-2	-10A	37.5W (T _a = 25°C)	100	-250	-30	35	-1.5	-8A	-2	500				0.7			102
" 407	"	PA	Ge. A	-30	-10	-7A	30W (T _a = 25°C)	85	-500	-30	80	-1.5	-1A	-1.5	500				0.35 [*]			103
" 408	"	"	"	-25	-12	-200	300	85	-15	-20	175	-1.5	-100	-1.5	30						<150	12B
" 409	"	AF	"	-12		-50	150	75	-15	-6				-6	1	80	3000	8	35			12B
" 410	"	PA, SW	Ge. DB	-135	-5	-15A	40W (T _a = 25°C)	85	-250	-30	50	-1.5	-8A	-1.5	-500				3 [*]			103
" 411	"	"	"	-200	-5	-11A	40W (T _a = 25°C)	85	-250	-30	40	-1.5	-8A	-1.5	-500				2.5 [*]			103
" 412	"	"	"	-300	-5	-11A	40W (T _a = 25°C)	85	-250	-30	50	-1.5	-8A									103
" 413	東 芝	PA	Ge. D	-60	-1	-1.5A	12.5W (T _a = 25°C)	85	-100	-12	>30	-1	-0.5A									101
" 414	"	"	"	-32	-1	-1.5A	12.5W (T _a = 25°C)	85	-100	-12	>30	-1	-0.5A									101
" 415	"	"	Ge. A	-32	-6	-1A	200	85	-14	-12	70	V _{CE} = 0	-0.3A	-1	100				1			12A
" 416	沖	AF	Ge. A	-25	-13	-80	150	85	-10	-12	60	-0.5	-10	-5	1	120	45	45	0.4 [*]			84B
" 417	"	"	"	-45	-13	-80	150	85	-10	-12	60	-0.5	-10	-5	1	120	45	45	0.4 [*]			84B
" 418	"	"	"	-70	-13	-80	150	85	-10	-12	60	-0.5	-10	-5	1	120	45	45	0.4 [*]			84B
" 419	日 立	PA	Ge. DB	-45	-1.2	-1.5A	6W (T _a = 25°C)	100	-250	-12	80	-1.5	-0.5A									100
" 420	"	"	"	-120	-1.5	-1.5A	6W (T _a = 25°C)	100	-250	-12	100	-1.5	-1A									100
" 421	東 芝	"	Ge. D	-80	-1	-600	300	85	-50	-12	70	-1	-150									77
" 422	"	AF	Ge. A	-18	-2	-40	60	75	-12	-12				-6	1	50	1500	4	20			12A
" 423	"	PA	"	-30	-12	-150	150	75	-30	-30	70	-1.5	-50									12A
2SB424	東 芝	SW	Ge. A	-80	-40	-3A	30W (T _a = 25°C)	85	-160	-12	60	-1.5	-1A									102
" 425	"	PA	"	-60	-12	-3A	30W (T _a = 25°C)	85	-160	-12	60	-1.5	-1A									102
" 426	"	"	"	-32	-12	-3A	30W (T _a = 25°C)	85	-160	-12	60	-1.5	-1A									102
" 427	富 士 通	SW	"	-45	-15	-500	225	70	-15	-45	60	-1	-100	-6	1				1			84B
" 428	"	PA	"	-45	-15	-500	225	70	-15	-45	90	-1	-100	-6	1				1			84B
" 429	日 電	"	"	-30		-50	100	85	-16	-30	150	-1	-20									19A
" 430	松 下	"	Ge. DB	-70		-20A	80W (T _a = 25°C)	90	-20mA	-70	60	V _{CE} = 0V	-4A									109
" 431	富 士 通	"	Ge. A	-32	-12	-500	200	85	-20	-12	120	-1	-150	-6	1	80	2400	8.9	38	1.2		12A
" 432	"	PA, SW	Ge. D	-150	-2	-5A	50W (T _a = 25°C)	100	-1mA	-40	70	-2	-5A	-5	500				3 [*]			102
" 433	"	SW	Ge. A	-70	-40	-15A	56W (T _a = 25°C)	85	-4mA	-30	50	-2	-5A									102
" 434	東 芝	PA	Si, EMe	-50	-5	-3A	25W (T _a = 25°C)	150	-10	-30	80	-5	-0.5A	-5	500				3 [*]	200		119
" 435	"	"	"	-35	-5	-3A	25W (T _a = 25°C)	150	-10	-30	80	5	-0.5A	-5	500				3 [*]	200		119
" 436	沖	AF	Ge. A	-25		-120	120	85	-10	-12	60	-0.5	-10	-5	1	80	33	2.4	0.4 [*]			12A
" 437	"	"	"	-45		-120	120	85	-10	-12	60	-0.5	-10	-5	1	80	33	2.4	0.4 [*]			12A
" 438	"	"	"	-70		-120	120	85	-10	-12	60	-0.5	-10	-5	1	80	33	2.4	0.4 [*]			12A
" 439	東 芝	"	"	-30	-12	-150	150	75	-14	-12				-6	1	130	4000	8	45	2		12A
" 440	"	LN	"	-30	-12	-150	150	75	-14	-12				-6	1	130	4000	8	45	NF = 3dB (f = 1kc)		12A
" 441	日 立	PA	Ge. DB	-160	-1	-6A	40W (T _a = 25°C)	100	-250	-30	50	-1.5	-200									103
" 442	"	SW	"	-160	-1.5	-6A	40W (T _a = 25°C)	100	-500	-30	50	-1.5	-4A									103
" 443	"	AF, LN	Ge. A	-18	-12	-10	100	85	-10	-12				-6	1	150	3900	7.4	53	3		12A
" 444	"	"	"	-18	-12	-10	100	85	-7	-12				-6	1	160	4300	7.7	59	3		12A
" 445	富 士 通	PA	Ge. D	-40	-1	-1.5A	10W (T _a = 25°C)	85	-200	-12	100	-2	-1A	-5	0.5A				1.5 [*]			101
" 446	"	"	"	-60	-1	-1.5A	10W (T _a = 25°C)	85	-100	-12	100	-2	-1A	-5	0.5A				1.5 [*]			101
" 447	"	PA, SW	"	-220	-3	-6A	45W (T _a = 25°C)	90	-500	-50	35	-1	-6A	-5	0.5A				1.5 [*]			102
" 448	松 下	PA	Ge. A	-32	-10	-1A	13W (T _a = 25°C)	90	-1mA	-32	50	-0.5	-1A									100
" 449	"	"	"	-50	-20	-3.5A	22.5W (T _a = 25°C)	100	-3mA	-14	35	V _{CE} = 0V	-3A	-2	0.5A				f _β > 7kHz			103
" 450	八 坂	PA	Ge. A	-25		-500	200	85	-20	-12	120	-1	-150									12A
" 451	三 菱	"	"	-25	-6	-1A	300	85	-30	-12	80	-1	-150									69
" 452	"	"	"	-25	-6	-1A	300	85	-30	-12	150	-1	-150									69
" 453	"	PA, SW	"	-30	-15	-300	250	85	-12	-25	120	-1	-100	-6	1				>1			68

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)													外 形	備 考
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大值		直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}		偏 置 情 况		h _{fe}	h _{ie} h _{is} * (Ω)	h _{re} h _{rs} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{os} * (μU)	f _{ab} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	τ _{bb} h _{re} (real) * (Ω)		
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
2SB511	三 洋	PA	Si.E	-35	-5	-1.5A	10W (T _c =25°C)	150	-100	-20	90	-2	-1A									162	
" 512	松 下	"	Si.EMe	-60	-8	-3A	25W (T _c =25°C)	150	-30	-20	60	-3	-1A									178	
" 513	"	"	"	-60	-8	-3A	25W (T _c =25°C)	150	-30	-20	60	-3	-1A									179	
" 514	三 洋	"	Si.E	-50	-5	-2A	20W (T _c =25°C)	150	-100	-20	90	-2	-1A									162	
" 515	"	"	"	-50	-5	-2A	20W (T _c =25°C)	150	-100	-20	90	-2	-1A									163	
" 516	日 立	"	Ge.A	-20		-100	150	85	-25	-12	110	-1.5	-50									12C	
" 517																							
" 518	SON	PA	Si.EMe	-90	-8	-7A	60W (T _c =25°C)	150	-100	-50	50	-2	-1A									103	
" 519	"	"	"	-110	-8	-10A	80W (T _c =25°C)	150	-100	-50	50	-2	-1A									102	
" 520	"	"	"	-140		-12A	100W (T _c =25°C)	150	-100	-50	50	-2	-1A									102	
" 521	"	"	"	-60		-5A	25W (T _c =25°C)	150	-100	-50	50	-2	-2.5A									240	
" 522	"	"	"	-60		-5A	25W (T _c =25°C)	150	-100	-50	50	-2	-2.5A									241	
" 523	三 菱	"	Si.EP	-40	-5	-2A	10W (T _c =25°C)	150	-1	-25	120	-4	-500									180	2SD360 之對稱
" 524	"	"	"	-60	-5	-1.5A	10W (T _c =25°C)	150	-1	-25	100	-4	-500									180	2SD361 之對稱
" 525	"	"	"	-30	-4	-1A	800	135	-1	-25	150	-1	-500					100 *				242	2SD335 之對稱
" 526	"	"	"	-90	-5	-800	10W (T _c =25°C)	150	-10	-25	100	-4	-300									180	2SD356 之對稱
" 527	"	"	"	-110	-5	-800	10W (T _c =25°C)	150	-10	-25	100	-4	-300									180	2SD357 之對稱
" 528	"	"	"	-130	-5	-800	10W (T _c =25°C)	150	-10	-25	100	-4	-300									180	2SD358 之對稱
" 529	"	"	"	-40	-5	-2A	10W (T _c =25°C)	150	-1	-25	120	-4	-500									180	2SD359 之對稱
" 530	東 芝	"	Si.EMe	-110	-5	-8A	80W (T _c =25°C)	150	-100	-50	80	-5	-1A									102	
" 531	"	"	"	-90	-5	-8A	50W (T _c =25°C)	150	-100	-50	80	-5	-1A									102	
" 532	松 下	"	"	-80	-5	-5A	60W (T _c =25°C)	150	-1mA	-50	100	-4	-1A	-10	500				10 *			102	
" 533	"	"	GeA	-20	-12	-2A	6W (T _c =25°C)	85	-200	-20	150	V _{CB} 0 V	I _E 2A	-2	100				1.2 *			84C	
" 534	日 立	"	"	-20	-6	-500	200	85	-25	-12	150	-1	-150									12A	
" 535	"	"	"	-35		-1A	5W (T _c =25°C)	85	-20	-12	100	-0.5	-500									84B	
" 536	日 電	PA	SiE	-140	-5	-1.5A	20W (T _c =25°C)	150	-1	-120	90	-5	-300									151	
" 537	"	"	"	-140	-5	-1.5A	20W (T _c =25°C)	150	-1	-120	90	-5	-300									152	
" 538	日 立	PA SW	GeA	-65	-30	-15A	75W (T _c =25°C)	100	-10mA	-65	100	-2	-10A									102	
" 539	日 電	PA	Si.TMe	-130	-6	-10A	100W (T _c =25°C)	150	-100	-120	75	-5	-2A									102	
" 540	東 芝	"	GeA	-50		-3A	250	85	-100	-25	100	-2	-3A									245	
2SB541	日 電	PA	Si.TMe	-110	-6	-8A	80W (T _c =25°C)	150	-100	-100	80	-5	-1A									102	
" 542	三 菱	"	Si.EP	-20	-5	-300	300	125	-1	-20	150	-2	-150	-6	10				150 *			138B	2SD392 之對稱
" 543																							
" 544																							
" 545																							
" 546																							
" 547																							
" 548	日 電	PA	Si.E	-100	-5	-800	5W (T _c =25°C)	150	-1	-80	80	-5	-200									225	
" 549	"	"	"	-100	-5	-800	5W (T _c =25°C)	150	-1	-80	80	-5	-200									225	
" 550																							
" 551																							
" 552																							
" 553																							
" 554	東 芝	PA	Si.TMe	-160	-5	-15A	150W (T _c =25°C)	150	-100	-80	80	-5	-2A									102	
" 555	"	"	"	-140	-5	-12A	100W (T _c =25°C)	150	-100	-60	80	-5	-2A									102	
" 556	"	"	"	-120	-5	-12A	100W (T _c =25°C)	150	-100	-60	80	-5	-2A									102	
" 557	"	"	"	-120	-5	-8A	80W (T _c =25°C)	150	-100	-60	80	-5	-1A									102	
" 558	"	"	"	-100	-5	-7A	60W (T _c =25°C)	150	-100	-50	80	-5	-1A									102	
" 559																							
" 560																							
" 561	日 立	PA	Si.EP	-25	-5	-700	500	150	-1	-20	130	-1	-150									138	
" 562	"	"	"	-25	-5	-1A	900	150	-1	-20	140	-2	-500									251	
" 563																							
" 564																							
" 565																							
" 566																							
" 567																							
" 568																							
" 569	ALP	PA	Si.E	-40	-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-500	-40	6000	-3	-2A									252	2SD479 之對稱
" 570	"	"	"	-60	-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-500	-60	6000	-3	-2A									252	2SD480 之對稱

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)										外 形	備 考			
				V _{CE0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CE0} 最大値		直 流 及 脈 沖 下 之 h _{FE}		偏 置 情 況		h _{FE} h _{FS} *	h _{FE} h _{FS} *	h _{FE} h _{FS} *	h _{FE} h _{FS} *			f _T f _T *	C _{ob} (pF)	r _{ab} h _{ie} (real)* (Ω)
									(μA)	V _{CE} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)									
2SB571	ALP	PA	Si.E	-80	-5	-4A	40W (T _a =25℃)	150	-500	-80	6000	-3	-2A								252	2SD481 之對稱	
" 572	"	"	"	-40	-5	-3A	30W (T _a =25℃)	150	-100	-40	50	-1	-500								252	2SD488 之對稱	
" 573	"	"	"	-60	-5	-3A	30W (T _a =25℃)	150	-100	-60	50	-1	-500								252	2SD489 之對稱	
" 574	"	"	"	-80	-5	-3A	30W (T _a =25℃)	150	-100	-80	50	-1	-500								252	2SD490 之對稱	
" 575	"	"	"	-40	-5	-4A	40W (T _a =25℃)	150	-100	-40	50	-2	-1.5A								252	2SD485 之對稱	
" 576	"	"	"	-60	-5	-4A	40W (T _a =25℃)	150	-100	-60	50	-2	-1.5A								252	2SD486 之對稱	
" 577	"	"	"	-80	-5	-4A	40W (T _a =25℃)	150	-100	-80	50	-2	-1.5A								252	2SD487 之對稱	
" 578	"	"	"	-70	-5	-10A	90W (T _a =25℃)	150	-1mA	-70	40	-4	-4A								253	2SD491 之對稱	
" 579	"	"	"	-60	-5	-5A	75W (T _a =25℃)	150	-100	-60	40	-2	-2.5A								253	2SD493 之對稱	
" 580	"	"	"	-80	-5	-5A	75W (T _a =25℃)	150	-100	-80	40	-2	-2.5A								253	2SD494 之對稱	
" 581	"	"	"	-100	-5	-5A	75W (T _a =25℃)	150	-100	-100	40	-2	-2.5A								253	2SD495 之對稱	
" 582	"	"	"	-60	-5	-8A	75W (T _a =25℃)	150	-500	-60	3000	-4	-4A								253	2SD492 之對稱	
" 583	"	"	"	-80	-5	-8A	75W (T _a =25℃)	150	-500	-80	3000	-4	-4A								253	2SD497 之對稱	
" 584	"	"	"	-100	-5	-8A	75W (T _a =25℃)	150	-500	-100	3000	-4	-3A								253	2SD498 之對稱	
" 585	"	"	"	-60	-5	-8A	100W (T _a =25℃)	200	-500	-60	3000	-3	-4A								102	2SD502 之對稱	
" 586	"	"	"	-80	-5	-8A	100W (T _a =25℃)	200	-500	-80	3000	-4	-8A								102	2SD503 之對稱	
" 587	"	"	"	-60	-5	-12A	150W (T _a =25℃)	200	-500	-50	3000	-3	-6A								102	2SD504 之對稱	
" 588	"	"	"	-80	-5	-12A	150W (T _a =25℃)	200	-500	-80	3000	-3	-6A								102	2SD505 之對稱	
" 589	"	"	"	-100	-5	-12A	150W (T _a =25℃)	200	-500	-100	3000	-3	-6A								102	2SD506 之對稱	
" 590																							
" 591																							
" 592																							
" 593																							
" 594																							
" 595																							
" 596																							
" 597																							
" 598																							
" 599																							
" 600																							

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 気 的 特 性 (T _a = 25℃)										外 形	備 考			
				V _{CE0} (V)	V _{BE0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (℃)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CE} (V)	直 流 及 脈 冲 下 之 h _{FE}		偏 置 情 况		h _{FE}	h _{ie} (Ω)	h _{re} (×10 ⁻⁴)	h _{oe} (μU)			f _β (Mc)	C _{ob} (pF)	h _{ie} (real) [*] (Ω)
2SC 11	東 芝	SW	Ge. A	18	12	24	55	75	9	12	44	1	24	6	- 1		t _r = 0.06μs, t _f = 0.07μs t _s = 1 μs	6	<20	<200	12A		
" 12	"	"	Si. Me	60	8	250	180	150	10	30	20	10	200				t _r = 0.32μs, t _f = 0.19μs t _s = 0.21μs	9			84A		
" 13	"	"	Ge. A	18	12	40	65	75	9	12	48	1	24	6	- 1		t _r = 0.24μs, t _f = 0.11μs t _s = 0.19μs	15			84A		
" 14	"	"	"	18	12	40	65	75	9	12	48	1	24	6	- 1						84A		
" 15	SON	RF	Si. Me	30	5	50	750	175	1	30	30	5	10	20	- 10	21	5	0.36	150 [*]	2	100 [*]	84C	
" 16	東 芝	SW	Si. P	25	5	30	250	175	2.5	15	25	1	10				t _r = 20nS, t _f = 45nS t _s = 250nS		< 7		49C		
" 16A	"	"	"	25	5	50	250	175	1	15	30	1	10								49C		
" 17	"	RF	"	20		50	250	175	2.5	12				6	- 2	30			150 [*]	4	90	49C	
" 17A	"	"	"	25		30	250	175	1	15				10	- 10	30			150 [*]	4	30	49C	
" 18	"	"	"	25	2	30	250	175	0.1	6	12	0.3	0.1	6	- 1	20			50	6	40	49C	
" 19	"	SW	"	40	5	400	600	150	1	30	50	2	150				t _r = 40nS, t _f = 120nS t _s = 650nS	> 70 [*]	30		84A		
" 20	"	RF	"	40	3	400	600	150	1	30				10	- 10	- 0.98			90	30	25	84A	
" 21	"	SW	"	60	5.5	2 A	60 W (T _c = 85℃)	150	1 mA	30	25	10	1 A	30	- 300				6 [*]	450		102	
" 22	日 電	RF	Si. EP	75	5	600	13 W (T _c = 85℃)	175	2	50	50	10	150	10	- 50	50			110 [*]	20		83	
" 23	"	"	"	75	5	500	13 W (T _c = 85℃)	175	5	50	50	10	150	10	- 50	50			110 [*]	20		83	
" 24	"	"	"	100	5	500	13 W (T _c = 85℃)	175	5	70	50	10	150	10	- 50	50			110 [*]	20		83	
" 25	松 下	RF, IF, Conv Mix. Osc	Si. Me	60		60	500	150	10	12				12	- 10	50			70	10	70	84B	
" 26	富士通	RF	"	60		100	500	150	1	30				10	- 10	50			150	4	70	79	
" 27	"	"	Si. P	60		100	650	175	1	30				6	- 1	80			350 [*]	4	50 [*]	84C	
" 28	"	"	"	40	5	50	225	150	1	10				10	- 10	30			100 [*]	4	50	84C	
" 29	"	"	"	40	5	25	115	150	1	10				10	- 10	30			100 [*]	4	50	84C	
" 30	日 電	"	Si. EP	60	5	80	500	150	0.1	30				10	- 10	45	h _{FE} = 23 dB (f = 20 Mc)		280 [*]	4	35	84A	
" 31	"	RF, PA	"	60	5	200	750	175	0.1	30				10	- 10	35			200 [*]	4	35	84A	
" 32	"	"	"	60	5	200	750	175	0.1	30				10	- 10	60			250 [*]	4	40	84A	
" 32A	"	"	"	60	5	200	750	175	1	30				10	- 10	60			250 [*]	4	40	84A 2SA544 之對應	
" 33	"	RF	"	45	3	150	150	150	0.1	20				10	- 5	55	h _{FE} = 22 dB (f = 20 Mc)		250 [*]	3.5	40	48C	
" 34	松 下	SW	Ge. A	20	20	250	140	75	3	5	30	0.5	200	5	- 3				6 [*]	20		20	
" 35	"	"	"	20	20	400	140	75	3	5	65	0.5	200	5	- 3				12 [*]	20		20	
" 36	"	"	"	20	20	400	140	75	3	5	100	0.5	200	5	- 3				20 [*]	20		20	
" 37	日 電	RF, IF, Conv Mix. PA	Si. EP	40	3	200	200	175	0.1	20				10	- 10	50			200 [*]	4	50	84A	
2SC 38	日 電	RF, IF, Conv Mix. Osc.	Si. EP	40	3	200	750	175	0.1	30				10	- 10	50			200 [*]	4	50	84C	
" 39	富士通	RF	Si. Me	25	3	50	250	150	0.1	10				6	- 1	50			500 [*]	2.3	80 [*]	49C	
" 39A	"	"	"	25	3	50	250	150	0.1	10				6	- 3	120	NF < 6 dB (f = 1 Mc)		350 [*]	3	65 [*]	49C	
" 40	"	"	"	25	3	50	250	150	0.1	10				6	- 1	50			750 [*]	2.3	80 [*]	49C	
" 41	SON	"	"	150		5 A	50 W (T _c = 85℃)	150	60 mA	150	28	10	1 A	10	- 0.5A				20	250	5	103	
" 42	"	"	"	150	6	5 A	50 W (T _c = 85℃)	150	60 mA	150	28	10	1 A	10	- 0.5A				20	250	5	103	
" 42A	"	"	"	200	6	5 A	50 W (T _c = 85℃)	150	30	50	40	10	1 A	10	- 0.5A				20 [*]	250		103	
" 43	"	"	"	100	6	5 A	50 W (T _c = 85℃)	150	60 mA	100	28	10	1 A	10	- 0.5A				20	250	5	103	
" 44	"	"	"	50	6	5 A	50 W (T _c = 85℃)	150	60 mA	50	28	10	1 A	10	- 0.5A				20	25	5	103	
" 45	日 電	RF, IF, Conv Mix. Osc	Si. P	45		100	500	150	1	30	50	2	10	10	- 10	50			160 [*]	4	130 [*]	84A	
" 46	富士通	RF, IF, Conv Mix. Osc, SW	Si. Me	60	5	300	600	150	0.1	10	50	1	10	6	- 1	50	28 [*]	0.8 [*]	0.1 [*]	180 [*]	15	35 [*]	84C
" 47	"	"	"	40	5	300	600	150	1	6	50	1	10	6	- 1	50	28 [*]	0.8 [*]	0.1 [*]	180 [*]	15	35 [*]	84C
" 48	"	"	"	120	5	300	600	150	0.1	10	50	1	10	6	- 1	50	28 [*]	0.8 [*]	0.1 [*]	180 [*]	15	35 [*]	84C
" 49	日 電	RF, IF, Conv Mix. Osc	Si. EP	120	6	300	800	175	0.5	60	60	10	150	10	- 50	60			175 [*]	9		84A	
" 50	松 下	RF, Conv Mix. Osc	Ge. A	20	20	200	100	75	3	5				6	- 1	45			12	20	100	20	
" 51	富士通	RF, IF, Conv Mix. Osc, PA	Si. Me	60	5	300	1 W	150	0.1	10	50	1	10	6	- 1	50	28 [*]	0.8 [*]	0.1 [*]	180 [*]	15	35	80
" 52	"	"	Si. P	40	5	100	500	150	0.03	10	50	1	10	6	- 1	50	28 [*]	1.5 [*]	0.1 [*]	350 [*]	4	40 [*]	84C
" 53	"	RF, IF, Conv Mix. Osc, PA	"	25	3	100	600	150	0.5	10	50	1	10	6	- 1	50			300 [*]	4	40 [*]	84C	
" 54	"	RF, IF, Conv Mix. Osc, SW	"	40	5	100	300	150	0.03	10	50	1	10	6	- 1	50	28 [*]	1.5 [*]	0.1 [*]	350 [*]	4	40 [*]	49C
" 55	"	RF, IF, Conv Mix. Osc, PA	"	25	3	100	360	150	0.5	10	50	1	10	6	- 1	50			300 [*]	4	40 [*]	49C	
" 56	"	RF, Conv Mix. Osc	"	20	3	25	200	120	2	12				6	- 2	80			180 [*]	2.3	80 [*]	30	
" 57	日 電	PA	Si. Me	75	4	500	13 W (T _c = 85℃)	175	30	30	30	10	150						110 [*]	22		83	
" 58	松 下	RF, IF, Conv Mix. Osc, PA	"	60	1.5	60	600	175	2	12	50	12	10	12	- 10	50			250 [*]	2.5	170	84A	
" 58A	"	"	"	140	1.5	60	600	175	2	12	50	12	10	12	- 10	50			250 [*]	2.5	170	84A	
" 59	日 電	RF, IF, Conv Mix. Osc	Si. EP	120	6	300	800	175	0.5	60	35	10	150	10	- 50	35			140 [*]	9		84A	
" 60	三 洋	RF	Ge. A	20	10	20	100	85	15	20				6	- 1	50			5	15	80	12A	
" 61	富士通	RF, IF, Conv Mix. Osc, SW	Si. Me	30	5	300	1.2 W	175	1	10	50	1	10	6	- 1	50	28 [*]	0.8 [*]	0.1 [*]	180 [*]	15	35	80
" 62	日 立	SW	Si. P	40	5	50	360	175	0.025	15	100	1	10	10	- 10				300 [*]	5.5		49C	
" 63	日 電	"	Si. Me	25	3	50	300	150	1	15	40	1	10	10	- 10				400 [*]	4.5		49C	
" 64	三 洋	RF	"	80	2	50	600	175	1.5	20				20	- 5	50			100 [*]	5	80	84B	

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)					電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)												外 形	備 考		
				V_{CB0} (V)	V_{EB0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^{\circ}\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直 流 及 脈 冲 下 之 h_{FE}				偏置情况	h_{fe}	$h_{1\beta}$ $h_{1\beta}^*$ (Ω)	h_{re} h_{re}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{oe}^* (μU)	$f_{\alpha h}$ $f_{\alpha h}^*$ (Mc)			C_{ob} (pF)	r_{re} r_{re}^* (Ω)
									$V_{CE(V)}$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB(V)}$	$I_E(\text{mA})$	$V_{CE(V)}$	$I_C(\text{mA})$										
2SC 65	三 洋	RF	Si.Me	150	4	50	600	175	15	150	30	20	5	20	— 5	20				200*	<10	<200	84B	
" 66	"	"	"	150	2	50	600	175	1.5	20				20	— 5	70				130*	5	100	84B	
" 67	日 電	SW	Si.EP	40	5	200	360	175	0.1	15	80	1	10				$t_{\alpha s} < 20\text{nS}, t_{\alpha f} < 40\text{nS}$ $t_{\alpha s} < 20\text{nS}$					49C		
" 68	"	SW	"	25	5	200	300	150	1	15	40	1	10	10	— 10		$t_{\alpha s} < 60\text{nS}, t_{\alpha f} < 60\text{nS}$ $t_{\alpha s} < 80\text{nS}$			400*	4.5	50	49C	
" 69	"	RF, IF, Conv Mix, Osc	"	120	6	300	800	175	0.5	60	50	1	150	10	— 50	50				160*	9		84A	
" 70	東 芝	RF	Si.TMe	180		20	800	150	1	30				30	— 2	45				125*	1.8	100	84A	
" 71	"	SW	Ge. A	18	12	200	150	85	7	12	100	0.5	100										84A	
" 72	"	"	"	18	12	200	150	85	7	12	100	0.5	100										84A	
" 73	SON	RF, Conv, Mix Osc	Ge. G	15		5	30	75	8	15				6	— 1	—0.976*	$PG = 27\text{ dB}$ ($f = 2\text{ Mc}$)			20	2		18	2S132 2T 73
" 74	東 芝	RF	Si. P	30	5	100	360	175	4	15				6	— 2	50				100	2.5	100	84A	
" 75	SON	IF	Ge. G	15		5	30	75	8	15				6	— 1	—0.96*	$PG = 41\text{dB}$ ($f = 455\text{kc}$)			10	2.1		18	2S133 2T 75
" 76	"	"	"	15		5	30	75	8	15				6	— 1	—0.96*	$PG = 37\text{ dB}$ ($f = 455\text{kc}$)			10	2.1		18	2S134 2T 76
" 77	"	"	"	15		5	30	75	8	15				6	— 1	—0.96*	$PG = 32\text{ dB}$ ($f = 455\text{kc}$)			10	2.1		18	2S135 2T 77
" 78	"	RF, Conv, Mix Osc	"	15		5	30	75	2	15				6	— 1	—0.98*	33*	2*	0.2*	20	1.5		18	2S136 2T 78
" 79	富士通	"	Si. Me	15	3	50	300	175	1	10				6	— 1	50				500*	2.3	80*	49C	
" 80	日 電	"	Si. EP	30	3	80	200	175	0.1	20				10	— 5	55				200*	3.5	40	48C	
" 81	三 菱	PA	Si. Me	50		5 A	$\frac{125\text{ W}}{(R=25^{\circ}\text{C})}$	150	10 mA	50	30	10	1 A	10	— 1A	30				5	300	5	108	
" 82	"	"	"	100		5 A	$\frac{125\text{ W}}{(R=25^{\circ}\text{C})}$	150	10 mA	100	30	10	1 A	10	— 1A	30				5	300	5	108	
" 83	"	"	"	150		5 A	$\frac{125\text{ W}}{(R=25^{\circ}\text{C})}$	150	10 mA	150	30	10	1 A	10	— 1A	30				5	300	5	108	
" 84	"	SW	Ge. A	25	20	200	120	85	25	25	40	0.5	20										12A	
" 85	"	"	"	25	20	400	120	85	25	25	30	0.3	200										12A	
" 86	"	"	"	25	20	400	120	85	25	25	60	0.3	200										12A	
" 87	富士通	RF, Conv, Mix Osc, SW, PA	Si. Me	30	3	100	600	175	1	10	50	1	10	10	— 10	50				250*	4	90*	84C	
" 88	"	"	"	120	3	100	600	175	1	10	50	1	10	10	— 10	50				250*	3	70*	84C	
" 92	日 電	PA	Si. EP	100	5	2 A	$\frac{20\text{ W}}{(R=25^{\circ}\text{C})}$	175	0.1	50	35	10	350	10	— 350		$P_s = 9\text{ W}$ ($f = 100\text{Mc}$)			190*	35	25*	83	
" 93	"	"	"	80	5	2 A	$\frac{20\text{ W}}{(R=25^{\circ}\text{C})}$	175	0.1	50	35	10	350	10	— 350		$P_s = 9\text{ W}$ ($f = 100\text{Mc}$)			190*	35	25*	83	
" 94	"	"	"	100	5	2 A	$\frac{20\text{ W}}{(R=25^{\circ}\text{C})}$	175	0.1	50	35	10	350	10	— 350		$P_s = 9\text{ W}$ ($f = 100\text{Mc}$)			190*	35	25*	83	
" 95	東 芝	RF, PA	Si. Me	140		100	800	150	1	30				10	— 10					140*	10	80	84A	
" 96	"	chopper	Si. EP	25	5	150	500	175	0.01	15	60			10	— 10					150*	17	50	88A 複合管	
★ " 97	日 電	RF, SW	"	60	5	1 A	800	175	1	40	60	10	150	10	— 50	90	$t_{\alpha s} = 25\text{nS}, t_{\alpha f} = 75\text{nS}$ $t_{\alpha s} < 50\text{nS}$			250*	10	17*	84A	
2SC 98	松 下	SW	Si. EP	20	5	100	300	175	10	20	45	0.35	10	2	— 10					350*	<5		49C	
" 99	"	"	"	20	5	100	300	175	10	20	80	0.35	10	2	— 10					350*	<5		49C	
★ " 100	日 電	RF, SW	"	40	5	200	150	200	0.025	20	60	1	10	10	— 10	80	$t_{\alpha s} + t_{\alpha f} < 40\text{nS}$ $t_{\alpha s} + t_{\alpha f} < 70\text{nS}$			400*	35	40*	23	
" 101	東 芝	RF	Si. Me	60	5.5	2 A	$\frac{60\text{ W}}{(R=25^{\circ}\text{C})}$	150	10 mA	20				10	— 0.5A	30	$h_{1\beta} = 16$ ($f = 1\text{ Mc}$)			350	$C_{ob} = 18\text{ nS}$		101	
" 102	"	"	"	50		7 A	$\frac{100\text{ W}}{(R=25^{\circ}\text{C})}$	150	45 mA	50				10	— 0.5A	25	$h_{1\beta} = 10$ ($f = 1\text{ Mc}$)			850	$C_{ob} = 10\text{ nS}$		109	
" 103	"	SW	Si. P	25	5	50	250	175	1	15	35	1	10				$t_{\alpha s} + t_{\alpha f} < 40\text{nS}$ $t_{\alpha s} < 500\text{nS}, t_{\alpha f} < 60\text{nS}$						49C	
" 103A	"	"	"	30	5	80	250	175	0.2	15	100	1	10										49C	
" 104	"	RF	"	25		50	250	175	1	15				10	— 10	32				250*	4	30	49C	
" 104A	"	"	"	30	5	80	250	175	0.2	15	60	1	10										49C	
" 105	"	"	"	30	5	80	250	175	0.005	15	35	1	0.1	10	— 10	60				250*	4	30	49C	
" 106	"	SW, PA	Si. E	60	5	1.5 A	$\frac{15\text{ W}}{(R=25^{\circ}\text{C})}$	150	3 mA	30	20	5	0.5A	12	— 200	30				100*	50	7	83	
" 107	"	"	"	60	5	1 A	$\frac{15\text{ W}}{(R=25^{\circ}\text{C})}$	150	3 mA	30	20	5	0.5A	12	— 200	30				100*	50	7	83	
" 108	"	RF, SW	Si. EMe	90	5	600	600	150	1	30	35	2	150	10	— 10					90*	20	55	84A	
" 109	"	SW	"	50	5	600	600	150	1	30	35	2	150										84A	
" 110	日 立	RF, PA	Si. Me	40	5	200	750	175	1	20				6	— 10	80				160*	7	55	84A	
" 111	"	"	"	50	5	200	750	175	1	20				6	— 10	50				160*	10	60	84A	
" 112	"	SW	"	40	5	200	750	175	1	20	50	2	200										84A	
" 113	"	"	"	50	5	200	750	175	1	20	50	2	200										84A	
" 114	"	"	"	50	5	200	750	175	1	20	50						$t_{\alpha s} = 20\text{nS}, t_{\alpha f} = 110\text{nS}$ $t_{\alpha s} = 50\text{nS}, t_{\alpha f} = 20\text{nS}$						84A	
" 115	SON	RF	Si. EMe	30	5	50	750	175	3	30	50	5	3	20	— 10	50				200*	3	100*	84A	
" 116	日 立	RF, PA	"	50	5	200	750	175	1	20	40	2	200	6	— 10	40				120*	14	70	84A	
" 117	"	SW, PA	Si. TP	75	5	600	$\frac{13\text{ W}}{(R=25^{\circ}\text{C})}$	175	5	40	40	15	30	15	— 30	45				112*	15	20	83	
" 118	"	PA	"	80	5	600	$\frac{13\text{ W}}{(R=25^{\circ}\text{C})}$	175	5	40				15	— 30	45				120*	15	20	83	
" 119	"	"	"	75	5	600	$\frac{13\text{ W}}{(R=25^{\circ}\text{C})}$	175	5	40				15	— 30	45				130*	15	20	83	
" 120	日 電	RF	Si. P	40	1	25	250	150	0.1	10	40	10	0.05	10	— 1	90	27	2	0.1	200*	4	40	84A	
" 121	"	RF, Conv, Mix Osc	"	40	1	25	250	175	1	30				10	— 1	40	35*	2*	0.15*	130*	4	30*	84A	
" 122	"	"	"	40	1	25	250	175	1	30				10	— 1	90	35*	2*	0.15*	160*	4	40*	84A	
" 123	"	"	"	40	1	25	250	175	1	30				10	— 1	140	35*	2*	0.1*	180*	4	40*	84A	
" 124	"	"	"	40	1	25	250	175	0.2	30	40	10	0.05	10	— 1	90	35*	2*	0.1*	200*	4	40*	84A	
" 125	SON	RF, SW	Si. EMe	100	5	50	750	175	3	30	50	5	3	20	— 1									

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)					電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)													外 形	備 考		
				V_{CB0} (V)	V_{EB0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_J ($^{\circ}\text{C}$)	I_{CBO} 最大值		直 流 及 脈 沖 下 之 h_{FE}				偏置情况	h_{fe}	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μS)	$f_{\alpha B}$ f_T^* (Mc)	C_{ob} (pF)	r_{bb} $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)			
									I_{CBO}	V_{CB0}	$V_{CE}(V)$	$I_C(mA)$	$V_{CB}(V)$	$I_E(mA)$											
2SC126	SON	RF. SW	Si. EMe	140	5	50	750	175	3	30	50	5	3	20	-10	50				200*	3	3	84 C		
* 127	日 電	RF. Conv. Mix Osc.	Si. P	20		25	200	175	2	15				10	-1	150				200*	4	40*	84 A		
* 128	松 下	SW	Ge. A	30	20	200	150	85	3	5	40	0.5	100	5	-3					7*	9		84 A		
* 129	"	"	"	25	20	200	150	85	3	5	60	0.5	100	5	-3					10*	9		84 A		
* 130	富士通	RF. Conv. Mix Osc. PA	Si. EP	60		1 A	1.8 W	175	0.1	10	40	10	20	10	-20	40				160*	15	35*	83		
* 131	"	SW	"	40	5	300	350	175	0.05	10	60	1	10				$t_r = 8 \text{ nS}, t_f = 20 \text{ nS}$ $t_s = 20 \text{ nS}$						49 C		
* 132	"	"	"	20	5	300	350	175	0.05	10	60	1	10				$t_r = 8 \text{ nS}, t_f = 20 \text{ nS}$ $t_s = 20 \text{ nS}$						49 C		
* 133	"	"	"	20	5	300	350	175	0.05	10	60	1	10				$t_r = 8 \text{ nS}, t_f = 20 \text{ nS}$ $t_s = 20 \text{ nS}$						49 C		
* 134	"	"	"	40	5	300	350	175	0.02	10	60	1	10				$t_r = 10 \text{ nS}, t_f = 25 \text{ nS}$ $t_s = 100 \text{ nS}$						49 C		
* 135	"	"	"	20	5	300	350	175	0.02	10	60	1	10				$t_r = 10 \text{ nS}, t_f = 25 \text{ nS}$ $t_s = 100 \text{ nS}$						49 C		
* 136	"	"	"	80	5	300	350	175	0.02	10	60	1	10				$t_r = 10 \text{ nS}, t_f = 25 \text{ nS}$ $t_s = 100 \text{ nS}$						49 C		
* 137	"	"	"	25	5	300	350	175	0.05	10	50	1	10										49 C		
* 138	日 電	RF. Conv. Mix Osc.	"	60	5	500	800	175	1	40				10	-30	50				400*	4	40*	85 A		
* 138A	"	"	"	60	5	500	800	175						10	-30	50				400*	4	40*	85 A		
* 139	"	"	"	60	5	500	800	175	2	40				10	-30	50				400*	4	40*	85 A		
* 140	SON	RF	Si. EMe	60		1 A	1.7 W	175	12	30				10	-50	-0.97*				150*	13	20*	74		
* 141	冲	"	Si. EP	20	5	200	360	175	0.1	15	75	1	10	10	-10	95				450*	4	70*	49 C		
* 142	"	RF. SW	"	30	5	200	360	175	0.1	15	75	1	10	10	-10	95	$t_d = 12 \text{ nS}, t_{rth} = 10 \text{ nS}$ $t_r = 16 \text{ nS}, t_{off} = 32 \text{ nS}$			450*	4	70*	49 C		
* 143	"	"	"	40	5	200	360	175	0.1	15	75	1	10	10	-10	95	$t_d = 12 \text{ nS}, t_{rth} = 10 \text{ nS}$ $t_r = 16 \text{ nS}, t_{off} = 32 \text{ nS}$			450*	4	70*	49 C		
* 144	"	"	"	50	5	200	360	175	0.1	15	65	1	10	10	-10	85	$t_d = 12 \text{ nS}, t_{rth} = 15 \text{ nS}$ $t_r = 16 \text{ nS}, t_{off} = 32 \text{ nS}$			450*	3	70*	49 C		
* 144A	"	"	"	60	5	200	360	175	0.1	15	65	1	10	10	-10	85	$t_d = 12 \text{ nS}, t_{rth} = 15 \text{ nS}$ $t_r = 16 \text{ nS}, t_{off} = 32 \text{ nS}$			450*	3	70*	49 C		
* 145	"	RF	"	30	5	200	360	175	0.1	15				10	-10	70				500*	3	70*	49 C		
* 146	"	"	"	50	5	200	360	175	0.1	15				10	-10	80				500*	3	70*	49 C		
* 146A	"	"	"	60	5	200	360	175	0.1	15				10	-10	80				500*	3	70*	49 C		
* 147	SON	"	Si. EMe	30	5	1 A	750	175	5	30	50	4	100	10	-50	-0.96*				120*	12	20*	74		
* 149	日 電	RF. IF. Conv Osc	Si. DB	120	6	300	800	175	10	60	45	10	150	10	-50	45				160*	14	45*	84 A		
* 150	日 立	RF	Si. Me	20	1	100	750	175	10	20				6	-10					80*	7	70	84 A		
* 151	"	"	"	40	4	100	750	175	10	40				6	-10					100*	7	70	84 A		
* 152	"	"	"	60	4	100	750	175	10	60				6	-10					120*	7	70	84 A		
* 153	"	"	"	120	4	100	750	175	10	120	65	5	50	5	-10	40				140*	6	80	84 A		
2SC154	日 立	RF	Si. EMe	120	5	100	750	175	10	120				10	-10	60				150*	2.5	20	84 A		
* 154A	"	"	"	150	5	100	750	175	10	150				10	-10	60				150*	2.5	20	84 A		
* 155	富士通	RF. Conv. Mix Osc	Si. P	20	2	25	100	125	2	12				6	-2	35				200*	2	60*	35		
* 156	"	"	"	20	2	25	100	125	2	12				6	-2	50				200*	2	80*	35		
* 157	日 立	RF	Si. GD	20	1	20	125	150	1	12				6	-2	30				25	3.5	80	84 A		
* 158	"	"	"	20	1	20	125	150	1	12				6	-2	40				40	3.5	80	84 A		
* 159	"	"	"	20	1	20	125	150	1	12				6	-2	50				60	3.5	80	84 A		
* 160	"	"	"	20	1	20	125	150	1	12				6	-2	60				100	3.5	80	84 A		
* 161	東 芝	SW. PA	Si. Me	60	5.5	4 A	50 W ($T_c = 25^{\circ}\text{C}$)	150	2 mA	30	25	5	3 A	10	-200					30*	350	50	102		
* 162	冲	RF	Si. EP	30	5	250	500	175	0.1	15	60	1	50	10	-20	90				500*	3.5	90*	84 A		
* 163	"	"	"	50	5	250	500	175	0.1	15	60	1	50	10	-20	90				500*	3.3	90*	84 A		
* 164	"	"	"	60	5	250	500	175	0.1	15	60	1	50	10	-20	90				500*	3.2	90*	84 A		
* 165	"	"	"	60	5	250	500	175	0.1	15	60	1	50	10	-20	90				500*	3.3	90*	84 A		
* 166	日 立	RF. SW	Si. GD	30	5	30	200	175	0.1	20	80	12	3	12	-3					16	13	90*	49 C		
* 167	"	"	"	55	5	30	200	175	0.1	20	80	12	3	12	-3					16	13	90*	49 C		
* 170	富士通	RF. PA	Si. P	25	3	50	110	175	0.5	20	40	1	10	6	-10	60				250*	5	50	49 C		
* 171	"	"	"	25	3	50	200	175	0.5	20	30	6	0.1	6	-10	60				250*	5	50	49 C		
* 172	"	"	"	25	5	50	300	175	0.1	20	30	6	0.1	6	-10	60				350*	5	50	49 C		
* 172A	"	"	"	40	5	50	360	200	0.025	20				6	-10	60				350*	5	50	49 C		
* 173	SON	RF. Conv. Mix Osc	Ge. G	15		5	30	75	8	15				6	-1	-0.976*				20	2		7		
* 174	富士通	"	Si. P	30	5	25	200	175	1	12				6	-2	45				170*	1.5	65*	50 C		
* 174A	"	"	"	60	5	25	200	175	1	30				6	-2	45				200*	1.5	65*	50 C		
* 175	SON	IF	Ge. G	15		5	30	75	8	15				6	-1	-0.96*				10	2.1		7		
* 176	"	"	"	15		5	30	75	8	15				6	-1	-0.96*				10	2.1		7		
* 177	"	"	"	15		5	30	75	8	15				6	-1	-0.96*				10	2.1		7		
* 178	"	RF. Conv. Mix Osc	"	15		5	30	75	2	15				6	-1	-0.98*	33*	2*	0.2*	20	1.5		7		
* 179	日 立	SW	Ge. A	25	20	400	120	85	8	12	40	0.2	20	6	-1		$t_r = 0.4 \mu\text{S}, t_f = 0.2 \mu\text{S}$ $t_s = 0.25 \mu\text{S}$			3	25	300	12 A		
* 180	"	"	"	25	20	400	120	85	8	12	35	0.3	200	6	-1		$t_r = 0.3 \mu\text{S}, t_f = 0.15 \mu\text{S}$ $t_s = 0.25 \mu\text{S}$			5	25	250	12 A		
* 181	"	"	"	25	20	400	120	85	8	12	60	0.3	200	6	-1		$t_r = 0.25 \mu\text{S}, t_f = 0.13 \mu\text{S}$ $t_s = 0.25 \mu\text{S}$			10	25	250	12 A		
* 182	日 電	RF. AF. PA	Si. EP	25	5	150	150	150	1	26	80	1	20	6	-1	55				90*	6.5	25	23	V81 A	

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)						電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)										外 形	備 考					
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CEO} 最大值		直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}			偏 置 情 况		h _{FE}	h _{FE} (Ω)	h _{FE} (×10 ⁻⁴)	h _{FE} (μU)			f _{αB} (Mc)	C _{αB} (pF)	h _{FE} (real) (Ω)		
									(μA)	(V _{CE} (V))	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)	h _{FE} *											
★ 2SC183	日 電	RF.Conv. Mix Osc. AF	Si. EP	20	5	30	100	125	0.1	15	75	3	0.5	6	-1	80	2000	0.55	10	150*	1.6	50*	23	V81 B		
★ " 184	"	RF.Conv. Mix Osc	"	20	5	30	100	125	0.1	15				6	-1	80				200*	1.6	50*	23	V81 C		
★ " 185	"	"	"	20	5	30	100	125	0.1	15				6	-1	80				250*	1.6	50*	23	V81 D		
" 186	富士通	"	Si. P	20	2	25	85	120	2	12				6	-2.5	40				200*	4	35	12A			
" 187	"	RF.Conv. Mix Osc	"	20	2	25	85	120	2	12				6	-2.5	50				200*	4	50	12A			
" 188	"	RF. PA	"	40	3	500	600	175	1	30	40	10	150	6	-10	50				150*	9	35	84B			
" 189	"	RF. SW. PA	"	60	5	500	600	175	1	30	40	10	150	6	-10	50				150*	9	35	84B			
" 190	"	"	"	60	5	500	600	175	1	30	75	10	150	6	-10	80				180*	9	35	84B			
" 191	SON	RF	Si. GD	60	1	10	250	150	2	60				20	-1	-0.955	60*	1.2*	0.15*	50	3	200	84A			
" 192	"	"	"	60	1	10	250	150	2	60				20	-1	-0.955	60*	1.2*	0.15*	10	3	200	84A			
" 193	"	"	"	60	1	10	250	150	2	60				20	-1	-0.955	60*	1.2*	0.15*	30	3	200	84A			
" 194	"	"	"	60	1	10	250	150	2	60				20	-1	-0.955	60*	1.2*	0.15*	50	3	200	84A			
" 195	"	"	"	30	1	10	250	150	1	30				20	-1	-0.955	60*	1.2*	0.15*	10	3	200	84A			
" 196	"	"	"	30	1	10	250	150	1	30				20	-1	-0.955	60*	1.2*	0.15*	30	3	200	84A			
" 197	"	"	"	30	1	10	250	150	1	30				20	-1	-0.955	60*	1.2*	0.15*	50	3	200	84A			
" 198	富士通	RF. PA	Si. EP	50	5	500	800	175	1	10				10	-20	40				350*	6	50*	85B			
★ " 199	東 芝	SW	Si. Me	80	15	50	600	175	0.1	15	70	12	3	12	-3	70	h _{FE} = 2 (f = 50 MHz)			2	100	84B				
" 200	富士通	RF.Conv. Mix Osc. PA	Si. EP	40		300	650	175	0.02	10				6	-1	60				350*	4	50*	84C			
" 201	"	"	"	20		300	650	175	0.1	10				6	-1	60				350*	4	50*	84C			
" 202	"	"	"	80		300	650	175	0.02	10				6	-1	60				350*	4	50*	84C			
" 203	"	"	"	40		200	350	175	0.02	10				6	-1	60				350*	4	50*	49C			
" 204	"	RF. SW	"	30	5	200	350	175	0.05	10	60	1	10	6	-2	70	t _r < 20nS, t _f < 50nS t _r < 250nS			250*	4	80*	49C			
" 205	"	RF. Conv. Mix Osc. PA	"	80		200	350	175	0.02	10				6	-1	60				350*	4	50*	49C			
" 206	"	"	Si. P	20	2	25	200	175	2	12				6	-2	35				200*	2	80*	50C			
" 207	"	"	"	20	3	25	200	175	0.1	12				6	-2	80				800*	1.0	80*	50C			
" 208	"	"	"	20	3	25	200	175	1	12				6	-2	60				550*	1.2	80*	50C			
" 209	"	"	"	20	3	25	200	175	1	12				6	-2	40				450*	1.2	80*	50C			
" 210	"	RF.Conv. Mix Osc	"	50		500	650	175	0.1	10				10	-20	50				150*	15	35*	84B			
" 211	"	RF	"	25		500	650	175	1	10				10	-20	50				150*	15	35*	84B			
" 212	"	"	"	80		500	650	175	0.1	10				10	-20	50				150*	15	35*	84B			
2SC213	富士通	RF. PA	Si. P	50		600	1.5W	175	0.1	10				10	-20	50				150*	15	35*	83			
" 214	"	"	"	25		600	1.5W	175	1	10				10	-20	50				150*	15	35*	83			
" 215	"	"	"	80		600	1.5W	175	0.1	10				10	-20	50				150*	15	35*	83			
" 216	"	SW	"	50	5	300	650	175	0.1	10	50	1	50										84B			
" 217	"	"	"	25	5	300	650	175	1	10	50	1	50										84B			
" 218	"	"	"	80	5	300	650	175	0.1	10	50	1	50										84B			
" 220	"	RF	Si. EP	50		700	650	175	0.1	10				10	-20	50				150*	15	25*	84B			
" 221	"	"	"	25		700	650	175	1	10				10	-20	50				150*	15	25*	84B			
" 222	"	"	"	80		700	650	175	0.1	10				10	-20	50				150*	15	25*	84B			
" 223	"	RF. PA	"	50		1A	1.5W	175	0.1	10				10	-20	20				150*	15	25*	83			
" 224	"	"	"	25		1A	1.5W	175	1	10				10	-20	20				150*	15	25*	83			
" 225	"	"	"	80		1A	1.5W	175	0.1	10				10	-20	20				150*	15	25*	83			
" 226	"	SW	"	50	5	700	650	175	0.1	10	50	1	100										84B			
" 227	"	"	"	25	5	700	650	175	1	10	50	1	100										84B			
" 228	"	"	"	80	5	700	650	175	0.1	10	50	1	100										84B			
" 229	"	"	"	80	5	1A	1.5W	175	0.1	10	50	1	100										83			
" 230	"	RF.Conv. Mix Osc. PA	"	80	3	200	350	175	0.02	10				6	-2	60				350*	4	50*	49C			
" 231	"	SW	Si. EMe	50	5	700	650	175	1	10	40	1	150										84B			
" 232	"	"	"	25	5	700	650	175	1	10	40	1	150										84B			
" 233	"	"	"	80	5	700	650	175	1	10	40	1	150										84B			
" 234	"	RF. PA	"	100		1.5A	1.8W	175	1mA	30				10	-150	20				140*	35	25*	83			
" 235	"	"	"	100		1.5A	1.5W	175	1mA	30				10	-150	20				120*	35	25*	83			
" 236	"	"	"	90		500	1.8W	175	0.1	10				10	-20	17				100*	15	25*	83			
" 237	"	RF	Si. EP	25		300	350	175	0.05	10				6	-1	80				450*	5	50*	49C			
" 238	"	RF. AF	"	40	5	100	650	175	0.1	10				6	-1	80				30*	3*	0.1*	350*	4	50*	84B
" 239	"	SW	"	50	5	300	350	175	0.05	10	60	1	10				t _r < 20nS, t _f < 50nS t _r < 100nS						49C			
★ " 240	日 電	SW	Si. EMe	100	5	5A	75W (T _a = 25℃)	175	5mA	100	35	10	1A	2	-1A						35			104		
★ " 241	"	"	"	60	5	5A	75W (T _a = 25℃)	175	10mA	60	35	10	1A	10	-1A									102		
★ " 242	"	"	"	100	5	5A	75W (T _a = 25℃)	175	10mA	100	35	10	1A	10	-1A									102		
★ " 243	"	"	"	140	5	5A	75W (T _a = 25℃)	175	10mA	140	35	10	1A	10	-1A									102		

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)				電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)												外 形	備 考				
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (℃)	I _{CB0} 最大値		直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}						偏 置 情 况								
									I _{CB0} (μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{FE}	h _{FE} *	h _{FE}	h _{FE} *	h _{FE}	h _{FE} *	f _β (MHz)	C _β (pF)	r _β (real) (Ω)		
2SC244	日 電	SW	Si.EMe	60	5	5 A	75 W (T _a =25℃)	175	50mA	60	35	10	1 A	10	-1 A		t _{on} =0.03μS, t _{off} =1μS t _{on} =0.47μS, t _{off} =0.5μS		35					102	
" 245	"	"	"	120	5	5 A	75 W (T _a =25℃)	175	20mA	120	35	10	1 A	10	-1 A		t _{on} =0.03μS, t _{off} =1μS t _{on} =0.47μS, t _{off} =0.5μS		35					102	
" 246	"	"	"	180	5	5 A	75 W (T _a =25℃)	175	20mA	180	35	10	1 A	10	-1 A		t _{on} =0.03μS, t _{off} =1μS t _{on} =0.47μS, t _{off} =0.5μS		35					102	
" 247	富士通	RF. PA	Si. P	100	3	100	600	175	1	30				6	-2	60			150*	3	70*		84B		
" 248	"	"	"	70	5	50	300	175	1	30				6	-2.5	60			170*	2.5	50		49C		
" 249	"	"	"	70	5	70	500	175	1	30				6	-2.5	60			170*	2.7	50		84B		
" 250	"	RF.Conv.Mix Osc	"	20	2	25	60	150	2	12				6	-2	45			170*	2	65		13A		
" 251	日 電	"	Si. EP	30	3	30	200	150	1	15				6	-5	50	NF < 6 dB (f = 1 Mc)			900*	1	70*		50C	
" 251A	"	"	"	30		30	200	150	1	15				6	-5	50	NF < 6 dB (f = 1 Mc)			900*	1	70*		50C	
" 252	"	"	"	30	3	30	200	150	1	15				6	-5	50	NF < 6 dB (f = 70 Mc)			900*	1	70*		50C	
" 253	"	"	"	30	3	30	200	150	1	15				6	-5	50	NF < 6 dB (f = 70 Mc)			900*	1	70*		50C	
" 254	冲	RF. PA	"	50	5	800	650	175	2	40	50	1	150	10	-50	55			250*	13	20*		84A		
" 255	"	"	"	80	5	800	650	175	1	40	45	1	150	10	-50	50			250*	13	20*		84A		
" 256	"	"	"	90	5	800	650	175	1	40	45	1	150	10	-50	50			250*	13	20*		84A		
" 257	"	"	"	50	5	800	800	175	2	40	50	1	150	10	-50	55			250*	13	20*		91		
" 258	"	"	"	80	5	800	800	175	1	40	45	1	150	10	-50	50			250*	13	20*		91		
" 259	"	"	"	90	5	800	800	175	1	40	45	1	150	10	-50	50			250*	13	20*		91		
" 260	"	PA	"	30	5	1 A	1.6W	175	2	20	60	10	150	10	-50	65			280*	15	23*		83		
" 261	"	"	"	60	5	1 A	1.6W	175	1	20	60	10	150	10	-50	65			280*	14	23*		83		
" 262	"	"	"	80	5	1 A	1.6W	175	1	20	60	10	150	10	-50	65			280*	13	23*		83		
" 263	"	RF	"	15		120	100	100	0.4	9				5	-1	60			200*	3	70*		21		
" 264	"	RF. SW	"	30	5	120	100	100	0.1	9	75	1	10	5	-5	85	t _{on} =12nS, t _{off} =10nS t _{on} =15nS, t _{off} =30nS		400*	3	70*		21		
" 265	"	"	"	40	5	120	100	100	0.1	9	75	1	10	5	-5	85			400*	3	70*		21		
" 266	日 電	RF. AF	"	30	5	30	100	150	0.1	25	75	3	0.5	6	-1	80	2000	0.55	10	250*	1.6	45		23	
" 267	"	RF. PA	"	35	5	200	150	150	1	35	70	1	20	6	-1	45			90*	6.5	25		23		
" 268	"	RF. PA. SW	"	60	5	30	150	150	5	50	40	1	1	6	-1	55			150*	1.6	50		23		
" 269	"	SW	"	25	5	200	150	150	1	15	85	0.5	1				t _{on} <20nS, t _{off} <40nS t _{sig} <20nS						139		
" 270	SON	PA	Si. Me	270	6	5 A	50 W (T _a =25℃)	150	1mA	50	40	3	2 A	10	-500	56			22*	250	5		103		
" 271	日 電	RF.Conv.Mix Osc	Si. EP	25	3	20	100	150	1	12				6	-2	70	NF < 8 dB (f = 70 Mc)			1100*	0.7	C _β max 10 pS		23	
" 272	"	"	"	25	3	20	100	150	1	12				6	-2	70	NF < 8 dB (f = 900 Mc)			1200*	0.7	C _β max 3 pS		23	
2SC273	日 電	RF.Conv.Mix Osc	Si. P	120	5	50	500	150	1	60				30	-3	50			150*	2.5	25		84A		
" 274																									
" 275																									
" 276																									
" 277																									
" 278																									
" 279																									
" 280	日 立	Diff	Si. E	30	5	10	80	125	0.01	20	80	-6	0.1											15	
" 281	"	RF	Si. EPa	30	5	100	200	175	0.1	20	170	6	10	6	-0.1	50	h _{FE} = 8 (6 V, 10mA, 20Mc)				7	70		12C	
" 282	"	SW	"	30	5	100	350	175	1	20	100	6	10	6	-10				180*	7	60		12A		
" 283	"	PA	"	50	5	100	350	175	0.1	20	65	6	10	6	-10	100			180*	7	60		12A		
" 284	"	SW	"	70	5	100	350	175	1	20	60	6	10	6	-10				160*	7	60		12A		
" 285	富士通	PA	Si. EP	50		200	500	150	0.1	10				10	-10	60			320*	3.5	80*		84B		
" 285A	"	RF. PA	"	50		300	500	150	0.1	10				10	-10	60	KF _β >30dB, KF _α >55dB (15V, 50mA, 1Mc)		500*	3.5	60*		84B		
" 286	日 電	RF.Conv.Mix Osc	"	20		10	100	150	1	12				6	-2	70	PG = 24 dB (f = 100Mc)		900*	0.7	C _β max 15 pS		23		
" 287	"	"	"	20	2	10	100	150	1	12				6	-2	70	PG = 20 dB (f = 200Mc)		900*	0.7	C _β max 12 pS		23		
" 288	"	"	"	30	2	20	100	150	1	12				6	-2	70	P ₀ = 23 mW (f = 900Mc)		1100*	0.7	C _β max 10 pS		23		
" 289	"	"	"	25	2	20	100	150	1	12				6	-2	70	NF = 9 dB (f = 900Mc)		1100*	0.7	C _β max 4 pS		23		
" 290	"	PA	Si. EP	70	5	2 A	20 W (T _a =25℃)	175	3mA	30	35	10	350	10	-350		P ₀ = 6 W (f = 100Mc)		160*	3.5	25*		83		
" 291	SON	"	Si. E	70	5	3 A	1 W	175	3	30	70	2	100	10	-50	70			90*	18	C _β max 50 pS		84C		
" 292	"	"	"	100	5	3 A	1 W	175	3	30	70	2	100	10	-50	70			90*	18	C _β max 50 pS		84C		
" 293	"	"	"	130	5	3 A	1 W	175	3	30	70	2	100	10	-50	70			90*	18	C _β max 50 pS		84C		
" 294	日 電	Diff	Si. EP 複 合	25	5	50	300	175	0.1	10	80	1	1	6	-2		h _{FE1} /h _{FE2} = 0.8~1.0			200*	4.5	40		87B	複合管
" 295	"	Ch	"	15	5	50	300	175	1	10	50	1	0.2	6	-2					200*	4.5	40		86B	複合管
" 296	富士通	RF.Conv.Mix Osc	Si. P	20	3	25	200	175	1	12				6	-2	80			180*	2.5	100*		50C		
" 297	SON	PA	Si. E	70	5	3 A	10 W (T _a =25℃)	175	3	30	70	2	100	10	-50	70			90*	18	C _β max 50 pS		97C		
" 298	"	"	"	100	5	3 A	10 W (T _a =25℃)	175	3	30	70	2	100	10	-50	70			90*	18	C _β max 50 pS		97C		
" 299	"	"	"	130	5	3 A	10 W (T _a =25℃)	175	3	30	70	2	100	10	-50	70			90*	18	C _β max 50 pS		97C		
" 300	三 菱	RF	Si. EP	25	5	100	260	150	0.5	15	85	10	0.1	15	-10				400*	3.5	C _β max 250pS	49A		丹登録	
" 301	"	"	"	25	5	100	260	150	0.01	15	85	10	0.1	15	-10				400*	3.5	C _β max 250pS	49A		丹登録	

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)										外 形	備 考							
				V _{CBO} (V)	V _{CEO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CBO} 最大值		直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}				偏 置 情 况		h _{FE}	h _{FE} (Ω)			h _{FE} (×10 ⁻⁴)	h _{FE} (μU)	f _{osc} (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{as} (Ω)		
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{FE} *												
2SC302	三 菱	RF. Conv. Mix. Osc.	Si. EP	50	5	100	360	200	0.01	15	50	10	0.1	15	-10						420*	3.5	65*	49C			
" 303	"	RF. PA	"	50	3	500	800	200	50	28	20	28	100	20	-50						200*	10		84B			
" 304	"	"	"	60	4	500	800	200	10	28	25	28	100	20	-50						220*	10		84B			
" 305	"	"	"	80	5	500	800	200	0.05	28	30	28	100	20	-50						220*	10		84B			
" 306	"	RF. SW	"	50	5	500	800	200	0.1	30	85	10	150	10	-30						240*	10	30*	84B 再登録			
" 307	"	"	"	80	5	500	800	200	10nA	30	85	10	150	10	-30						240*	10	30*	84B 再登録			
" 308	"	"	"	100	5	500	800	200	1	90	65	10	150	10	-30						90*	10	30*	84B			
" 309	"	"	"	120	5	500	800	200	1	90	65	10	150	10	-30						120*	6	30*	84B 再登録			
" 310	"	"	"	140	5	500	800	200	10nA	90	65	10	150	10	-30						120*	6	30*	84B 再登録			
" 311																											
" 312																											
" 313	日 立	RF. Conv. Mix. Osc.	Si. EP	30	2	50	200	200	0.5	10	40	10	10	10	-10	50					1000*	1	C _{ext} = 10pS	9			
" 314	"	PA	Si. TMe	75	4	1.2 A	2 W	175	10	40				4	-100	25					70*	20	27	83			
" 315	"	"	"	75	4	1.2 A	2 W	175	10	40				4	-100	25					80*	20	25	83			
" 316	松 下	RF. Conv. Mix. Osc. PA	Si. P	45	5	30	300	175	0.01	10				5	-2	300	6500	1.4	32		80*	4.5	80	49C			
" 317	日 立	SW	Si. Me	70	5	100	350	175	0.1	20	100	6	10	6	-10		t _d + t _r < 0.00μs t _s < 0.7μs, t _f + t _r < 0.2μs			240*	4.5	75	12A				
" 318	SON	RF	Si. E	50	5	100	300	175	0.2	25	90	3	1	6	-2		h _{FE} = 4.5dB (f = 100Mc)				3	C _{ext} = 100pS	49C				
" 319	日 電	RF. Conv. Mix. Osc. PA	Si. EP	40	4	300	1.75 W (T _a = 25℃)	175	1	20				10	-30	40	P _D = 1.2W (f = 200Mc)				500*	6.5	40*	84A			
" 320	"	"	"	40	4	500	2.5 W (T _a = 25℃)	175	1	20				10	-30	40	P _D = 2.4W (f = 200Mc)				600*	6.5	40*	84A			
" 321	日 立	SW	"	40	5	200	360	175	1	20	40	1	10	10	-20						450*	4		49C			
" 322	"	"	"	40	5	200	360	175	0.25	20	40	1	10	10	-20						450*	4		49C			
" 323	東 芝	"	"	40	5	100	250	175	1	30	50	1	10											49C			
" 324	富士通	RF. Conv. Mix. Osc.	Si. P	20	3	25	200	175	2	12				6	-2	70					180*	4.5	60*	49C			
" 325	沖	RF	Si. EP	12	3	50	250	175	0.02	6				5	-5	110					1000*	1.7	90*	50C			
" 326	"	"	"	20	3	50	250	175	0.02	6				5	-5	110					1000*	1.7	90*	50C			
" 327	"	"	"	30	3	50	250	175	0.02	6				5	-5	110					1000*	1.7	90*	50C			
" 328	"	"	"	30	3	20	200	175	0.2	15				6	-5	60	NF = 24b (f = 70Mc)				1500	0.65	C _{ext} = 5pF	50C			
" 329	"	"	"	30	3	20	200	175	0.2	15				6	-5	60	NF = 1.5dB (f = 70Mc)				1500*	0.65	C _{ext} = 5pS	50C			
" 330	"	RF. LN	"	20	3	20	200	175	0.5	15	60	10	10	10	-10		NF = 2.5dB (6 V, -3mA, 450MHz)				3500*	0.75	C _{ext} = 2.5pS	128			
" 331	"	"	"	20	3	20	200	175	0.5	15	60	10	10	10	-10		NF = 2.0dB (6 V, -3mA, 450MHz)				3500*	0.75	C _{ext} = 1.5pS	128			
2SC332	沖	RF. SW	Si. EP	30	5	200	150	175	0.1	15	75	1	10	10	-10	95	t _{on} < 40nS, t _{off} < 44nS t _s < 26nS				450*	3	70*	48C			
" 333	"	"	"	40	5	200	150	175	0.1	15	75	1	10	10	-10	95	t _{on} < 40nS, t _{off} < 44nS t _s < 26nS				450*	3	70*	48C			
" 334	"	"	"	60	5	200	150	175	0.1	15	65	1	10	10	-10	85	t _{on} < 40nS, t _{off} < 44nS t _s < 26nS				450*	2	70*	48C			
" 335	"	"	"	50	5	200	250	175	0.1	15	75	1	10	10	-10	100	t _{on} < 40nS, t _{off} < 44nS t _s < 26nS				450*	3	70*	49C			
" 336	"	"	"	60	5	200	250	175	0.1	15	75	1	10	10	-10	100	t _{on} < 40nS, t _{off} < 44nS t _s < 26nS				450*	3	70*	49C			
" 337	"	RF	Si. P	20	5	20	360	175	0.1	15	73	1	2	5	-1	80					100*	3	50*	49C			
" 338	"	"	"	70	5	20	360	175	0.1	15	73	1	2	5	-1	80					100*	3	50*	49C			
" 339	"	"	"	110	5	20	360	175	0.1	15	73	1	2	5	-1	80					100*	3	50*	49C			
" 340	"	"	"	20	5	20	100	100	0.1	15	170	1	2	5	-1	2200					130*	1.4	60*	21			
" 341	"	"	"	70	5	20	100	100	0.1	15	73	1	2	5	-1	80					120*	1.4	60*	21			
" 342	"	"	"	110	5	20	100	100	0.1	15	73	1	2	5	-1	80					120*	1.4	60*	21			
" 343	"	RF. SW	Si. EP	35	5	500	600	175	0.4	20	55	1	150	10	-30	70					430*	6.5	45*	84A			
" 344	"	"	"	60	5	500	600	175	0.4	20	55	1	150	10	-30	70					430*	6	45*	84A			
" 345	"	"	"	80	5	500	600	175	0.4	20	55	1	150	10	-30	70					430*	5	45*	84A			
" 346	"	RF. SW	"	45	5	700	600	175	1	40	70	1	100	10	-30	75	t _{on} < 80nS, t _{off} < 70nS t _{isg} < 35nS				320*	10	40*	84A			
" 347	"	"	"	60	5	700	600	175	1	40	70	1	100	10	-30	75	t _{on} < 80nS, t _{off} < 70nS t _{isg} < 35nS				320*	10	40*	84A			
" 348	"	"	"	60	5	700	600	175	1	40	70	1	100	10	-30	75	t _{on} < 80nS, t _{off} < 70nS t _{isg} < 35nS				320*	7.5	40*	84A			
" 349	"	"	"	90	5	700	600	175	1	40	70	1	100	10	-30	75	t _{on} < 80nS, t _{off} < 70nS t _{isg} < 35nS				320*	7.5	40*	84A			
" 350	日 立	RF. AF. LN	Si. Me	30	5	100	200	175	0.01	20	120	6	0.1	6	-1	160					7000	2	25	180*	7	60	12A
" 351	東 芝	RF	Si. P	40	2	20	200	150	0.5	18				10	-4	50						600*	1.4	15	33		
" 352	SON	"	Si. EP	50	5	100	750	175	0.2	25	90	3	1	6	-2		h _{FE} = 4.5dB (f = 100Mc)							84C			
" 353	"	"	"	100	5	100	750	175	0.2	25	90	3	1	6	-2		h _{FE} = 4.5dB (f = 100Mc)							84C			
" 354	富士通	RF. PA	Si. TP	40	4	1.5A	7 W (T _a = 25℃)	200	1	30	100	4	500	4	-100	50					180*	20	10*	84B			
" 355	"	PA	"	75	4	2.5A	15 W (T _a = 25℃)	200	1	30	100	4	500	4	-100	50					P _D = 3 W (f = 150Mc)	180*	20	10*	111		
" 356	日 電	SW	Si. EP	30	5	200	300	175	1	20	60	1	10				t _d + t _r < 20nS, t _s + t _f < 40nS							46C			
" 357																											
" 358																											
" 359																											
" 360	東 芝	RF	Si. P	30	5	100	250	175																			

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)														外 形	備 考	
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CBO} 最大値		直 流 及 脈 沖 下 之 hFE				偏 置 情 況		h _{FE}	h _{FE} (Ω)	h _{FE} (×10 ⁻⁴)	h _{FE} (μU)	f _T (Mc)	C _{ob} (pF)			h _{FE} (real) (Ω)
									(μA)	V _{CE} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)	h _{FE} *										
2SC422																									
423	三 洋	RF.Conv.Mix Osc. PA	Si. EP	40	4	300	500	175	1	35	80	10	20	10	-20						500*	5	C _r r _{sub} 120pS	84B	
424	"	"	"	40	4	300	200	175	1	35	80	10	20	10	-20						500*	5	C _r r _{sub} 120pS	84B	
425	"	"	"	20	4	300	500	175	1	15	80	10	20	10	-20						500*	5	C _r r _{sub} 120pS	84B	
426	"	"	"	20	4	300	200	175	1	15	80	10	20	10	-20						500*	5	C _r r _{sub} 120pS	84B	
427	"	RF.Conv.Mix Osc. PA. SW	"	40	5	100	300	175	1	35	80	6	1	10	-20	50					180*	5	60	49C	
428	"	"	"	20	5	100	300	175	1	15	80	6	1	10	-20	50					180*	5	60	49C	
429	日 電	RF.Conv.Mix Osc.	"	25	2	10	100	150	1	12				6	-1	27			NF < 7dB (f = 70Mc)		380*	1.2	C _r r _{sub} 19pS	23	
430	"	"	"	25	2	10	100	150	1	12				6	-1	46			NF < 7dB (f = 70Mc)		420*	1.2	C _r r _{sub} 19pS	23	
431	新電元	SW	Si. DB	150	4	30A	200W (T _J = 25℃)	150	50mA	150	20	5	10A	10	-2.5A						J _{sub} = 0.4			105	
432	"	"	"	150	4	30A	200W (T _J = 25℃)	150	50mA	150	40	5	10A	10	-2.5A						J _{sub} = 0.4			105	
433	"	"	"	200	4	30A	200W (T _J = 25℃)	150	20mA	200	20	5	10A	10	-2.5A						J _{sub} = 0.4			105	
434	"	"	"	200	4	30A	200W (T _J = 25℃)	150	20mA	200	40	5	10A	10	-2.5A						J _{sub} = 0.4			105	
435	"	"	"	300	4	30A	200W (T _J = 25℃)	150	5mA	300	20	5	10A	10	-2.5A						J _{sub} = 0.4			105	
436	"	"	"	300	4	30A	200W (T _J = 25℃)	150	5mA	300	40	5	10A	10	-2.5A						J _{sub} = 0.4			105	
437	三 菱	PA	Si. TP	100	5	2A	13W (T _J = 25℃)	175	10	28	20	28	350	28	-300	30					210*	45	8*	83	MT-301
438	"	"	"	75	5	2A	13W (T _J = 25℃)	175	100	28	20	28	350	28	-300	30					210*	45	8*	83	MT-302
439	"	RF.Conv.Mix Osc.	"	25	5	100	500	200	0.5	15	50	10	0.1	10	-1	100					420*	3.5	65*	84B	
440	"	"	"	25	5	100	500	200	0.5	15	50	10	0.1	10	-1	100					420*	3.5	65*	84B	MTF-156
441	"	"	"	25	5	100	500	200	0.01	15	50	10	0.1	10	-1	100					420*	3.5	65*	84B	MTF-157
442	"	"	"	50	5	100	500	200	0.01	15	50	10	0.1	10	-1	100					420*	3.5	65*	84B	MTF-158
443	"	I/A	"	50	3	500	800	200	0.05	28	20	28	100	28	-5	15			PG 10dB (f = 70Mc)		200*	10		84B	MTF-206
444	"	"	"	60	4	500	800	200	0.01	28	25	28	100	28	-5	20			PG 12dB (f = 70Mc)		220*	10		84B	MTF-207
445	"	"	"	80	5	500	800	200	0.05	28	30	28	100	28	-5	25			PG 13dB (f = 70Mc)		220*	10		84B	MTF-208
446	"	"	"	60	4	500	800	200	0.01	28	25	28	100	28	-5	20			PG = 12dB (f = 70Mc)		220*	10		84B	
447	"	"	"	75	4	2A	5W	175	50	28	20	28	350	28	-100	30					210*	29	8*	112	
448	"	"	"	100	5	2A	5W	175	10	30	20	28	350	28	-100	30					190*	29	8*	112	MTD-306
449	"	"	"	75	5	2A	5W	175	100	30	20	28	350	28	-100	30					190*	29	8*	112	MTD-307
450	"	"	"	60	4	2A	5W	175	100	30	20	28	350	28	-100	30					210*	29	8*	112	MTD-308
451	"	"	"	100	4	1.2A	25W (T _J = 25℃)	200	100	28	>15	28	350	28	-100	30					180*	20	15*	112	
2SC452	三 菱	PA	Si. TP	100	4	1.2A	25W (T _J = 25℃)	200	500	28	>15	28	350	28	-100	30					180*	20	15*	112	
453	"	"	"	90	4	1.2A	25W (T _J = 25℃)	200	500	28	>10	28	350	28	-100	30					170*	20	15*	112	
454	日 立	RF.Conv.Mix Osc.	Si. EPa	30	5	100	200	125	0.5	18				12	-2	150					230*	1.8	C _r r _{sub} 100pS	37	
455	"	"	"	30	5	100	200	125	1	18				12	-2	40					230*	1.8	40	37	
456	松 下	PA	Si. EP	50	1.5	600	750	175	1	12	12	6	80	6	-80	20					200*	10	C _r r _{sub} 100pS	84A	
457	日 電	Diff	"	25	5	50	300	175	0.1	10	80	1	1	6	-2				hFE1/hFE2 = 0.8-1.0		200*	4.5	40*	87B	複合管
458	日 立	RF	Si. EPa	30	5	100	200	125	0.5	18	140	6	2	5	-0.1	130			16.5k 0.7 11		230*	1.8	100	37	
459	"	RF.Conv.Mix Osc.	"	30	5	100	200	125	1	18	160	12	2	12	-2	110			2800 1.6 20		230*	1.8	100	37	
460	"	"	Si. P	30	5	100	200	125	0.5	18				12	-2	85					230*	1.8	40	37	
461	"	"	"	30	5	100	200	125	0.5	18				12	-2	85					230*	1.8	40	37	
462	"	RF	"	40	4	50	200	200	0.5	20				10	-4	90			PG = 26dB (f = 45Mc)		600*	0.9		9	
463	"	"	"	40	4	50	200	200	0.5	20				10	-4	90			PG = 15dB (f = 200Mc)		600*	0.8		9	正向 A/GC
464	"	RF.Conv. Mix. Osc.	"	30	2	50	200	200	0.5	10				6	-1	40			PG = 26dB (f = 45Mc)		1100*	1	C _r r _{sub} 10pS	9	
465	"	"	"	30	2	50	200	200	0.5	10				6	-1	40					1100*	1	C _r r _{sub} 10pS	9	
466	"	"	"	30	2	50	200	200	0.5	10				6	-1	40			PG = 14dB (f = 200Mc)		1100*	1	C _r r _{sub} 10pS	9	
467	富士通	SW	Si. EP	20	4	50	300	175	0.5	10	40	1	10											49C	
468	日 立	"	"	40	5	200	200	175	1	20	60	1	10	10	-20						450*	4.		8A	
469	日 電	RF.Conv.Mix Osc.	"	20	5	30	100	125	0.1	15	90	3	0.5	6	-1	100					250*	1.6	50*	23	
470	SON	RF	"	90	5	100	750	175	1	25	60	5	3	6	-5						150*	2	C _r r _{sub} 20pS	84C	
471	日 立	AF	Si. Me	30	5	100	200	175	0.1	20				6	-0.1	50					160*	7	70	8A	
472	"	SW	"	V _{CE} 30	5	100	200	175	0.1	20	100	6	10								180*	7	60	8A	
473	"	"	Si. TMe	70	5	100	200	175	0.1	20	80	6	10								180*	4.5	75	8A	
474	"	"	Si. Me	V _{CE} 70	5	100	200	175	0.1	20	60	6	10								160*	7		8A	
475	日 電	RF.AF LN	Si. EP	20	5	100	150	150	0.1	15	300	3	0.5	3	-0.5	350			15kΩ 18 3.5		100*			23	
476	"	RF.AF	"	20	5	100	150	150	0.1	15	350	3	0.5	3	-0.5	400			15kΩ 20 3.8		100*			23	
477	松 下	RF	"	50	5	30	140	175	1	10	170	10	1								230*	C _r r _{sub} 0.5pS		49C	
478	"	RF.Conv.Mix Osc.	Si. EP	50	1.5	120	300	175	1	15	20	12	20	12	-1	15					180*	4	C _r r _{sub} 75pS	49C	
479	日 立	SW	"	60	5	600	650	175	1	40	80	1	100											84A	
480	"	"	"	60	5	600	800	175	1	30	80	1	150				</								

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)												外 形	備 考	
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CB0} 最大值 (μA)	V _{CB} (V)	直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}		偏 置 情 况		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} *(Ω)	h _{re} h _{rb} *(×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} *(μU)	f _β f _T *(Mc)	C _{ob} (pF)			r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)
2SC482	東 芝	RF. PA	Si. EP	40	5	600	600	175	1	30	30~300	2	150	2	-150				>50*	15	7	84B	
★	★	★	★	100	5	1 A	15 W (T _c =85℃)	150	1mA	30	120	2	150	2	-30	100			25*	80	5	99	
★	★	★	★	150	5	1.5A	800	175	10	30	30~300	2	200	10	-30				20*	50	10	84B	2SA484 之對稱
★	★	★	★	100	5	1.5A	800	175	10	30	30~300	2	200	10	-30				20*	50	10	84B	2SA485 之對稱
★	★	★	★	70	5	1.5A	800	175	10	30	30~300	2	200	10	-200				20*	50	10	84B	2SA486 之對稱
★	★	★	★	110	5	1.5A	15 W (T _c =85℃)	150	1mA	30	120	2	200	2	-200	100			20*	85	5	99	
★	★	★	★	140	5	3 A	16 W (T _c =85℃)	150	3mA	50				5	-0.5A	80			10*	130	5	99	
★	★	★	★	100	5	3 A	16 W (T _c =85℃)	150	3mA	50				5	-0.5A	80			10*	130	5	99	
★	★	★	★	60	5	3 A	16 W (T _c =85℃)	150	3mA	50				5	-0.5A	80			10*	130	5	99	
★	★	★	★	50	5	1.5A	15 W (T _c =85℃)	150	10	30	70	2	0.5A	2	-0.5A	70			40*	40	25	99	
★	★	★	★	110	5	5 A	50 W (T _c =85℃)	150	10mA	50				5	-1A	60			20*	80	15	102	
★	★	★	★	80	5	5 A	50 W (T _c =85℃)	150	10mA	50				5	-1A	60			20*	80	15	102	
★	★	★	★	50	5	5 A	50 W (T _c =85℃)	150	10mA	50				5	-1A	60			20*	80	15	102	
★	★	★	★	70	5	800	550	125	1	30	40~240	2	50	10	-10				100*	10	10	164	2SA505 之對稱
★	★	★	★	40	5	800	550	125	1	30	40~240	2	50	10	-10				100*	10	10	164	2SA496 之對稱
★	★	★	★	100	5	800	600	150	1	30	40~240	2	200	10	-10				80*	15	10	84B	2SA497 之對稱
★	★	★	★	80	5	800	600	150	1	30	40~240	2	200	10	-10				80*	15	10	84B	2SA498 之對稱
★	★	★	★	100	2	20	300	125	1	18				12	-2	80			150*	2	40	33	
★	★	★	★	120	5	20	600	150	1	30				30	-3	140			175*	2	40	84A	
★	★	★	★	60	5	300	750	175	0.1	30				10	-10	80			200*	4	40	84B	2SA501 之對稱
★	★	★	★	60	5	1 A	10 W (T _c =85℃)	150	10	30	30	5	200	5	-200	30	PG = 12dB (f = 50Mc, P _{in} = 0.1W)					84C	
★	★	★	★	60	5	600	800	175	0.5	30	30~300	2	150	10	-10				150*	13	8	84B	2SA503 之對稱
★	★	★	★	40	5	600	800	175	0.5	30	30~300	2	150	10	-10				150*	13	8	84B	2SA504 之對稱
★	★	★	★	300	3	100	600	150	1	100	40~140	2	50	10	-10				60*	<20	<20	84B	
★	★	★	★	200	3	100	600	150	1	100	40~140	2	50	10	-10				60*	<20	<20	84B	
★	★	★	★	170	5	80	750	175	0.5	100	70	5	10	20	-10				250*	2.8	50*	84B	
★	★	★	★	180	5	4 A	20 W (T _c =85℃)	150	120	50	40	5	4 A	5	-4A				60*	50	12	99	
★	★	★	★	35	5	500	600	150	0.1	20	100	2	50	10	-10				100*	11	10	131	2SC509 之對稱
★	★	★	★	140	5	1.5A	800	175	1	30	30~150	2	200	10	-30				60*	25	10	84B	2SA510 之對稱
★	★	★	★	120	5	1 A	800	150	3	30				10	-50				50*	30	10	84B	2SA511 之對稱
★	★	★	★	100	5	1.5A	800	175	1	30	30~150	2	200	10	-30				60*	25	10	84B	2SA512 之對稱
★	★	★	★	70	5	1 A	800	150	3	30				10	-50	50			50*	30	10	84A	2SA513 之對稱
★	★	★	★	300	3	100	4 W (T _c =85℃)	150	0.1	300				10	-50	60			20*	7	30	98	
★	★	★	★	300	3	100	6 W (T _c =85℃)	150	100	300				10	-50	60			20*	7	30	99	
★	★	★	★	100	5	1.5A	800	175	0.5	30	60	2	200	5	-200	60			50*	25	10	84B	
★	★	★	★	140	5	1.5A	800	175	0.5	30	60	2	200	5	-200	60			50*	25	10	84B	
★	★	★	★	60	4	2 A	10 W (T _c =85℃)	175	10	30	30	5	500	10	-200				300*	25	10	97B	
★	★	★	★	140	5	5 A	50 W (T _c =85℃)	150	10mA	50	40	5	5 A	5	-5A	40			$h_{re} = \frac{2}{f}$ (f = 20Mc)	70	10	102	
★	★	★	★	180	5	5 A	50 W (T _c =85℃)	150	1 mA	50	40	5	5 A	5	-5A	40			$h_{re} = \frac{2}{f}$ (f = 20Mc)	70	10	102	
★	★	★	★	110	5	7 A	50 W (T _c =85℃)	150	10mA	50	50	5	1 A	5	-0.5A	50			20*	150	15	102	
★	★	★	★	130	5	7 A	50 W (T _c =85℃)	150	100	50	30~300	5	1 A	10	-1A				20*	150	15	102	
★	★	★	★	80	5	7 A	50 W (T _c =85℃)	150	10mA	50	50	5	1 A	5	-0.5A	50			20*	150	15	102	
★	★	★	★	100	5	7 A	50 W (T _c =85℃)	150	100	50	30~300	5	1 A	10	-1A				20*	150	15	102	
★	★	★	★	50	5	7 A	50 W (T _c =85℃)	150	10mA	50	50	5	1 A	5	-0.5A	50			20*	150	15	102	
★	★	★	★	70	5	7 A	50 W (T _c =85℃)	150	100	50	30~300	5	1 A	10	-1A				20*	150	15	102	
★	★	★	★	140	5	1.5A	10 W (T _c =85℃)	175	1	30	30~150	2	200	10	-30				60*	25	10	97B	2SA510 之對稱
★	★	★	★	120	5	1.5A	10 W (T _c =85℃)	175	3	30				10	-50	50			50*	25	10	97B	
★	★	★	★	100	5	1.5A	10 W (T _c =85℃)	175	1	30	30~150	2	200	10	-30				60*	25	10	97B	2SA512 之對稱
★	★	★	★	70	5	1.5A	10 W (T _c =85℃)	150	3	30				10	-50	50			50*	35	10	97B	
★	★	★	★	165	5	55	2.3 W (T _c = 5℃)	175	2	12				20	-45	20			250*	2.5	C _c r _{as} 25pS	84A	
★	★	★	★	35	3	10	130	175	1	10				10	-2.5	50			340*	1	20	50C	
★	★	★	★	20	5	150	200	125	0.5	20	100	1	150	6	-1	70			100*	12	35	37	
★	★	★	★	30	5	100	100	125	0.5	18	160	12	2	12	-2	160	2800	0.7	20	230*	1.8	100	36
★	★	★	★	30	5	100	100	125	0.5	18				12	-2	150			230*	1.8	100	36	
★	★	★	★	30	5	100	100	125	0.5	18				12	-2	40			230*	1.8	40	36	
★	★	★	★	30	5	100	100	125	0.5	18				12	-2	110			PG = 26dB (f = 10.7Mc)	230*	1.8	100	36
★	★	★	★	30	5	100	100	125	0.5	18				12	-2	85			PG = 20dB (f = 10.7Mc)	230*	1.8	40	36
★	★	★	★	30	5	100	100	125	0.5	18				12	-2	85			PG = 17dB (f = 100Mc)	230*	1.8	40	36
★	★	★	★	30	4	20	100	125	0.5	10	80	6	1	6	-1	70			700*	0.9	C _c r _{as} 5 pS	37	
★	★	★	★	40	5	100	200	125	1	35	120	6	1	6	-1				180*	3	C _c r _{as} 250pS	27	

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考						
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大值		直 流 及 脈 沖 下 之 h _{FE}				偏 置 情 況		h _{FE}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)			h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _β f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	τ _β τ _{ib} (real) * (ns)		
									I _{CEO} (μA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)	h _{FE}	h _{ib} *												
2SC537	三 洋	RF.Conv.Mix Osc.	Si. P	20	5	100	200	125	1	15	120	6	1	6	-1	80				180 *	3	C _e τ _β 250pS		27	2SA550 之對稱		
* 538	松 下	RF. AF	Si. EP	25	5	50	300	175	1	10	250	5	2	5	-2	250	3500	2.5	35	80 *	4.5	70	49C		49C	2SA550A 之對稱	
* 538A	"	"	"	45	5	50	300	175	1	10	250	5	2	5	-2	250	3500	2.5	35	80 *	4.5	70	49C		49C		
* 539	"	RF	"	25	5	50	300	175	1	10	250	5	2	5	-2	250	3500	2.5	35	80 *	4.5	70	49C		49C		
* 540	日 電	RF. AF. LN	"	30	5	100	150	150	0.1	25	270	3	0.5	3	-0.5	300	15kΩ	16		100	8	30	23				
* 541	富 士 通	PA	"	50	4	1 A	7 W (T _a = 25°C)	200	5	30	30	4	100	4	-100	30				400 *	7	12 *	84B				
* 542	"	"	"	65	4	1.5A	11.6 W (T _a = 25°C)	200	5	30	25	4	500	4	-150	30				400 *	7	10 *	111				
* 543	"	"	"	65	4	3 A	23 W (T _a = 25°C)	200	12	30	20	4	1 A	4	-200	30				300 *	14	7 *	111				
* 544	三 洋	RF.Conv.Mix Osc.	"	40	4	30	120	125	1	30	60	6	1	6	-1					350 *	1.4	C _e τ _β 40pS		27			
* 545	"	"	"	20	4	30	120	125	1	15	60	6	1	6	-1					350 *	1.4	C _e τ _β 40pS		27			
* 546	"	"	"	30		30	150	125	1	30				10	-2	80				600 *	1	C _e τ _β 9pS		27			
* 547	東 芝	PA	"	65	4	1 A	6 W (T _a = 25°C)	175	100	30				28	-150					500 *	<10	12	84B				
* 548	"	RF. PA	"	36	4	500	6 W (T _a = 25°C)	175	100	15				13.5	-100	30				550 *	13	10 *	84B				
* 549	"	PA	"	65	4	1.5A	10 W (T _a = 25°C)	175	100	30				28	-150	30				500 *	<10	7	111				
* 550	"	"	"	36	4	1.5A	10 W (T _a = 25°C)	175	100	15				13.5	-150	30				400 *	18	7 *	111				
* 551	"	"	"	65	4	3 A	20 W (T _a = 25°C)	175	250	30				28	-150					400 *	<20	6.5 *	111				
* 552	"	"	"	36	4	3 A	20 W (T _a = 25°C)	175	250	15				13.5	-300	30				350 *	40	5 *	111				
* 553	"	"	"	55	4	3 A	20 W (T _a = 25°C)	175	250	30				28	-200	30				400 *	15	6.5 *	111				
* 554	"	"	"	36	4	500	6 W (T _a = 25°C)	175	100	15				13.5	-100	30				400 *	17	10 *	84B				
* 555	"	"	"	55	3.5	400	4.2 W (T _a = 25°C)	175	20	28				28	-25					800 *	3	25 *	84B				
* 556	"	RF. PA	"	40	2	400	750	150	25	20				15	-50	45				850 *	2.8	100 *	84B				
* 557	"	PA	"	40	3.5	2 A	20 W (T _a = 25°C)	175	20	15	50	2	400	10	-200					350 *	25	10 *	111				
* 558	"	"	Si. TMe	250	5	5 A	50 W (T _a = 25°C)	150	1mA	50	40	5	5 A	5	-5A							20	70	10	102		
* 559	"	"	Si. EP	60	5	300	600	175	10	30	80	1	100	10	-10							3.2	10	84B			2SA560 之對稱
* 560	東 芝	RF	Si. EP	80	5	800	800	175	0.5	30	30-120	2	150	10	-50	70				150 *	11	15	84B				
* 561	富 士 通	RF.Conv.Mix Osc	Si. P	20	2	25	200	125	2	12				6	-2	35				200 *	2	60 *	30				
* 562	松 下	RF	"	40	4	25	130	175	1	10	>26	10	4	10	-4	80				330 *	C _e 0.15pF	C _e τ _β 45pS	117C			正向 AGC	
* 563	"	"	Si. EP	40	4	25	200	175	1	10	>38	10	7	10	-5	130				550 *	C _e 0.23pF	C _e τ _β 80pS	117C				
* 564	富 士 通	SW	"	50	5	500	650	175	1	10	50	1	150													84B	
* 565	"	"	"	50	5	200	350	175	1	10	45	1	10													49C	
2SC566	日 電	RF. PA	Si. EP	50	4	300	800	175	0.2	35	70	10	100	10	-30					700 *	4		85A				
* 567	"	RF.Conv.Mix Osc	"	30	3	20	200	150	0.5	15				6	-2	80				1300 *	0.65	C _e τ _β 3pS	50C				
* 568	"	"	"	30	3	20	200	150	0.1	15				6	-2	80				1000 *	0.65	C _e τ _β 3pS	50C				
* 569	協 同	SW	"	40	4.5	150	150	150	0.5	20	60	1	10													22 KT 200	
* 570	"	"	"	40	4.5	200	300	150	0.5	20	60	1	10													28 KT 210	
* 571	松 下	PA	"	36	4	500	6 W (T _a = 25°C)	175	5	20	70	13.5	100	13.5	-100	70				320 *	27	5 *	84B				
* 572	"	"	"	36	4	1 A	10 W (T _a = 25°C)	175	5	20	80	13.5	200	13.5	-200	80				330 *	27	5 *	111				
* 573	"	"	"	36	4	2 A	20 W (T _a = 25°C)	175	10	20	80	13.5	400	13.5	-400	80				350 *	27	4.5 *	111				
* 574	"	RF. PA	"	80	4	1 A	7.5 W (T _a = 25°C)	175	0.5	80	>5	10	500	10	-100	15				280 *	15	C _e τ _β 20pS	110				
* 575	"	"	"	80	4	1 A	5 W (T _a = 25°C)	175	0.5	40	20	5	500	10	-100	20				210 *	7	C _e τ _β 18pS	84C				
* 576	"	RF. SW	"	40	5	500	360	200	0.1	20	40	1	10	6	-2	60										49C	
* 577	"	"	"	40	5	500	360	200	0.1	20	80	1	10	6	-2	80										49C	
* 578	日 電	SW	"	60	5	500	600	175	1	30	60	1.5	150													84A	
* 579	"	"	"	30	5	200	360	175	0.1	15	80	0.4	50													49C	
* 580	"	RF.Conv.Mix Osc. PA	"	60	5	1 A	800	175	1	40	60	10	150	10	-50	80				250 *	10	20 *	84A				
* 581	松 下	RF. Conv. Mix. Osc	"	30	5	30	140	175	1	10				10	-1	85				230 *	1.5	20	50C				
* 582	"	PA	Si. Me	300	3	100	6.5 W (T _a = 70°C)	150	100	300	65	10	50	10	-50	60				35 *	8	30	99				
* 583	"	RF. Conv Mix. Osc	"	30	2.5	20	200	200	0.01	15				5	-2	80				1300 *	1.2	C _e τ _β 8pS	50C				
* 584	"	RF. PA	"	80	4	2 A	17.5 W (T _a = 25°C)	200	1mA	80	10	10	500	10	-500	15				200 *	30	C _e τ _β 20pS	111				
* 585	"	PA	Si. EP	65	4	3 A	20 W (T _a = 25°C)	175	12	30	80	28	200	28	-200	30				350 *	14	6.5 *	111				
* 586	"	"	Si. EMe	150	6	5 A	50 W (T _a = 25°C)	150	15mA	150	30	4	5 A	4	-5A	20				55 *	130	8	102				
* 587	松 下	RF	Si. P	45	5	30	300	175	0.01	10				10	-2	300				80 *	3	80	49C				
* 587A	"	"	"	45	5	30	300	175	0.01	10				10	-2	300										49C	
* 588	富 士 通	"	Si. DB	30	5	100	600	175	1	15				10	-10	100				200 *	2.5	50	84B				
* 589	松 下	"	"	165	5	80	750	175	2	25	40	5	3														

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)														外 形	備 考
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CBO} 最大值		直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}		偏 置 情 况		h _{FE} h _{FS}	h _{ie} h _{is} * (Ω)	h _{re} h _{rs} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{os} * (μU)	f _{os} f _T * (Mc)	C _{ob} C _{os} * (pF)	f _{max} h _μ (real) * (GHz)			
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										
2SC595	日立、東芝、富士通、日電	SW	Si.EP	30	5	200	300	150	1	15	60	1	10	10	-10	60	t _{on} < 100nS, t _{off} < 100nS	450 *	4	40 *	49C			
" 596	日電	RF.PA	"	60	5	500	800	175	0.5	20	25-100	10	30	10	-30	50		400 *	6	40 *	85B			
" 597	富士通、東芝、松下	PA	"	65	4	1 A	6 W (T _a = 25℃)	175	5	30				28	-100	30		400 *	7	12 *	84B			
" 598	日立、東芝、日電、富士通、東芝	"	"	65	4	1.5 A	10 W (T _a = 25℃)	175	5	30				28	-100	30		400 *	7	12 *	111			
" 599	三 菱	"	"	60	4	1.5 A	20 W (T _a = 25℃)	200	500	28	30	28	50	28	-50	50	PG = 8 dB (f = 220Mc, P _i = 1.9W)	500 *	25	7 *	114			
" 600	富士通、東芝、日電	"	"	65	4	3 A	20 W (T _a = 25℃)	175	12	30				28	-200	30		400 *	14	7.5 *	111			
" 601	松下、富士通	RF.SW	"	40	5	100	300	175	0.1	20	60	1	10	10	-10	80	t _r < 12nS, t _f < 18nS	580 *	2.4	20	49C			
" 602	東芝、日電、富士通、日立	RF	"	30	3	30	200	150	1	15				6	-5	60	NF = 5 dB (f = 70Mc)	800 *	1.3	70 *	50C			
" 603	日電	Ch	"	7	7	50	200	150	1	6	100	0.5	0.1	h _{FE1} /h _{FE2} = 0.1-1.0, ΔV _{BE} < 100μV γΔV _{BE} < 5μV/℃, ΔI _{BE} < 2nA				70 *	5.5	C _r r _{ab} 2nS	47	複合管 反方向性		
" 604																								
" 605	日電	RF.Conv.Mix Osc	Si.P	30	4	20	150	150	0.2	20				10	-2	70		480 *	0.5	C _r r _{ab} 2pS	23	正向 AGC		
" 606	"	"	"	30	4	20	150	150	0.2	20				10	-2	70		530 *	0.5	C _r r _{ab} 1.6pS	23	正向 AGC		
" 607	日立	PA	Si.T	75	4	600	1-W	175	5	40				10	-50	50		70 *	25	20 *	84A			
" 608	"	"	"	75	4	1.5 A	10 W (T _a = 25℃)	175	5	40				10	-50	60		70 *	25	20 *	97B			
" 609	"	"	"	75	4	1.5 A	10 W (T _a = 25℃)	175	5	40				10	-50	60		80 *	25	25 *	97B			
" 610	松下	"	Si.TP	100	4	10 A	100 W (T _a = 25℃)	175	10mA	40	50	1	1 A	P _s = 32W (f = 40MHz, V _{CE} = 40V, P _i = 7.5W)							109			
" 611	日電、富士通、東芝、松下	RF.Conv.Mix Osc	Si.EP	20	3	20	200	150	1	10				10	-2	80	NF = 2.5dB (f = 70Mc)	1000 *	1	C _r r _{ab} 3pS	50C			
" 612	日電、富士通、東芝、松下	RF	"	35	2	20	180	175	1	10				10	-2	80	NF = 2.5dB (f = 70Mc)	1300 *	1	Z _{in} 30Ω	50C			
" 613	日電	SW	"	40	5	200	360	200	0.1	20	80	1	10	t _{on} < 25nS, t _{off} < 25nS t _r < 20nS							49C			
" 614	三 洋	Osc.PA	Si.P	80	4	1.5 A	7.5 W (T _a = 25℃)	175	1	40	80	10	250	10	-250			200 *	12.5	8	84B			
" 615	"	"	"	30	4	1.5 A	7.5 W (T _a = 25℃)	175	1	10	80	10	250	10	-250			200 *	12.5	8	84B			
" 616	"	"	"	80		1.5 A	13 W (T _a = 25℃)	175	1	40				10	-250	80		200 *	12.5	8	83			
" 617	"	"	"	30		1.5 A	13 W (T _a = 25℃)	175	1	10				10	-250	80		200 *	12.5	8	83			
" 618	富士通	RF	"	25	3	20	150	150	0.1	12				6	-2	50	NF = 4.5dB (f = 70Mc)	600 *	1.2	60 *	50C			
" 618A	"	"	"	25	3	20	150	150	0.1	12				6	-2	50	NF = 3 dB (f = 70Mc)	600 *	1.2	60 *	50C			
" 619	三 菱	SW.PA	Si.EP	30	5	200	250	125	1	25	110	6	10	t _{on} < 40nS, t _{off} < 250nS t _{sig} < 150nS							40			
" 620	"	RF.PA	"	50	5	200	250	125	1	25	90	6	10	6	-1	80		250 *	7	C _r r _{ab} 100pS	40			
" 621	"	RF.Conv.Mix Osc.SW	"	25	4	100	150	150	1	25	75	6	10	6	-1	80	2500	0.4	15	150 *	2.5	C _r r _{ab} 100pS	8 A	
" 622	"	RF.Conv.Mix Osc	"	25	4	100	150	150	1	25	75	6	10	6	-1	80	2500	0.4	15	150 *	2.5	C _r r _{ab} 100pS	11A	
" 623	協 同	SW	"	40	4.5	150	150	150	0.5	20	60	1	10	t _r < 30nS, t _f < 30nS t _r < 30nS, t _f < 60nS							22	KT-2093		
2SC624	協 同	SW	Si.EP	40	4.5	200	300	150	0.5	20	60	1	10	t _r < 30nS, t _f < 30nS t _r < 60nS							28	KT-2103		
" 625																								
" 626	日電	RF.Conv.Mix Osc.PA	Si.EP	50	5	200	750	175	0.1	20				10	-10	130		350 *	4	45 *	84A			
" 627	富士通	RF.AF.SW	Si.T	200	4	100	700	175	5	100	80	10	50	6	-2	50	1000	0.8	10	20 *	6	25	84B	
" 628	日電	RF.PA	Si.EP	40	4	500	2.5 W (T _a = 25℃)	175	0.4	20	40	10	100	10	-30	40	P _s = 2 W (f = 200Mc, V _{CE} = 15V)	700 *	5.5	40 *	84A			
" 629	SON	RF.Conv.Mix Osc	Si.DB	18		30	150	120	0.2	15	30	3	1	6	-1	36		800 *	1.3	C _r r _{ab} 15pS	38			
" 630																								
" 631	SON	RF.LN	Si.E	25		100	180	120	0.2	25	350	3	1	6	-0.1	170	36kΩ	2.4	3.3	140 *	4.5	C _r r _{ab} 350pS	38	
" 632	"	"	"	40		100	180	120	0.2	25	350	3	1	6	-0.1	170	36kΩ	2.4	3.3	140 *	4.5	C _r r _{ab} 350pS	38	
" 633	"	RF.Conv.Mix Osc.SW	"	25	6	100	180	120	0.2	25	90	3	1	6	-1	110	t _r < 0.06μS, t _f < 0.15μS t _{sig} < 0.50 μS	140 *	4.5	C _r r _{ab} 350pS	38			
" 634	"	"	"	40	6	100	180	120	0.2	25	90	3	1	6	-1	110	t _r < 0.06μS, t _f < 0.15μS t _{sig} < 0.50 μS	140 *	4.5	C _r r _{ab} 350pS	38			
" 635	日電	PA	Si.EP	65		1.5 A	10 W (T _a = 25℃)	175	3	18				10	-150	50	P _s > 4 W (f = 175Mc, V _{CE} = 18V)	450 *	10	10 *	111			
" 636	"	"	"	65	4	3 A	20 W (T _a = 25℃)	175	10	18				18	-150	50	P _s > 7 W (f = 260Mc)	350 *	16	8 *	111			
" 637	"	"	"	40	4	1 A	10 W (T _a = 25℃)	175	10	20				10	-100	50		450 *	16	10 *	111			
" 638	"	"	"	40	4	2 A	20 W (T _a = 25℃)	175	20	20				13.5	-200	50		300 *	28	8 *	111			
" 639	"	SW	"	40	5	200	360	200	0.1	20	100	1	10	t _{on} < 12nS, t _{off} < 18nS t _r < 3nS							49C			
" 640	"	RF	"	30	5	100	150	150	0.1	25	270	3	0.5	3	-0.5	300	15kΩ	16	3	100 *	8	30 *	23	
" 641	日立	SW	"	40	5	100	100	125	0.25	20	85	1	10	t _{on} = 20nS, t _{off} = 20nS t _r = 10nS							36			
" 642	東 芝	PA	Si.TMe	1100	5	1 A	50 W (T _a = 25℃)	150	10	500	30-160	15	150	15	-200				70.5	70	10	102		
" 643	"	"	"	1100	5	2.5 A	50 W (T _a = 25℃)	150	10	500	> 7	15	2 A	15	-2A	15			> 2	80	10	102		
" 644	松下	RF.AF.LN	Si.EP	30	5	50	150	125	1	10	250	5	2	5	-2	200	5000	0.7	10	160 *	2.3	C _r r _{ab} 110pS	138	
" 645	"	RF.Conv.Mix Osc	"	30	5	30	140	175	1	10				10	-1	100		200 *	C _r 0.65	22	54			
" 646	"	PA	Si.TMe	60	5	4 A	25 W (T _a = 25℃)	150	10mA	60	55	4	2.5 A	4	-100	70		50 *	110	12	102			
" 647	"	"	"	80	5	5 A	50 W (T _a = 25℃)	150	10mA	80	40	4	4 A	4	-4A	30		43 *	160	7	102			
" 648	日立	RF	Si.E	30		30	100	150	0.1	20	280	6	0.1	5	-0.1	320	17kΩ	1.9	12	350 *	1.7	80 *	182C	
" 649	"	RF.AF.LN	Si.E	30	6	30	200	175	0.1	20	120	6	0.1	5	-0.1	150	36kΩ	9.4	3.1	220 *	2.7	85	12A	
" 650	"	"	"	30	6	30	200	175	0.1	20	250	6	0.1	5	-0.1	300	86kΩ	2.8	8.5	220 *	2.7	75	12A	
" 651	日電	PA	Si.EP	45	4	300	750	150	0.1	20				10	-30	80			1100 *	2.4	27 *	84A		
" 652	"	"	"	40	3	300	750	150	0.2	20				10	-30	80			1100 *	2.4	27 *	84A		
" 653	"	RF	"	25	3	20	200	150	0.1	12				6	-2	120	NF < 4 dB (1 Mc) NF < 22dB (1 kc)	1400 *	0.6	60 *	50C			

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考				
				V _{CBO} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CBO} 最大値 (μA)	V _{CE} (V)	直流及脉冲下之h _{FE} I _C (mA)	偏置情况 V _{CE} (V)	I _E (mA)	h _{FE} h _{FE} *	h _{ie} h _{ie} * (Ω)	h _{re} h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{oe} * (μS)	f _β f _β * (Mc)	C _{ob} (pF)			r _{bb} r _{bb} (real)* (Ω)			
2SC654	日 電	RF	Si. EP	40	3	300	800	150	1	35			V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)	h _{FE} *	h _{ie} * (Ω)	h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} * (μS)	f _β * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} (Ω)	形	
* 655	松 下	RF. AF. PA	"	10	2	10	75	125	1	10	400	5	2	5	-2	250	3500	2.5	35	80*	4.5	70	34	85A	
* 656	"	RF	"	10	2	5	50	125	1	10					10	-5	130			550*	1.5	C _{r, FAB} 80pS	34		
* 657	SON	RF. Conv. Mix. Osc.	Si. DB	18		30	150	120	0.2	15	50	10	4	6	-1	50			500*	1.1	C _{r, FAB} 15pS	38			
* 658	三 菱	"	"	25	4	20	150	150	1	12	60	6	1	6	-1	60			550*	1.5	C _{r, FAB} 30pS	8A			
* 659	"	"	"	25	4	20	150	150	1	12	60	6	1	6	-1	60			400*	1.5	C _{r, FAB} 40pS	8A			
* 660	"	RF. Conv. Mix.	Si. P	25	4	20	150	150	0.5	20	60	10	3	10	-3	60			600*	1	C _{r, FAB} 3pS	11A	正向 AGC		
* 661	"	"	"	25	4	20	150	150	0.5	20	60	10	3	10	-3	60			600*	1	C _{r, FAB} 4pS	11A	正向 AGC		
* 662	"	RF. Conv. Mix. Osc.	Si. EP	25	2	20	150	150	0.5	10				6	-2	40			800*	1	C _{r, FAB} 4pS	9			
* 663	"	"	"	25	2	20	150	150			10-300	10	10						900*	1.4	C _{r, FAB} 5pS	11A			
* 664	日 立	PA	Si. T	100	5	5A	50W (T _a = 25°C)	150	1mA	30	80	5	1A	5	-1A	60			15*	300	10	103			
* 665	"	"	"	125	5	5A	50W (T _a = 25°C)	150	1mA	30	80	5	1A	5	-1A	60			15*	300	10	103			
* 666																									
* 667																									
* 668	三 洋	RF. Conv. Mix.	Si. TP	15	3	30	120	125	1	10	60	6	1	6	-1				560*	1.1	C _{r, FAB} 20pS	27			
* 669																									
* 669A	SON	PA	Si. EMe	30	5	4A	1W	175	5	25	70	2	100	10	-50	70			70*	18	C _{r, FAB} 50pS	84A			
* 670																									
* 671																									
* 672																									
* 673																									
* 674	三 洋	RF. Conv. Mix.	Si. TP	15	4	30	120	125	1	10	60	6	1	6	-1				560*	1.1	C _{r, FAB} 15pS	27			
* 675	芝 電	SW	Si. Me	250	6	7A	50W (T _a = 25°C)	180	10	30	30	10	0.5A					t _r < 0.5μS, t _f < 0.5μS t _s < 2.5μS					102		
* 676	"	"	"	200	6	7A	50W (T _a = 25°C)	180	10	30	30	10	0.5A					t _r < 0.5μS, t _f < 0.5μS t _s < 2.5μS					102		
* 677	"	"	"	150	6	7A	50W (T _a = 25°C)	180	30	30	40	10	0.5A					t _r < 1μS, t _f < 1μS t _s < 3.5μS					102		
* 678	"	"	"	100	6	7A	50W (T _a = 25°C)	180	100	30	40	10	0.5A					t _r < 1μS, t _f < 1μS t _s < 3.5μS					102		
* 679	日 立	PA	Si. T	300	6	2A	30W (T _a = 25°C)	175	1	30	60	10	20	10	-200	190			20*	75	20	153			
* 680	"	"	"	200	6	2A	12.5W (T _a = 25°C)	150	1	30	180	10	200	10	-200	190			20*	75	20	153			
* 681	"	SW	"	200	5	6A	50W (T _a = 25°C)	150	I _{CBO} 15mA	30	30	4	4A					t _r < 4μS, t _f < 1μS t _s < 3μS					102		
* 682	"	RF	Si. P	20	3	20	180	175	0.1	10	60	10	2	10	-2	75	PG = 28dB (f = 45Mc)		550*	0.37		9	正向 AGC		
2SC683	日 立	RF	Si. P	20	3	20	180	175	0.1	10	60	10	2	10	-2	75	PG = 21dB (f = 200Mc)		550*	0.37		9	正向 AGC		
* 684	"	RF. Conv. Mix. Osc.	Si. EP	30	2	50	200	125	0.5	10	740	10	10	10	-10	50	P _{oss} = 8mW (f = 930Mc)		1100*	1.1	C _{r, FAB} 10pS	37			
* 685	"	PA	Si. T	300	3	100	6.25W (T _a = 25°C)	150	100	300				10	-50	60			25*	5	20	153			
* 686	日 電	RF	Si. EP	150	6	50	800	175	0.01	100	90	10	25	10	-25	100			180*	2.6	10*	84A			
* 687	松 下	SW	"	150	6	5A	50W (T _a = 25°C)	150	15mA	150	30	4	5A					t _r < 2μS, t _f < 1μS t _s < 2μS					102		
* 688	三 菱	PA	"	60	4	1.5A	20W (T _a = 25°C)	200	500	25				10	-100	30	PG = 8.5dB (f = 150Mc, P ₁ = 1.9W)		20				114		
* 689	日 立	SW	Si. T	40	5	100	300	175	0.25	20	50	1	100				t _{rr} < 13nS, t _{fi} < 15nS t _i < 10nS						49C		
* 690	三 菱	PA	Si. EP	60	5	3A	35W (T _a = 25°C)	200	500	30	50	10	100				P ₁ = 25W (f = 150Mc, V _{CC} = 25V, P ₁ = 5W)						113	再登録	
* 691	"	"	"	60	4	500	10W (T _a = 25°C)	200	200	30	50	10	100				P ₁ = 3.5W (f = 150Mc, V _{CC} = 24V, P ₁ = 0.3W)						113	再登録	
* 692	"	"	"	60	5	1A	17.5W (T _a = 25°C)	200	200	30	50	10	100				P ₁ = 9W (f = 400Mc, V _{CC} = 28V, P ₁ = 3W)						113	再登録	
* 693	三 洋	RF. LN	Si. P	40		50	100	125	1	35	230	6	1	6	-1	NF = 8dB (f = 25%)	3000	0.7	9	140*	4	C _{r, FAB} 250pS	27		
* 694	"	"	"	40		50	100	125	1	35	230	6	1	6	-1	NF = 15dB (f = 25%)	3000	0.7	9	140*	4	C _{r, FAB} 250pS	27		
* 695	日 電	AF. RF	Si. EP	20	5	30	100	150	0.1	15	150	3	0.1	6	-1	200	6000	0.9	20	150*	2	50*	23		
* 696	松 下	PA	"	100	5	3A	750	175	3	30	55	V _{CE} = 2V	100	2	-100	80			100*	20	C _{r, FAB} 40pS	84A	2SA546 之對稱		
* 696A	"	"	"	130	5	3A	750	175	3	30	55	V _{CE} = 2V	100	2	-100	80			100*	20	C _{r, FAB} 40pS	84A	2SA546A 之對稱		
* 697	"	"	"	100	5	3A	10W (T _a = 25°C)	175	3	30	55	V _{CE} = 2V	100	2	-100	80			100*	22	C _{r, FAB} 40pS	97B	2SA547 之對稱		
* 697A	"	"	"	130	5	3A	10W (T _a = 25°C)	175	3	30	55	V _{CE} = 2V	100	2	-100	80			100*	22	C _{r, FAB} 40pS	97B	2SA547A 之對稱		
* 698	日 電	RF. PA	"	100	5	3A	10W (T _a = 25°C)	175	1	60	80	2	0.5A	10	-50	85			90*	35	15*	97A			
* 699	三 菱	PA	Si. TP	50	4	1A	10W (T _a = 25°C)	200	50	12				12	-100	30	PG = 9dB (f = 27Mc, P ₁ = 0.5W)		20				97A		
* 700	"	"	Si. EP	60	3	500	5W (T _a = 25°C)	200	100	20				20	-50	30	PG = 11dB (f = 150Mc, P ₁ = 0.2W)		6				84C		
* 701	"	"	"		3	750	5W (T _a = 25°C)	200	100	15				15	-50	30	PG = 10dB (f = 150Mc, P ₁ = 0.2W)		7				84C		
* 702	"	"	"	40	4	750	10W (T _a = 25°C)	200	100	15	50	10	100				P ₁ = 3W (f = 150Mc, V _{CC} = 15V, P ₁ = 0.25W)						113	再登録	
* 703	"	"	"	40	5	2A	25W (T _a = 25°C)	200	1mA	15	50	10	100				P ₁ = 12W (f = 175Mc, V _{CC} = 13.5V, P ₁ = 3.5W)						113	再登録	
* 704	"	"	"	40	5	4A	40W (T _a = 25°C)	200	2mA	15	50	10	100				P ₁ = 17W (f = 175Mc, V _{CC} = 13.5V, P ₁ = 5.5W)						113	再登録	
* 705	三 洋	RF. Conv. Mix. Osc.	"	15	3	30	120	125	1	10	70	6	1	6	-1				700*	1.5	C _{r, FAB} 14pS	27			
* 706	"	RF	"																						

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)					電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)										外 形	備 考						
				V_{CEO} (V)	V_{CEU} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_J ($^{\circ}\text{C}$)	I_{CBO} 最大値 (μA)	$V_{\text{CE}}(V)$	直 流 及 脉 冲 下 之 h_{FE}	偏 置 情 况	h_{FE} h_{FE}^*	h_{ic} (Ω)	h_{re} ($\times 10^{-4}$)	h_{or} (μU)	f_{β} (Mc)	C_{ob} (pF)			f_{max} (MHz)					
2SC710	三 菱	RF.Conv.Mix.Osc	Si.EP	30	4	30	200	125	1	25	90	6	1	6	-1			8500	0.6	40	150*	2.5	$C_{r, \text{FBS}}$ 200pS	138B	再登録	
* 711	"	RF.	"	30	4	50	200	125	0.1	25	250	6	1	6	-1			2500	0.4	15	150*	2.5	$C_{r, \text{FBS}}$ 150pS	138B	再登録	
* 712	"	"	"	30	4	100	200	125	1	25	90	6	10	6	-1			2500	0.4	15	180*	2.5	$C_{r, \text{FBS}}$ 150pS	41		
* 712A	"	"	"	30	4	100	200	125	1	25	75	6	10	6	-1	80		$t_{on} < 60\text{nS}$, $t_{off} < 150\text{nS}$ $t_{sig} < 120\text{nS}$			>100	2.5		138B	再登録	
* 713	"	SW	"	30	4	100	200	125	0.1	25	90	6	10				$t_{on} < 40\text{nS}$, $t_{off} < 250\text{nS}$ $t_{sig} < 150\text{nS}$			200*	7		41			
* 714	"	"	"	70	5	200	250	125	0.1	25	60	6	10	6	-10			3500	0.8		140*	4	$C_{r, \text{FBS}}$ 250pS	27		
* 715	"	RF.V	"	40	5	100	120	125	1	35	180	6	1	6	-1			3500	0.8	13	140*	4	$C_{r, \text{FBS}}$ 250pS	27		
* 716	"	"	"	20	5	100	100	125	1	15	180	6	1	6	-1			PG = 18dB ($f = 200\text{Mc}$)			1100*	1	$C_{r, \text{FBS}}$ 10pS	37		
* 717	日 立	RF.Conv.Mix.Osc	"	30	2	50	200	125	0.5	10	>40	10	10	6	-1	40		$t_{on} < 4\text{nS}$, $t_{off} < 9\text{nS}$ $t_{sig} < 6\text{nS}$			800*	2		49C		
* 718	富士通	SW	"	20	4	200	300	175	0.4	15	60	1	10	10	-10			$t_{on} < 4\text{nS}$, $t_{off} < 9\text{nS}$ $t_{sig} < 6\text{nS}$			800*	2		46C		
* 719	"	"	"	20	4	200	200	175	0.4	15	60	1	10	10	-10			PG = 30dB ($f = 45\text{Mc}$)			500*	1.2	80*	50C	正相 AGC	
* 720	"	RF	Si.P	25	3	20	200	175	0.05	6							100	PG = 30dB ($f = 45\text{Mc}$)			500*	1.4	80*	30	正相 AGC	
* 721	"	"	"	25	3	20	200	120	0.05	6							100									
* 722	"	RF.Conv.Mix.Osc	Si.EP	20		25	200	125	0.5	12							6	-2	80			700*	1.5	80*	30	
* 723	"	"	Si.P	20		25	200	125	1	12							6	-2	60			500*	1.5	80*	30	
* 724	"	RF.SW	Si.EP	30	5	200	200	125	0.05	10	60	1	10	6	-2	70		$t_{on} < 20\text{nS}$, $t_{off} < 50\text{nS}$ $t_{sig} < 250\text{nS}$			250*	4	80*	30		
* 725	"	"	"	60	5	200	200	125	0.05	10	60	1	10	6	-2	70		$t_{on} < 20\text{nS}$, $t_{off} < 50\text{nS}$ $t_{sig} < 250\text{nS}$			250*	4	80*	30		
* 726	"	SW	"	20	4	200	200	125	1	15	60	1	10		-2			$t_{on} < 4\text{nS}$, $t_{off} < 9\text{nS}$ $t_{sig} < 6\text{nS}$						30		
* 727	"	RF.AF.SW	Si.T	100	3	100	350	175	1	30	90	4	10	6	-2	60		1200	1	12	20*	9	40	49C		
* 728	"	"	"	200	6	100	350	175	1	30	90	4	10	6	-2	60		1200	1	12	20*	9	40	49C		
* 729	日 電	RF	Si.EP	50	5	200	600	175	0.5	30					-10	60					250*	4	40	84A		
* 730	三 菱	PA	"	40	4	400	1 W	175	10	15	50	10	100					$P_{s1} = 1.5\text{W}$ ($f = 150\text{Mc}$, $V_{\text{CC}} = 13.5\text{V}$, $P_{\text{in}} = 0.1\text{W}$)					84B	再登録		
* 731	松 下	"	"	40	4	500	2.5 W ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	175	1	20	70	13.5	100					$P_{s1} = 1.2\text{W}$ ($f = 500\text{MHz}$, $V_{\text{CC}} = 13.5\text{V}$, $P_{\text{in}} = 0.3\text{W}$)					84B			
* 732	東 芝	RF	Si.EP	35	5	100	300	125	0.1	18	200~700	6	2	6	-2						80*	6	100	33		
* 733	"	"	"	35	5	100	300	125	0.1	18	70~700	6	2	6	-2	200					>80*	7	$C_{r, \text{FBS}}$ 150pS	33		
* 734	"	"	"	70	5	150	300	125	0.1	18	70~400	1	20	6	-10						150*	5	15	33	2SA561 之付編	
* 735	"	"	"	35	5	400	300	125	0.1	18	70~400	1	100	5	-50						300*	7	$C_{r, \text{FBS}}$ 150pS	33	2SA562 之付編	
* 736	日 電	SW	"	135	5	5 A ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	50 W ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	175	500	60	60	10	1 A					$t_{on} < 2\mu\text{S}$, $t_{off} < 4\mu\text{S}$ $t_{sig} = 3\mu\text{S}$						102		
* 737	三 菱	PA	"	60	5	1.5 A ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	20 W ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	200	500	30	50	10	100					$P_{s1} = 14\text{W}$ ($f = 150\text{Mc}$, $V_{\text{CC}} = 25\text{V}$, $P_{\text{in}} = 1.9\text{W}$)						113	再登録	
* 738	"	RF	"	25	4	20	150	125	1	12	20~300	6	1	6	-1	60					400*	1.5	$C_{r, \text{FBS}}$ 30pS	40		
2SC739	三 菱	RF.Conv.Mix.Osc	Si.EP	25	4	20	150	125	1	12							6	-1	60			350*	1.5	$C_{r, \text{FBS}}$ 30pS	40	
* 740	"	"	"	25	2	20	150	150	0.5	10	40	10	10	10	-10	40					900*	1.4	$C_{r, \text{FBS}}$ 5 pS	11A		
* 741	"	PA	"	40	4	300	680	175	1	15	50	10	100					$P_{s1} = 0.3\text{W}$ ($f = 150\text{Mc}$, $V_{\text{CC}} = 13.5\text{V}$, $P_{\text{in}} = 10\text{mW}$)					84B	再登録		
* 742	富士通	"	"	65	4	1.5 A ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	12.5 W ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	175	5	30							10	-150	30			400*	8	10*	111	
* 743	"	"	"	65	4	3 A ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	25 W ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	175	10	30							10	-300	30			350*	16	7*	111	
* 744	"	"	"																							
* 745	富士通	PA	Si.EP	50	4	1.5 A ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	12.5 W ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	175	10	10							10	-150	45			450*	7	8*	111	
* 746	"	"	"	45	4	3 A ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	25 W ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	175	20	10							10	-300	35			400*	20	6*	111	
* 747	"	"	"																							
* 748	富士通	PA	Si.EP	36	4	1 A ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	12.5 W ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	175	10	10							10	-150	25			400*	16	7*	111	
* 749	"	"	"	36	4	2 A ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	25 W ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	175	25	10							10	-300	25			350*	32	5*	111	
* 750	"	"	"																							
* 751	東 芝	RF	Si.EP	20	2	20	100	150	1	10							10	-8	50			650*	1.9	30	46C	
* 752	"	"	"	30	4	100	100	125	0.5	20							10	-10	80			300*	4	30	33	
* 753	日 電	RF.Conv.Mix.Osc	"	25		20	100	150	1	12							6	-2	70			1100*	0.7	$C_{r, \text{FBS}}$ 12pS	23	
* 754	"	RF.AF	"	20		150	150	150	1	20	100	1	20	6	-1	80						90*	6.5	25	23	
* 755	"	RF	"	15		100	150	150	0.1	15	270	3	0.5	3	-0.5	300		15k Ω	16	3	100*	8	30*	23		
* 756	SON	PA	Si.E	100	6	4 A ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	10 W ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	175	3	50	80	2	100	10	-50	60						65*	35	$C_{r, \text{FBS}}$ 50pS	84C	
* 757	日 電	RF.Conv.Mix.Osc	"	30		20	100	150	1	12							6	-2	70			1100*	0.7	$C_{r, \text{FBS}}$ 10pS	23	
* 758	芝 電	PA	Si.TMe	280	5	8 A ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	60 W ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	150	10	30							5	-0.5A	35			18*	275	10	102	
* 759	"	"	"	180	5	8 A ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	60 W ($T_c = 85^{\circ}\text{C}$)	150																		

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)											外 形	備 考			
				V _{CBO} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (℃)	I _{CBO} 最大值 (μA)	V _{CE} (V)	直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE} V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)	h _{fe} f _T (MHz)	h _{ie} (Ω)	h _{re} (×10 ⁻⁴)	h _{oe} (μS)	f _β (Mc)			C _{ob} (pF)	r _π (Ω)	
2SC769	三 菱	PA. SW	Si. TMe	120	5	10A	50W (T _c = 25℃)	150	1mA	30	25	4	2A											102
" 770	"	"	"	200	5	10A	50W (T _c = 25℃)	150	1mA	30	25	4	2A											102
" 771	"	"	"	250	5	10A	50W (T _c = 25℃)	150	1mA	30	25	4	2A											102
" 772	三 洋	RF. Conv. Mix. Osc.	Si. EP	15		30		125	1	10	60	6	1	6	-1				300*	1.5	C _r 30pS		27	
" 773	三 菱	Osc	"	50	5	200	500	125	1	25				6	-10	60								138B
" 774	"	"	"	50	4	500	800	200	10	30	70	10	100											84B 再登録
" 775	"	PA	"	75	4	1A	800	200	10	30	70	10	100											84B 再登録
" 776	"	"	"	75	4	1A	1W	200	10	30	70	10	100											84B 再登録
" 777	"	"	"	75	4	1A	2W	200	10	30	50	10	100											97B 再登録
" 778	"	"	"	80	4	2A	2.5W	200	10	30	50	10	100											97B 再登録
" 779	東 芝	SW	Si. TMe	300	6	2A	25W (T _c = 25℃)	150	100	200	30~200	10	100	10	-100				20*	40				99
" 780	"	RF	Si. EP	70	2	20	150	125	5	70				10	-2	60				100*	3	50	33	2SA429 之對稱
" 781	日 電	RF. PA	"	75	5	1A	5W (T _c = 25℃)	175	1	40				10	-150	80				350*	11	13*		84A
" 782	東 芝	PA	Si. TMe	300	5	1.5A	20W (T _c = 25℃)	150	100	200	30~240	10	100	10	-100	100				10*	50	25		99
" 783	"	"	"	200	5	1.5A	20W (T _c = 25℃)	150	100	200	30~240	10	100	10	-100				10*	50	25		99	
" 784	"	RF	Si. EP	40	4	20	100	125	0.5	18	25~140	6	1	6	-1				500*	C _r 0.65 10pS	C _r 10pS		33	
" 785	"	Conv. Mix Osc	"	40	4	20	100	125	0.5	18	25~140	6	1	6	-1				500*	C _r 0.65 10pS	C _r 10pS		33	
" 786	"	RF	"	20	3	20	200	150	0.05	10	20~200	5	4	10	-4			NF = 3.5dB (f = 100MHz)	>250*	C _r 0.65 10pS	<25		50C	
" 787	"	RF. LN	Si. P	25	3	20	150	150	0.025	10	>25	10	2	10	-2			NF = 5dB (f = 800MHz)	1000*	C _r 0.3			50C	
" 788	"	RF. SW	Si. EP	250	5	50	800	150	0.1	30	100	5	10	30	-10				120*	4	25		84B	
" 789	"	RF. PA	Si. TMe	70	5	4A	30W (T _c = 25℃)	150	30	50	40~240	5	500	5	-500				>3*	150			119	
" 790	"	PA	"	50	5	3A	25W (T _c = 25℃)	150	10	30	40~240	2	500	2	-500				>3*	70			119	
" 791	"	"	Si. TMe	90	5	1.5A	15W (T _c = 25℃)	150	120	30	40~250	2	200	5	-500				60*	40			99	
" 792	"	"	"	300	5	1.5A	50W (T _c = 25℃)	150	50	300	90	10	300	10	-100				10*	80			102	
" 793	"	"	Si. TMe	100	5	7A	60W (T _c = 25℃)	150	100	50	80	5	1A	5	-500				9*	220			102	
" 794	"	"	"	70	5	7A	60W (T _c = 25℃)	150	1mA	30	50	5	1A	5	-500	50			9*	230	15		102	
" 795	SON	"	Si. DB	250	6	100	9W (T _c = 25℃)	150	10	100	70	10	10	10	-10	70				180*	7	C _r 50pS		100
" 796	富士通	RF. Osc	Si. EP	40		500	1W (T _c = 25℃)	175	5	12	50	4	150	20	-15				230*	5	20*		84B	
" 797	"	PA	"	60		500	1W (T _c = 25℃)	175	5	12	30	4	150	20	-15			P _o = 1.3W (f = 27Mc, V _{CE} = 12V, P _i = 75mW)	150*	5	12*		84B	
" 798	"	"	Si. TP	60		1.5A	5W (T _c = 25℃)	175	5	12	70	4	400					P _o = 3.5W (f = 27Mc, V _{CE} = 12V, P _i = 0.5W)					84B	
2SC799	日 電	RF. PA	Si. EP	80	5	1.5A	10W (T _c = 25℃)	175	1	40	90	10	150	10	-150			P _o = 3.5W (f = 27MHz, V _{CE} = 12V, P _i = 0.4W)	250*	15			97B	
" 800	"	RF	Si. TMe	30	4	20	100	150	0.1	25	8	6	2	6	-2	85				800*	0.5	C _r 2pS		23
" 801	"	RF. PA	"	75	5	500	13W (T _c = 25℃)	175	1	50	50	10	150	10	-50	45				100*	32	12*		83
" 802	富士通	PA. SW	Si. EP	60	4	500	1W (T _c = 25℃)	175	5	12	30	4	150	20	-15			P _o = 1.3W (f = 27Mc, V _{CE} = 12V, P _i = 75mW)	180*	5	12*		84B	
" 803	"	"	Si. TP	60	4	1.5A	5W (T _c = 25℃)	175	1	12	70	4	400					P _o = 3.5W (f = 27Mc, V _{CE} = 12V, P _i = 0.5W)	90*	9	7*		84B	
" 804	SON	RF. Conv. Mix. Osc	Si. DB	15		20	150	100	0.5	15	50	3	1	6	-4			h _{re} = 12 (f = 100Mc)		0.32	40*		24	
" 805	"	RF. AF. SW	Si. DB	100	5	200	475	120	1	25	100	5	3	10	-2				160*	3	C _r 80pS		84B	
" 806	"	PA	Si. TMe	650	10	10A	125W (T _c = 25℃)	150	5mA	500	30	3	2A	10	-0.5A	50				5*	280	5		102
" 807	"	"	"	500	10	10A	125W (T _c = 25℃)	150	5mA	500	50	3	100	10	-0.5A	50				5*	300	5		102
" 808	"	"	"	300	8	5A	80W (T _c = 25℃)	150	30	50	100	3	2A	10	-500				12*	310	C _r 700pS		102	
" 809	富士通	RF	Si. EP	25	3	20	200	155	0.1	12				6	-2	90				1200*	1.4	40*		50C
" 810	"	RF. PA	"	40	3	300	500	150	1	35				15	-50	70				750*	3.8	25*		85B
" 811	"	RF	"		4	30	180	175	0.5	15	60	10	2	10	-2				800*	0.9	50		50C	
" 812	富士通	SW	Si. EP	20	4	100	250	150	0.5	10	50	1	10						t _r < 10nS, t _f < 15nS t _{sig} < 12nS		2.5			49C
" 813	"	"	"																					
" 814	日 電	RF. PA	Si. EP	30	5	500	400	125	0.2	18	150	5	50	10	-10	140				180*	13	25		44
" 815	"	RF. Osc	"	60	5	200	250	125	0.2	30	80	10	10	10	-10	80				200*	5.5	25		43
" 816	三 菱	RF	"	60		1A	1W	200	10	28	100	6	0.1	10	-30				140*	12	C _r 60pS		84B 再登録	
" 817	"	"	"	30		20	120	150	0.1	12	80	10	1					G _{re} = 13dB (f = 500MHz, V _{CE} = 6V, I _C = 4mA)					50C	
" 818	三 菱	"	Si. TP	160	5	100	800	200			20~180	10	10						106*	4.5	C _r 14pS			
" 819	日 立	PA	Si. EP	65	4	1A	6W (T _c = 25℃)	175	100	65				28	-100	30				500*	7.5	12		84C
" 820	"	"	"	65	4	1.5A	10W (T _c = 25℃)	175	100	65				28	-100	30				500*	7.5	10		121
" 821	松 下	RF. Conv. Mix. Osc. PA	"	40	4	300	2.5W (T _c = 25℃)	175	1	20				13.5	-100	70				450*	6.5	15*		84B
" 822	"	"	"	40	4	500	2.5W (T _c = 25℃)	175	1	20				13.5	-100	70				550*	6.5	15*		84B
" 823	日 電	RF	"	30	3	60	600	150	0.1	10				10	-15	130			NF < 3.5dB (f = 150Mc)	1500*	0.9	C _r 3pS		85A
" 824	"	"	"	50	3	120	650	150	0.1															

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)												外 形	備 考	
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _c (mA)	P _c (mW)	T _j (℃)	I _{CB0} 最大值 (μA)	V _{CB0} (V)	直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}		偏 置 情 况		h _{fe}	h _{ie} h _{ie} * (Ω)	h _{re} h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{fs} h _{fs} * (μU)	f _β f _β * (Mc)	C _{ob} C _{ob} * (pF)			r _{bb} r _{bb} * (Ω)
2SC828A	松 下	RF. AF	Si. EP	45	5	50	250	125	1	10				5	- 2	220	3600	0.4	20	150*	2.2	70	42 2SC564A 之 對 稱
" 829	"	RF. Conv. Mix. Osc	"	30	5	30	250	125	1	10				10	- 2	130				230*	1.3	35	42
" 830	日 立	PA	Si. TMe	50	4	3 A	25 W (T _c = 25℃)	150	100	20	80	4	1 A	4	-500					20*	75	15	
" 831	日 電	PA	Si. EP	50	4	2 A	23 W (T _c = 25℃)	175	5	20	15~200	10	1 A	10	-30	80	P _o = 12 W (V _{CE} = 18 V, P _i = 2 W, f = 260 Mc)		500*	18		111	
" 832																							
" 833	日 立 電 子 通 信 機 械 有 限 公 司	SW	Si. TMe	450	6	2 A	25 W (T _c = 25℃)	150	100	200	80	10	100	10	-100	100	t _{on} < 2 μS, t _{off} < 3 μS t _{sig} < 4 μS			50		99	
" 834																							
" 835																							
★ " 836	日 電	RF	Si. P	30	4	20	200	125	0.2	20	70	10	4	10	- 4	60			600*	0.9	C _{ce} r _{bb} 3 pS	43 正 向 A.G.C.	
" 837	"	"	Si. EP	30	4	20	250	125	0.2	20	40	10	10	10	-10	30	PG = 20 dB (f = 45 Mc)		550*	1.6		43	
" 838	"	RF. Conv. Mix. Osc	"	50	5	30	250	125	0.1	15	80	3	0.5	6	- 1	90			250*	1.8	C _{ce} r _{bb} 20 pS	43	
" 839	"	"	"	50	5	30	250	125	0.1	15	80	3	0.5	6	- 1	90	NF = 2 dB (f = 1 Mc)		250*	1.8	C _{ce} r _{bb} 20 pS	43	
" 840	松 下	PA	Si. TMe	100	5	2 A	20 W (T _c = 25℃)	150	5mA	100	60	3	1 A	3	-100	60			50*	90	25	99	
" 840A	"	RF. Conv. Mix. Osc	Si. EP	150	5	2 A	20 W (T _c = 25℃)	150	5mA	100	60	3	1 A	3	-100	60			50*	90	25	99	
" 841	富 士 通	PA	"	36			6 W (T _c = 25℃)	175	5	12	50	4	500	12	-150				450*	12	12*	84B	
" 842	"	"	"	36		1 A	10 W (T _c = 25℃)	175	5	12	40	4	1 A	12	-150				450*	13	10*	111	
" 843	"	"	"	36		2 A	20 W (T _c = 25℃)	175	12	12	50	4	2 A	12	-150				350*	25	7*	111	
" 844	"	"	"	40	2	400	3.5 W (T _c = 25℃)	175	1	12	25	5	100	15	-30	40	P _o = 1.1 W (f = 175 Mc, V _{CE} = 12 V)		800*	3	20*	84B	
" 845	"	"	"	55	3.5	400	3.5 W (T _c = 25℃)	175	1	12	25	5	100	15	-30	40	P _o = 1.4 W (f = 100 Mc, V _{CE} = 28 V)		800*	3	20*	84B	
" 846																							
" 847	富 士 通	RF	Si. EP	30	5	200	350	175	0.5	12	160	4	10	6	- 1				70*	10	40	49C	
" 848	"	RF. LN	"	30	5	200	350	175	0.1	12	160	4	10	6	- 1		3500	0.1	5	60*	10	40	49C
" 849	"	SW. AF	"	30	5	300	350	175	0.5	12	160	4	10	6	- 1		3500	0.1	5	t _r < 0.08 μS, t _f < 0.15 μS t _{sig} < 0.8 μS			49C
" 850	"	SW. PA	"	50	7	500	350	175	0.5	12	160	4	10										49C
★ " 851	日 電	PA	"	50	5	8 A	75 W (T _c = 25℃)	200	500	30	50	5	5 A										118
" 852	"	RF	"	45	3	80	500	150	0.5	15	100	6	20	6	- 20				1100*	2	C _{ce} r _{bb} 3.7 pS	85B	
" 853	日 電	RF. PA	Si. EP	70		200	400	125	0.1	60	70	2	150	10	- 10	110			90*	7.5	40*	44 2SA545 之 對 稱	
" 854	富 士 通	PA	"	40	2	300	2.5 W (T _c = 25℃)	175	1	12	25	5	100	15	-30	40	P _o = 0.75 W (f = 175 Mc, V _{CE} = 12 V)		800*	2.5	20*	84B	
" 855	"	"	"	40	2	400	3 W (T _c = 25℃)	175	1	12	25	5	100	15	-30	40	P _o = 0.9 W (f = 175 Mc, V _{CE} = 12 V)		800*	2.5	20*	84B	
" 856	日 立	RF	Si. TPa	150	5	50	300	175	1	20	50	6	10	6	- 10				150*	2.5	25*	12A	
2SC857	日 立	SW. RF	Si. TMe	200	5	50	200	175	0.1	20	80	6	10	6	- 10				100*	3	40	12A	
" 858	日 立	RF. LN	Si. P	20		50	100	125	1	15	230	6	1	6	- 1	NF 8dB f 25℃	3000	0.7	9	140*	4	C _{ce} r _{bb} 250 pS	27
" 859	"	"	"	20		50	100	125	1	15	230	6	1	6	- 1	NF 15dB f 25℃	3000	0.7	9	140*	4	C _{ce} r _{bb} 250 pS	27
" 860	"	RF	Si. EP	15	3	30	80	125	1	10	80	6	1	6	- 1				700*	1.5	C _{ce} r _{bb} 50 pS	265C	
" 861	日 立	PA	Si. TMe	450	6	1 A	50 W (T _c = 25℃)	150	1mA	30	50	5	200	15	-200				7*	140	10	102	
" 862	"	"	"	650	6	5 A	50 W (T _c = 25℃)	150	1mA	30	9	2	3.5 A	15	-200				7*	140	10	102	
★ " 863	東 芝	RF	Si. EP	60	4	25	175	150	1	10				10	- 5	100			600*	1.5	10	117C	
" 864	"	"	"	40	4	25	175	150	1	10				10	- 5	100			600*	1.5	10	117C	
" 865	富 士 通	PA	Si. TP	60		2 A	20 W (T _c = 25℃)	175	5	30	70	4	1 A				P _o 4.8 W f 50Mc, V _{ce} 20 V, P _i 1 W					83	
" 866	"	"	"	60		1.5 A	5 W (T _c = 25℃)	175	5	12	70	4	400				P _o 3.5 W f 27Mc, V _{ce} 12 V, P _i 0.5 W					97B	
" 867	SON	PA. SW	Si. TMe	400	10	1 A	18 W (T _c = 25℃)	150	100	50	80	3	100	10	-200				8*	120	12	100	
" 868	日 電	SW	Si. EP	130	5	30	200	125	0.1	25	90	6	1				t _{on} < 80 nS, t _{off} < 90 nS, t _{sig} < 200 nS					138B 內 含 錄	
" 869	"	"	"	160	5	30	200	125	0.1	25	90	6	1				t _{on} < 80 nS, t _{off} < 90 nS, t _{sig} < 200 nS					138B 內 含 錄	
" 870	"	RF. AF. LN	"	30	4	30	200	125	0.1	25	160	6	0.1	6	- 0.1	190	50 k	1.2	3.5	150*	2.5	C _{ce} r _{bb} 200 pS	41
" 871	"	"	"	30	4	30	200	125	0.1	25	250	6	0.1	6	- 0.1	270	70 k	1.4	3.5	150*	2.5	C _{ce} r _{bb} 200 pS	41
" 872	富 士 通	PA	"	40		400	3.5 W (T _c = 25℃)	175	1	12	25	5	100	13.5	- 30	$P_o = 1.3\text{ W}$ $f = 400\text{ Mc}$, $V_{ce} = 13.5\text{ V}$, $P_i = 0.4\text{ W}$			800*	3	20*	84C	
" 873	"	"	"	75	4	1 A	500	150	100	70	60	6	50						200*		C _{ce} r _{bb} 50 pS	2SA533 之 對 稱	
" 874	"	"	"	50	4	1 A	500	150	100	45	60	6	50						200*		C _{ce} r _{bb} 50 pS	2SA533 之 對 稱	
" 875	"	RF. PA	Si. TP	75	5	200	500	150	10	40	100	6	50	6	- 10				170*	5		84B	
" 876	"	"	"	50	5	200	500	150	10	40	100	6	50	6	- 10				170*	5		84B	
" 877	協 同	SW	Si. EP	40	4.5	200	300	175	0.1	20	60	1	10				t _{on} < 20 nS, t _{off} < 35 nS t _{sig} < 20 nS					49C	
" 878	"	"	"	40	4.5	200	300	175	0.1	20	70	1	10				t _{on} < 12 nS, t _{off} < 22 nS t _{sig} < 13 nS					49C	
" 879	"	"	"	60	5	1 A	800	175	1	40	80	1	100				t _{on} < 70 nS, t _{off} < 100 nS t _{sig} < 50 nS					84A	
" 880	"	"	"	60	5	1 A	800	175	1	40	80	1	100				t _{on} < 70 nS, t _{off} < 100 nS t _{sig} < 50 nS					84A	
" 881	日 電	RF. PA	"	60		200	400	125	0.1	45	70	2	150	10	- 10	110			200*	5.5	25	44	
" 882	日 電	RF. Conv. Osc	"	150	5	2 A	25 W (T _c = 25℃)	150	50	30				5	- 0.5A	50			30*	45	7	102	
" 883	"	"	"	90	5	2 A	25 W (T _c = 25℃)	150	100	30				5	- 0.5A	50			30*	45	7	102	
" 884	"	PA	Si. TMe	80	5	2																	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)													外形	備考		
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CB0} 最大值		直流及脉冲下之 h _{FE}			偏置情况		h _{FE}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _β f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)			h _{ie(rss)} (Ω)	
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _B (mA)											
2SC887	芝 電	SW	Si.TMe	210	5	7 A	50 W (T _a =25℃)	150	50	30	35	5	1 A				t _{on} < 2 μs, t _{off} < 3 μs							102	
" 888	"	"	"	150	5	7 A	50 W (T _a =25℃)	150	100	30	35	5	1 A				t _{on} < 2 μs, t _{off} < 3 μs							102	
" 889	三 菱	RF.AF.LN	Si.EP	90	5	7 A	50 W (T _a =25℃)	150	100	30	35	5	1 A				t _{on} < 2 μs, t _{off} < 3 μs							102	
" 890	日 電	PA	"	40	3	400	750 (T _a =25℃)	175	5	20				10	-50	40	P _a = 1.3 W (f = 500Mc, P _i = 0.3W, V _{CE} = 13.5V)							84C	
" 891	"	"	"	40	4	600	10.3W (T _a =25℃)	175	10	20				10	-100	40	P _a = 3.7 W (f = 500Mc, P _i = 1 W, V _{CE} = 13.5V)							115	
" 892	"	"	"	40	4	1.2A	17.7W (T _a =25℃)	175	20	20				10	-300	40	P _a = 7.5 W (f = 500Mc, P _i = 1 W, V _{CE} = 13.5V)							115	
" 893	富士通	RF	Si.TMe	100	6	500	12 W (T _a =25℃)	175	1	30	100	4	50	6	-10	100				20 *	10	30	97		
" 894	SON	RF.SW	Si.DB	25	6	100	100 (T _a =25℃)	120	0.2	25	100	3	1	6	-2					200 *	2.4	C _r r _{bb} 120pS	38		
" 895	"	PA.SW	Si.TMe	150	8	2.5A	20W (T _a =25℃)	150	50	50	120	3	100	10	-200					20 *	145	24	100		
" 896	日 電	RF	Si.EP	55	5	200	300 (T _a =25℃)	175	1	20				10	-5	70				200 *	3.5	35 *	46C		
" 897	日 立	PA	Si.TMe	150	6	7 A	60 W (T _a =25℃)	150	1mA	30	80	5	1 A	5	-1 A					15 *	140	10 *	102	2SA757 之封筒	
" 898	"	"	"	150	5	7 A	80 W (T _a =25℃)	150	1mA	30	50	5	1 A	5	-1 A					15 *	140	10 *	102	2SA758 之封筒	
" 899	日 電	RF.AF.LN	Si.EP	50	5	50	250 (T _a =25℃)	125	0.1	15	110	3	0.5	6	-1	140	4000	0.65	8.5	250 *	1.8	C _r r _{bb} 70pS	43		
" 900	"	RF.LN	Si.E	30	5	30	250 (T _a =25℃)	125	0.1	25	400	3	0.5	3	-1		14K	5.8	23	100 *	3.5	50 *	138		
" 901	松 下	PA	Si.TMe	200	6	5 A	50 W (T _a =25℃)	150	15mA	150	25	4	5 A				t _{on} < 3 μs, t _{off} < 1 μs							102	
" 901A	"	PA	Si.EP	250	6	5 A	50 W (T _a =25℃)	150	15mA	150	25	4	5 A				t _{on} < 3 μs, t _{off} < 1 μs							102	
" 902	富士通	SW	Si.TMe	150	6	10A	75 W (T _a =25℃)	175	15	30	50	4	5 A				t _{on} < 2 μs, t _{off} < 1.5 μs							102	
" 903	三 菱	PA	Si.EP	35	4	300	200 (T _a =25℃)	125	1	25	100	2	150	6	-10					150 *	10	C _r r _{bb} 100pS	41		
" 904	"	"	"	50	4	300	200 (T _a =25℃)	125	1	25	100	2	150	6	-10					150 *	10		41		
" 905	"	"	"	65	4	300	200 (T _a =25℃)	125	1	25	80	2	150	6	-10					150 *	10		41		
" 906	富士通	PA.SW	"	50	7	500	600 (T _a =25℃)	175	0.5	12	160	4	10				t _{on} < 0.08 μs, t _{off} < 0.15 μs							89	
" 907	日 立	RF.SW.AF	Si.DB	40	5	100	200 (T _a =25℃)	175	0.5	20	200	1	10	6	-1		4000	2	10	240 *	1.7	150	12A		
" 907A	"	"	"	60	5	100	200 (T _a =25℃)	175	0.5	20	120	1	10	6	-1		4000	2	10	240 *	1.7	150	12A		
" 908	三 菱	PA	Si.EP	40	4	500	860 (T _a =25℃)	175	50	15	50	10	100				P _a = 1.2W (f = 500Mc, V _{CE} = 13.5V, P _i = 0.4W)							84B	再登録
" 909	"	"	"	40	4	500	7 W (T _a =25℃)	200	50	15	50	10	100				P _a = 3.5 W (f = 500Mc, P _i = 1 W, V _{CE} = 13.5V)							113	
" 910	"	"	"	40	3	1 A	10 W (T _a =25℃)	200	100	15				10	-100	50	PG = 5 dB (f = 500Mc, P _i = 2 W, V _{CE} = 13.5V)							113	
" 911	"	"	"	40	4	500	1.7W (T _a =25℃)	175	50	15	50	10	100				P _a = 1.4 W (f = 500 MHz, V _{CE} = 13.5V, P _i = 0.3W)							125	再登録
" 912	"	RF.Conv.Mix Osc.SW	Si.EP	30	5	100	150 (T _a =25℃)	150	0.1	25	90	6	10	6	-1	80	2500	0.35	15	150 *	2.5	C _r r _{bb} 100pS	8 A		
" 913	富士通 日立	SW	"	40	5	300	300 (T _a =25℃)	175	0.2	20	70	1	30				t _{on} < 45nS, t _{off} < 42nS							49C	
" 914	"	"	"	40	5	300	300 (T _a =25℃)	175	0.2	20	70	1	30				t _{on} < 80nS, t _{off} < 86nS							49C	
2SC915	富士通 日立	SW	Si.EP	30	5	300	300 (T _a =25℃)	175	0.2	20	70	1	30				t _{on} < 45nS, t _{off} < 42nS							49C	
" 916	"	"	"	100	5.5	1.5 A	2 W (T _a =25℃)	175	10	80	70	1	400				t _{on} < 63nS, t _{off} < 210nS							83	
" 917	日 立	RF	Si.P	40		50	300 (T _a =25℃)	175	10	40	40	10	10	10	-10					800 *	1	C _r r _{bb} 5 pS	56C		
" 918	SON	"	Si.DB	20		30	188 (T _a =25℃)	100	0.2	15	80	10	4	10	-4		h _{re} = 12dB (f = 100 MHz)				0.7	C _r r _{bb} 10pS	205C		
" 919	"	"	"																						
" 920	日 電	RF.Conv. Mix.Osc.LN	Si.EP	50	5	30	150 (T _a =25℃)	150	0.1	15	75	3	0.5	6	-1		NF = 2.5dB (f = 1 Mc)				250 *	1.6	C _r r _{bb} 30pS	23	
" 921	"	RF.Conv. Mix.Osc.	"	25	2	10	100 (T _a =25℃)	150	0.1	12	65	3	0.5	6	-1					650 *	0.9	C _r r _{bb} 9 pS	23		
" 922	"	"	Si.E	30	5	20	250 (T _a =25℃)	125	0.1	20	80	6	1	6	-1					650 *	1.1	C _r r _{bb} 15pS	138		
" 923	"	RF.AF	"	30	5	30	250 (T _a =25℃)	125	0.1	25	400	3	0.5	3	-1		14K	5.8	23	100 *	3.5	50 *	138	2SA641 之封筒	
" 924	"	"	Si.EP	30		50	250 (T _a =25℃)	125	0.1	15	100	3	0.5	6	-1	130	3800	0.6	8	250 *	1.8	C _r r _{bb} 20pS	43		
" 925	"	RF.AF.SW	"	30	5	50	250 (T _a =25℃)	125	0.1	30	130	12	2	12	-2	140	2300	3.5	45	250 *	1.8	50	43		
" 926	SON	RF.SW	Si.DB	115	3.5	100	100 (T _a =25℃)	120	0.2	115	50	3	1	10	-2					160 *	2.5	C _r r _{bb} 40pS	38		
" 927	三 洋	RF.LN	Si.TP	30	3	20	150 (T _a =25℃)	125	1	25	80	6	1	6	-3					500 *	0.7	C _r r _{bb} 3.0 pS	205C		
" 928	"	RF	"	30	3	20	150 (T _a =25℃)	125	1	25	80	6	1	6	-3					500 *	0.7	C _r r _{bb} 3 pS	205C		
" 929	"	RF.Conv.LN	Si.EP	15	5	30	120 (T _a =25℃)	125	1	10	100	6	1	6	-1					300 *	1.5	C _r r _{bb} 20pS	166		
" 930	"	RF	"	15	5	30	120 (T _a =25℃)	125	1	10	80	6	1	6	-1					300 *	1.5	C _r r _{bb} 20pS	166		
" 931	"	PA	Si.TMe	50		3 A	10 W (T _a =25℃)	125	1mA	45	70	2	1 A	5	-0.5A					120 *	100	35	120		
" 932	"	"	"	30		3 A	10 W (T _a =25℃)	125	1mA	25	70	2	1 A	5	-0.5A					120 *	100	35	120		
" 933	"	RF.AF	Si.EP	50	5	300	300 (T _a =25℃)	125	1	45	150	5	20	6	-5					300 *	5	C _r r _{bb} 120pS	138		
" 934	"	"	"	20	5	300	300 (T _a =25℃)	125	1	15	150	5	20	6	-5					300 *	5	C _r r _{bb} 120pS	138		

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)														外 形	備 考
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB(V)}	直 流 及 脈 沖 下 之 h _{FE}		偏 置 情 況		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _β f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ib} (real)* (Ω)			
2SC945	日 電	RF. AF	Si. E	50	5	100	250	125	0.1	40	150	6	1	6	-1		4500	4.5	17	250*	4.5	25*	138	2SA733 之對稱
" 946	"	"	"																					
" 947	松 下	RF. Conv. Mix. Osc. PA	Si. P	25	3	15	150	175	100	25	50	10	2	10	-3					650*	C _{re} 0.33pF	20	50C	
" 948	"	RF	"	25	3	15	150	175	100	25	60	10	3	10	-3					800*	C _{re} 0.33pF	30	50C	
" 949	新 日 無	RF. AF. LN	Si. EP	30		50	200	125	0.05	20	150	6	1	6	-0.1		50k	5	15	40*	6	C _{e rbb} 60pS	29	
" 950	"	RF. AF	"	30		100	300	125	0.1	20	100	6	1	10	-2		5000	1	20	55*	5	C _{e rbb} 40pS	29	
" 951	"	"	"																					
" 952	新 日 無	RF	Si. EP	90		200	300	125	0.1	20	90	1	50	10	-2					40*	5	C _{e rbb} 50pS	29	
" 953	"	"	"	30		200	600	125	0.5	20	80	1	100	10	-5					90*	5	C _{e rbb} 50pS	31	
" 954	"	RF. PA	"	60		400	600	125	0.5	20	100	1	100	10	-5					90*	5	C _{e rbb} 50pS	31	
" 955	"	RF	"	20		50	150	125	1	10	100	6	1	6	-2					150*	2	C _{e rbb} 250pS	29	
" 956	"	RF. AF	"	50	5	50	150	125	0.1	20	250	6	1	6	-1		30kΩ	6	30	200*	2	C _{e rbb} 200pS	29	
" 957	SON	RF	Si. DB	30		100	360	100	0.3	15	30	3	1	10	-10		h _{fe} = 16dB (f = 100MHz)				1.5	C _{e rbb} 10pS	206C	
" 958	"	"	"																					
" 959	日 電	PA	Si. EP	120	5	700	0.7	150	3	80	100	5	200	5	-150					80*	17	35	84B	2SA606 之對稱
" 960	"	"	"	120	5	700	1W	150	3	80	80	5	300	10	-100					100*	30	35*	97B	2SA607 之對稱
" 961	芝 電	PA	Si. TMe	120	5	7A	60W (T _c = 85℃)	150	100	30	60	4	1A	5	-500					13*	350	5	102	
" 962	"	"	"	100	5	7A	60W (T _c = 85℃)	150	100	30	60	4	1A	5	-500								102	
" 963	富 士 通	RF	Si. EP	35		50	250	175	2	12	70	6	1	6	-1					200*	2	50*	55C	
" 964	"	"	"	35		50	250	175	2	12	100	6	1	6	-1		4000	5	20	200*	2	50*	55C	
" 965	"	RF. SW	"	45	4	100	250	175	0.5	12	130	6	1	6	-1		t _{re} < 80nS, t _{tr} < 100nS t _{re} < 200nS			200*	2	50*	55C	
" 966	"	RF. AF. LN	"	30		200	500	175	0.5	12	160	4	10	6	-1		3500	0.1	5	60*	10	80	55C	
" 967	"	RF. AF. PA	"	30		500	500	175	1	12	160	4	10	6	-1		3500	0.1	5	60*	10	70	55C	
" 968	"	RF. PA	"	50		500	500	175	1	12	160	4	10	6	-1					60*	10	70	55C	
" 969	"	RF. AF. LN	"	50		200	500	175	0.1	12	160	4	10	6	-1		3500	0.1	5	60*	10	80	55C	
" 970	"	RF. SW	"	50	7	500	500	175	0.5	12	160	4	10	6	-1		t _{re} < 80nS, t _{tr} < 150nS t _{re} < 800nS			70*	10	70	55C	
" 971	"	RF. PA	"	50		500	1W	175	1	12	160	4	10	6	-1					60*	10	70	90	
" 972	"	"	"																					
" 973	三 菱	PA	Si. EP	40	4	500	7W (T _c = 85℃)	200	50	15	50	10	100				P _{ce} = 4W (f = 500MHz, V _{ce} = 13.5V, P _i = 1W)						126	
" 974	"	"	"	35		1A	10W (T _c = 85℃)	200	100	15	50	10	100				P _{ce} = 6W (f = 500MHz, V _{ce} = 13.5V, P _i = 2W)						183	再 登 録
2SC975	三 菱	PA	Si. EP	35	5	1.5A	17W (T _c = 85℃)	175	200	15	50	10	100				P _{ce} = 8W (f = 500MHz, V _{ce} = 13.5V, P _i = 3W)						183	再 登 録
" 976	"	"	"	55	4	400	5W (T _c = 85℃)	175	100	30	50	28	20				P _{ce} = 1.1W (f = 1GHz, V _{ce} = 28V, P _i = 0.3W)						126	
" 977	"	"	"	55	4	600	10W (T _c = 85℃)	175	300	30	50	28	50				P _{ce} = 3W (f = 1GHz, V _{ce} = 28V, P _i = 0.75W)						126	
" 978	"	"	"	55	4.5	1.2A	18W (T _c = 85℃)	175	500	30	50	28	50				P _{ce} = 5.5W (f = 1GHz, V _{ce} = 28V, P _i = 2W)						126	
" 979	東 芝	RF	"	70	5	100	300	175	0.1	50	40~240	1	10	10	-10					250*	3		49C	
" 980	"	"	"	70	5	100	200	125	1	50	70	1	10	10	-10					400*	3	30	33	
" 981	"	PA	"	100	5	5A	25W (T _c = 85℃)	150	10	40	70	1.5	5A	5	-500					10*	80	10	99	
" 982	"	AF. SW	"	30	10	300	300	125	0.1	30	>5000	5	10	10	-10					100*	6	100	185	
" 983	"	"	Si. TP	250	5	50	600	150	0.1	30	40~240	5	10	30	-10					120*	<5.5	25	131	
" 984	日 立	"	Si. EP	50	4	500	350	175	0.5	20	80	3	10	3	-10					230*	5	24*	12A	2SA565 之對稱
" 985	日 電	RF. LN	"	20	3	40	200	150	0.5	10	80	5	15	5	-15		NF = 5.3dB (f = 2Gc, 5V, -4mA)			3200*	0.6	C _{e rbb} 1pS	26	
" 986	"	RF	Si. E	35	3	200	3.5W (T _c = 85℃)	200	1	20	100	15	70	15	-70					2500*	1	C _{e rbb} 3pS	187	
" 987	"	"	Si. EP	20	3	30	150	150	0.5	10	80	10	10	10	-10		NF = 8dB (f = 4Gc, 10V, -3mA)			4500*	0.35	C _{e rbb} 0.6pS	26	
" 988	"	"	"	20	3	30	200	200	0.1	10	80	10	10	10	-10		NF = 2dB (f = 500Mc, 10V, -3mA)			3000*	0.5	30*	50C	
" 989	"	"	"	20	3	50	300	200	0.5	10	80	1	30	3	-15					3000*	0.9	30*	25	
" 990	"	PA	"	50	4	2A	24W (T _c = 85℃)	175	10	20	40	10	1A	10	-300		P _{ce} = 15W (f = 400Mc, V _{ce} = 18V, P _i = 4.3W)			400*	25		116	
" 991	東 芝	"	"	36	4	400	600	175	1	15	30	3	100	10	-50		P _{ce} = 1.3W (f = 175Mc, V _{ce} = 12V, P _i = 0.1W)			500*	5	10	84B	
" 992	"	"	"	36	4	600	600	175	1	15	30	3	100	10	-50		P _{ce} = 2.5W (f = 175Mc, V _{ce} = 12V, P _i = 0.5W)			500*	5	10	84B	
" 993	富 士 通	RF	"	25		200	200	175	0.05	10				6	-1	80				400*	3.5	50*	46C	
" 994	東 芝	RF. PA	"	36	3	100	600	175	1	15	40	3	100	10	-10					500	3.8		84B	
" 995	"	RF. PA	Si. TP	300	5	100	800	150	0.1	100	100	10	50	10	-30					100*	4.2	10	84B	
" 996	"	"	"	300	5	100	1.2W	150	0.1	100	100	10	50	10	-30					100*	4.2	10	97B	
" 997	"	RF	Si. P	40		25	150	150	0.025	10	70	10	4	10	-4					600*	1.5		117C	
" 998	"	PA	Sj. EP	40	4	400	600	175	1	15	>20	5	50	5	-50					550*	6.5		84B	
" 999	"	RF. PA. SW	Si. TMe	1500	5	1.5A	50W (T _c = 85℃)	150	10	500	50	15	150	15	-200					1	70	10	102	
" 1000	"	RF. LN	Si. EP	55	5	100	200	125	0.1	18	200~700	6	2	6	-1	280	7500	0.62	6.4	80*	6	100	33	
" 10																								

型 名	用 途	構 造	最大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)					電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)												外 形	備 考			
			V_{CB0} (V)	V_{EB0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW) ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	T_j ($^{\circ}\text{C}$)	I_{CBO} 最大值		直 流 及 脉 冲 下 之 h_{FE}		偏 置 情 况		h_{fe} h_{fs}^*	h_{ie} h_{is}^* (Ω)	h_{re} h_{rs}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{os}^* (μS)	$f_{\beta B}$ f_T^* (Mc)	C_{ob} C_{os}^* (pF)			r_{bb} r_{bs}^* (Ω)		
								(μA)	$V_{CB(V)}$	$V_{CE(V)}$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB(V)}$	$I_E(\text{mA})$											
2SC1004A	東 芝	PA. SW	Si. TMe	1500	5	500	50 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	10	500	70	15	150	15	-200				5.5 *	40		102		
★ 1005	"	PA	"	1100	5	5 A	50 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	10	500	12	15	4 A	15	-500				3 *	150	5	102		
★ 1006	日 電	RF. AF	Si. E	50	5	30	300	150	0.05	30	600	3	1	3	-1	18 K	2	45	200 *	3	50 *	49C		
★ 1007	"	RF. SW	Si. EP	60	8	20	300	150	0.1	40	150	1	10	10	-10				220 *	3	30 *	49C		
★ 1008	"	RF	Si. E	80	8	700	800	150	0.1	60	160	2	50	10	-50				*	17	25 *	84B		
★ 1009	"	RF. Conv. Mix. Osc. LN	"	50	5	50	150	125	0.1	25	80	3	0.5	6	-1	$NF = 2\text{ dB}$ ($f = 1\text{ MHz}$, 6V, 0.5mA)			250 *	$C_{ext} 25\text{ pS}$	176			
★ 1010	"	AF. LN	"	50	5	30	300	150	0.05	30	550	3	1	3	-1	18 K	2	45	120 *	3	50 *	49C		
★ 1011	三 菱	PA	Si. EP	40	4	750	2.5 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	200	100	15	50	10	100		$P_o = 3\text{ W}$ ($f = 150\text{ MHz}$, $V_{ce} = 15\text{ V}$, $P_i = 250\text{ mW}$)						125			
★ 1012	松 下	RF. AF	Si. TP	165	5	60	2.5 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	2	12	60	20	40	10	-3	35	300	0.4	2.7	*	3.5	$C_{ext} 60\text{ pS}$	84B	
★ 1013	三 菱	SW. P	Si. EP	35	5	1.5 A	7 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	1	25	80	4	500		$t_{on} < 0.2\mu\text{S}$, $t_{off} < 1.2\mu\text{S}$ $t_r < 1\mu\text{S}$						132			
★ 1014	"	"	"	50	5	1.5 A	7 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	1	25	70	4	500		$t_{on} < 0.2\mu\text{S}$, $t_{off} < 1.2\mu\text{S}$ $t_r < 1\mu\text{S}$						132			
★ 1015	"	PA	"	40	4.5	3 A	33 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	500	15	50	10	100		$P_o = 14\text{ W}$ ($f = 450\text{ MHz}$, $V_{ce} = 13.5\text{ V}$, $P_i = 6\text{ W}$)						183	再登録		
★ 1016	"	"	"	35		500	2 W	200	50	15	50	10	100		$P_o = 1.3\text{ W}$ ($f = 500\text{ MHz}$, $V_{ce} = 12\text{ V}$, $P_i = 0.3\text{ mW}$)						186			
★ 1017	"	"	"	75	4	1 A	4 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	10	30	50	10	100		$P_o = 60\text{ mW}$ ($f = 27\text{ MHz}$, $I_C = 25\text{ mA}$, $V_{ce} = 12\text{ V}$)						132			
★ 1018	"	"	"	75	4	1 A	4 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	10	30	50	10	100		$P_o = 1.4\text{ W}$ ($f = 27\text{ MHz}$, $P_i = 75\text{ mW}$, $V_{ce} = 12\text{ V}$)						132			
★ 1019	"	"	"	60		4 A	40 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	1mA	30	50	10	100		$P_o = 28\text{ W}$ ($f = 500\text{ MHz}$, $V_{ce} = 28\text{ V}$, $P_i = 20\text{ W}$)						188			
★ 1020	"	"	"	60		8 A	70 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	2mA	30	50	10	100		$P_o = 45\text{ W}$ ($f = 500\text{ MHz}$, $V_{ce} = 28\text{ V}$, $P_i = 20\text{ W}$)						188			
★ 1021	"	"	"	60	5	6 A	60 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	2 mA	30	50	10	100		$P_o = 45\text{ W}$ ($f = 90\text{ MHz}$, $V_{ce} = 28\text{ V}$, $P_i = 5\text{ W}$)						127	再登録		
★ 1022	"	"	"	60	5	6 A	60 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	2 mA	30	50	10	100		$P_o = 45\text{ W}$ ($f = 150\text{ MHz}$, $V_{ce} = 28\text{ V}$, $P_i = 10\text{ W}$)						127	再登録		
★ 1023	富士通	RF. Conv. Mix. Osc.	Si. P	25		25	150	125	2	12	40	6	1	6	-2				200 *	1.8		138		
★ 1024	"	"	"																					
★ 1025	"	"	"																					
★ 1026	富士通	RF. Conv.	Si. P	25	3	25	150	125	2	12	100	6	1	6	-2	$NF = 2.5\text{ dB}$ ($f = 1\text{ MHz}$, 6V, 1mA)			200 *	1.8	70	138		
★ 1027	"	"	"																					
★ 1028	"	"	"																					
★ 1029	"	"	"																					
★ 1030	日 立	PA	Si. TMe	150	6	6 A	50 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	1 mA	30	80	5	1 A	5	-1 A				10 *	180	12 *	102	2SA756 之對稱	
★ 1031	富士通	SW	"	300	6	2 A	30 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	5	150	220	10	500		$t_{on} < 5\mu\text{S}$, $t_{off} < 15\mu\text{S}$ $t_{sig} < 5\mu\text{S}$						99			
★ 1032	"	RF	Si. P	25	3	25	150	125	2	12	100	6	1	6	-2				200 *	1.8	70 *	138		
★ 1033	松 下	RF. AF	Si. TP	200	5	25	300	175	2	12	70	10		10	-3	38	300	0.4	2.9	135 *	3.3	$C_{ext} 60\text{ pS}$	49C	
2SC1034	SON	PA. SW	Si. TMe	1100	13	1 A	25 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	5 mA	800	18	3	750	10	-200				5 *	95	$C_{ext} 220\text{ pS}$	100		
★ 1035	三 洋	LN	Si. TP	30	3	20	150	150	1	25	100	6	1	6	-3	$NF = 6\text{ dB}$ ($f = 800\text{ MHz}$, 11V, 2mA)			700 *	0.7	$C_{ext} 2.5\text{ pS}$	205C		
★ 1036	"	RF	"	30	3	20	150	150	1	25	100	6	1	6	-3				700 *	0.7	$C_{ext} 2.5\text{ pS}$	205C		
★ 1037	日 電	PA	Si. EP	60	4	4 A	50 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	1 mA	30	50	10	1 A		$P_o = 33\text{ W}$ ($f = 160\text{ MHz}$, $V_{ce} = 28\text{ V}$, $P_i = 10\text{ W}$)						111			
★ 1038	"	"	"	40	3	150	3.75 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	50	20	50	10	70	10	-70	$P_o = 800\text{ mW}$ ($f = 2.3\text{ GHz}$, $V_{ce} = 18\text{ V}$, $P_i = 250\text{ mW}$)			2000 *	2.5		129		
★ 1039	"	"	"	40	3	250	7.5 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	100	20	50	10	100	10	-100	$P_o = 1.4\text{ W}$ ($f = 2.3\text{ GHz}$, $V_{ce} = 18\text{ V}$, $P_i = 630\text{ mW}$)			2000 *	4		129		
★ 1040	"	"	Si. E	45	4	1.2 A	15 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	1 mA	30	50	10	1 A		$P_o = 8\text{ W}$ ($f = 500\text{ MHz}$, $V_{ce} = 18\text{ V}$, $P_i = 2\text{ W}$)						184			
★ 1041	日 電	PA	Si. EP	40	3	150	3.75 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	50	20	50	10	70	10	-70	$P_o = 900\text{ mW}$ ($f = 2\text{ GHz}$, $V_{ce} = 18\text{ V}$, $P_i = 250\text{ mW}$)			2000 *	2.5		129		
★ 1042	"	"	"	40	3	250	7.5 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	100	20	50	10	100	10	-100	$P_o = 1.6\text{ W}$ ($f = 2\text{ GHz}$, $V_{ce} = 18\text{ V}$, $P_i = 630\text{ mW}$)			2000 *	4		129		
★ 1043	"	RF. LN	Si. E	45	3	300	6 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	0.1	30	80	10	100	15	-50	$P_o = 15\text{ dB}$ ($f = 500\text{ MHz}$, 50 mA) $NF = 3.5\text{ dB}$ ($f = 200\text{ MHz}$, 50 mA)			2200 *	2.5		129		
★ 1044	"	RF	"	45	4	30	250	200	50 nA	30	100	6	6	6	-6	$G_P = 22\text{ dB}$ ($f = 200\text{ MHz}$)			1000 *	$NF = 3\text{ dB}$ ($f = 200\text{ MHz}$)		50C		
★ 1045	"	"	"																					
★ 1046	"	"	"																					
★ 1047	松 下	RF	Si. EP	30	3	15	150	125	10	30	120	6	1	6	-1				650 *	$C_{ext} 0.89\text{ pF}$	30	138		
★ 1048	三 洋	"	Si. Me	200	6	50	600	150	10	100	90	10	25	10	-10				120 *	3.5		84B		
★ 1049	"	"	"																					
★ 1050	"	"	"																					
★ 1051	"	"	"																					
★ 1052	富士通	SW	Si. EP	75	5	1 A	800	175	0.5	50	40	1	500		$t_{on} < 50\text{ nS}$, $t_{off} < 70\text{ nS}$ $t_{sig} < 40\text{ nS}$						84B			
★ 1053	"	"	"	75	5	700	800	175	0.2	40	50	1	500		$t_{on} < 40\text{ nS}$, $t_{off} < 60\text{ nS}$ $t_{sig} < 45\text{ nS}$						84B			
★ 1054	"	RF. LN	"	35	3	50	180	175	0.5	12	60	6	1	6	-2	$NF = 3\text{ dB}$ ($f = 200\text{ MHz}$, 6V, 1mA)			700 *	1	30 *	205C		
★ 1055	日 立	PA. SW	Si. TMe	130	6	7 A	25 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	200	30	60	4	5 A	5	-1 A				25 *	200	12 *	99		
★ 1056	SON	RF	Si. PaMe	260	5	100	750	175	1	100	150	5	3	10	-10				150 *	10	$C_{ext} 50\text{ pS}$	84B		
★ 1057	富士通	PA	Si. EP	50	3.5	1 A	12 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	500	20	50	5	500		$P_o = 6.5\text{ W}$ ($V_{ce} = 24\text{ V}$, $f = 700\text{ MHz}$, $P_i = 2\text{ W}$)						133			
★ 1058	"	"	"	50	3.5	2 A	20 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	1 mA	20	50	5	1 A		$P_o = 11.5\text{ W}$ ($V_{ce} = 24\text{ V}$									

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)											外 形	備 考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB} (V)	直 流 及 脈 沖 下 之 h _{FE}		偏 置 情 況		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μS)	f _{αb} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)	
2SC1064	協 同	SW	Si.EP	60	5	1 A	800	175	0.5	40	45	1	500									84A		
" 1065	"	"	"	90	5	1 A	800	175	0.5	40	40	3	500						400 *				84B	
" 1066	富士通	RF	"	20	3	25	200	175	0.1	12				6	-2	120			800 *	1.4	80 *		46C	
" 1067	"	"	"	35	3	50	180	175	0.5	12	60	6	1	6	-2				500 *	1	30 *		205C	
" 1068	"	"	"	25	3	150	600	175	0.5	20	100	10	40	10	-40				2000 *	2	40 *		84B	
" 1069	"	SW	"	100	6	1 A	800	175	0.5	70	40	3	500	10	-10	t _{on} < 60nS, t _{off} < 100nS t _{sig} < 90nS				400 *	< 9		84B	
" 1070	日 電	RF	"	30	4	20	150	150	0.1	25	100	10	3	10	-3				900 *	0.5	C _e r _{AB} , 3pS		210	
" 1071	富士通、 日電、日立	SW	"	30	5	200	300	175	0.2	20	80	1	30			t _{on} < 45nS, t _{off} < 42nS t _{sig} < 27nS							49C	
" 1072	"	"	"	60	5	700	800	175	0.3	40	50	1	500			t _{on} < 40nS, t _{off} < 60nS t _{sig} < 50nS							123	
" 1072A	"	"	"	66	5	700	800	175	0.3	40	50	1	500			t _{on} < 40nS, t _{off} < 60nS t _{sig} < 50nS							123	
" 1073	松 下	PA	"	36	4	500	2 W (T _c = 25℃)	175	5	20	70	13.5	100			P _D = 1.8W (f = 500MHz, V _{CE} = 13.5V, P _i = 0.4W)							142	
" 1074	"	"	"	36	4	1 A	10W (T _c = 25℃)	175	5	20	50	13.5	200			P _D = 4 W (f = 500MHz, V _{CE} = 13.5V, P _i = 1.0W)							142	
" 1075	"	"	"	36	4	2 A	20W (T _c = 25℃)	175	10	20	60	13.5	400			P _D = 8 W (f = 500MHz, V _{CE} = 13.5V, P _i = 3 W)							142	
" 1076	"	"	"	36	4	3 A	30W (T _c = 25℃)	175	30	20	50	13.5	600			P _D = 15W (f = 500MHz, V _{CE} = 13.5V, P _i = 6 W)							142	
" 1077	東 芝	"	"	65	4	5 A	50W (T _c = 25℃)	175	10mA	20	>20	10	1 A	20	-200	P _D = 42W (f = 175MHz, V _{CE} = 28V, P _i = 1W)				150 *	45		141	
" 1078	"	"	Si.TMe	700	5	500	20W (T _c = 25℃)	150	10	500	70	15	150	15	-150				2 *	40	10		99	
" 1079	"	"	"	150	5	12 A	100W (T _c = 25℃)	150	100	50	40~140	5	2 A	5	-2A				4 *	350			102	
" 1080	"	"	"	110	5	12 A	100W (T _c = 25℃)	150	100	30	40~140	5	2 A	5	-2A				4 *	350			102	
★ " 1081	日 電	"	"	40	4	2.5 A	30W (T _c = 25℃)	175	1mA	30	70	10	1 A	10	-300	P _D = 14W (f = 500MHz, V _{CE} = 13.5V, P _i = 5.5W)				400 *			115	
" 1082	富士通	"	Si.EP	50	3.5	500	7 W (T _c = 25℃)	175	100	20	50	5	200			P _D = 3 W η = 55% (f = 700MHz, V _{CE} = 24V, P _i = 0.5W)							192 再登録	
" 1083	"	"	"	40	3.5	500	3 W (T _c = 25℃)	175	100	20	80	5	200	12	-100	P _D = 1.2W (f = 175MHz, V _{CE} = 12V, P _i = 0.1W)				1600 *	4		84B	
" 1084	"	RF.AF	"	35	4	50	250	175	0.5	12	300	6	1	6	-1		8000	1.7	7.8	300 *	2	50 *	55C	
" 1085	日 立	RF.LN	Si.DB	30	5	100	200	125	0.1	30	160	6	2	6	-1		4000	0.3	145	230 *	1.8	100 *	137	
★ " 1086	SON	PA.SW	Si.TMe	1000	14	4 A	125 W (T _c = 25℃)	120	2mA	800	12	3	2 A	10	-500				5 *	175	C _e r _{AB} , 450pS		102	
" 1087	"	"	"																					
★ " 1088	三 菱	PA	Si.TP	300	5	100	12.5 W (T _c = 25℃)	150	3	300	70	10	50	50	-20				40 *	5	C _e r _{AB} , 20pS		180	
★ " 1089	"	"	"	300	5	100	12.5 W (T _c = 25℃)	150	3	300	70	10	50	50	-20				50 *	3	C _e r _{AB} , 20pS		180	
" 1090	日 電	RF	Si.EP	20	3	50	300	200	0.5	10	80	1	30	3	-15				3000 *	0.9	30 *		130	
" 1091																								
" 1092																								
2SC1093																								
" 1094																								
" 1095																								
" 1096	日 電	PA	Si.E	40	5	2 A	10W (T _c = 25℃)	150	100	30	80	5	1 A	5	-150				60 *				167 2SA434 之對應	
" 1097																								
" 1098	日 電	PA	Si.E	70	5	1 A	10W (T _c = 25℃)	150	100	40	80	5	500	5	-150				40 *				167 2SA636 之對應	
★ " 1099	日 電	SW	Si.TMe	1200	7	4.5 A	50W (T _c = 25℃)	150	1mA	1000	25	15	3 A			t _r < 2.5μS, t _f < 1μS, t _{sig} < 1.5μS							102	
★ " 1100	"	"	"	1100	7	4.5 A	50W (T _c = 25℃)	150	1mA	1000	25	15	3 A			t _r < 2.5μS, t _f < 1μS, t _{sig} < 1.5μS							102	
" 1101	"	"	"	1100	5	1.5 A	50W (T _c = 25℃)	150	1mA	1000	60	15	500			t _r < 10μS, t _f < 2μS, t _{sig} < 2μS							102	
★ " 1102	"	PA.SW	"	300	7	100	11W (T _c = 25℃)	150	100	300	90	10	10	30	-10				80 *	3.5	10		134	
★ " 1103	"	PA	Si.TP	250	7	100	800	150	100	250	80	10	10	30	-10				80 *	4.5	30		84B 再登録	
" 1104	"	SW	"	300	5	1.5 A	20W (T _c = 25℃)	150	100	200	80	10	400			t _r < 2.5μS, t _f < 2μS, t _{sig} < 1.5μS							134	
★ " 1105	"	PA	"	300	5	100	15W (T _c = 25℃)	150	100	200	80	10	50	50	-20				20 *	5	30		134	
" 1106	"	SW	"	350	5	3 A	80W (T _c = 25℃)	150	1mA	200	90	15	500			t _r < 3μS, t _f < 3μS, t _{sig} < 2μS							102	
" 1107	SAK	PA	Si.TMe	80	4	A	25W (T _c = 25℃)	150	100	80	120	4	1 A	10	-200				10 *	25	26 *		211	
" 1108	"	"	"	100	4	A	25W (T _c = 25℃)	150	100	100	120	4	1 A	10	-200				10 *	25	26 *		211	
" 1109	"	"	"	80	4	A	25W (T _c = 25℃)	150	100	80	120	4	1 A	10	-200				10 *	25	26 *		212	
" 1110	"	"	"	100	4	A	25W (T _c = 25℃)	150	100	100	120	4	1 A	10	-200				10 *	25	26 *		212	
" 1111	"	"	"	140	6	6 A	50W (T _c = 25℃)	150	1mA	140	60	4	3 A	12	-500				10 *	115	12 *		102	
" 1112	"	"	"	160	6	6 A	50W (T _c = 25℃)	150	1mA	160	60	4	3 A	12	-500				10 *	115	12 *		102	
" 1113	"	PA.SW	"	120	10	6 A	40W (T _c = 25℃)	150	10	120	60	4	5 A	12	-500	t _r < 1.5μS, t _f < 1μS t _{sig} < 4μS				10 *			99 再登録	
" 1114	"	PA	"	300	7	4 A	100W (T _c = 25℃)	150	1mA	300	60	4	1 A	12	-100				10 *	50	26 *		102	
" 1115	"	"	"	140	6	10 A	100W (T _c = 25℃)	150	1mA	140	60	4	3 A	12	-500				10 *	165	13 *		102	
" 1116	"	"	"	180	6	10 A	100W (T _c = 25℃)	150	1mA	180	60	4	3 A	12	-500				10 *	165	13 *		102	
" 1117	日 立	RF	Si.P	20	3	20	150	150	1	15	150	10	2			G _{ps} = 13dB (11V, 2mA, f = 800MHz)				850 *	C _{re} 0.35		56C	
" 1118	日 電	"	Si.E	45	4	2 A	27W (T _c = 25℃)	175	2	30	50	10	1 A			P _D = 14.5 W (f = 500MHz, V _{CE} = 18V, P _i = 5W)							184	
" 1119	日 電	RF																						

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)															外 形	備 考
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大值		直 流 及 脈 沖 下 之 h _{FE}			偏 置 情 況		h _{FE} h _{FE} *	h _{FE} h _{FE} *	h _{FE} h _{FE} *	h _{FE} h _{FE} *	f _{αB} f _T *	C _{αB} f _T *	r _{αB} h _{FE} (real)* (Ω)			
									(μA)	V _{CE} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)	h _{FE} *								h _{FE} *	h _{FE} *	h _{FE} *
2SC1123	SON	Mix	Si.DB	35	3	100	300	100	0.2	15	70	3	1	10	-5	h _{FE} =15dB (f=100MHz)					2.1	C _{αB} 8 pS	208		
" 1124	"	PA	Si.PaMe	140	6	1 A	950	120	1	50	160	2	100	10	-10					120 *	6.5	C _{αB} 150 pS	174		
" 1125																									
" 1126	SON	RF. Osc	Si.DB	30	3	50	250	100	0.2	15	50	3	1	10	-8	h _{FE} =15dB (f=100MHz)					1.5	C _{αB} 16 pS	208		
" 1127	"	RF	Si.PaMe	180	8	100	950	120	1	100	60	5	3	10	-2					30 *	2.5	C _{αB} 80 pS	174		
" 1128	"	"	"	35	3	100	300	100	0.3	15	70	3	1	10	-10	h _{FE} =16dB (f=100MHz)					1.6	C _{αB} 7 pS	208		
" 1129	"	"	"	35	3	30	300	100	0.2	15	70	10	4	10	-4	h _{FE} =12dB (f=100MHz)					1	C _{αB} 12 pS	208		
" 1130	ORG	PA. SW	SiT	800	6	3.5A	80W (T _a =25°C)	150	2mA	800	15	5	2 A	10	-1A	t _{on} <1μS, t _{off} <2μS				4 *	150	10	102		
" 1131	"	"	"	600	6	3.5A	80W (T _a =25°C)	150	2mA	600	15	5	2 A	10	-1A	t _{on} <1μS, t _{off} <2μS				4 *	150	10	102		
" 1132	"	"	"	1200	6	2.5A	30W (T _a =25°C)	125	1mA	1200	15	5	0.5A	10	-1A	t _{on} <1μS, t _{off} <1.2μS				3.5 *	110	10	102		
" 1133																									
" 1134																									
" 1135																									
" 1136	ORG	PA. SW	Si. T	200	6	30A	200W (T _a =25°C)	150	5mA	200	20	5	10A	10	-1A					9 *	650	5	154		
" 1137																									
" 1138	ORG	PA. SW	Si. T	800	6	30 A	200 W (T _a =25°C)	150	5mA	800	20	15	10 A	10	-1A					9 *	650	5	154		
" 1139	"	"	"	600	6	30 A	200 W (T _a =25°C)	150	5mA	600	20	5	10 A	10	-1A					9 *	650	5	154		
" 1140	"	"	"	800	6	15 A	150W (T _a =25°C)	150	3mA	800	15	5	7.5A	10	-1A	t _{on} <1.5μS, t _{off} <5μS				10 *	350	10	102		
" 1141	"	"	"	600	6	15 A	150W (T _a =25°C)	150	3mA	600	15	5	7.5A	10	-1A	t _{on} <1.5μS, t _{off} <5μS				10 *	350	10	102		
" 1142	"	"	"	800	6	10A	125W (T _a =25°C)	150	3mA	800	15	5	5 A	10	-1A	t _{on} <1.5μS, t _{off} <3μS				4 *	270	10	102		
" 1143	"	"	"	600	6	10A	125W (T _a =25°C)	150	3mA	600	15	5	5 A	10	-1A	t _{on} <1.5μS, t _{off} <3μS				4 *	270	10	102		
" 1144																									
" 1145																									
" 1146																									
" 1147																									
" 1148																									
" 1149																									
" 1150	富士通	SW	Si. EP	60	.5	1 A	800	175	0.5	50	50	1	500			t _{on} <35nS, t _{off} <55nS t _{sig} <50nS							123		
" 1151	三 菱	RF. PA	Si. EMe	900	5	1 A	50W (T _a =25°C)	125	200	500	60	10	150	15	-200					5 *	65	25	102		
" 1152	"	"	"	300	5	2.5A	50W (T _a =25°C)	125	200	300	60	10	500	15	-200					5 *	65	25	102		
2SC1153	三 菱	SW	Si. EMe	1200	6	2.5A	50W (T _a =25°C)	125	1mA	1200	20	10	2.5 A			t _r <1.5μS, t _{sig} <2μS, t _f <3μS							102		
" 1154	"	"	"	1200	6	3.5A	50W (T _a =25°C)	125	1mA	1200	20	10	3.5 A										102		
" 1155	"	SW. PA	Si. EP	70	5	800	7 W (T _a =25°C)	150	10	25	100	4	300			t _{on} <0.2μS, t _{sig} <1μS, t _{off} <1.2μS							132		
" 1156	"	"	"	90	5	800	7 W (T _a =25°C)	150	10	25	100	4	300										132		
" 1157	"	"	"	110	5	800	7 W (T _a =25°C)	150	10	25	100	4	300										132		
" 1158	日 電	Osc	"	35	4	20	150	150	1	15	80	10	5	10	-5					1100 *	0.8	C _{αB} 6 pS	139		
" 1159	"	"	"	35	4	20	150	150	1	15	80	10	5	10	-5					1100 *	0.8	C _{αB} 6 pS	139		
" 1160	"	PA	"	200	6	1 A	15W (T _a =25°C)	150	5	200	80	5	200	10	-200					20 *	30	40 *	134		
" 1161	"	"	"	200	6	1 A	15W (T _a =25°C)	150	5	200	80	5	200	10	-200					20 *	30	40 *	134		
" 1162	日 立	RF. PA	"	35	5	1.5A	10W (T _a =25°C)	150	20	35	130	2	500	2	-200					180 *	30	9.5 *	160		
" 1163	松 下	PA	Si. P	300	3	100	20.8W (T _a =25°C)	150	100	300	70	10	50	10	-20					55 *	8	30	133		
" 1164	東 芝	RF	Si. EP	40	3	300	600	150	0.3	20	25-90	10	50	20	-50					1400 *	2.2	10	85B		
" 1165	"	PA	"	40	4	500	700	175	1	15	>20	5	100	10	-50	P _a =1.0W, P _i =0.3W (f=470MHz, V _{CE} =12.6V)				600 *	6.5	25 *	84B		
" 1166	"	"	Si. EP	70	5	200	600	150	0.1	20	100	1	50	10	-10					120 *	6	10	131	2SA661 之對稱	
" 1167	"	"	Si. TMe	1200	5	1.5A	50W (T _a =25°C)	150	10	500	>10	10	500	15	-200					> 2			102		
" 1168	"	"	Si. TP	300	5	150	12.5W (T _a =25°C)	150	0.1	100	100	10	50	10	-30					100 *	5	10	99		
" 1169	"	RF. Conv	Si. EP	40	4	1 A	800	175	1	15	>20	5	100	10	-50	P _a >2.5W (f=175MHz, V _{CE} =13.5V, P _i =0.25W)				600 *	6.5	25	97B		
" 1170	"	PA	Si. TMe	1200	5	3.5A	50W (T _a =25°C)	150	10	500	12	10	3 A	10	-0.5A					4 *	80	10	102		
" 1170A	"	"	"	1400	5	3.5A	50W (T _a =25°C)	150	10	500	12	10	3 A	10	-0.5A					4 *	80	10	102		
" 1171	"	"	"	1100	5	1 A	50W (T _a =25°C)	150	10	500	30-160	15	150	15	-200					>0.5	70	10	102		
" 1172	"	"	"	1500	5	5 A	50W (T _a =25°C)	150	10	500	20	10	2 A	10	-500					5 *	80	10	102		
" 1173	"	RF. PA	Si. EP	30	5	3 A	10W (T _a =25°C)	150	1	20	40-400	2	500	2	-500					100 *	35		119		
" 1174	日 立	PA	Si. TMe	1200	6	3.5A	50W (T _a =25°C)	150	IC _{RR} 1 mA	1200	8	10	3.5 A	15	-200	t _f <1.2μS				4 *	120	10	102		
" 1175	三 洋	RF	Si. TP	50	4	200	300	125	10	40	100	6	50	6	-10					170 *	5		138		
" 1176	三 菱	PA	Si. EP	40	4.5	1 A	15W (T _a =25°C)	175	100	15	50	10	100			P _a =7.5W, η=70% (f=175MHz, P _i =1.5W, V _{CE} =13.5V)							113		
" 1177	"	"	"	40	4.5	2.5A	25W (T _a =25°C)	175	1mA	15	30	10	100			P _a =16W, η=80% (f=175MHz, P _i =3.5W, V _{CE} =13.5V)							113		
" 1178																									
" 1179																									
" 1180																									

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)											外 形	備 考					
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CB0} 最大值		直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}		偏 置 情 况		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} *	h _{re} h _{rb} *	h _{oe} h _{ob} *	f _{αB} f _T *			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)			
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)												
2SC1181																										
* 1182																										
* 1183																										
* 1184	日 電	SW	Si.TMe	900	5	1 A	50W (T _c =25℃)	150	500	800	60	10	200										102			
* 1185	"	"	"	300	5	1.5 A	50W (T _c =25℃)	150	100	200	90	10	400										102			
* 1186																										
* 1187	日 電	RF	Si.P	40	4	25	250	125	0.1	20	90	10	3	10	-3				600*	1	C _c r _{bb} 12pS	138C	正向 AGC			
* 1188	"	"	Si.E	40	4	30	250	125	0.1	20	100	10	10	10	-10				850*	1.3	C _c r _{bb} 9pS	138C				
* 1189	"	"	"	50	4	30	250	125	0.1	20	100	10	10	10	-10				850*	1.3	C _c r _{bb} 9pS	138C				
* 1190	松 下	PA	Si.EP	36	4	2.5 A	30W (T _c =25℃)	175	100	20	50	13.5	400							600*	17		142			
* 1191	"	"	"	36	4	3.5 A	45W (T _c =25℃)	175	0.5mA	20	50	13.5	800								50		143			
* 1192	"	"	"	36	4	5 A	60W (T _c =25℃)	175	1mA	20	60	13.5	1 A								350*	100	143			
* 1193	東 芝	LN	"	20	2	30	200	175	0.1	10	70	10	10	10	-10						4500*	0.8	20*	140		
* 1194																										
* 1195	東 芝	RF.PA	Si.TMe	200	5	2.5 A	100W (T _c =25℃)	150	10	200	50	5	1 A	10	-100					10*	80	25	102			
* 1196	"	PA	Si.EP	60	4.5	750	10W (T _c =25℃)	175	5	15	50	10	1 A	10	-150					800*	5		135 再登録			
* 1197	"	"	"	60	4.5	2 A	30W (T _c =25℃)	175	10	15	55	10	1 A	10	-150					700*	<25		135 再登録			
* 1198	"	"	"	45	4	3.5 A	30W (T _c =25℃)	175	50	15	>20	10	1 A	10	-150					800*	30		213			
* 1199	"	RF.LN	"	50	3	300	600	150	0.1	20	80	10	20	10	-20					NF = 2.5dB (10V, 10mA, 200MHz)	1400*	2.2	C _c r _{bb} 5pS	85B		
* 1200	"	PA	"	40	3.5	180	2.5W (T _c =25℃)	175	1	20	120	5	100	5	-100					P _o = 1.05W (f = 2GHz, P _i = 0.4W, V _{ce} = 18V)	1700*	2.3		136		
* 1201																										
* 1202																										
* 1203																										
* 1204	日 立	RF.AF	Si.EP	30		100	310	125	0.5	18	250	12	2	12	-0.1	130	16.5k	0.7	11	230*	1.8	60*	207			
* 1205	"	RF.Mix Conv. Osc	Si.P	30		100	310	125	0.5	18	120	12	2	12	-2					230*	1.5	C _c r _{bb} 15pS	37			
* 1206	三 菱	RF.PA	Si.EP	45	4.5	1.7 A	25W (T _c =25℃)	175	1mA	30	50	25	50										209			
* 1207	"	"	"	45	4.5	3 A	30W (T _c =25℃)	175	2mA	30	50	25	50										209			
* 1208	"	"	"	36	5	10 A	60W (T _c =25℃)	175	2mA	15	50	10	500										127			
* 1209	"	"	"	25	4	700	500	125	1	25	100	1	500	6	-10					150*	15	C _c r _{bb} 100pS	138B 2SA695 之對稱			
* 1210	"	"	"	45	4	500	500	125	1	25	100	2	150	6	-10					150*	10	C _c r _{bb} 100pS	138B 2SA696 之對稱			
2SC1211	三 菱	RF.PA	Si.EP	65	4	500	500	125	1	25	100	2	150	6	-10					150*	10	C _c r _{bb} 100pS	138B 2SA697 之對稱			
* 1212	日 立	RF	"	50	4	1 A	750	150	5	50	180	4	50	4	-30					160*	30	4*	160 再登録			
* 1213	"	"	"	35	4	500	400	125	0.5	20	180	3	10	6	-1					50*	5	9*	170 2SA673 之對稱			
* 1214	"	"	"	50	4	500	600	125	0.5	20	180	3	10	6	-1					50*	5	9*	170			
* 1215	松 下	"	"	30	3	50	200	125	100	30	100	10	2	10	-10					1200*	C _c r _{bb} 1pF	30	138			
* 1216	日 電	SW	Si.E	40	5	200	300	150	0.1	30	140	1	10	10	-10					t _{on} < 20nS, t _{off} < 40nS t _{sig} < 20nS	500*	3		49C		
* 1217	"	RF.SW	"	150	5	300	750	175	0.1	100	70	10	50	10	-50					250*	3.7	13*	84B			
* 1218	"	"	"	80	5	500	750	175	0.1	50	80	10	50	10	-50					370*	3.5	20*	84B			
* 1219	富士通	RF	Si.EP	30	5	500	200	125	1	12	160	2	100	6	-1					60*	12	70*	138			
* 1220	"																									
* 1221																										
* 1222	日 電	RF.LN	Si.E	50	5	30	250	125	0.1	40	400	3	0.5	3	-1					14k	5.8	23	100*	3.5	50	138 2SA640 之對稱
* 1223	三 菱	PA	Si.EP	30	4	500	800	175	50	15	70	15	30							G _{pe} = 13.3dB(f = 220MHz, I _C = 30mA, V _{ce} = 13.5V)			84B 再登録			
* 1224	"	SW.PA	"	130	5	800	7 W (T _c =25℃)	150	10	25	100	4	300							t _{on} < 0.2μS, t _{off} < 1.2μS t _{sig} < 1μS				132		
* 1225																										
* 1226	松 下	PA	Si.EP	40	5	2 A	10W (T _c =25℃)	150	-1	20	120	5	1 A	5	-500					150*	50	3.3*	161 2SA699 之對稱			
* 1227	富士通	SW	Si.TMe	300	5	10 A	100 W (T _c =25℃)	175	20	150	50	5	5 A	5	-1A					t _{on} < 1μS, t _{off} < 1.5μS t _{sig} < 4μS	27*			102		
* 1228	"	"	"	500	5	10 A	100 W (T _c =25℃)	175	20	150	15	5	5 A	5	-1A					t _{on} < 2.5μS, t _{off} < 2.5μS t _{sig} < 4μS	15*			102		
* 1229	"	"	"	250	5	10 A	100 W (T _c =25℃)	175	100	150	50	5	5 A	5	-1A					t _{on} < 1μS, t _{off} < 1.5μS t _{sig} < 4μS	27*			102		
* 1230	"	"	"	450	5	10 A	100 W (T _c =25℃)	175	100	150	15	5	5 A	5	-1A					t _{on} < 2.5μS, t _{off} < 2.5μS t _{sig} < 4μS	15*			102		
* 1231	"	"	Si.EP	20	4	200	300	175	0.4	15	60	1	10	10	-10					t _i < 10nS, t _f < 15nS t _{sig} < 15nS	800*	2		49C		
* 1232	"	PA	"	45	3.5	1 A	12W (T _c =25℃)	175	500	20	50	5	500							P _o = 6 W (f = 700MHz, V _{ce} = 18V, P _i = 2 W)				133		
* 1233	"	"	"	45	3.5	2 A	20W (T _c =25℃)	175	1mA	20	50	5	1 A							P _o = 11W (f = 700MHz, V _{ce} = 18V, P _i = 4 W)				133		
* 1234																										
* 1235																										
* 1236	東 芝	LN	Si.EP	20	2	30	200	175	0.1	10	70	10	10	10	-10					NF = 5.0dB (10V, 5mA, 4GHz)	PG = 7.0dB (10V, 10mA, 4GHz)	6500*	0.8	20*	140	
* 1237	"	PA	Si.EMe	85	4	2 A	10W (T _c =25℃)	150	10	20	40	5	500	5	-100					P _o = 3.5W (f = 27MHz, V _{ce} = 12V, P _i = 0.4W)	100*	30		119		
* 1238	三 菱	"	Si.EP	35	4	150	5 W (T _c =25℃)	175	50	25	50	15	40							PG = 11dB(f = 770MHz, I _C = 40mA, V _{ce} = 15V)				157		
* 1239	"	"	"	80	4.5	4 A	12.5W (T _c =25℃)	175	10	30	50	10	100							P _o = 3.4W(f = 27MHz, P _i = 0.4W, V _{ce} = 12V)				97B		
* 1240	"	RF	"	40	3	50	350	175	0.1	25	70	10	10	10	-10					600*	1.5	C _c r _{bb} 5pS	138B			

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)														外 形	備 考		
				V _{CEO} (V)	V _{CEO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CBO} 最大値		直 流 及 脈 沖 下 之 h _{FE}				偏 置 情 況		h _{FE}	h _{FE} (Ω)	h _{FE} (×10 ⁻⁴)	h _{FE} (μA)	f _{ab} (Mc)	C _{ob} (pF)			r _{bb} (Ω)	r _{bb} (Ω)
									I _{CBO} (μA)	V _{CE} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)												
2SC1241	東 芝	PA	Si.EP	40	4	1.5A	10W (T _a =25°C)	175	100	15	>10	5	500	10	-250	P _{CE} > 6W (f=175MHz, V _{CE} =13.5V, P _I =1W)	400*	18	7*	135						
" 1242	"	"	"	40	4	3A	20W (T _a =25°C)	175	250	15	>10	5	800	10	-500	P _{CE} = 14W (f=175MHz, V _{CE} =13.5V, P _I =2.5W)	350*	40	5*	135					2SA703 之對稱	
" 1243	三 菱	SW. PA	"	25	5	1.5A	7W (T _a =25°C)	150	1	16	100	4	500			t _{on} < 0.2μs, t _{off} < 1.2μs t _{avg} < 1μs										
" 1244	"	"	"																							
" 1245	"	"	"																							
* " 1246	富士通	RF	Si.EP	30	5	500	400	175	1	12	160	2	100	6	-1		60*	12	70*	138						
" 1247	"	"	"	50	5	500	400	175	1	12	160	2	100	6	-1		60*	12	70*	138						
" 1248	日 電	LN	Si.E	20	3	30	300	150	0.1	10	100	10	7	10	-7	NF=2dB (f=60MHz, 10V, 7mA)	2500*	1.2		145						
" 1249	"	RF	"	45	3	300	300	150	1	25	80	15	65	15	-65	K _{FE} > 53dB, K _{FI} > 85dB (15V, 65mA, 60kHz, P _o =0dB)	1700*	3		146						
" 1250	"	"	"	45	3	300	300	150	1	25	80	15	65	15	-65	K _{FE} > 70dB, K _{FI} > 100dB (15V, 65mA, 60kHz, P _o =0dB)	1900*	3		146						
" 1251	"	"	"	45	3	300	300	200	0.1	30	80	10	50	15	-50	G _p = 15dB (f=500MHz)	2200*	NF=3.5dB (f=200MHz)		202						
" 1252	"	"	"	45	3	300	800	200	0.5	20	80	15	50	15	-70	G _p = 17dB (f=200MHz)	1700*	NF=3.4dB (f=200MHz)		84B						
" 1253	"	"	"	45	3	300	800	200	0.5	20	80	15	50	15	-50	G _p = 18dB (f=200MHz)	2000*	NF=3.4dB (f=200MHz)		84B						
" 1254	"	"	"	45	4	30	250	200	0.1	30	100	6	6	6	-6	G _p = 22dB (f=200MHz)	1000*	NF=3.4dB (f=200MHz)		50C						
" 1255	"	"	"	30	3	100	3.5W (T _a =25°C)	200	0.1	20	100	10	50	15	-50	G _p = 10dB (f=2GHz)					202					
" 1256	"	PA	"	36	4	800	5.5W (T _a =25°C)	200	10	20	50	10	300			P _{CE} = 3W (f=175MHz, V _{CE} =12V, P _I =0.3W)					84B					
" 1257	"	"	"	36	4	1.5A	14W (T _a =25°C)	200	20	20	50	10	800			P _{CE} = 8W (f=175MHz, V _{CE} =12V, P _I =1W)					184					
" 1258	"	"	"	36	4	3A	28W (T _a =25°C)	200	50	20	50	10	1.5A			P _{CE} = 14W (f=175MHz, V _{CE} =12V, P _I =3W)					184					
" 1259	"	"	"	36	4	6A	58.3W (T _a =25°C)	200	1mA	20	50	10	3A			P _{CE} = 30W (f=175MHz, V _{CE} =12V, P _I =10W)					203					
" 1260	"	RF	"	45	4	30	250	200	0.1	30	100	6	6	6	-6	G _p = 14dB (f=500MHz)	2000*	NF=3.4dB (f=500MHz)		50C						
" 1261	富士通	LN	Si.EP	20	3	20	300	150	0.1	10	100	10	7	10	-7	NF=2dB (f=60MHz, 10V, 7mA)	2500*	1.2		147						
" 1262	"	RF	"	45	3	300	300	150	1	25	80	15	65	15	-65	K _{FE} > 70dB, K _{FI} > 100dB (15V, 65mA, 60kHz, P _o =0dB)	1700*	3		148						
" 1263	"	"	"	45	3	300	300	150	1	25	80	15	65	15	-65	K _{FE} > 70dB, K _{FI} > 100dB (15V, 65mA, 60kHz, P _o =0dB)	1900*	3		148						
" 1264	"	"	"	30	3	100	400	150	0.5	25	100	10	40	10	-40		2000*	2.3	25*	147						
" 1265	日 電	Diff	Si.E	20	3	50	300	175	0.5	10	100	5	1	5	-15	h _{FE} /h _{FE} =0.8-1.0, ΔV _{BE} <8mV (V _{CE} =5V, I _C =1mA)	3000*	1.5	30*	189	再登録					
" 1266	"	SW	"	100	5.5	1.5A	2W	175	25	80	60	1	400	1	-100	t _{on} < 63ns, t _{off} < 210ns t _{avg} < 19ns	150*	30		83						
" 1267	"	RF	"	45	3	300	7W (T _a =25°C)	200	0.1	30	80	15	50	15	-50	G _p = 15dB (f=200MHz)					202					
" 1268	"	"	"	20	3	30	200	200	0.01	8	100	8	10	8	-10	G _{pe} = 7dB (f=4GHz)	6500*	NF=5.5dB (f=4GHz)		190						
" 1269	"	"	"	20	3	30	200	200	0.01	8	100	8	10	8	-10	G _{pe} = 6.5dB (f=4GHz)	6500*	NF=6.4dB (f=4GHz)		190						
" 1270	"	"	"	20	3	30	200	200	0.01	8	100	8	10	8	-10	G _{pe} = 7dB (f=4GHz)	6500*	NF=6.5dB (f=4GHz)		190						
2SC1271	日 電	RF	Si.E	20	3	30	200	200	0.01	8	100	8	10	8	-10	G _{pe} = 6.5dB (f=4GHz)		NF=6.4dB (f=4GHz)		190						
" 1272	"	"	"	20	3	30	200	200	50nA	15	80	10	40	10	-60	G _{pe} = 4dB (f=4GHz)					190					
" 1273	"	"	"	20	3	100	1W (T _a =25°C)	175	50nA	15	80	10	40	10	-60	G _{pe} = 4dB (f=4GHz)					190					
" 1274	"	SW	"	40	5	300	300	175	0.25	20	70	1	30	8	-10	t _{on} < 80ns, t _{off} < 86ns t _{avg} < 65ns	350*	2.5		49C						
" 1275	"	RF	"	30	3	50	250	200	50nA	15	80	10	10	10	-10	G _p < 15dB, NF=3dB (f=500MHz, 3mA)	2000*	1.1		50C						
" 1276	"	RF. SW	"	40	5	100	200	125	0.1	30	120	1	10	10	-10	t _{on} < 80ns, t _{off} < 40ns t _{avg} < 20ns	600*	3	60*	138						
" 1277	"	RF	"	60	5	500	250	125	0.5	30	140	2	100	10	-20		60*	20	30*	138						
" 1278	"	RF. SW	"	150	5	50	250	125	0.1	100	130	3	15	10	-10		150*	4.5	15	138						
" 1279	"	"	"	180	5	50	250	125	0.1	100	130	3	15	10	-10		150*	4.5	15	138						
" 1280	"	RF	シリコン Si.E	15	10	300	250	125	0.1	10	20,000	5	100	10	-10		180*	5	220*	138						
" 1281	沖	"	Si.P	20	5	20	300	175	0.1	15	200	1	10μA	5	-1		120*	2	60*	49C						
" 1282	"	"	"	70	5	20	300	175	0.1	15	73	1	2	5	-1		120*	2	60*	49C						
" 1283	"	"	"	110	5	20	300	175	0.1	15	73	1	2	5	-1		120*	2	60*	49C						
" 1284	"	"	"																							
" 1285	三 洋	RF. AF	Si.EP	40	5	100	200	125	1	35	200	6	1	6	-1	180 2000 0.8 12	140*	3	C _{ob} 200pS	138						
" 1286	"	"	"																							
" 1287	"	"	"																							
" 1288	沖	RF. SW	Si.EP	7	3	60	200	175	0.5	6	50	1	20	4	-20	t _d < 600pS, t _r < 850pS t _{sig} < 650pS	4500*	1	50*	144						
" 1289	"	"	"																							
" 1290	沖	PA	Si.EP	40	3	200	750	175	0.5	20	70	10	100	10	-50		1500*	2	35*	84B						
" 1291	"	"	"																							
" 1292	三 菱	PA. SW	Si.Eme	300	5	2.5A	80W (T _a =25°C)	150	200	300	25	10	500			t _r < 1.5μs, t _f < 3μs, t _{sig} < 2μs					102					
" 1293	"	"	"																							
" 1294	"	"	"																							
" 1295	"	"	"																							

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)					電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)												外 形	備 考	
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^{\circ}\text{C}$)	I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB} (V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE} (V)	I_C (mA)	V_{CB} (V)	I_E (mA)	h_{fe} $h_{f\beta}$ *	h_{ie} * (Ω)	h_{re} * ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} * (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T * (Mc)			C_{ob} (pF)
2SC1301	富士通	SW	Si.TMe	250	5	30 A	200 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	200	150	40	5	10 A	5	-2A	$t_{on}<2.5\mu\text{S}$, $t_{sig}<4\mu\text{S}$			25 *			191	
" 1302	"	"	"	400	5	30 A	200 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	200	150	25	5	15 A	5	-2A	$t_{on}<4\mu\text{S}$, $t_{sig}<4\mu\text{S}$			20 *			191	
" 1303	松下	PA	Si.EP	40	4	300	600 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	1	20	70	13.5	100	10	-30	$P_o=0.6\text{W}$ ($f=175\text{MHz}$, $V_{ce}=15\text{V}$, $P_i=0.05\text{W}$)			700 *	6.5	15	84	
" 1304	日立	"	Si.T	300	5	500	20 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	I_{CBO} 100	300	60	10	100	10	-50				7 *	16	20 *	153	
" 1305	"	"	"																				
" 1306	日電	PA	Si.E	65	4	3 A	12 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	10	40	80	10	500	10	-150	$P_o=5.5\text{W}$ ($f=50\text{MHz}$, $V_{ce}=12\text{V}$, $P_i=0.5\text{W}$)			300 *	20		151	
" 1307	"	"	"	70	4	8 A	25 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	20	40	60	10	2 A	10	-500	$P_o=15\text{W}$ ($f=50\text{MHz}$, $V_{ce}=12\text{V}$, $P_i=3\text{W}$)			150 *	80		151	
" 1308	"	"	"																				
" 1309	三菱	SW	Si.Eme	1200	6	5 A	80 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	1mA	1200	20	10	5 A			$t_{on}<1.5\mu\text{S}$, $t_{sig}<2\mu\text{S}$						102	
" 1310	"	RF.AF.LN SW	Si.EP	30	4	100	100	125	0.1	25	250	6	1	6	-1	8500	0.6	40	150 *	2.5	$C_{ex}f_{AB}$ 200 pS	175	
" 1311	"	RF.AF.SW	"	30	4	100	100	125	0.1	25	250	6	1	6	-1	8500	0.6	40	150 *	2.5	$C_{ex}f_{AB}$ 200 pS	175	
" 1312	"	RF.AF.LN	"	35	4	100	200	125	0.1	35	500	6	1	6	-1	19k	1.3	22	150 *	2.5	$C_{ex}f_{AB}$ 230 pS	138B	
" 1313	"	"	"	50	4	100	200	125	0.1	50	350	6	1	6	-1	19k	1.3	22	180 *	2	$C_{ex}f_{AB}$ 230 pS	138B	
" 1314	"	PA	"	40	4.5	5 A	45 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	2mA	15	30	10	200			$P_o=34\text{W}$ ($f=175\text{MHz}$, $V_{ce}=13.5\text{V}$, $P_i=9\text{W}$)						127	
" 1315	"	"	"	35	4.5	500	4 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	50	15	50	10	100			$P_o=0.5\text{W}$ ($f=150\text{MHz}$, $V_{ce}=13.5\text{V}$, $P_i=0.2\text{W}$)						84B	
" 1316	SON	PA.SW	Si.TMe	750	10	2 A	23 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	120	50	50	8	3	2 A	10	-200				8.5 *	120	$C_{ex}f_{AB}$ 410 pS	100	
" 1317	松下	PA	Si.EP	30	5	500	400	125	0.1	20	160	10	150	10	-50				200 *	6	3.5 *	138	2SA719 之對稱
" 1318	"	"	"	60	5	500	400	125	0.1	20	160	10	150	10	-50				200 *	6	3.5 *	138	2SA720 之對稱
" 1319	日電	RF	Si.P	40	4	25	250	125	0.1	20	90	10	3	10	-3				600 *	1.2	$C_{ex}f_{AB}$ 12 pS	138	正向 AGC
" 1320	"	"	Si.E	50	4	30	250	125	0.1	20	100	10	10	10	-10				850 *	1.4	$C_{ex}f_{AB}$ 9 pS	138	
" 1321	"	RF.Conv. Mix.Osc	"	30	4	10	100	125	0.1	25	90	6	2	6	-2				1000 *	0.7	$C_{ex}f_{AB}$ 3 pS	176	
" 1322	富士通	SW	Si.TMe	250	5	4 A	100 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	100	150	50	5	5 A	5	-1A	$t_{on}<1\mu\text{S}$, $t_{sig}<4\mu\text{S}$				27 *		102	
" 1323	三菱	PA	Si.EP	30	4	500	5 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	50	15	70	15	30			$PG=14.2\text{dB}$ ($f=220\text{MHz}$, $I_C=30\text{mA}$, $V_{ce}=13.5\text{V}$)						125	
" 1324	"	"	"	35	4	150	800	175	50	25	70	10	30			$P_o=10\text{W}$ ($f=770\text{MHz}$, $I_C=30\text{mA}$, $V_{ce}=15\text{V}$)						85B	
" 1325	日電	SW	Si.TMe	1500	6	6 A	80 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	20	1000	19	15	1 A			$t_{on}<2.5\mu\text{S}$, $t_{sig}<1\mu\text{S}$, $t_{sig}<1.5\mu\text{S}$						102	
" 1326	松下	"	"																				
" 1327	"	RF.LN	Si.EP	35	5	50	150	125	0.1	10	540	5	2	5	-2	5500	0.4	25	250 *	2.2	70	138	
" 1328	"	"	"	55	5	50	150	125	0.1	10	540	5	2	5	-2	5500	0.4	25	250 *	2.2	70	138	
" 1329	日電	RF	"	50	5	8 A	60 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	200	2mA	30	100	10	5 A			$P_o=32\text{W}$ ($f=70\text{MHz}$, $V_{ce}=12\text{V}$, $P_i=8\text{W}$)						203	
" 1330	"	RF.AF	Si.E	50	5	100	400	125	0.1	40	150	6	1	6	-1	4800	4.5	17	250 *	4.5	25 *	44	
2SC1331	日電	RF.Conv. Mix.Osc	Si.P	20	3	20	150	150	50nA	10	100	5	4	10	-4				750 *	C_{ex} 0.37	$C_{ex}f_{AB}$ 10 pS	50C	
" 1332	"	"	"																				
" 1333	日電	PA	Si.EP	45	3	1 A	8.3 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	100	30	60	10	300	10	-200	$G_{ps}=5\text{dB}$ ($f=1\text{GHz}$, $V_{ce}=18\text{V}$, $P_i=1\text{W}$)			1200 *	7		115	
" 1334	"	"	Si.E	45	3	1 A	11.6 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	200	100	30	60	10	300			$G_{ps}=4\text{dB}$ ($f=1\text{GHz}$, $V_{ce}=24\text{V}$, $P_i=2\text{W}$)						184	
" 1335	日立	LN	Si.EPa	30	5	100	200	125	0.5	18	500	12	2		$NF=3\text{dB}$ ($f=120\text{Hz}$, $I_C=0.1\text{mA}$)	110k	95	12	230 *	1.8	$C_{ex}f_{AB}$ 12 pS	37	
" 1336	日電	RF	"	20	3	25	250	200	0.5	10	100	10	10	10	-10	$G_{ps}=11\text{dB}$ ($f=2\text{GHz}$)			4500 *	$NF=3\text{dB}$ ($f=2\text{GHz}$)		190	
" 1337	三菱	PA	Si.EP	35	4.5	2 A	20 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	200	15	50	10	100			$P_o=8.5\text{W}$ ($f=485\text{MHz}$, $V_{ce}=13.5\text{V}$, $P_i=2\text{W}$)						183	
" 1338	"	"	"	35	4.5	3 A	30 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	500	15	50	10	100			$P_o=16\text{W}$ ($f=485\text{MHz}$, $V_{ce}=13.5\text{V}$, $P_i=6\text{W}$)						183	
" 1339	"	"	"	35	5	500	40 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	1mA	15	50	10	100			$P_o=28\text{W}$ ($f=485\text{MHz}$, $V_{ce}=13.5\text{V}$, $P_i=12\text{W}$)						183	
" 1340	"	"	"	35	4	1 A	5 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	100	25	70	10	100			$G_{ps}=19\text{dB}$ ($f=220\text{MHz}$, $V_{ce}=15\text{V}$, $I_C=100\text{mA}$)						157	
" 1341	"	"	"																				
" 1342	日立	RF.Conv. Mix.Osc	Si.P	30	4	30	100	125	0.5	10	100	6	1	6	-1				250 *	1.1	$C_{ex}f_{AB}$ 20 pS	37	
" 1343	"	RF.PA	Si.T	150	5	10 A	100 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	1mA	30	100	5	1 A	5	-1A				14 *	240	7 *	102	2SA753 之對稱
" 1344	"	RF.LN	Si.EPa	30	5	100	200	125	0.5	18	500	12	2		$NF=0.5\text{dB}$ ($f=1\text{kHz}$, $I_C=0.1\text{mA}$)	110k	9.5	12	230 *	1.8	$C_{ex}f_{AB}$ 12 pS	37	
" 1345	"	"	"	55	5	100	200	125	0.5	18	500	12	2		$NF=0.5\text{dB}$ ($f=1\text{kHz}$, $I_C=0.1\text{mA}$)	110k	9.5	12	230 *	1.8	$C_{ex}f_{AB}$ 12 pS	37	
" 1346	松下	PA	Si.EP	30	5	500	600	125	0.1	20	160	10	150	10	-50				200 *	6	3.5 *	171	
" 1347	"	"	"	60	5	500	600	125	0.1	20	160	10	150	10	-50				200 *	6	3.5 *	171	
" 1348	SON	SW	Si.TMe	1000		4 A	125 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	120	2mA	800	8	3	2 A	10	-2A				5 *	175	$C_{ex}f_{AB}$ 200 pS	102	
" 1349	"	"	"																				
" 1350	"	"	"																				
" 1351	"	"	"																				
" 1352	"	"	"																				
" 1353	"	"	"																				
" 1354	松下	PA	Si.EP	55	4	5 A	60 W (

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)												外 形	備 考			
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CBO} 最大値		直 流 及 脈 沖 下 之 h _{FE}				偏 置 情 況		h _{fe}								
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{FE} *	h _{FE} *	h _{FE} *	h _{FE} *	f _T *	f _T *	C _{ob}	τ _{amb}			
				(V)	(V)	(mA)	(mW)	(℃)	(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{FE} *	h _{FE} *	h _{FE} *	h _{FE} *	f _T *	f _T *	C _{ob}	τ _{amb}			
2SC1361	SON	LN		25	6	200	320	120	0.2	25		3	1									4.5	C _{tr} = 300pS		
" 1362	"	"	Si.PaMe	50	6	200	320	120	0.2	25		3	1									4.5	C _{tr} = 300pS		
" 1363	"	RF	Si.E	25	6	200	250	120	0.2	25	200	3	1	6	-2							4.5	C _{tr} = 300pS		
" 1364	"	"	Si.PaMe	50	6	200	320	120	0.2	25	200	3	1	6	-2							4.5	C _{tr} = 300pS		
" 1365	日 電	"	Si.E	45	3	300	800	200	0.5	20	80	15	50	15	-70							1700*	NF = 3dB (f = 200MHz)	84B	
" 1366	"	"	"	45	3	300	800	200	0.5	20	80	10	50	15	-50							2000*	NF = 3dB (f = 200MHz)	84B	
" 1367	日 立	PA	Si.TMe	1000	5	1A	50W (T _a = 25℃)	125	10	500	45	10	200	15	-200							6*	60	25	102
" 1368	"	RF.PA	Si.EP	25	5	1.5A	8W (T _a = 25℃)	150	20	25	130	2	500	2	-200							180*	30	9.5*	160
" 1369																									
" 1370																									
" 1371																									
" 1372	富士通	RF.SW	Si.EP	30	5	200	200	125	0.5	10	100	1	10	6	-2							250*	4	80*	138
" 1373	日 立	SW	"	25	4	100	300	175	1	20	90	4	35				t _{on} < 100nS, t _{off} < 325nS t _{sig} < 290nS							49C	
" 1374	"	"	"	25	4	100	300	175	0.25	20	70	1	70				t _r < 14nS, t _f < 12nS t _{sig} < 20nS							49C	
" 1375	"	"	"	25	4	100	300	175	0.2	5	80	0.4	50				t _{on} < 45nS, t _{off} < 60nS t _{sig} < 50nS							49C	
" 1376	"	"	"	40	4	150	300	175	1	20	70	1	150				t _{on} < 25nS, t _{off} < 60nS t _{sig} < 50nS							49C	
" 1377	東 芝	PA	"	90	4	6A	20W (T _a = 25℃)	150	10	60	>20	5	1A	5	-200		P _a > 8W (f = 20MHz, V _{CC} = 12V, P _i = 1W)			100*	60			119	
" 1378	"	"	"	40	4	4A	35W (T _a = 25℃)	175	100	15	>10	5	10A	10	-200		P _a = 25W (f = 175MHz, V _{CC} = 13.5V, P _i = 6W)			150*	65	2*		135	
" 1379	"	"	"	40	4	7A	70W (T _a = 25℃)	175	100	15	>10	5	1A	10	-200		P _a = 40W (f = 175MHz, V _{CC} = 13.5V, P _i = 12W)			150*	130	1*		193	
" 1380	"	RF	"	55	5	100	200	150	0.1	18	200	6	2	6	-1		15k	1.3	13	80*	6	100	49C		
" 1381	"	RF.PA	"	100	5	1A	800	150	1	30	70~240	2	150	2	-150						50*	20	10	164	
" 1382	"	"	"	80	5	750	800	150	0.5	30	120	2	150	2	-150						100*	15		164	
" 1383	松 下	PA	"	30	5	1A	750	135	0.1	20	160	10	500	10	-50						200*	11	3.5*	165	
" 1384	"	"	"	60	5	1A	750	135	0.1	20	160	10	500	10	-50						200*	11	3.5*	165	
" 1385	日 立	SW	"	60	5	500	800	175	0.5	30	80	1.1	300				t _{on} < 40nS, t _{off} < 60nS t _{sig} < 50nS							84B	
" 1386	"	"	"	70	5	700	800	175	100	60	80	1	60				t _{on} < 35nS, t _{off} < 55nS t _{sig} < 50nS							84B	
" 1387																									
" 1388																									
" 1389																									
" 1390																									
2SC1391	日 立	PA	Si.T	300	4	100	6.5W (T _a = 25℃)	150	100	300	60	10	50	50	-20							25*	5	20*	153
" 1392																									
" 1393	日 電	RF.LN	Si.E	30	5	20	250	125	0.1	20	100	10	2	10	-3		NF = 2dB (f = 200MHz)			700*	0.35	C _{tr} = 10pS	138C		
" 1394	"	RF.Conv. Mix. Osc	"	30	5	20	250	125	0.1	20	100	10	2	10	-3						700*	0.35	C _{tr} = 10pS	138C	
" 1395	"	"	Si.EP	30	5	20	250	125	0.1	12	100	10	5	10	-5						1100*	1.2	C _{tr} = 12pS	138	
" 1396	"	"	"	30	5	20	250	125	0.1	12	100	10	5	10	-5						1100*	1.2	C _{tr} = 12pS	138	
" 1397																									
" 1398	松 下	RF.PA	Si.EP	70	5	2A	15W (T _a = 25℃)	150	1	40	130	5	1A	5	-500						150*	50	3*	172	
" 1399																									
" 1400	日 電	LN	Si.EPa	85	5	50	300	125	0.1	60	500	6	1	6	-1		NF = 0.5dB (f = 1kHz)	15K	6	35	100*	2.5	50*	138	
" 1401	富士通	SW	Si.TMe	400	5	30A	200W (T _a = 25℃)	175	200	150	25	5	15A	5	-2A		t _{on} < 4μS, t _{off} < 2.5μS t _{sig} < 4μS			20*				191	
" 1402	SAK	PA	Si.TMe	140	6	8A	70W (T _a = 25℃)	150	1mA	140	60	4	3A	12	-500						10*	130	7*	102	
" 1403	"	"	"	160	6	8A	70W (T _a = 25℃)	150	1mA	160	60	4	3A	12	-500						10*	130	7*	102	
" 1404	松 下	"	Si.EP	36	4	3.5A	50W (T _a = 25℃)	200	25mA	36	30	5	1A	5	-1A		P _a = 18W (f = 470MHz, V _{CC} = 12.5V, P _i = 6.8W)			1000*	55			229	
" 1405	"	"	"	36	4	750	10W (T _a = 25℃)	175	50	20	40	10	100	10	-100		P _a = 3.5W, G _{av} = 10dB (f = 175MHz, V _{CC} = 13.5V, P _i = 0.35W)			350*	13			228	
" 1406	"	"	"	30	5	1A	1W	135	0.1	20	160	10	500	10	-50						200*	11	3.5*	173	
" 1407	"	"	"	60	5	1A	1W	135	0.1	20	160	10	500	10	-50						200*	11	3.5*	173	
" 1408																									
" 1409	日 立	PA	Si.TMe	200	6	2A	12.5W (T _a = 25℃)	150	1	30	100	10	50	10	-50						20*	95	20	158	
" 1410	"	"	"	200	6	2A	12.5W (T _a = 25℃)	150	1	30	100	10	50	10	-50						20*	95	20	159	
" 1411	富士通	SW	Si.EP (双方向)	6	6	50	200	150	0.1	5	100						t _r < 390nS, t _f < 500nS t _{sig} < 600nS				6			49C	
" 1412																									
" 1413	日 立	PA	Si.T	1200	6	5A	50W (T _a = 25℃)	150	10	500	10	10	3.5A	15	-200						4*	175	10	102	
" 1414	富士通	"	Si.EP	40	3.5	2A	20W (T _a = 25℃)	175	400	20	80	5	1A	12	-500		P _a = 10W (f = 700MHz, V _{CC} = 18V, P _i = 4W)			1500*	13			192	
" 1415	"	"	"	40	3.5	3A	25W (T _a = 25℃)	175	600	20	80	5	2A	12	-500		P _a = 16W (f = 700MHz, V _{CC} = 18V, P _i = 7.5W)			1200*	18			192	
" 1416	東 芝	RF	"	55	5	50	200	150	0.1	30	350	6	2	6	-1		NF = 2dB (f = 100Hz, V _{CE} = 6V, I _K = 0.1mA)			100*	3	45		195	
" 1417	日 立	RF.Conv. Mix. Osc	Si.P	20		30	100	125	1	10	100	6	1	6	-1						300*	1.4	C _{tr} = 24pS	37	
" 1418																									
" 1419																									
" 1420	富士通	RF	Si.EP	15	3	70	300	150	0.5	10	80	6	40	6	-40						6000*	1	25*	199	

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)												外 形	備 考
				V _{CE0} (V)	V _{BE0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CBO} 最大值 (μA)	V _{CB} (V)	直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}		偏 置 情 况		h _{FE} h _{FE} *	h _{FE} h _{FE} *	h _{FE} h _{FE} *	h _{FE} h _{FE} *	f _α f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)		
2SC1421	富士通	RF	Si.EP	15	3	30	250	150	0.5	10	80	6	10	6	-10	NF = 6 dB (f = 2GHz, I _C = 4mA)	5500*	0.7	25*	199		
" 1422	"	"	"	15	3	40	250	150	0.5	10	80	6	20	6	-20	"	5500*	0.8	25*	199		
" 1423	"	"	"	15	3	30	250	150	0.5	10	80	6	15	6	-15	NF = 3.5dB (f = 2GHz, I _C = 4mA)	7000*	0.7	25*	199		
" 1424	日 電	"	Si.E	30	3	50	250	200	50nA	15	80	10	10	10	-10	G _p = 15dB (f = 300MHz)	2000*	1.1		50C		
" 1425	"	PA	"	45	3	1A	11.6W (T _J = 25℃)	200	100	30	60	10	300			G _p = 5dB (f = 1GHz, V _{CE} = 18V, P _i = 1W)				184		
" 1426	"	RF	"	35	3	200	3.5W (T _J = 25℃)	200	0.1	20	100	10	50	10	-50	G _p = 20dB (f = 200MHz)	2500*	1		85B		
" 1427	"	RF, Conv. Mix. Osc.	"	30	4	10	100	125	0.1	25	120	6	2	6	-2		1000*	0.7	C _{r,ab} 3pS	176		
" 1428	"	"	"	50	5	50	150	125	0.1	15	110	3	0.5	6	-1		250*	1.5	C _{r,ab} 25pS	176		
" 1429	SON	PA	Si.E PaMe	12	6	2A	950	120	0.1	16	200	2	100	2	-10		80*	26	C _{r,ab} 300pS	174		
" 1430	"	RF.PA	Si.EMe	110		1.5A	500	150	100	50	100	2	400	2	-200		50*	50	C _{r,ab} 25pS	181		
" 1431	"	"	"	110		1.5A	1.5W	150	0.1	50	100	2	400	2	-200		50*	25	C _{r,ab} 25pS	99		
" 1432	新日無	SW	Si.EP	30	10	300	150	125	0.1	20	40,000	6	100			t _{on} < 600nS, t _{off} < 1.2μS t _{sig} < 600nS				194		
" 1433	東 芝	PA.SW	Si.TMe	600	5	5A	50W (T _J = 25℃)	150	100	500	20~300	5	1A			t _{on} < 2μS, t _f < 1.5μS t _{sig} < 10μS		100		102		
" 1434	"	"	"	600	5	15A	150W (T _J = 25℃)	150	500	500	30~300	5	3A			t _{on} < 2μS, t _f < 2.5μS t _{sig} < 15μS		200		102		
" 1435	"	"	"	600	5	40A	300W (T _J = 25℃)	150	1mA	500	30~300	5	10A			t _{on} < 11μS, t _f < 1.5μS t _{sig} < 10μS		600		196		
" 1436	SAK	SW	Si.T	230	6	15A	100W (T _J = 25℃)	150	1mA	230	20	4	5A	12	-500	t _r < 1.5μS, t _f < 1μS t _{sig} < 4μS, t _d < 0.5μS	10*			102		
" 1437	"	"	"	230	6	50A	200W (T _J = 25℃)	150	1mA	230	20	4	10A	12	-500	t _r < 1.5μS, t _f < 1μS t _{sig} < 4μS	10*			230		
" 1438																						
" 1439																						
" 1440	SAK	SW	Si.T	150	6	15A	100W (T _J = 25℃)	150	1mA	150	20	4	5A	12	-500	t _r < 1.5μS, t _f < 1μS t _{sig} < 4μS, t _d < 0.5μS	10*			102		
" 1441	"	"	"	200	6	15A	100W (T _J = 25℃)	150	1mA	200	20	4	5A	12	-500	t _r < 1.5μS, t _f < 1μS t _{sig} < 4μS, t _d < 0.5μS	10*			102		
" 1442	"	"	"	150	6	50A	200W (T _J = 25℃)	150	1mA	150	20	4	10A	12	-500	t _r < 1.5μS, t _f < 1μS t _{sig} < 4μS	10*			230		
" 1443	"	"	"	200	6	50A	200W (T _J = 25℃)	150	1mA	200	20	4	10A	12	-500	t _r < 1.5μS, t _f < 1μS t _{sig} < 4μS	10*			230		
" 1444	"	PA	"	80	6	6A	40W (T _J = 25℃)	150	1mA	80	80	4	1A	10	-500		10*	85	12*	99		
" 1445	"	"	"	100	6	6A	40W (T _J = 25℃)	150	1mA	100	80	4	1A	10	-500		10*	85	12*	99		
" 1446	松 下	"	Si.TP	300	5	100	10W (T _J = 25℃)	150	100	300	70	10	50	30	-20		55*	8	10	78		
" 1447	東 芝	RF.PA	"	300	5	100	20W (T _J = 25℃)	150	1	240	100	10	50	50	-20		50*	7	30	119		
" 1448	"	"	Si.TMe	150	5	1.5A	25W (T _J = 25℃)	150	20	100	75	10	500	10	-500		5*	50	25	119		
" 1449	日 電	PA	Si.E	40	5	2A	5W (T _J = 25℃)	150	0.5	35	90	2	300	5	-100		65*	20	40*	225		
" 1450	松 下	"	Si.Me	150	5	400	20W (T _J = 25℃)	150	30	60	70	5	100	10	100		15*	50	25	99		
2SC1451	富士通	RF	Si.EP	150	5	50	700	175	1	140	150	5	10	5	-10	t _{on} < 1μS, t _{off} < 10μS t _{sig} < 9.5μS	130*	2	70*	248		
" 1452	"	"	"	150	5	50	700	175	1	140	150	5	10	5	-10	t _{on} < 1μS, t _{off} < 10μS t _{sig} < 9.5μS	130*	2	70*	248		
" 1453	東 芝	"	"	55	5	100	200	150	0.1	30	120	1	10	10	-1		150*	5	20	195		
" 1454	SAK	PA	Si.T	300	7	4A	50W (T _J = 25℃)	150						12	-100		10*			102		
" 1455																						
" 1456	日 電	PA	Si.TP	300	7	200	15W (T _J = 25℃)	150	0.1	200	80	10	10	30	-10		80*	3.8	30	99		
" 1457	"	RF	Si.E	35	3	150	800	200	0.1	20	100	10	50	10	-50	NF = 2.5dB (f = 20MHz, V _{CE} = 10V, I _C = 20mA)	2700*	1	45*	85B		
" 1458	"	"	"	20	3	50	300	200	0.1	10	100	5	30	5	-15	S ₂₁ = 9dB (f = 1GHz)	3000*	0.9	30*	197		
" 1459	富士通	"	Si.EP	15	3	70	300	150	0.5	10	80	6	40	6	-40		5000*	1	25*	199		
" 1460	"	"	"	15	3	30	250	150	0.5	10	80	6	10	6	-10	NF = 6dB (f = 2GHz, V _{CE} = 6V, I _C = 4mA)	4500*	0.7	25*	199		
" 1461	"	"	"	15	3	40	250	150	0.5	10	80	6	20	6	-20	"	4500*	0.8	25*	199		
" 1462	"	"	"	15	3	30	250	150	0.5	10	80	6	15	6	-15	NF = 3.5dB (f = 2GHz, V _{CE} = 6V, I _C = 4mA)	6500*	0.7	25*	199		
" 1463	"	SW	Si.T	450	5	4A	75W (T _J = 25℃)	175	10	150	18	5	1A	6	-300	t _r < 5μS, t _f < 3μS t _{sig} < 5μS	25*	125	5*	102		
" 1464	"	PA	Si.EP	50	3.5	500	4W (T _J = 25℃)	175	250	20	80	5	200	12	-100	P _α = 1.2W (f = 175MHz, V _{CC} = 12V, P _i = 50mW)	1300*	3.5		84C		
" 1465	"	"	"	50	3.5	500	7W (T _J = 25℃)	175	250	20	80	5	200	12	-100	P _α = 1.8W, η = 55% (f = 0.7GHz, V _{CC} = 24V, P _i = 0.3W)	1600*	4.5		231		
" 1466	新電元	SW	Si.DB	450	4	3A	30W (T _J = 25℃)	150	5mA	450	16	5	1.5A	10	1A	t _{on} < 2μS, t _f < 2μS t _{sig} < 4μS	10*	60		204		
" 1467	"	"	"	500	4	3A	30W (T _J = 25℃)	150	5mA	500	12	5	1.5A	10	1A	"	10*	60		204		
" 1468	"	"	"	450	4	10A	100W (T _J = 25℃)	150	10mA	450	16	5	5A	10	1A	"	10*	300		118		
" 1469	"	"	"	500	4	10A	100W (T _J = 25℃)	150	10mA	500	12	5	5A	10	2A	"	10*	300		118		
" 1470	"	"	"	450	4	30A	200W (T _J = 25℃)	150	10mA	450	16	5	10A	10	2A	"	10*	700		191		
" 1471	"	"	"	500	4	30A	200W (T _J = 25℃)	150	10mA	500	12	5	10A	10	2A	"	10*	700		191		
" 1472	日 立	RF	Si.EP	40		300	500	125	0.1	30	10,000	5	10	5	-10		150*	3.5	220	170		
" 1473																						
" 1474	SON	RF.PA	Si.PaMe	16	6	2A	750	120	0.2	16	300	2	100	2	-10		60*	30	C _{r,ab} 600pS	259		
" 1475	"	"	"	100	6	1A	750	120	0.2	25	300	2	100	2	-10		80*	16	C _{r,ab} 300pS	259		
" 1476	東 芝	PA	Si.EP	38		5A	40W (T _J = 25℃)	175	1mA	15	50	5	1A			P _α = 28W (f = 470MHz, V _{CC} = 12.6V, P _i = 12W)				135		
" 1477	SAK	SW	Si.T	230	6	9A	80W (T _J = 25℃)	150	1mA	2												

型 名	社 名	用 途	構 造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)				電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)												外 形	備 考		
				V_{CB0} (V)	V_{EB0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW) ($T_c=25^\circ\text{C}$)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値 (μA)		直 流 及 脈 冲 下 之 h_{FE}		偏置情况		h_{fe} h_{fe}^*	h_{ie} h_{ie}^*	h_{re} h_{re}^*	h_{oe} h_{oe}^*	f_{β} f_{β}^*	C_{ob} (pF)	r_{ab} r_{ab}^*	r_{ab}/r_{be}	
2SC1481	富士通	PA	Si. EP	36	3.5	1 A	12W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	200	12	50	2	1 A	12	-200	$P_a = 5\text{ W}$, $\eta = 60\%$ ($f = 470\text{ MHz}$, $V_{CC} = 12.5\text{ V}$, $P_i = 1\text{ W}$)			1000*	10		246	
" 1482	"	"	"	36	3.5	2 A	20W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	500	12	50	2	2 A	12	-500	$P_a = 8.5\text{ W}$, $\eta = 70\%$ ($f = 470\text{ MHz}$, $V_{CC} = 12.5\text{ V}$, $P_i = 2\text{ W}$)			800*	18		246	
" 1483	"	LN	"	20	3	40	300 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	0.1	10	100	6	10	6	-10	$NF = 2\text{ dB}$ ($f = 100\text{ MHz}$, $V_{CB} = 6\text{ V}$, $I_C = 5\text{ mA}$)			3000*	0.9	25*	214	
" 1484	"	RF	"	45	3	300	5 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1	25	80	15	65	15	-65				2000*	2.8	25*	215	
" 1485	"	SW	Si. T	250	6	125	350 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	1	30	90	4	10		$t_r < 2\text{ }\mu\text{S}$, $t_f < 2.5\text{ }\mu\text{S}$ $t_{sig} < 6\text{ }\mu\text{S}$							49C	
" 1486	ALP	PA	Si. EP	36	4	400	5 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	1mA	15	80	5	100		$G_{ps} = 10\text{ dB}$, $\eta > 60\%$ ($f = 470\text{ MHz}$, $V_{CC} = 12.5\text{ V}$, $I_C = 0.24\text{ A}$)				11			216 2N5944	
" 1487	"	"	"	36	4	800	15W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	1mA	15	80	5	200		$G_{ps} = 9\text{ dB}$, $\eta > 60\%$ ($f = 470\text{ MHz}$, $V_{CC} = 12.5\text{ V}$, $I_C = 0.5\text{ A}$)				18			216 2N5945	
" 1488	"	"	"	36	4	2 A	37.5W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	2mA	15	80	5	500		$G_{ps} = 7\text{ dB}$, $\eta > 60\%$ ($f = 470\text{ MHz}$, $V_{CC} = 12.5\text{ V}$, $I_C = 1.3\text{ A}$)				38			216 2N5946	
" 1489	"	"	"	36	4	6 A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	2.5mA	15	80	5	1 A		$G_{ps} = 4.3\text{ dB}$, $\eta > 65\%$ ($f = 470\text{ MHz}$, $V_{CC} = 12.5\text{ V}$, $P_i = 10\text{ W}$)				55			217 2N6136	
" 1490	"	"	"	36	4	1 A	12W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	250	15	80	5	250		$G_{ps} = 13\text{ dB}$, $\eta > 50\%$ ($f = 175\text{ MHz}$, $V_{CC} = 12.5\text{ V}$, $P_i = 0.25\text{ W}$)				15			217 2N6080	
" 1491	"	"	"	36	4	2.5 A	31W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	500	15	50	5	500		$G_{ps} = 7\text{ dB}$, $\eta > 60\%$ ($f = 175\text{ MHz}$, $V_{CC} = 12.5\text{ V}$, $P_i = 3.6\text{ W}$)				70			217 2N6081	
" 1492	"	"	"	36	4	4 A	65W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	1mA	15	50	5	1 A		$G_{ps} = 7\text{ dB}$, $\eta > 65\%$ ($f = 175\text{ MHz}$, $V_{CC} = 12.5\text{ V}$, $P_i = 6\text{ W}$)				110			217 2N6082	
" 1493	"	"	"	36	4	4 A	65W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	1mA	15	50	5	1 A		$G_{ps} = 6.5\text{ dB}$, $\eta > 65\%$ ($f = 175\text{ MHz}$, $V_{CC} = 12.5\text{ V}$, $P_i = 8.1\text{ W}$)				110			217 2N6083	
" 1494	"	"	"	36	4	6 A	80W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	2.5mA	15	40	5	1 A		$G_{ps} = 5\text{ dB}$, $\eta > 70\%$ ($f = 175\text{ MHz}$, $V_{CC} = 12.5\text{ V}$, $P_i = 14.3\text{ W}$)				170			217 2N6084	
" 1495	"	"	"	36	4	400	2 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	500	15	80	5	50		$G_{ps} = 9\text{ dB}$, $\eta > 60\%$ ($f = 470\text{ MHz}$, $V_{CC} = 12.5\text{ V}$, $P_i = 0.1\text{ W}$)				6			218 2N6256	
" 1496																							
" 1497																							
" 1498	ALP	PA	Si. EP	36	4	2.5 A	45W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	1mA	15	80	5	1 A		$G_{ps} = 7\text{ dB}$, $\eta > 60\%$ ($f = 470\text{ MHz}$, $V_{CC} = 12.5\text{ V}$, $P_i = 3.75\text{ W}$)				65			219	
" 1499	"	"	"	36	4	6 A	115W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	20mA	15	60	5	4 A		$G_{ps} = 6\text{ dB}$, $\eta > 55\%$ ($f = 470\text{ MHz}$, $V_{CC} = 12.5\text{ V}$, $P_i = 7.6\text{ W}$)				85			219	
" 1500	"	"	"	36	4	8 A	115W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	20mA	15	60	5	4 A		$G_{ps} = 4.9\text{ dB}$, $\eta > 55\%$ ($f = 470\text{ MHz}$, $V_{CC} = 12.5\text{ V}$, $P_i = 13\text{ W}$)				85			219	
" 1501	松下	PA	Si. TP	300	5	100	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	300	70	10	50	30	-20					55*	8	10	232
" 1502																							
" 1503	東 芝	PA	Si. EP	50		3 A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	500	20	50	5	1 A		$P_a = 13\text{ W}$ ($f = 260\text{ MHz}$, $V_{CC} = 20\text{ V}$, $P_i = 1\text{ W}$)							135	
" 1504	SAK	SW	Si. T	400	6	2 A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1mA	400	60	4	1 A	12	-100	$t_r < 2\text{ }\mu\text{S}$, $t_f < 5\text{ }\mu\text{S}$ $t_{sig} < 9\text{ }\mu\text{S}$				10*			99
" 1505	日 電	PA	"	300	7	200	15W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	0.1	200	80	10	10	30	-10					80*	4	30	151
" 1506	"	"	"	300	7	200	15W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	0.1	200	80	10	10	30	-10					80*	4	30	152
" 1507	"	"	"	300	7	200	15W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	0.1	200	80	10	10	30	-10					80*	4	30	250
" 1508																							
" 1509	松下	PA	Si. EP	80	5	500	750 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	135	0.1	20	160	10	150	10	-50					120*	11		165
" 1510	三 菱	"	"	47	4.5	1 A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	200	30	50	25	100		$P_a = 4.5\text{ W}$ ($f = 770\text{ MHz}$, $V_{CC} = 25\text{ V}$, $P_i = 1.2\text{ W}$)						2 k*	220	
2SC1511	日 電	PA	Si. E	50	4	3.5A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	2mA	30	60	10	1 A		$P_a = 25\text{ W}$ ($f = 275\text{ MHz}$, $V_{CC} = 18\text{ V}$, $P_i = 6\text{ W}$)							233	
" 1512	"	"	"	50	4	5 A	65.2W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	3mA	30	60	10	1.5A		$P_a = 37\text{ W}$ ($f = 275\text{ MHz}$, $V_{CC} = 18\text{ V}$, $P_i = 10\text{ W}$)							233	
" 1513	日 立	RF	Si. Pa	40	3	300	800 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175			35-250	15	30	15	-30	$G_{ps} > 15\text{ dB}$, $NF = 3.5\text{ dB}$ ($f = 200\text{ MHz}$, $I_C = 30\text{ mA}$)			1800*	$C_{re} < 3\text{ pF}$			85C
" 1514	"	RF. PA	Si. T	V_{CB0} 300	5	100	1.25W	150	I_{CBO} 0.5	V_{CE} 250	30-200	20	20										234
" 1515	"	RF	Si. T	200	5	50	200 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	125	0.1	20	80	6	10	6	-10					110*	3	C_{re} 40pS	170
" 1516	"	RF. PA	Si. EP	35		1.5A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	20	30	150	2	500	2	-200					110*	35	10*	234
" 1517	"	"	Si. T	50	4	1 A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	5	30	160	4	50	4	-50					10*	30	50*	234
" 1518	松下	PA	Si. EP	25	5	1 A	750 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	135	0.1	25	160	2	500	10	-50					150*	12	3.5k*	165
" 1519																							
" 1520																							
" 1521																							
" 1522																							
" 1523	日 立	RF. PA	Si. Pa	40	3	300	3.5W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	10	15	35-250	15	50		$G_{ps} > 17\text{ dB}$, $NF < 5\text{ dB}$ ($f = 200\text{ MHz}$, $V_{CC} = 15\text{ V}$)				2000*	$C_{re} < 3\text{ pF}$			269
" 1524	富士通	PA	Si. EP	50	3.5	1 A	12W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	500	20	50	5	500	12	-250	$P_a = 6\text{ W}$, $\eta = 55\%$ ($f = 700\text{ MHz}$, $V_{CC} = 24\text{ V}$, $P_i = 2\text{ W}$)			800*	8			246
" 1525	"	"	"	50	3.5	2 A	20W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	1mA	20	50	5	1 A	12	-500	$P_a = 13\text{ W}$, $\eta = 55\%$ ($f = 700\text{ MHz}$, $V_{CC} = 24\text{ V}$, $P_i = 4\text{ W}$)			800*	13			246
" 1526	"	"	"	50	3.5	3 A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	600	20	50	5	2 A		$P_a = 20\text{ W}$, $\eta = 55\%$ ($f = 700\text{ MHz}$, $V_{CC} = 24\text{ V}$, $P_i = 7.5\text{ W}$)				18			246	
" 1527																							
" 1528	三 菱	PA	Si. EP	40	4.5	2.5A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	500	25	40	10	100		$P_a = 16\text{ W}$ ($f = 175\text{ MHz}$, $V_{CC} = 13.5\text{ V}$, $P_i = 3.5\text{ W}$)							186	
" 1529	"	RF	"	30	4	20	120 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	0.1	12	60	10	5		$G_{ps} = 13\text{ dB}$ ($f = 770\text{ MHz}$, $V_{CC} = 10\text{ V}$, $I_C = 5\text{ mA}$)							50C	
" 1530	"	PA	"	50	4.5	350	5 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	30	50	10	100		$P_a = 5\text{ W}$ ($f = 10\text{ Hz}$, $V_{CC} = 28\text{ V}$, $P_i = 0.25\text{ W}$)							221	
" 1531																							
" 1532																							
" 1533	富士通	PA	Si. EP	45	3.5	500	7 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	100	20	50	5	200	12	-200	$P_a = 2\text{ W}$ ($f = 700\text{ MHz}$, $V_{CC} = 18\text{ V}$, $P_i = 0.5\text{ W}$)			1.8 GHz*	5			246
" 1534	"	"	"	45	3.5	1 A	12W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	200	20	50	5	500	12	-300	$P_a = 7\text{ W}$ ($f = 700\text{ MHz}$, $V_{CC} = 18\text{ V}$, $P_i = 2\text{ W}$)			1.6 GHz*	8			246
" 1535	"	"	"	45	3.5	2 A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	400	20	50	5	1 A	12	-500	$P_a = 12\text{ W}$ ($f = 700\text{ MHz}$, $V_{CC} = 18\text{ V}$, $P_i = 4\text{ W}$)			1.2 GHz*	13			246
" 1536	"	"	"	45	3.5	4 A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	800	20	50	5	3 A	12	-700	$P_a = 24\text{ W}$ ($f = 700\text{ MHz}$, $V_{CC} = 18\text{ V}$							

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)											外 形	備 考		
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CB0} 最大值		直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}		偏 置 情 况		h _{fe} h _{fs} *	h _{ie} h _{is} * (Ω)	h _{re} h _{rs} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{os} * (μU)	f _β f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	τ _{bb} h _{ω(100MHz)} *
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
2SC1601	新日無	RF,AF,LN	Si,EP	35		100	200	175	0.05	20	150	6	1	6	-0.1	NF=2dB (f=1kHz)	50k	5	15	200*	2	C _r τ _{as} 60pS	243
" 1602	"	RF,AF	"	35		100	150	125	0.05	20	150	6	1	6	-0.1		50k	5	15	200*	2	C _r τ _{as} 60pS	194
" 1603	三 菱	PA	"	18	4	600	6W (T _c =25℃)	175	100	10	50	7	100			P ₀ =1.5W (f=485MHz, V _{cc} =7.2V, P _i =0.3W)							254
" 1604	"	"	"	18	4	300	5W (T _c =25℃)	175	30	10	40	7	50			P ₀ =0.35W (f=485MHz, V _{cc} =7.2V, P _i =50mW)							255
" 1605	"	"	"	35	4.5	3.5A	30W (T _c =25℃)	175	500	25	50	10	100			P ₀ =16W (f=175MHz, V _{cc} =13.5V, P _i =1.7W)							256
" 1606	"	RF, PA	"	40	4	0.6A	6W (T _c =25℃)	175	100	25	10~180	10	0.1A			P ₀ =3W (f=175MHz, V _{cc} =13.5V, P _i =0.2W)							271
" 1607	富士通	RF	Si,EP	40	3.5	100	180	175	100	20	50	5	50	12.5	-10	G _{pe} =12dB (f=200MHz)				4			50C
" 1608	"	PA	"	40	3.5	500	5W (T _c =25℃)	175	100	20	50	5	200			P ₀ =1.6W (f=470MHz, V _{cc} =12.5V, P _i =0.3W)				5			231
" 1609																							
" 1610																							
" 1611																							
" 1612																							
" 1613																							
" 1614																							
" 1615																							
" 1616																							
" 1617	東 芝	PA	Si,T	300	5	7A	50W (T _c =25℃)	150	1mA	250	80	5	1A	5	-500					10*	100	100*	102
" 1618																							
" 1619																							
" 1620	松 下	PA	Si,EP	36	3	600	10W (T _c =25℃)	175	100	20	50	13.5	100	13.5	-150	P ₀ =2.6W, G _{pe} =6.34dB (f=500MHz, V _{cc} =13.5V, P _i =0.6W)			1200*	7			227
" 1621	日 電	SW	Si,E	25	5	200	150	125	0.1	15	85	0.5	1			t _{on} <20μS, t _{off} <40μS							176
" 1622	"	RF,AF	Si,PaE	30	5	30	150	125	0.05	25	400	3	0.5	3	-1	14k	5.8	23	100*	3.5	50		176
" 1623	"	"	Si,E	50	5	100	150	125	0.1	40	200	6	1	6	-1	4800	4.5	17	300*	4.5	25*		176
" 1624	東 芝	RF,PA	Si,Eb	120		750	1.5W	150	0.5	50	130	2	150	2	-150				25*	20	5		119
" 1625	"	"	"	100		750	1.5W	150	0.5	50	130	2	150	2	-150				25*	20	5		119
" 1626	"	"	Si,EP	80		750	1.5W	150	0.5	50	130	2	150	2	-150				25*	15	5		119
" 1627	"	"	"	70		200	600	150	0.1	20	130	2	50	2	-50				150*	6	5		131
" 1628	"	"	Si,TP	180		50	1W	150	1	100	130	5	10	10	-10				120*	3.5	10		249
" 1629																							
" 1630																							
2SC1631	SON	RF, LN	Si,PaMe	25	6	200	250	100	0.2	25	200	3	1	6	-0.1	170	36k	2.4	3.3	h _{re} =3dB (f=100MHz)	4.5	C _r τ _{as} 300pS	138
" 1632	"	"	"	50	6	200	250	100	0.2	25	200	3	1	6	-0.1	170	36k	2.4	3.3	h _{re} =3dB (f=100MHz)	4.5	C _r τ _{as} 300pS	138
" 1633	"	"	"	25	6	200	250	100	0.2	25	200	3	1						h _{re} =1.4dB (f=100MHz)	4.5	C _r τ _{as} 300pS	138	
" 1634	"	"	"	50	6	200	250	100	0.2	25	200	3	1						h _{re} =1.4dB (f=100MHz)	4.5	C _r τ _{as} 300pS	138	
" 1635																							
" 1636																							
" 1637																							
" 1638																							
" 1639																							
" 1640																							
" 1641																							
" 1642																							
" 1643																							
" 1644																							
" 1645																							
" 1646																							
" 1647																							
" 1648																							
" 1649																							
" 1650																							
" 1651																							
" 1652																							
" 1653	日 電	RF,SW	Si,E	150	5	50	150	125	0.1	100	130	3	15	10	-10	t _{on} <0.6μS t _{is} <1.5μS			t _{off} <2μS	150*	4.5	15	176
" 1654	"	"	"	180	5	50	150	125	0.1	100	100	3	15	10	-10	t _{on} <0.6μS t _{is} <1.5μS			t _{off} <2μS	150*	4.5	15	176
" 1655																							
" 1656																							
" 1657																							
" 1658																							
" 1659																							
" 1660																							

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)														外 形	備 考	
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直 流 及 脈 沖 下 之 h _{FE}				偏 置 情 況		h _{fe} h _{fs} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{ab} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)			r _{bb} h _{ib} (real)* (Ω)
									μA	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)									
2SC1661																									
" 1662																									
" 1663																									
" 1664	SAK	PA	Si.TMe	70	6	6 A	40W (T _c =25°C)	150	10	70	1200	4	1 A	10	-0.5A						10 *	75	12	99	
" 1665																									
" 1666																									
" 1667	松 下	RF.PA	Si.EMe	80	5	4 A	50W (T _c =25°C)	150	1 mA	50	100	4	1 A	10	-0.5A						10 *	120	10	102	
" 1668	東 芝	PA	Si.EP	35	3.5	6 A	40W (T _c =25°C)	175	1 mA	15	40	5	1 A	10	-200						400 *	60	3 *	135	
" 1669	"	"	Si.TMe	150	5	1.5A	25W (T _c =25°C)	150	20	100	100	10	500	10	-500						5 *	50	25	268	
" 1670																									
" 1671																									
" 1672																									
" 1673	日 電	PA	Si.E	35	3	300	7 W (T _c =25°C)	200	5	20	60	10	100			G _{pe} = 3.5dB (f = 2.3GHz, V _{cc} = 18V, P _i = 1W)								129	
" 1674	"	RF. Conv Mix. Osc	"	30	4	20	125	125	0.1	30	90	6	1	6	-1						600 *	1	C _c r _{bb} 12pS	138	
" 1675	"	"	"	50	5	30	125	125	0.1	50	90	6	1	6	-1						250 *	1.9	C _c r _{bb} 10pS	138	
" 1676																									
" 1677	東 芝	PA	Si.EP	50	4	5 A	45W (T _c =25°C)	175	200	20	40	5	1 A	10	-400						260 *	50	3 *	260	
" 1678	"	"	"	65	4	3 A	10W (T _c =25°C)	150	10	30	40	5	500	5	-100						150 *	30	5	268	
" 1679	"	"	"	65	4	1.5A	1.5W	150	10	30	30	5	500	5	-100						550 *	20	5	268	
" 1680																									
" 1681																									
" 1682																									
" 1683	松 下	PA	Si.TMe	200	5	500	20W (T _c =25°C)	150	500	200	120	10	400	10	-200						6 *	35	25	268	
" 1684	"	RF.AF	Si.EP	30	5	100	250	135	1	10	250	10	2	10	-2	250	5000	0.4	20	150 *	3.5	70	138		
" 1685	"	"	"	60	5	100	250	135	1	10	250	10	2	10	-2	250	5000	0.4	20	150 *	3.5	70	138		
" 1686	"	RF	Si.P	40	4	25	250	135	10	40	80	10	-4	10	-4						330 *	1	C _c r _{bb} 45pS	138	
" 1687	"	"	Si.EP	40	4	30	400	135	10	40	100	10	7	10	-5						550 *	1.5	C _c r _{bb} 80pS	138	
" 1688	"	"	"	50	4	30	400	135	10	50	100	10	7	10	-5						550 *	1.5	C _c r _{bb} 80pS	138	
" 1689	三 菱	PA	"	55	4	3 A	45W (T _c =25°C)	175	1 mA	40	50	10	100			P _o = 26W (f = 220MHz, V _{cc} = 28V, P _i = 5W)								224	
" 1690																									
2SC1691																									
1692																									
1693																									
1694																									
1695																									
1696																									
1697																									
1698																									
1699																									
1700																									
1701																									
1702																									
1703																									
1704																									
1705																									
1706																									
1707																									
1708	三 菱	AF. LN. RF	Si.EP	90	5	50	200	125	0.1	50	250~ 1200	6	-1	6	-1						100 *	2.5		138B	2SA847 之對稱
1709																									
1710	富士通	RF	Si.EP	15	3	130	1 W (T _c =25°C)	175	0.5	10	80	6	60	6	-60						7GHz *	0.8	20 *	261	
1711	"	LN	"	20	3	30	200	175	0.5	10	80	8	10	8	-10	G _{pe} = 10dB, NF = 3dB (f = 2GHz, 8V, 5mA)					7.5GHz *	0.25	30 *	262	
1712	"	RF	"	16	3	30	200	175	0.5	10	80	3	10	6	-15						8GHz *	0.3	30 *	262	
1713	"	Diff	"	16	3	30	200	175	0.5	10	80	3	10	6	-15	ΔV _{BE} < 20mV, γΔV _{BE} < 60μV/°C (3V, 10mA)					8GHz *	0.45	40 *	263	
1714	"	"	"	16	3	30	200	175	0.5	10	80	3	10	6	-15	ΔV _{BE} < 20mV, γΔV _{BE} < 60μV/°C (3V, 10mA)					8GHz *	0.45	40 *	264	
1715	"	"	"	16	3	30	200	175	0.5	10	80	3	10	6	-15	ΔV _{BE} < 20mV, γΔV _{BE} < 60μV/°C (3V, 10mA)					8GHz *	0.45	40 *	265	
1716	"	"	"	16	3	30	200	175	0.5	10	80	3	10	6	-15	ΔV _{BE} < 20mV, γΔV _{BE} < 60μV/°C (3V, 10mA)					8GHz *	0.45	40 *	264	
1717	東 芝	PA	"	40	4	1 A	10W (T _c =25°C)	175	1	15	50	5	100	10	-50	P _o = 2.2W (f = 220MHz, V _{cc} = 10V, I _E = 50mA)					600 *	6.5	25 *	97C	
1718	"	"	"	35	3.5	4.5A	30W (T _c =25°C)	175	100	15	50	5	1.5A	10	-200	P _o = 14W (f = 220MHz, V _{cc} = 13.5V, P _i = 1.5W)					600 *	35	4 *	135	
* 1719																									
1720																									

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)												外 形	備 考		
				V _{CE0} (V)	V _{BE0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CEO} 最大值		直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}			偏 置 情 况		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _β f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie(real)} * (Ω)
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										
2SC1721																								
" 1722																								
" 1723																								
" 1724	東 芝	PA	Si-EP	35	3.5	800	7.5W (T _c =25°C)	175	500	15	100	5	500	10	-100	P _o = 4 W (f = 470MHz, V _{CE} = 12.6V, P _i = 0.4W)				2000*	10	4 *	135	
" 1725	"	"	"	35	3.5	1.4A	15W (T _c =25°C)	175	1mA	15	100	5	1 A	10	-100	P _o = 7 W (f = 470MHz, V _{CE} = 12.6V, P _i = 1W)				1600*	15	3.5 *	135	
" 1726	"	"	"	35	3.5	2.8A	30W (T _c =25°C)	175	1.5mA	15	100	5	1.5A	10	-100	P _o = 13W (f = 470MHz, V _{CE} = 12.6V, P _i = 3W)				1200*	25	3 *	135	
" 1727																								
" 1728																								
" 1729	三 菱	RF. PA	Si-EP	35	4	3.5A	3.5W (T _c =25°C)	175	1mA	25V	10~180	10	0.1			P _o = 16W (f = 175MHz, V _{CE} = 13.5V, P _{in} = 1.4W)							272	
" 1730																								
" 1731																								
" 1732																								
" 1733																								
" 1734																								
" 1735	三 菱	AF Drive	Si-EP	100	5	300	800	135	1	50	50~300	6	10	6	10					130			242	
" 1736																								
" 1737																								
" 1738																								
" 1739																								
" 1740																								
" 1741																								
" 1742																								
" 1743																								
" 1744																								
" 1745																								
" 1746																								
" 1747																								
" 1748																								
" 1749																								
" 1750																								
2SC1751																								
" 1752																								
" 1753																								
" 1754																								
" 1755																								
" 1756																								
" 1757																								
" 1758																								
" 1759																								
" 1760																								
" 1761																								
" 1762																								
" 1763																								
" 1764																								
" 1765																								
" 1766																								
" 1767																								
" 1768																								
" 1769																								
" 1770																								
" 1771																								
" 1772																								
" 1773																								
" 1774																								
" 1775																								
" 1776																								
" 1777																								
" 1778																								
" 1779																								
" 1780																								

型 名	社 名	用 途	构 造	最大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)					電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)												外 形	備 考	
				V_{CB0} (V)	V_{EB0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_J ($^{\circ}\text{C}$)	I_{CB0} 最大值 (μA)	$V_{CB}(V)$	直 流 及 脉 冲 下 之 h_{FE}		偏 置 情 况		h_{fe} 性								
											$V_{CE}(V)$	$I_C(mA)$	$V_{CB}(V)$	$I_E(mA)$	h_{fs}^*	h_{ie}^* (Ω)	h_{re}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe}^* (μS)	f_{β}^* (Mc)	C_{ob} (pF)	r_{bb} $h_{ie}(real)^*$ (Ω)		
SC1781																							
"1782	SAK	PA	Si.TMe	140	6	10A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	140	60	4	3A	12	-500					10*	165	13*	102
"1783	"	"	"	180	6	10A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	180	60	4	3A	12	-500					10*	165	13*	102
"1784	"	"	"	150	6	15A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	150	20	4	5A			$t_r < 1.5\mu\text{S}$ $t_{fs} < 4\mu\text{S}$	$t_f < 1\mu\text{S}$					102	
"1785	"	"	"	200	6	15A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	200	20	4	5A			$t_r < 1.5\mu\text{S}$ $t_{fs} < 4\mu\text{S}$	$t_f < 1\mu\text{S}$					102	
"1786	"	"	"	230	6	15A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	230	20	4	5A			$t_r < 1.5\mu\text{S}$ $t_{fs} < 4\mu\text{S}$	$t_f < 1\mu\text{S}$					102	
"1787																							
"1788																							
"1789																							
"1790																							
"1791																							
"1792																							
"1793																							
"1794																							
"1795																							
"1796																							
"1797																							
"1798																							
"1799																							
"1800																							
"1801																							
"1802																							
"1803																							
"1804	三 菱	RF.PA	Si.EP	47	4	1A	10W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	200	30	10~180	25	0.1A			$P_o=4.5W$ ($f=770\text{MHz}$, $V_{cc}=25V$, $P_{in}=1W$)						273	
"1805	"	"	"	45	4	2A	30W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	1mA	35	10~180	25	0.1A			$P_o=12W$ ($f=770\text{MHz}$, $V_{cc}=25V$, $P_{in}=3.5W$)						273	
"1806	"	"	"	45	4	4A	50W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	2mA	35	10~180	25	0.2A			$P_o=25W$ ($f=770\text{MHz}$, $V_{cc}=25V$, $P_{in}=8W$)						273	
"1807	"	"	"	18	4	0.1A	300 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	30	10	10~180	7.2	20			$P_o=25mW$ ($f=485\text{MHz}$, $V_{cc}=7.2V$, $P_{in}=5mW$)							
"1808	"	"	"	35	3.5	1A	10W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	100	15	10~180	10	0.1A			$P_o=3.5W$ ($f=485\text{MHz}$, $V_{cc}=13.5V$, $P_{in}=0.4W$)						274	
"1809																							
"1810																							
3763	NOI	PS	Si	60	5	1.5A	1W	200			40	1A	30 ($I_{CB0}=100\mu\text{A}$)					150				} asym.	
3735	"	NS	Si	75	5	1.5					40	1A	40 ($I_{CB0}=200\mu\text{A}$)					250					
3906	"	PS	Si	40	5	0.2	0.31	135			100	0.01	40			50nA		300				} asym.	
3904	"	NS	Si	60	5	0.2	0.31	135			160	0.01	40			50nA		300					
3918	"	NS	Si	25	5	0.1	0.2	100			375		25			100nA		90					
109	TRK	NS	Si	25	5	0.1	0.2	100			460	0.02						300					
105	"	"	"	"	"	"	"	"			250	0.02						"					
107	"	"	"	"	"	"	"	"			"	"						"					
108A	"	"	"	"	"	"	"	"			187	0.02						"					
108B	"	"	"	"	"	"	"	"			365	0.02						"					
108C	"	"	"	"	"	"	"	"			675	0.02						"					
109B	"	"	"	"	"	"	"	"			675												
109C	"	"	"	"	"	"	"	"			365												
172A	"	NS	Si	30	5	0.1	0.3	125			229	0.02	30			15nA		250					
172B	"	"	"	"	"	"	"	"			330	"											
172C	"	"	"	"	"	"	"	"			620	"											
2923	"	NS	Si	25	5	0.1	0.2	100			116	0.02	25			50nA		160					
2924	"	"	"	"	"	"	"	"			150	0.02											
2925	"	"	"	"	"	"	"	"			216	"											
2926	"	Brown	"	"	"	"	"	"			50												
"	"	Green	"	"	"	"	"	"			350												
"	"	Orange	"	"	"	"	"	"			135												
"	"	Red	"	"	"	"	"	"			74												
"	"	Yellow	"	"	"	"	"	"			225												

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)												外 形	備 考		
				V _{CEO} (V)	V _{CEO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大值		直 流 及 脈 沖 下 之 h _{FE}		偏置情況		h _{FE} h _{FE} *	h _{FE} h _{FE} *	h _{FE} h _{FE} *	h _{FE} h _{FE} *	f _{ab} f _T (Mc)	C _{ab} (pF)			T _{th} h _{th} (real) (Ω)	
									μA	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)											
2SD 11	日 電	SW	Ge. A	25	15	300	150	85	10	25	70	1	20	6	-1					2.5			84 A	
" 12	松 下	PA	Si. Me	75	4	2.5A	150	150	10mA	75	50	4	1 A										103	
" 13	"	"	"	35	4	10 A	150	150	40mA	35	40	10	2.5A										109	
" 14	"	"	"	75	4	10 A	150	150	45mA	75	30	4	10 A										109	
" 15	SAK	PA. SW	Si. DJ	60	10	6 A	80 W (T _J = 85°C)	150	50	40	50	4	1.5 A	12	-500					2			102	
" 16	"	"	"	100	10	6 A	80 W (T _J = 85°C)	150	50	40	50	4	1.5 A	12	-500					2			102	
" 17	"	"	"	150	10	6 A	80 W (T _J = 85°C)	150	50	40	50	4	1.5 A	12	-500					2			102	
" 18	"	PA	"	200	10	6 A	80 W (T _J = 85°C)	150	50	40	50	4	1.5 A	12	-500					2			102	
" 19	日 電	"	Ge. A	25	10	300	150	85	12	12	31	1	20	6	-1					>1			84 A	2SB219 之對稱
" 20	"	"	"	25	10	300	150	85	12	12	50	1	20	6	-1					>1			84 A	2SB220 之對稱
" 21	"	"	"	25	10	300	150	85	12	12	72	1	20	6	-1					>1			84 A	2SB221 之對稱
" 22	"	"	"	25	10	300	150	85	12	12	97	1	20	6	-1					>1			84 A	2SB222 之對稱
" 23	"	"	"	25	10	300	150	85	12	12	150	1	20	6	-1					>1			84 A	2SB223 之對稱
" 24	三 洋	"	Si. Me	300	2	100	6 W (T _J = 75°C)	110	1.5	100	60	10	50	30	-20					25*	17		99	
" 25	日 電	"	Ge. A	25	10	100	110	75	14	12	70	1	50	6	-1					1			12A	
" 26	三 菱	PA. SW	Si. EP	40	5	7 A	50 W (T _J = 85°C)	175	100	30	10	4	5 A										103	
" 26A	"	"	"	60	5	7 A	50 W (T _J = 85°C)	175	100	30	10	4	5 A										103	
" 26B	"	"	"	100	5	7 A	50 W (T _J = 85°C)	175	100	30	10	4	5 A										103	
" 26C	"	"	"	150	5	7 A	50 W (T _J = 85°C)	175	100	30	10	4	5 A										103	
" 27	松 下	PA	Ge. A	32	10	500	280	90	10	0.5	95	0.5	300										12A	
" 28	SON	"	Si. DJ	70		3 A	18 W (T _J = 85°C)	150	20	30	100	1	100										100	
" 29	"	"	"	70		3 A	18 W (T _J = 85°C)	150	20	30	100	1	100										100	
" 30	三 洋	"	Ge. A	25	12	200	300	85	15	20	100	1.5	100	6	-1					1			63	2SB22 之對稱
" 31	松 下	"	"	25	10	125	125	75	15	10	50	1	100										12B	2SB172 之對稱
" 32	"	"	"	25	10	125	125	75	15	10	90	1	100										12B	2SB176 之對稱
" 33	富士通	"	"	20	2.5	50	150	85	14	12	70	1	50	6	-1	60	1780	3.8	17.3	2			12A	2SB33 之對稱
" 34	"	"	"	20	2.5	150	250	85	14	12	100	1	150	6	-1	60	1800	5	20	2			71A	2SB34 之對稱
" 35	松 下	"	"	20	10	60	83	75	10	10	72	1	18										4	
" 36	"	"	"	20	10	60	83	75	10	10	150	1	37.5										4	
" 37	富士通	"	"	30	12	50	150	85	14	30	7	1	50	6	-1	60	1780	3.8	17.3	2			12A	2SB37 之對稱
2SD 38	富士通	PA	Ge. A	30	12	150	250	85	16	30	75	1	150	6	-1	60	1800	5	20	2			71A	2SB38 之對稱
" 39																								
" 40																								
" 41	東 芝	PA	Si. DJ	80	10	10A	200 W (T _J = 85°C)	150	200	50	60	5	1 A										102	
" 42	"	"	"																					
" 43	東 芝	PA	Ge. A	25	12	50	110	75	14	12	70	1	50	6	-1					24	1		12A	
" 43A	"	"	"	45	12	150	110	75	14	12	70	1	50	6	-1					24	1		12A	
" 44	"	AF	"	25	12	50	80	75	14	12				6	-1	85	2500	5	30	>0.5	25		12A	
" 45	SON	PA	Si. Me	150	6	5 A	50 W (T _J = 85°C)	150	5mA	50	40	10	1 A										102	
" 46	"	"	"	150	6	5 A	50 W (T _J = 85°C)	150	5mA	50	40	10	1 A										102	
" 47	"	"	"	100	6	5 A	50 W (T _J = 85°C)	150	5mA	15	40	10	1 A										102	
" 48	富士通	"	Si. DJ	100	10	3 A	20 W (T _J = 85°C)	175	15	30	50	4	750							1.5			83	
" 49	SON	"	"	100	10	3 A	18 W (T _J = 85°C)	150	20	30	50	3	1 A	10	-0.5A					2			100	
" 50	富士通	"	"	100	10	6 A	50 W (T _J = 85°C)	175	15	30	30	4	1.5A							1.5			102	
" 51	SON	"	Si. Me	100	6	5 A	50 W (T _J = 85°C)	150	5mA	15	60	3	2 A	10	-0.5A					10			102	
" 52	SAK	PA. SW	Si. DJ	100	10	6 A	80 W (T _J = 85°C)	175	10	40	20	4	3 A	12	-0.5A					2			102	
" 53	富士通	"	"	90	12	10A	100 W (T _J = 85°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	-0.5A					1.2			102	
" 54	"	"	"	100	12	10A	150 W (T _J = 85°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	-0.5A					1.2			109	
" 55	東 芝	PA	"	100	10	20A	200 W (T _J = 85°C)	150	10mA	50	24	5	10A							1			102	
" 56	SON	"	"	220	18	3 A	30 W (T _J = 85°C)	150	50	50	50	1	100										100	
" 57	三 菱	PA. SW	"	30	10	3 A	20 W (T _J = 85°C)	150	200	20	20	4	1 A										100	
" 58	"	"	"	60	10	3 A	20 W (T _J = 85°C)	150	40	40	70	4	1 A										100	
" 59	"	"	"	100	5	6 A	50 W (T _J = 85°C)	150	30	50	60	4	1 A										102	
" 60	"	"	"	150	5	6 A	50 W (T _J = 85°C)	150	30	50	60	4	1 A										102	
" 61	SON	AF. PA. LN	Ge. A	30	10	100	120	75	10	25	50	1	10	6	-1	-0.977*	28*	1.2*	0.29*	1	35		58	
" 62	"	SW	"	30	10	100	120	75	10	25	50	1	10	6	-1	-0.977*	28*	1.2*	0.25*	1	35		58	
" 63	"	PA	"	25		100	120	75	10	25	50	1	10	6	-1	-0.977*	28*	1.2*	0.25*	1	35		58	
" 64	"	AF	"	25		100	120	75	15	25	100	1	10	6	-1	-0.987*	28*	1.2*	0.25*	1	35		58	
" 65	"	"	"	25		100	120	75	15	25	50	1	10	6	-1	-0.977*	28*	1.2*	0.25*	1	35		58	
" 66	"	"	"	25		100	120	75	15	25	25	1	10	6	-1	-0.958*	28*	1.2*	0.25*	0.8	35		58	

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)					電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)												外 形	備 考		
				V_{CB0} (V)	V_{EB0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^{\circ}\text{C}$)	I_{CBO} 最大值		直 流 及 脉 冲 下 之 h_{FE}		偏 置 情 况		h_{FE} h_{FE}^*	h_{ie} h_{ie}^* (Ω)	h_{re} h_{re}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{oe}^* (μS)	f_{β} f_{β}^* (Mc)	C_{ob} (pF)			r_{ob} $r_{ob}(\text{real})^*$ (Ω)	
									I_{CBO} (μA)	V_{CB} (V)	I_C (mA)	V_{CB} (V)	I_E (mA)											
2SD 67	三 洋	PA	Si.TMe	120	5	5 A	50 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	5 mA	80	80	5	1 A							100 *		102		
" 68	"	"	"	75	5	5 A	50 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	5 mA	60	80	5	1 A							100 *		102		
" 69	SON	"	"	140		3 A	50 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	50	150	3	100									102		
" 70	日 電	PA	Si.EP	40	5	2 A	15 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	100	24	80	2	1 A									101		
" 71	"	"	"	100	5	2 A	15 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	100	40	80	2	0.5 A									101		
" 72	三 洋	"	Ge. A	25		600	720 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	85	50	20	150	1.5	200									12 A	2SB405 之對稱	
" 73	日 電	"	Si.EMe	100	5	5 A	60 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	5 mA	100	50	10	1 A									102		
" 74	"	"	"	150	5	5 A	60 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	5 mA	150	50	10	1 A									102		
" 75	日 立	AF	Ge. A	25	12	100	150	85	14	25				6	- 1	40	1260	3	15.8	4		12 A	2SB75 之對稱	
" 75A	"	PA	"	45	12	100	150	85	25	45				6	- 1	40	1260	3	15.8	4		12 A	2SB77A 之對稱	
" 76																								
" 77	日 立	PA	Ge. A	25	12	100	150	85	14	25	55	1.5	50	6	- 1	55	1680	3.1	16.3	3.5		12 A	2SB77 之對稱	
" 77A	"	"	"	45	12	100	150	85	25	45	55	1.5	50	6	- 1	55	1680	3.1	16.3	3.5		12 A		
" 78	日 電	PA. SW	Si.EPa	100	12	2 A	1 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	1	60	80	2	500										84B	
" 79	"	"	Si. EP	100	12	2 A	15 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	1	60	80	2	500										97C	
" 80	SAK	PA. SW	Si. DJ	30	10	6 A	50 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	200	20	60	4	1 A	10	-200					3			102	
" 81	"	"	"	60	10	6 A	50 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	50	40	60	4	1 A	10	-200					3			102	
" 82	"	"	"	100	10	6 A	50 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	30	50	60	4	1 A	10	-200					3			102	
" 83	"	"	"	150	10	6 A	50 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	30	50	60	4	1 A	10	-200					3			102	
" 84	"	"	"	200	10	6 A	50 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	30	50	60	4	1 A	10	-200					3			102	
" 85																								
" 86																								
" 87																								
" 88	SON	PA	Si.TMe	100	8	5 A	80 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	50	80	3	2 A										102	
" 89	"	"	"																					
" 90	SAK	PA. SW	Si. DJ	30	10	3 A	20 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	200	20	40	4	1 A	10	-200					3.5			100	
" 91	"	"	"	60	10	3 A	20 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	50	40	40	4	1 A	10	-200					3.5			100	
" 92	"	"	"	100	10	3 A	20 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	30	50	40	4	1 A	10	-200					3.5			100	
" 93	"	"	"	150	10	3 A	20 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	30	50	40	4	1 A	10	-200					3.5			100	
" 94	"	"	"	200	10	3 A	20 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	30	50	40	4	1 A	10	-200					3.5			100	
2SD 95																								
" 96	日 立	PA	Ge. A	25	2.5	250	300 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	85	14	25	90	1.5	50	6	- 1					4		12 A	2SB406 之對稱	
" 97																								
" 98																								
" 99																								
" 100	東 芝	PA	Ge. A	32	12	400	250	85	40	12	75	1	150										77	
" 100A	"	"	"	45	12	400	250	85	40	12	75	1	150										77	
" 101	"	"	"	80	6	600	250	75	50	12	70	1	150										77	
" 102	"	"	Si. DJ	110	10	3 A	25 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	20	50	30-300	5	500	10	-500					1 *	200		99	
" 103	東 芝	PA. SW	"	80	10	3 A	25 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	20	50	30-300	5	500	10	-500					1 *	200		99	
" 104	"	PA	Ge. A	20	6	400	150	75	14	12	90	0.5	100									12 A		
" 105	"	"	"	20	6	400	150	75	14	12	60	0.5	100									12 A		
" 106																								
" 107	東 芝	PA	Si. TP	80	10	5 A	50 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	20	50	4000	5	1 A	10	-500					30 *		102	達林頓管	
" 108	"	"	"	80	10	5 A	50 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	2	50	4000	5	1 A									102	達林頓管	
" 109																								
" 110	東 芝	PA	Si. DJ	130	10	10 A	100 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	0.5 mA	50	30-300	5	1 A	10	-1A					2 *	200		102	
" 111	"	"	"	100	10	10 A	100 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	0.5 mA	50	30-300	5	1 A	10	-1A					2 *	200		102	
" 112																								
" 113	東 芝	PA	Si. DJ	100	10	30 A	200 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	2 mA	50	12	5	15 A		$t_{on}=3 \mu\text{S}, t_f=5 \mu\text{S}$ $t_{avg}=5 \mu\text{S}$					1.5 *	400		102	
" 114	"	"	"	70	10	30 A	200 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	2 mA	50	12	5	15 A		$t_{on}=3 \mu\text{S}, t_f=5 \mu\text{S}$ $t_{avg}=5 \mu\text{S}$					1.5 *	400		102	
" 115																								
" 116	富士通	PA	Si.TMe	100	6	7 A	75 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	15	30	100	4	1 A										102	
" 117	"	"	"	150	6	7 A	75 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	15	30	100	4	1 A										102	
" 118	東 芝	"	Si. DJ	130	10	7 A	100 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	50	50	30-200	5	1 A	10	-500					2 *	200		102	
" 119	"	"	"	100	10	7 A	100 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	50	50	30-200	5	1 A	10	-500					2 *	200		102	
" 120	日 立	"	"	60	12	1.5 A	4 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	10	30	40	4	200	12	-50		$t_d=0.2 \mu\text{S}, t_r=0.7 \mu\text{S}$	$t_f=1.2 \mu\text{S}$			>0.8		84 A	
" 121	"	"	"	100	12	1.5 A	4 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	10	30	40	4	200	12	-50		$t_d=0.2 \mu\text{S}, t_r=0.7 \mu\text{S}$	$t_f=1.2 \mu\text{S}$			>0.8		84 A	
" 122	"	"	"	60	12	3 A	15 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	15	30	40	4	750	12	-50		$t_d=0.25 \mu\text{S}, t_r=2.6 \mu\text{S}$	$t_f=1.6 \mu\text{S}$			>0.6		83	
" 123	"	"	"	100	12	3 A	15 W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	15	30	40	4	750	12	-50		$t_d=0.25 \mu\text{S}, t_r=2.6 \mu\text{S}$	$t_f=1.6 \mu\text{S}$			>0.6		83	

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)														外 形	備 考	
				V _{CEO} (V)	V _{CEO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CEO} 最大値		直 流 及 脈 沖 下 之 h _{FE}		偏 置 情 況		h _{FE}	h _{FE} h _{FE} *	h _{FE} h _{FE} *	h _{FE} h _{FE} *	f _{ab} f _T *	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{FE} (real)* (Ω)				
									I _{CEO} (μA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)	h _{FE}								I _E (mA)			
2SD124	日 立	PA	Si. DJ	60	10	6 A	60 W (T _a = 25℃)	175	25	30	30	4	1.5 A	12	- 50									102	
* 124A	"	"	Si. DB	75	10	7 A	60 W (T _a = 25℃)	175	25	30	30	4	1.5 A	4	- 1A									102	
* 125	"	"	"	100	10	6 A	60 W (T _a = 25℃)	175	25	30	30	4	1.5 A	12	- 50									102	
* 125A	"	"	"	100	10	7 A	60 W (T _a = 25℃)	175	25	30	30	4	1.5 A	4	- 1A									102	
* 126	"	PA. SW	Si. DJ	150	5	7 A	60 W (T _a = 25℃)	175	25	30	10	4	6 A	4	- 1A									102	
* 127	SON	PA	Ge. A	23		500	250 (T _a = 25℃)	85	15	15	82	1	20	6	- 1									12 A	
* 127A	"	"	"	23		500	250 (T _a = 25℃)	85	15	15	82	1	20	6	- 1									12 A	
* 128	"	"	"	32		500	250 (T _a = 25℃)	85	15	15	82	1	20	6	- 1									12 A	
* 128A	"	"	"	32		500	250 (T _a = 25℃)	85	15	15	82	1	20	6	- 1									12 A	
* 129	東 芝	"	Si. DJ	90	10	3 A	25 W (T _a = 25℃)	150	1mA	50	30~200	5	500	10	-500									99	
* 130	"	"	"	60	10	3 A	25 W (T _a = 25℃)	150	1mA	50	30~200	5	500	10	-500									99	
* 131	"	"	Si. T	100	5	5 A	50 W (T _a = 25℃)	150	100	50	60	5	1 A											102	
* 132	日 電	"	Si. EMe	100	6	20 A	150 W (T _a = 25℃)	175	5mA	65	40	5	20 A											106	
* 133	"	"	"																						
* 134	SON	SW	Ge. A	60	3	5	30 (T _a = 25℃)	65	8	15	40	5	3											18	
* 135	"	"	"																						
* 136	富士通	PA	Si. T	200	3	100	4 W (T _a = 25℃)	150	10	150	80	10	50											98 A	
* 137	"	"	"	300	3	100	4 W (T _a = 25℃)	150	10	150	80	10	50											98 A	
* 138	"	PA. SW	"	200	3	1 A	30 W (T _a = 25℃)	175	20	150	75	10	0.5 A											101	
* 139	"	"	"	300	3	1 A	30 W (T _a = 25℃)	175	20	150	75	10	0.5 A											101	
* 140	"	"	"																						
* 141	日 電	PA	Si. EP	20	5	3 A	15 W (T _a = 25℃)	175	100	12	80	2	1 A											101	
* 142	"	"	"	40	5	3 A	15 W (T _a = 25℃)	175	100	20	80	2	1 A											101	
* 143	"	"	"	80	5	2 A	15 W (T _a = 25℃)	175	100	40	80	2	0.5 A											101	
* 144	"	"	"	100	5	2 A	15 W (T _a = 25℃)	175	100	50	80	2	0.5 A											101	
* 145	"	"	"																						
* 146	富士通	PA. SW	Si. DJ	40	5	1 A	20 W (T _a = 25℃)	175	20	30	60	4	500	6	-0.5 A									101	
* 147	"	"	"	60	5	1 A	20 W (T _a = 25℃)	175	20	30	50	4	500	6	-0.5 A									101	
* 148	"	SW	"	70	5	2 A	20 W (T _a = 25℃)	175	20	30	35	4	2 A											101	
* 149	"	PA. SW	"	70	5	1 A	800 (T _a = 25℃)	175	20	30	40	4	1 A											84 B	
* 2SD150	日 電	PA	Si. DB	50	5	1 A	15 W (T _a = 25℃)	150	100	40	80	2	1 A											150	2SA613 之對稱
* 151	"	SW	Si. EMe	100	6	10 A	120 W (T _a = 25℃)	175	1mA	20	35	10	10 A											102	
* 152	"	PA	Si. EP	150	6	1 A	15 W (T _a = 25℃)	175	100	70	70	2	0.5 A											150	
* 153	"	PA. SW	Si. TMe	250	6	10 A	120 W (T _a = 25℃)	175	1mA	200	70	5	1 A											200	
* 154	"	"	"																						
* 155	日 電	PA	Si. EMe	80	5	3 A	25 W (T _a = 25℃)	150	1mA	60	65	2	2 A											134	2SA616 之對稱
* 156	富士通	"	Si. T	200	3	100	4 W (T _a = 25℃)	150	10	150	80	10	50	30	- 10									99	
* 157	"	"	"	300	3	100	4 W (T _a = 25℃)	150	10	150	80	10	50	30	- 10									99	
* 158	"	PA. SW	"	200	3	1 A	30 W (T _a = 25℃)	175	20	150	75	10	0.5 A											99	
* 159	"	"	"	300	3	1 A	30 W (T _a = 25℃)	175	20	150	75	10	0.5 A											99	
* 160	"	"	Si. DJ	100	8	1.5 A	25 W (T _a = 25℃)	175	10	30	50	10	750											83	
* 161	"	PA	"	120	12	10 A	100 W (T _a = 25℃)	175	20	30	30	4	5 A											102	
* 162	"	AF. PA	Ge. A	20	2.5	30	65 (T _a = 25℃)	85	12	12	80	1.5	30	6	- 1	60	2000	4	17	3				4	2SB262 之對稱
* 163	SAK	PA. SW	Si. DJ	60	10	10 A	100 W (T _a = 25℃)	150	50	40	30	4	5 A	12	- 500									102	
* 164	"	"	"	100	10	10 A	100 W (T _a = 25℃)	150	50	40	30	4	5 A	12	- 500									102	
* 165	"	"	"	150	10	10 A	100 W (T _a = 25℃)	150	50	40	30	4	5 A	12	- 500									102	
* 166	"	"	"	200	10	10 A	100 W (T _a = 25℃)	150	50	40	30	4	5 A	12	- 500									102	
* 167	富士通	AF. PA	Ge. A	20	2.5	500	200 (T _a = 25℃)	85	20	12	120	1	150											12 A	
* 168	"	SW	Si. DJ	80	6	10 A	50 W (T _a = 25℃)	175	30	30	2500	4	5 A											102	通線銀管
* 169	"	"	"																						
* 170	日 立	PA	Ge. A	25	6	500	200 (T _a = 25℃)	85	20	12	150	1	150											12 A	2SB370 之對稱
* 171	SON	PA	Si. TMe	450		3.5 A	125 W (T _a = 25℃)	150	100	50	70	3	1 A											102	
* 172	富士通	PA. SW	Si. DJ	60	6	10 A	100 W (T _a = 25℃)	175	20	30	25	4	5 A											102	
* 173	"	"	"	100	6	10 A	100 W (T _a = 25℃)	175	20	30	25	4	5 A											102	
* 174	"	PA	"	60	6	5 A	50 W (T _a = 25℃)	175	20	30	25	4	5 A	6	- 500									102	
* 175	"	PA. SW	"	100	6	5 A	50 W (T _a = 25℃)	175	20	30	25	4	5 A	6	- 500									102	
* 176	"	"	"	90	12	10 A	100 W (T _a = 25℃)	175	20	30	25	4	5 A	6	- 500									102	
* 177	"	"	"	120	12	10 A	100 W (T _a = 25℃)	175	20	30	25	4	5 A	6	- 500									102	
* 178	松 下	PA	Ge. A	20	6	300	225 (T _a = 25℃)	75	27	12	90	0.5	300											17	2SB178 之對稱
* 178A	"	"	"	40	6	300	225 (T _a = 25℃)	75	27	12	90	0.5	300											17	

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)												外 形	備 考	
				V _{CBO} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (℃)	I _{CBO} 最大値 (μA)	V _{CB} (V)	直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}		偏 置 情 况		h _{fe}	h _{ie} * (Ω)	h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} * (μU)	f _{αb} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)			r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)
2SD179	日 電	PA. SW	Si. TMe	300	6	40 A	580 W (T _c =25℃)	175	1mA	300	30	5	20 A									201	
★ 180	"	PA	Si. EMe	80	7	5 A	50 W (T _c =25℃)	150	2 mA	60	60	10	3 A					20 *				102	2SA626 之對稱
★ 181	"	PA. SW	Si. TMe	150	7	15 A	100 W (T _c =25℃)	175	1mA	100	60	5	5 A									102	
★ 182	富士通	PA	Si. DB	40	12	1 A	10 W (T _c =25℃)	175	15	30	35	4	750	6	-500				1.5			83	
★ 183	"	"	"	100	12	1 A	10 W (T _c =25℃)	175	15	30	35	4	750	6	-500				1.5			83	
★ 184	"	SW	"	60	12	1.5A	25 W (T _c =25℃)	175	10	30	35	4	750	6	-500				1.5			83	
★ 185	"	"	"	100	12	1.5A	25 W (T _c =25℃)	175	10	30	35	4	750	6	-500				1.5			83	
★ 186	三 洋	PA	Ge. A	25	12	150	200	85	15	20				6	-1	120	2500	10	35	1	60	12 A	
★ 187	"	"	"	25	12	150	200	85	15	20	100	1.5	30	6	-1				1			12 A	2SB187 之對稱
★ 188	日 電	PA	Si. EMe	100	5	5 A	60 W (T _c =25℃)	150	2 mA	70	70	2	3 A									102	2SA627 之對稱
★ 189	松 下	PA	Si. TMe	80	5	5 A	50 W (T _c =25℃)	150	5 mA	80	50	4	4 A	10	-500				12 *			102	
★ 189A	"	"	"	100	5	5 A	50 W (T _c =25℃)	150	5 mA	100	50	4	4 A	10	-500				12 *			102	
★ 190	日 立	"	Si. T	300	3	100	4 W (T _c =25℃)	150	100	300	60	10	50									98	
★ 191	東 芝	"	Ge. A	30	12	150	150	75	14	12	80	1	50									84 A	
★ 192	"	"	"	30	12	150	150	75	14	12	80	1	50									84 A	
★ 193	"	SW	"	35	12	400	250	85	35	12	100	1	150									84 A	
★ 194	"	PA	"	32	12	400	250	85	40	12	75	1	150									84 A	
★ 195	富士通	SW	"	20	15	50	150	85	14	12	70	1	50	6	-1				>2.5			12 A	
★ 196	"	"	Si. DJ	100	12	10 A	125 W (T _c =25℃)	175	20	30	25	4	5 A									109	
★ 196A	"	PA. SW	"	100	12	10 A	150 W (T _c =25℃)	175	20	30	25	4	5 A									109	
★ 197	"	SW	"	130	12	10 A	125 W (T _c =25℃)	175	20	30	25	4	5 A									109	
★ 197A	"	PA. SW	"	130	12	10 A	150 W (T _c =25℃)	175	20	30	25	4	5 A									109	
★ 198	松 下	PA	Si. TMe	300	6	1 A	25 W (T _c =25℃)	150	5 mA	150	120	5	100	10	-100				25 *			102	
★ 199	"	"	"	800	6	500	25 W (T _c =25℃)	150	1 mA	800	55	10	200	10	-100				7 *			102	
★ 200	"	SW	Si. Me	1500	5	2.5 A	10 W (T _c =90℃)		1 mA	1500	2.5	5	2 A			t _f < 1.5 μS						102	
★ 201	SAK	PA. SW	Si. DJ	90	7	6 A	50 W (T _c =25℃)	150	50	40	50	4	3 A	12	-500				8			102	
★ 202	"	"	"	110	7	6 A	50 W (T _c =25℃)	150	50	40	50	4	3 A	12	-500				8			102	
★ 203	"	"	"	130	7	6 A	50 W (T _c =25℃)	150	50	40	50	4	3 A	12	-500				8			102	
★ 204	日 電	PA	Si. DB	60	5	700	9 W (T _c =25℃)	150	3	50	80	2	300									84B	
★ 205	"	"	Si. EP	60	5	700	1 W	150	3	30	80	2	300									97B	
2SD206	新電元	PA. SW	Si. DJ	50	8	10 A	150 W (T _c =25℃)	150	50	30	20	5	5 A	10	1 A				f _{oe} 18kc			102	
★ 207	"	"	"	100	8	10 A	150 W (T _c =25℃)	150	50	30	20	5	5 A	10	1 A				f _{oe} 18kc			102	
★ 208	"	"	"	150	8	10 A	150 W (T _c =25℃)	150	50	30	20	5	5 A	10	1 A				f _{oe} 18kc			102	
★ 209																							
★ 210																							
★ 211	SAK	PA. SW	Si. DJ	60	7	10 A	100 W (T _c =25℃)	150	50	40	35	4	5 A	12	-500				8			102	
★ 212	"	"	"	90	7	10 A	100 W (T _c =25℃)	150	50	40	35	4	5 A	12	-500				8			102	
★ 213	"	"	"	110	7	10 A	100 W (T _c =25℃)	150	50	40	35	4	5 A	12	-500				8			102	
★ 214	"	"	"	130	7	10 A	100 W (T _c =25℃)	150	50	40	35	4	5 A	12	-500				8			102	
★ 215	富士通	PA	"	40		1 A	800	175	20	30	70	4	500									84B	
★ 216	"	"	"	60		1 A	800	175	20	30	70	4	500									84B	
★ 217	日 電	"	Si. EMe	120	7	7 A	60 W (T _c =25℃)	150	2mA	80	60		4 A									102	2SA648 之對稱
★ 218	"	"	"	150	7	7 A	60 W (T _c =25℃)	150	2mA	80	60	5	4 A									102	2SA649 之對稱
★ 219	SAK	PA. SW	Si. DJ	40	7	1 A	500	150	1	20	100	4	200	5	-100				8			84B	
★ 220	"	"	"	80	7	1 A	500	150	1	20	80	4	200	5	-100				8			84B	
★ 221	"	"	"	110	7	1 A	500	150	1	20	60	4	200	5	-100				8			84B	
★ 222	"	"	"	40	7	1.5 A	10 W (T _c =25℃)	150	10	20	80	4	500	5	-100				8			97B	
★ 223	"	"	"	80	7	1.5 A	10 W (T _c =25℃)	150	10	20	60	4	500	5	-100				8			97B	
★ 224	"	"	"	110	7	1.5 A	10 W (T _c =25℃)	150	10	20	40	4	500	5	-100				8			97B	
★ 225																							
★ 226	松 下	PA	Si. DJ	40	8	3 A	25 W (T _c =25℃)	150	30	20	50	3	1 A						f _{oe} 25kHz			99	
★ 227	日 電	"	Si. EP	30		300	250	125	0.1	15	120	1	300	10	-10	200						43	2SA642 之對稱
★ 228	"	"	"	30		300	400	125	0.1	15	120	1	300	10	-10	200						44	
★ 229																							
★ 230																							
★ 231	富士通	SW. AF	Si. TMe	50	5	30 A	125 W (T _c =25℃)	175	100	30	25	4	10 A									102	
★ 232	"	"	"	120	7	30 A	125 W (T _c =25℃)	175	1 mA	50	25	4	10 A									102	
★ 233																							
★ 234	東 芝	PA	Si. DJ	60	10	3 A	25 W (T _c =25℃)	150	100	20	80	5	500	10	-500				1 *	250		119	
★ 235	"	"	"	50	10	3 A	25 W (T _c =25℃)	150	100	20	80	5	500	10	-500				1 *	250		119	

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考		
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大值 (μA)	V _{CB} (V)	直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}		偏 置 情 况		h _{fe} h _{fs} *	h _{ie} h _{is} * (Ω)	h _{re} h _{rs} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{os} * (μU)	f _β f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)
											V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
2SD236	SAK	PA. SW	Si. DJ	40	7	1 A	10 W (T _c =25°C)	150	10	20	80	4	500	5	-100				8		99		
" 237	"	"	"	80	7	1 A	10 W (T _c =25°C)	150	10	20	60	4	500	5	-100				8		99		
" 238	"	"	"	110	7	1 A	10 W (T _c =25°C)	150	10	20	40	4	500	5	-100				8		99		
" 239																							
" 240																							
" 241	SAK	PA. SW	Si. DJ	60	7	4 A	25 W (T _c =25°C)	150	10	20	80	4	1 A	10	-200				8		100		
" 242	"	"	"	90	7	4 A	25 W (T _c =25°C)	150	10	20	80	4	1 A	10	-200				8		100		
" 243	"	"	"	110	7	4 A	25 W (T _c =25°C)	150	10	20	60	4	1 A	10	-200				8		100		
" 244	"	"	"	130	7	4 A	25 W (T _c =25°C)	150	10	20	60	4	1 A	10	-200				8		100		
" 245																							
" 246	松下	PA. SW	Si. Me	1500	5	4.5 A	16 W (T _c =90°C)	115	1mA	1500	5	10	2.5 A			V _{CE(sat)} < 10 V (4.5A, 2 A)		V _{BE(sat)} < 1.6 V (4.5A, 2 A)			102		
" 247	芝 電	PA	Si. TMe	80	5	5 A	50 W (T _c =25°C)	150	100	30	60	5	1 A								102		
" 248																							
" 249	富士通	PA. SW	Si. DJ	50	5	30 A	125 W (T _c =25°C)	175	100	30	25	4	10 A								102		
" 250	"	"	"	100	7	30 A	125 W (T _c =25°C)	175	100	50	25	4	10 A								102		
" 251	富士通	SW. AF	Si. TMe	200	5	2 A	30 W (T _c =25°C)	175	5	150	100	10	500								99		
" 252																							
" 253																							
" 254	日 電	PA	Si. EMe	70	5	3 A	20 W (T _c =25°C)	150	1 mA	60	65	2	2 A										
" 255	"	"	"	70	5	3 A	20 W (T _c =25°C)	150	1 mA	60	65	2	2 A								134 2SA615 之對稱		
" 256	SAK	PA. SW	Si. DJ	60	7	4 A	25 W (T _c =25°C)	150	10	20	80	4	1 A	10	-200				8		99		
" 257	"	"	"	90	7	4 A	25 W (T _c =25°C)	150	10	20	80	4	1 A	10	-200				8		99		
" 258	"	"	"	110	7	4 A	25 W (T _c =25°C)	150	10	20	60	4	1 A	10	-200				8		99		
" 259	"	"	"	130	7	4 A	25 W (T _c =25°C)	150	10	20	60	4	1 A	10	-200				8		99		
" 260	芝 電	PA	Si. TMe	100	5	5 A	50 W (T _c =25°C)	150	100	30	60	4	1 A								102		
" 261	日 電	"	Si. EP	40	5	700	500 (T _c =25°C)	125	0.2	15	100	1	500								44 2SA643 之對稱		
" 262	SON	"	Si. TMe	300		12 A	125 W (T _c =25°C)	150	100	50	50	3	5 A								102		
" 263																							
" 264																							
" 265	ORG	PA. SW	Si. T	800	10	6 A	100 W (T _c =25°C)	150	2mA	800	20	5	3 A								102		
2SD266	ORG	PA. SW	Si. T	800	10	6 A	100 W (T _c =25°C)	150	2mA	800	40	5	3 A								102		
" 267																							
" 268																							
" 269																							
" 270																							
" 271	ORG	PA	Si. T	800	10	2 A	30 W (T _c =25°C)	150	2mA	800	20	5	1 A	12	500			f _{os} 150kHz			100		
" 272	"	"	"	800	10	2 A	30 W (T _c =25°C)	150	2mA	800	40	5	1 A	12	500			f _{os} 150kHz			100		
" 273	"	PA. SW	"	800	10	5 A	80 W (T _c =25°C)	150	2mA	800	20	5	2 A	12	1 A			f _{os} 150kHz			102		
" 274	"	"	"	800	10	5 A	80 W (T _c =25°C)	150	2mA	800	40	5	2 A	12	1 A			f _{os} 150kHz			102		
" 275																							
" 276																							
" 277																							
" 278																							
" 279																							
" 280																							
" 281																							
" 282																							
" 283	日 電	PA. SW	Si. E	120	5	5 A	25 W (T _c =25°C)	150	200	40	55	1	5 A								134		
" 284	"	"	"	120	5	5 A	25 W (T _c =25°C)	150	200	40	40	1	5 A								134		
" 285	"	"	"	100	5	5 A	25 W (T _c =25°C)	150	200	40	40	1	5 A								134		
" 286	"	PA	Si. TMe	180	7	10 A	100 W (T _c =25°C)	150	300	100	75	5	2 A								102		
" 287	"	"	"	200	7	10 A	100 W (T _c =25°C)	150	300	100	75	5	2 A								102		
" 288	日 電	"	Si. TP	80	5	2 A	20 W (T _c =25°C)	150	50	50	80	5	500								151		
" 289	"	"	"	80	5	2 A	20 W (T _c =25°C)	150	50	50	80	5	500								152		
" 290	SON	PA. SW	Si. TMe	80		5 A	10 W (T _c =25°C)	120	100	150	100	3	2 A								153		
" 291	"	RF. PA	Si. DJ	70	10	3 A	10 W (T _c =25°C)	150	20	30	100	1	100								153		
" 292	"	PA	"	70	10	3 A	10 W (T _c =25°C)	150	20	30	100	1	100								153		
" 293	ORG	"	Si. T	800	10	10 A	125 W (T _c =25°C)	150	3mA	800	20	5	5 A								102		
" 294	"	"	"	800	10	10 A	125 W (T _c =25°C)	150	3mA	800	40	5	5 A								102		
" 295	ORG	PA. SW	Si. T	800	10	30 A	200 W (T _c =25°C)	150	5 mA	800	20	5	10 A	12	2.5A			f _{os} 150kHz			154		

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)													外 形	備 考	
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値		直 流 及 脈 冲 下 之 AFE			偏 置 情 况		h _{fe}	h _{ie} * (Ω)	h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} * (μU)	f _β * (Mc)	C _{ob} (pF)			r _{bb} * h _{ie} (real) * (Ω)
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										
2SD296	ORG	PA. SW	Si. T	800	10	30 A	200 W (T _c =25°C)	150	5 mA	800	40	5	10 A	12	-2.5A								154	
" 297	H 電	"	Si. TMe	150	7	5 A	25 W (T _c =25°C)	150	500	80	70	2	2 A										134	
" 298																								
" 299	松 下	PA. SW	Si. Me	1500	5	5 A	16 W (T _c =25°C)	115	1mA	1500	3	5	4 A			V _{CE(sat)} < 10 V, V _{BE(sat)} < 1.6 V (4.5 A, 2 A)							102	
" 300	"	"	"	1500	5	5 A	16 W (T _c =25°C)	115	1mA	1500	5	10	2.5 A			V _{CE(sat)} < 10 V, V _{BE(sat)} < 1.6 V (2.5 A, 0.85 A) (2.5 A, 0.85 A)							102	
" 301	富士通	SW	Si. DJ	80	6	10 A	50 W (T _c =25°C)	175	30	30	2500	4	5 A			t _r < 11 μS, t _r < 53 μS, t _{stg} < 16 μS							102	直 流 通 管
" 302																								
" 303																								
" 304																								
" 305																								
" 306																								
" 307																								
" 308																								
" 309																								
" 310	ORG	PA. SW	Si. T	800	10	15 A	150 W (T _c =25°C)	150	3mA	800	20	5	7.5 A	12	2 A									
" 311	"	"	"	800	10	15 A	150 W (T _c =25°C)	150	3mA	800	40	5	7.5 A	12	2 A								102	
" 312	松 下	PA	Si. TMe	800	6	500	25 W (T _c =25°C)	150	1 mA	800	60	10	600	10	-100								102	
" 313	三 洋	"	Si. T	60	5	3 A	30 W (T _c =25°C)	150	100	20	90	2	1 A										162	
" 314	"	"	"	60	5	3 A	30 W (T _c =25°C)	150	100	20	90	2	1 A										163	
" 315	"	"	"	60	5	4 A	35 W (T _c =25°C)	150	100	20	90	2	1 A										99	
" 316	SON	"	Si. TMe	80	5	7 A	80 W (T _c =25°C)	150	100	50	70	2	3 A										102	
" 317	松 下	PA	Si. T	60	8	3 A	25 W (T _c =25°C)	150	30	20	60	3	1 A	10	-200								155	
" 318	"	"	"	60	8	3 A	25 W (T _c =25°C)	150	30	20	60	3	1 A	10	-200								156	
" 319	"	"	Si. DJ	110	7	10 A	100 W (T _c =25°C)	150	30	40	35	4	5 A	10	-500								102	
" 320	三 洋	PA. SW	Si. T	300	6	2 A	50 W (T _c =25°C)	150	100	100		15	1 A											
" 321	松 下	"	Si. TMe	250	6	6 A	60 W (T _c =25°C)	150	2 mA	250	40	5	5 A			t _r < 1 μS							102	
" 322	日 電	PA	"	120	7	7 A	80 W (T _c =25°C)	150	300	120	60	5	4 A										102	
" 323	"	"	"	150	7	7 A	80 W (T _c =25°C)	150	300	150	60	5	4 A										102	
" 324	松 下	"	"	300	3	100	10 W (T _c =25°C)	150	100	300	80	10	50										153	
" 325	三 洋	"	Si. T	35	5	1.5 A	10 W (T _c =25°C)	150	100	20	90	2	1 A											
2SD326	SON	PA. SW	Si. TMe	330	5	1 A	23 W (T _c =25°C)	150	15	100	80	5	100										100	
" 327	日 電	PA	Si. E	40	5	500	250	125	0.2	25	140	1	100										138	2SA723 之 對 稱
" 328	"	PA. SW	Si. EP	100	7	1.5 A	800	150	1	60	100	2	200										84B	
" 329																								
" 330	三 洋	PA	Si. T	50	5	2 A	20 W (T _c =25°C)	150	100	20	90	2	1 A										162	
" 331	"	"	"	50	5	2 A	20 W (T _c =25°C)	150	100	20	90	2	1 A										163	
" 332																								
" 333																								
" 334	松 下	PA	Si. DJ	110	7	6 A	75 W (T _c =25°C)	150	1mA	110	100	4	1 A	10	-500								102	
" 335	日 電	"	Si. EMe	80	7	3 A	30 W (T _c =25°C)	150	300	60	80	5	2 A										102	
" 336	"	"	Si. E	40	5	500	750	135	0.2	25	140	1	100										177	2SA707 之 對 稱
" 337																								
" 338	SON	PA	Si. EMe	70	8	7 A	60 W (T _c =25°C)	150	100	50	50	2	3 A										102	
" 339	"	"	"	90	8	10 A	80 W (T _c =25°C)	150	100	50	50	2	4 A										102	
" 340	"	"	"	110	8	12 A	100 W (T _c =25°C)	150	100	50	50	2	5 A										102	
" 341	日 立	PA. SW	Si. DJ	100	7	15 A	115 W (T _c =25°C)	200	5mA	100	40	4	4 A										102	
" 342	SON	PA	"	70		3 A	35 W (T _c =25°C)	150	100	30	100	1	100										240	
" 343	"	"	"	70		3 A	35 W (T _c =25°C)	150	100	30	100	1	100										241	
" 344	"	"	"	70		3 A	35 W (T _c =25°C)	150	100	30	100	1	100										240	
" 345	"	"	"	70		3 A	35 W (T _c =25°C)	150	100	30	100	1	100										241	
" 346	"	"	Si. EMe	60		5 A	25 W (T _c =25°C)	150	100	50	50	2	2.5 A										240	
" 347	"	"	"	60		5 A	25 W (T _c =25°C)	150	100	50	50	2	2.5 A										241	
" 348																								
" 349	日 電	AF	Si. E	30	5	50	150	125	0.1	25	500	3	0.5	3	-1		14k	5.8	23				176	
" 350	松 下	SW	Si. Me	1500	5	5 A	22 W (T _c =25°C)	115	1mA	1500	5	10	4 A			t _r < 1 μS							102	
" 351	"	PA	Si. TMe	650	6	5 A	80 W (T _c =25°C)	150	5mA	650	15	5	5 A	10	-500								102	
" 352	"	"	Ge. A	32	10	1 A	650	90	25	10	150	0.5	300	2	-10	NF < 25 dB (f = 1kHz, V _{CB} = 5V, I _E = -5mA)				40 * 150			12A	
" 353																								
" 354																								
" 355	三 菱	PA	Si. EP	30	4	1 A	800	135	1	25	150	1	500										242	2SB525 之 對 稱

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)												外 形	備 考	
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (℃)	I _{CB0} 最大值 (μA)	V _{CB} (V)	直 流 及 脈 沖 下 之 h _{FE}		偏 置 情 況		h _{fe} h _{fs} *	h _{ie} h _{is} * (Ω)	h _{re} h _{rs} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{os} * (μΩ)	f _{os} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)			r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)
2SD356	三 菱	PA	Si.EP	90	5	800	10W (T _c =25℃)	150	10	25	100	4	300									180	2SB526 之對稱
" 357	"	"	"	110	5	800	10W (T _c =25℃)	150	10	25	100	4	300									180	2SB527 之對稱
" 358	"	"	"	130	5	800	10W (T _c =25℃)	150	10	25	100	4	300									180	2SB528 之對稱
" 359	"	"	"	40	5	2 A	10W (T _c =25℃)	150	1	25	120	4	500									180	
" 360	"	"	"	40	5	2 A	10W (T _c =25℃)	150	1	25	120	4	500									180	
" 361	"	"	"	60	5	1.5A	10W (T _c =25℃)	150	1	25	100	4	500									180	
" 362																							
" 363	日 電	SW	Si.TMe	250	6	30A	200W (T _c =25℃)	175	100	200	30	5	15A			t _{on} < 2μs, t _{off} < 6.5μs						106	
" 364	"	"	"	450	6	30A	200W (T _c =25℃)	175	100	400	30	5	15A			t _{on} < 2μs, t _{off} < 6.5μs						106	
" 365	松 下	PA	"	60	5	3 A	25W (T _c =25℃)	150	30	20	70	3	1 A	10	-200				f _{os} 70kHz			178	
" 366	"	"	"	60	5	3 A	25W (T _c =25℃)	150	30	20	70	3	1 A	10	-200				f _{os} 70kHz			179	
" 367	"	"	Ge.A	25	6	300	150	85	20	12	150	0.5	150	2	-10	NF < 30dB (f = 1kHz, V _{CB} = 5V, I _B = -5mA)		f _{os} > 10kHz			12A		
" 368																						102	
" 369																						102	
" 370																						102	
" 371	東 芝	PA	Si.TMe	90	5	6 A	50W (T _c =25℃)	150	100	50	80	5	1 A									102	
" 372	日 電	SW	"	150	6	30A	200W (T _c =25℃)	175	100	100	40	5	20A									106	
" 373	"	"	"	250	6	30A	200W (T _c =25℃)	175	100	200	30	5	15A									106	
" 374	"	"	"	450	6	30A	200W (T _c =25℃)	175	100	400	30	5	15A									106	
" 375	"	PA.SW	"	150	7	10A	100W (T _c =25℃)	175	100	100	60	5	5 A			t _{on} < 1.5μs, t _{off} < 5μs						102	
" 376	"	"	"	250	7	10A	100W (T _c =25℃)	175	100	200	40	5	5 A			t _{on} < 1.5μs, t _{off} < 5μs						102	
" 377	"	"	"	450	7	10A	100W (T _c =25℃)	175	100	400	30	5	5 A			t _{on} < 1.5μs, t _{off} < 5μs						102	
" 378	日 電	PA.SW	Si.E	100	12	2 A	1 W	175	0.5	60	80	2	500									84B	
" 379	松 下	PA	Si.EMe	80	5	5 A	60W (T _c =25℃)	150	1mA	50	100	4	1 A	10	-500				10 *			102	
" 380	"	SW	Si. Me	1500	5	5 A	50W (T _c =25℃)	130	1mA	1500	9	10	5 A			t _f < 0.9μs						102	
" 381	日 電	PA	Si. E	140	5	1.5A	20W (T _c =25℃)	150	1	120	90	5	300									151	
" 382	"	"	"	140	5	1.5A	20W (T _c =25℃)	150	1	120	90	5	300									152	
" 383	日 立	"	Si. T	300	6	5 A	100W (T _c =25℃)	150	10	250	80	10	500									102	
" 384	新 電 元	PA.SW	Si.DJ 達林頓管	80	4	7 A	30W (T _c =25℃)	150	500	80	5000	5	5 A									204	
" 385	"	"	"	100	4	7 A	30W (T _c =25℃)	150	500	100	5000	5	5 A									204	
2SD386																							
" 387																							
" 388	日 電	PA	Si.TMe	150	7	8 A	80W (T _c =25℃)	150	100	100	80	5	1 A									102	
" 389	松 下	"	Si.DJ	60	8	3 A	25W (T _c =25℃)	150	30	20	70	3	1 A	10	-200				f _{os} 25kHz			178	
" 390	"	"	"	60	8	3 A	25W (T _c =25℃)	150	30	20	70	3	1 A	10	-200				f _{os} 25kHz			179	
" 391																							
" 392	三 菱	PA	Si.EP	20	5	300	300	125	1	20	150	2	150	6	-10				150 *			138B	2SB542 之對稱
" 393	"	PA.SW	Si.EMe	500	5	6 A	100W (T _c =25℃)	150	10	400	7	5	5 A			t _{off} = 4μs (I _C = 5A, I _{B1} = -I _{B2} = 1.3A)						102	
" 394	"	"	"	700	5	6 A	100W (T _c =25℃)	150	10	450	7	5	5 A									102	
" 395	"	"	"	700	5	8 A	100W (T _c =25℃)	150	10	450	8	5	7 A									102	
" 396	日 立	"	Si.TMe	700	6	15A	125W (T _c =25℃)	150	5	400	30	2	7.5A			t _{on} < 15μs, t _{off} < 40μs						102	
" 397																							
" 398																							
" 399																							
" 400																							
" 401																							
" 402																							
" 403																							
" 404	東 芝	PA	Si.DJ	50	7	6 A	40W (T _c =25℃)	150	100	40	200	1	1 A									119	
" 405																							
" 406																							
" 407																							
" 408																							
" 409																							
" 410																							
" 411																							
" 412																							
" 413	富 士 通	PA.SW	Si.TMe	200	5	500	800	175	5	150	65	5	200	5	-50	t _r < 2μs, t _f < 2μs			25 *	12.5		84B	
" 414	日 電	PA	Si.E	120	5	800	5 W (T _c =25℃)	150	1	80	80	5	200									225	
" 415	"	"	"	120	5	800	5 W (T _c =25℃)	150	1	80	80	5	200									225	

型 名	社 名	用 途	構造	最大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)												外 形	備 考	
				V_{CB0} (V)	V_{EB0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_J ($^{\circ}\text{C}$)	I_{CBO} 最大値		直 流 及 脈 冲 下 之 h_{FE}		偏 置 情 况		h_{FE} h_{FE}^*	h_{FE} h_{FE}^*	h_{FE} h_{FE}^*	h_{FE} h_{FE}^*	f_{β} f_T^*	C_{ob} (pF)			τ_{bb} τ_{bb}^*
									(μA)	$V_{CB}(\text{V})$	$V_{CE}(\text{V})$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB}(\text{V})$	$I_E(\text{mA})$									
2SD416																							
" 417	富士通	SW	Si.TMe	250	5	4 A	75W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	10	30	25	5	3 A	6	-300	$t_{on}<2.5\mu\text{S}$ $t_{off}<2.5\mu\text{S}$	$t_f<2\mu\text{S}$		30 *				102
" 418	松 下	PA	Si.TMe	1000	5	5 A	80W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	1mA	1000	15	5	5 A			$t_f=1.5\mu\text{S}$							102
" 419	SAK	"	Si.DJ	100	6	7 A	40W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	1mA	100	2500	4	7 A						6 *				99 通称管
" 420	"	"	"	120	6	7 A	40W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	1mA	120	2500	4	7 A						6 *				99 "
" 421	"	"	"	140	6	7 A	40W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	1mA	140	2500	4	7 A						6 *				99 "
" 422	東 芝	SW	Si.TMe	250	6	4 A	30W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	100	150	20	5	3 A	6	-300	$t_{on}<2.5\mu\text{S}$ $t_{off}<2.5\mu\text{S}$	$t_f<2\mu\text{S}$		30 *				99
" 423	"	"	Si.TP	250	6	4 A	30W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	100	150	20	5	3 A			$t_{on}<2.5\mu\text{S}$ $t_{off}<1.5\mu\text{S}$	$t_f<1\mu\text{S}$						99
" 424	東 芝	PA	Si.TMe	160	5	15A	150W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	80	80	5	2 A										102
" 425	"	"	"	140	5	12A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	60	80	5	2 A										102
" 426	"	"	"	120	5	12A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	60	80	5	2 A										102
" 427	"	"	"	120	5	8 A	80W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	60	80	5	1 A										102
" 428	"	"	"	100	5	7 A	60W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	50	80	5	1 A										102
" 429	日 立	PA.SW	Si.T	800	6	15A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	5	60	15	5	9 A			$t_{on}<20\mu\text{S}$ $t_{off}<5\mu\text{S}$	$t_f<15\mu\text{S}$						102
" 430	湯 浅	PA	Si.TMe	120	10	5 A	50W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	30	60	4	1 A	5	-0.5A				15 *				102
" 431	"	"	"	120	10	7 A	60W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	30	60	5	1 A	5	-0.5A				20 *				102
" 432	"	"	"	130	10	10A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	30	60	5	1 A	5	-0.5A				15 *				102
" 433	"	"	"	250	10	10A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	30	60	5	1 A	5	-0.5A				15 *				102
" 434	"	"	"	200	10	20A	200W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	100	60	5	1 A										102
" 435	"	"	"	300	10	20A	200W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	100	60	5	1 A										102
" 436	"	"	"	400	10	20A	200W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	100	60	5	1 A										102
" 437																							
" 438																							
" 439																							
" 440																							
" 441																							
" 442																							
" 443																							
" 444																							
" 445																							
2SD446																							
" 447																							
" 448																							
" 449																							
" 450																							
" 451																							
" 452																							
" 453																							
" 454																							
" 455																							
" 456																							
" 457																							
" 458	松 下	PA	Si.TMe	600	5	5 A	80W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	1mA	600	20	5	5 A										102
" 459	新電元	PA.SW	Si.DJ	80	4	7 A	50W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	10mA	80	5000	5	5 A	10	1 A	$t_{on}<10\mu\text{S}$ $t_{off}<6\mu\text{S}$	$t_f<10\mu\text{S}$		f_{oe} 20kc				257 通称管
" 460	"	"	"	100	4	7 A	50W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	10mA	100	5000	5	5 A	10	1 A	$t_{on}<10\mu\text{S}$ $t_{off}<6\mu\text{S}$	$t_f<10\mu\text{S}$		f_{oe} 20kc				257 "
" 461	日 立	"	Si.T	250	8	3 A	80W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	250	90	5	1 A										102
" 462																							
" 463	新電元	PA.SW	Si.DJ	80	4	7 A	80W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	10mA	60	3000	5	5 A	10	1 A	$t_{on}<10\mu\text{S}$ $t_{off}<6\mu\text{S}$	$t_f<10\mu\text{S}$		f_{oe} 20kc				102 通称管
" 464	"	"	"	100	4	7 A	80W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	10mA	80	3000	5	5 A	10	1 A	$t_{on}<10\mu\text{S}$ $t_{off}<6\mu\text{S}$	$t_f<10\mu\text{S}$		f_{oe} 20kc				102 "
" 465	"	"	"	500	4	50A	400W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	1mA	500	200	5	50A	5	50A	$t_{on}<2.7\mu\text{S}$ $t_{off}<12\mu\text{S}$	$t_f<11\mu\text{S}$		6.5 *				258 "
" 466	"	"	"	600	4	50A	400W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	1mA	600	200	5	50A	5	50A	$t_{on}<2.7\mu\text{S}$ $t_{off}<12\mu\text{S}$	$t_f<11\mu\text{S}$		6.5 *				258 "
" 467	日 立	PA	Si.EP	25	5	700	500	150	1	20	150	1	150										138
" 468	"	"	"	25	5	1 A	900	150	1	20	130	2	500										251
" 469																							
" 470																							
" 471																							
" 472																							
" 473																							
" 474																							
" 475																							

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25℃)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25℃)										外 形	備 考					
				V _{CEO} (V)	V _{CEO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CBO} 最大値		直 流 及 脉 冲 下 之 h _{FE}				偏 置 情 况		h _{FE} h _{FE} *	h _{FE} h _{FE} *			h _{FE} h _{FE} *	h _{FE} h _{FE} *	f _{os} f _T *	C _{ob} (pF)	r _{as} h _{re} (real)* (Ω)
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)											
2SD476																									
" 477																									
" 478																									
" 479	ALP	PA	Si.E	40	5	4 A	40W (T _a =25℃)	150	500	40	6000	3	2 A						JEDEC 2N6037相当 達林頓管	252	25B569 之對稱				
" 480	"	"	"	60	5	4 A	40W (T _a =25℃)	150	500	60	6000	3	2 A						JEDEC 2N6038相当 達林頓管	252	25B570 之對稱				
" 481	"	"	"	80	5	4 A	40W (T _a =25℃)	150	500	80	6000	3	2 A						JEDEC 2N6039相当 達林頓管	252	25B571 之對稱				
" 482	"	"	Si.TP	275	6	500	20W (T _a =25℃)	150	10	275	80	10	100						JEDEC 2N5650相当	252					
" 483	"	"	"	325	6	500	20W (T _a =25℃)	150	10	325	80	10	100						" 2N5656 "	252					
" 484	"	"	"	375	6	500	20W (T _a =25℃)	150	10	375	80	10	100						" 2N5657 "	252					
" 485	"	"	Si.E	40	5	4 A	40W (T _a =25℃)	150	100	40	50	2	1.5A						" 2N5190 "	252	25B575 之對稱				
" 486	"	"	"	60	5	4 A	40W (T _a =25℃)	150	100	60	50	2	1.5A						" 2N5191 "	252	25B576 之對稱				
" 487	"	"	"	80	5	4 A	40W (T _a =25℃)	150	100	80	50	2	1.5A						" 2N5192 "	252	25B577 之對稱				
" 488	"	"	"	40	5	3 A	30W (T _a =25℃)	150	100	40	50	1	500						" 2N4921 "	252	25B572 之對稱				
" 489	"	"	"	60	5	3 A	30W (T _a =25℃)	150	100	60	50	1	500						" 2N4922 "	252	25B573 之對稱				
" 490	"	"	"	80	5	3 A	30W (T _a =25℃)	150	100	80	50	1	500						" 2N4923 "	252	25B574 之對稱				
" 491	"	"	"	70	5	10A	90W (T _a =25℃)	150	1mA	70	40	4	4 A						MJE3055 "	253	25B578 之對稱				
" 492	"	"	"	100	7	15A	115W (T _a =25℃)	200	1mA	100	40	4	4 A						JEDEC 2N3055 "	102					
" 493	"	"	"	60	5	5 A	75W (T _a =25℃)	150	100	60	40	2	2.5A						" 2N5977 "	253	25B579 之對稱				
" 494	"	"	"	80	5	5 A	75W (T _a =25℃)	150	100	80	40	2	2.5A						" 2N5978 "	253	25B580 之對稱				
" 495	"	"	"	100	5	5 A	75W (T _a =25℃)	150	100	100	40	2	2.5A						" 2N5979 "	253	25B581 之對稱				
" 496	"	"	"	60	5	8 A	75W (T _a =25℃)	150	500	60	3000	4	4 A						MJE3043相当 達林頓管	253	25B582 之對稱				
" 497	"	"	"	80	5	8 A	75W (T _a =25℃)	150	500	80	3000	4	4 A						MJE3044相当 達林頓管	253	25B583 之對稱				
" 498	"	"	"	100	5	8 A	75W (T _a =25℃)	150	500	100	3000	4	4 A						MJE3045相当 達林頓管	253	25B584 之對稱				
" 499	"	"	"	60	5	8 A	90W (T _a =25℃)	150	100	60	60	2	4 A						JEDEC 2N5983相当	253					
" 500	"	"	"	80	5	8 A	90W (T _a =25℃)	150	100	80	60	2	4 A						" 2N5984 "	253					
" 501	"	"	"	100	5	8 A	90W (T _a =25℃)	150	100	100	60	2	4 A						" 2N5985 "	253					
" 502	"	"	"	60	5	8 A	100W (T _a =25℃)	200	500	60	3000	3	4 A						JEDEC 2N6055相当 達林頓管接續	102	25B585 之對稱				
" 503	"	"	"	80	5	8 A	100W (T _a =25℃)	200	500	80	3000	3	4 A						JEDEC 2N6056相当 達林頓管	102	25B586 之對稱				
" 504	"	"	"	60	5	12A	150W (T _a =25℃)	200	500	60	3000	3	6 A						JEDEC 2N6057相当 達林頓管	102	25B587 之對稱				
" 505	"	"	"	80	5	12A	150W (T _a =25℃)	200	500	80	3000	3	6 A						JEDEC 2N6058相当 達林頓管	102	25B588 之對稱				
2SD506	ALP	PA	Si.E	100	5	12A	150W (T _a =25℃)	200	500	100	3000	3	6 A						JEDEC 2N6059相当 達林頓管	102	25B589 之對稱				
" 507																									
" 508																									
" 509																									
" 510																									
" 511																									
" 512																									
" 513																									
" 514																									
" 515																									
" 516																									
" 517																									
" 518	富士通	SW	Si.TP	220	5	4 A	30W (T _a =25℃)	175	100	150	20	5	3 A						t _{on} < 2.5μS t _{off} < 2.5μS		99				
" 519	"	"	Si.TMe	400	5	7 A	100W (T _a =25℃)	175	200	150	15	5	5 A						t _{on} < 2.5μS t _{off} < 2.5μS t _{off} < 4μS		102				

大利電器行有限公司 (分行)	香港德輔道中 48-50 號一樓 九龍彌敦道 300 號七樓	電話：5-223388 電話：3-853211
寶新無線電器材公司	香港英皇道 299 號商場 No. 5-5A	電話：5-701354
香港寶樹無線電行	香港中環萬宜里 21 至 23 號一樓	電話：5-253221
蔚和無線電零件行	九龍油蔴地寧波街 11 號A	電話：3-846415
寶樹無線電器材公司	香港灣仔道 121 號地下	電話：5-744061 5-744063
偉明無線電器行	九龍奶路臣街 6 號G	電話：3-855973
香港電子零件行 (分行)	香港灣仔菲林明道 33 號A地下 九龍彌敦道 498 — 500 號 泰盛商業大廈 601 室	電話：5-750867 電話：3-306033
勝利電子有限公司	九龍旺角西洋菜街 36 號	電話：3-881233-4
鈞益無線電器行	九龍深水埗黃竹街十五號E	電話：3-811190 3-811542
超力霸電子公司	香港中環威靈頓街 31 號5樓	電話：5-220744
精工電子貿易公司	九龍旺角花園街 164 號地下	電話：3-945323
總統無線電器行	香港銅鑼灣景隆街 2 C地下	電話：5-771353
美通無線電器行	香港北角英皇道 315 號B	電話：5-701560
永安無線電器零件	九龍官塘輔仁街 99 號	電話：3-451881
九龍電視工程電子零件公司	九龍山東街 50 號B1地下	電話：3-853522
保華電子零件公司	九龍漆咸道 250 號地下	電話：3-640936

無線電製作 1975 增刊①

1975 年 9 月 5 日出版

中華民國六十四年

編輯者 無線電製作出版社 電話 3-654837 地址
香港九龍土瓜灣道 297 號三樓・督印人 林秋和・承
印者 華生印刷廠 九龍新蒲崗彩虹道 202 號二樓・

香港總代理 同德書報社 九龍砵蘭街 269 號 電話
3-962751・星馬總代理 東亞文化事業有限公司
星加坡大坡馬路 167 號 電話 76376・台灣總代理
雨辰書報社 台灣台北市中華路二段 75 巷一弄 26
號 電話 3811897 郵政劃撥儲金第 13165 號雨辰書
報社・印尼區代理 椰城集源公司 TOKO SUM-
BER ANEKA JL. TIANG BENDER 87A,
JAKARTA-KOTA, INDONESIA.

電子零件

電工器材



登美洋行

TEL. 12-424911

BRIGHT TRADING CO.,

18, SHUI WO ST., 3/F

TSUN WAN. H.K.

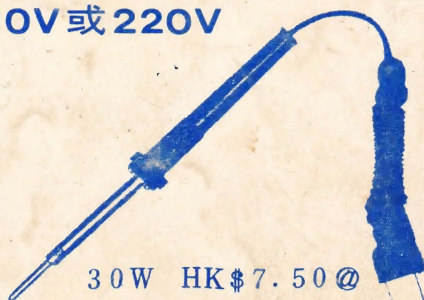
mail order

WELCOME

歡迎郵購

總代理 R & S PENCIL SOLDERING IRON

30W 及 50W
110V 或 220V



30W HK\$7.50 @

50W HK\$9.50 @

IC 萬用板
BEL 001
至 005
@ 2.50
BEL 101
@ 6.00
DIGITAL
BOARD
@ 3.00

玻璃纖維
及
油布通

Dia. 1mm

至 6mm

ZENER
DIODE
BZY 88
Series
2V-91V
@ 2.00

請到

庇利金街38號地下
新油麻地門市部已開始營業

電話：3-685648

玻璃纖維及
膠木電路底板

0.5mm

0.8mm

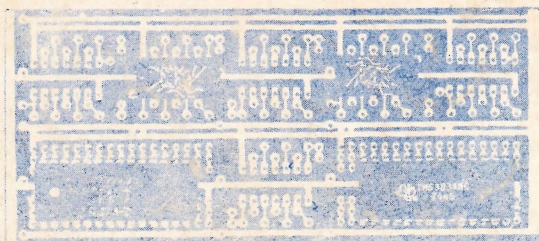
1mm

1.5mm

雙面銅現貨

新

DIGITAL EXPERIMENTAL BOARD
SPECIAL DESIGNED FOR
DIGITAL PURPOSES



@HK3.00

Calculator
Chip
MM5738
DM8864
DM8865
CT5001
CT5005
TMS0105
CZL550

CLOCK
PANEL
LD8132
AM/PM
@ 35.00
CT7001
@ 40.00
TMS3834
@ 35.00



西德特力牌 UL Grade 膠木底板，大量到港。
0.8mm、1mm、1.6mm 雙、單面銅膜，特
價發售。